

Bruksela, 23 października 2014 r.
(OR. en)

14093/14
ADD 1

COMER 213
PESC 1026
CONOP 91
ECO 139
UD 229
ATO 72
DELECT 210

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU
Data otrzymania:	22 października 2014 r.
Do:	Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	C(2014) 7567 final - Annex 1
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do Rozporządzenia delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2014) 7567 final - Annex 1.

Załącznik: C(2014) 7567 final - Annex 1



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 22.10.2014 r.
C(2014) 7567 final

ANNEX 1

ZAŁĄCZNIK

[...]

Rozporządzenie delegowane Komisji

**zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system
kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów
podwójnego zastosowania**

ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia

WYKAZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO-ZASTOSOWANIA

Niniejszy wykaz wprowadza uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym kontrolę produktów i technologii podwójnego zastosowania, w tym przez Porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Jądrowych (GDJ), Grupę Australijską i Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej (CWC).

SPIS TREŚCI

Uwagi

Akronimy i skróty

Definicje

Kategoria 0	Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe
Kategoria 1	Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia
Kategoria 2	Przetwarzanie materiałów
Kategoria 3	Elektronika
Kategoria 4	Komputery
Kategoria 5	Telekomunikacja i „ochrona informacji”
Kategoria 6	Czujniki i lasery
Kategoria 7	Nawigacja i awionika
Kategoria 8	Urządzenia okrętowe
Kategoria 9	Kosmonautyka, aeronautyka, napęd

UWAGI OGÓLNE DO ZAŁĄCZNIKA I

1. W przypadku towarów, które są zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych, należy sprawdzić także odpowiedni wykaz kontrolny uzbrojenia publikowany w danym państwie członkowskim. Odsyłacz, który mówi „ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA”, odnosi się do tych wykazów.
2. Cel kontroli przewidzianej w niniejszym wykazie nie może być omijany przez eksportowanie jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (łącznie z instalacjami) zawierających jeden lub więcej składników podlegających kontroli, gdy kontrolowany składnik lub składniki są zasadniczymi elementami tych towarów i możliwe jest ich wydzielenie lub zastosowanie do innych celów.

NB.: Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany składnik lub składniki mają być uważane za elementy zasadnicze, konieczne jest rozważenie czynników: ilości, wartości, zawartości technologicznego know-how i innych szczególnych okoliczności, które mogą zdecydować, że kontrolowany składnik lub składniki są zasadniczymi elementami dostarczanych towarów.
3. Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.
4. W niektórych przypadkach podana jest nazwa i numer CAS chemikaliów. Wykaz ma zastosowanie do chemikaliów o tym samym wzorze strukturalnym (w tym do hydratów), niezależnie od nazwy i numeru CAS. Numery CAS są podane, by ułatwić identyfikację danych chemikaliów lub mieszanin, bez względu na nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być stosowane jako jedyne źródło informacji służące do identyfikacji chemikaliów, gdyż niektóre postacie wymienionych chemikaliów mają różne numery CAS, a mieszaniny zawierające chemikalia wymienione w wykazie mogą także mieć różne numery CAS.

UWAGA DO TECHNOLOGII JĄDROWEJ (UdTJ)

(Czytać łącznie z grupą E kategorii 0)

„Technologia” bezpośrednio związana z którymkolwiek towarami wymienionymi w kategorii 0 objęta jest kontrolą zgodnie z postanowieniami kategorii 0.

„Technologia” służąca „rozwojowi”, „produkcji” lub „użytkowaniu” towarów objętych kontrolą pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

Zgoda na wywóz określonych towarów upoważnia również do wywozu do tego samego użytkownika minimalnej „technologii” wymaganej dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania i naprawy tych towarów.

Kontrolę transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” lub związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi”.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII (UOdT)

(Czytać łącznie z grupą E kategorii od 1 do 9)

Wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kontroli na warunkach podanych w każdej z tych kategorii.

„Technologia”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych kontrolą, pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

Kontrolą nie obejmuje się minimalnej „technologii” wymaganej do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towarów niekontrolowanych lub takich, które uzyskały odrębną zgodę na wywóz.

NB.: Powyższe nie zwalnia od kontroli „technologii” wymienionych w pozycjach 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a i 8E002.b.

Kontrola transferu „technologii” nie ma zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimum informacji koniecznych przy składaniu wniosków patentowych.

UWAGA OGÓLNA DO OPROGRAMOWANIA (UOdO)

(Niniejsza uwaga jest nadrzędna w stosunku do kontroli określonych w grupie D kategorii od 0 do 9)

Kategorie 0 do 9 niniejszego wykazu nie obejmują kontrolą „oprogramowania”, będącego którymkolwiek z poniższych:

- a. oprogramowanie jest ogólnie dostępne poprzez:
 - 1. sprzedaż gotowego oprogramowania w punktach sprzedaży detalicznej bez żadnych ograniczeń w wyniku:
 - a. bezpośrednich transakcji sprzedaży;
 - b. transakcji realizowanych na zamówienie pocztowe;
 - c. transakcji zawieranych drogą elektroniczną; lub
 - d. transakcji zawieranych telefonicznie; oraz
 - 2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności dalszej znacznej pomocy ze strony sprzedawcy;

NB.: Punkt a uwagi ogólnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli „oprogramowania” wymienionego w kategorii 5 – część 2 („Bezpieczeństwo informacji”).

- b. oprogramowanie jest uznawane za „będące własnością publiczną”; lub
- c. jest minimalnym „kodem obiektu” wymagany do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towarów, które uzyskały odrębną zgodę na wywóz.

NB.: Punkt c uwagi ogólnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli „oprogramowania” wymienionego w kategorii 5 – część 2 („Bezpieczeństwo informacji”).

PRAKTYKA REDAKCYJNA W *DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ*

Zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.5 na str. 108 Międzyinstytucjonalnego przewodnika redakcyjnego (wydanie z 2011 r.) w tekstach w języku angielskim publikowanych w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*:

- do oddzielenia liczby całkowitej od wartości dziesiętnych używa się przecinka (np. 3,67 cm),
- w liczbach wielocyfrowych rząd tysięcy jest oddzielony spacją (np. 100 000).

W tekście zamieszczonym w niniejszym załączniku stosowane są wyżej wymienione zasady.

AKRONIMY I SKRÓTY UŻYWANE W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

Akronimy lub skróty użyte jako zdefiniowany termin znajdują się w „Definicjach terminów używanych w niniejszym załączniku”.

AKRONIM LUB ZNACZENIE SKRÓT

ABEC	Komitet Inżynierów Łożysk Pierścieniowych
AGMA	Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Przekładni
AHRS	układy informujące o położeniu i kursie
AISI	Amerykański Instytut Żelaza i Stali
ALU	jednostka arytmetyczno-logiczna
ANSI	Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji
ASTM	Amerykańskie Towarzystwo Materiałoznawcze
ATC	kontrola ruchu lotniczego
AVLIS	instalacje do rozdzielania izotopów za pomocą „laserów” w parach atomowych
CAD	projektowanie wspomagane komputerowo
CAS	Serwis Dokumentacji Chemicznej
CDU	jednostka sterowania i wyświetlania
CEP	krąg równego prawdopodobieństwa
CNTD	rozkład termiczny z regulowanym zarodkowaniem
CRISLA	reakcja chemiczna wywołana selektywną laserową aktywacją izotopów
CVD	osadzanie chemiczne z pary
CW	wojna chemiczna
CW (dotyczy laserów)	fala ciągła (w laserach)
DME	radiodalmierz
DS	ukierunkowane krzepnięcie
EB-PVD	fizyczne osadzanie pary z wiązką elektronów
EBU	Europejska Unia Nadawców
ECM	elektromechaniczne techniki obróbki
ECR	rezonans elektronowo-cyklotronowy
EDM	elektroiskrowe obrabiarki
EEPROMS	elektronicznie wymazywalna programowana pamięć tylko do odczytu
EIA	Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego
EMC	kompatybilność elektromagnetyczna
ETSI	Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
FFT	szybka transformata Fouriera
GLONASS	globalny system nawigacji satelitarnej
GPS	globalny system lokalizacji
HBT	tranzystory heterobipolarne
HDDR	cyfrowy zapis magnetyczny z dużą gęstością
HEMT	tranzystory o wysokiej ruchliwości elektronów
ICAO	Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
IEC	Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
IEEE	Instytut Inżynierów Elektryki i Elektroniki
IFOV	chwilowe pole widzenia
ILS	system lądowania na przyrządy
IRIG	grupa oprzyrządowania międzyzakresowego
ISA	międzynarodowa atmosfera wzorcowa
ISAR	radar z odwróconą syntezą apertury

AKRONIM LUB ZNACZENIE SKRÓT

ISO	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
ITU	Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
JIS	Japońska Norma Przemysłowa
JT	Joule-Thomson
LIDAR	radar optyczny
LRU	liniowy element wymienny
MAC	kod uwierzytelniania wiadomości
Mach	stosunek prędkości obiektu do prędkości dźwięku (od nazwiska Ernsta Macha)
MLIS	instalacje do rozdzielania izotopów za pomocą „laserów” molekularnych
MLS	mikrofalowe systemy lądowania
MOCVD	osadzanie z par lotnych związków metaloorganicznych
MRI	tworzenie obrazów za pomocą rezonansu magnetycznego
MTBF	średni czas międzyawaryjny
Mtops	milion teoretycznych operacji na sekundę
MTTF	średni czas do awarii
NBC	jądrowy, biologiczny i chemiczny
NDT	badanie nieniszczące
PAR	urządzenia radiolokacyjne dokładnego podejścia do lądowania
PIN	osobisty numer identyfikacyjny
ppm	części na milion
PSD	gęstość widmowa mocy
QAM	modulacja kwadraturowa
RF	częstotliwość radiowa
SACMA	Stowarzyszenie Dostawców Wysokojakościowych Materiałów Kompozytowych
SAR	radar z syntezą apertury
SC	monokryształ
SLAR	radar pokładowy obserwacji bocznej
SMPTE	Stowarzyszenie Inżynierów Filmowych i Telewizyjnych
SRA	warsztatowy zespół wymienny
SRAM	statyczna pamięć o dostępie swobodnym
SRM	metody zalecane przez SACMA
SSB	pojedyncza wstęga boczna
SSR	radar wtórnego nadzorowania
TCSEC	kryteria oszacowania poufnych systemów komputerowych
TIR	całkowity wskazany odczyt
UV	nadfiolet
UTS	wytrzymałość na rozciąganie
VOR	radiolatarnia kierunkowa wysokiej częstotliwości
YAG	granat itrowo-aluminiowy

DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

Definicje terminów w ‘cudzysłowie pojedynczym’ podano w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

Definicje terminów w „cudzysłowie podwójnym” są następujące:

NB.: Odnośniki do kategorii podano w nawiasach po zdefiniowanym terminie.

„Dokładność” (2, 6), zazwyczaj określana w kategoriach niedokładności, oznacza maksymalne odchylenie, dodatnie lub ujemne, danej wartości od uznanej wartości standardowej lub prawdziwej.

„Układy aktywnego sterowania lotem” (7) oznaczają układy zapobiegające niepożądanym ruchom lub obciążeniom konstrukcyjnym „statku powietrznego” lub pocisku raketowego przez autonomiczne przetwarzanie sygnałów z wielu czujników i wydawanie niezbędnych poleceń do realizacji sterowania automatycznego.

„Piksel aktywny” (6, 8) oznacza najmniejszy (pojedynczy) element sieci elementów półprzewodnikowych mający możliwość realizacji funkcji fotoelektrycznych w odpowiedzi na promieniowanie świetlne (elektromagnetyczne).

„Przystosowany do użycia w działaniach wojennych” (1) oznacza dowolną modyfikację lub dobór (np. zmiana czystości, dopuszczalnego okresu magazynowania, agresywności, charakterystyki propagacji lub odporności na promieniowanie nadfioletowe), których celem jest wzmocnienie efektów wywoływania strat w ludności lub zwierzętach, unieszkodliwiania sprzętu lub powodowania strat w uprawach rolnych lub środowisku.

„Skorygowana wydajność szczytowa” (4) oznacza skorygowaną największą prędkość, z jaką „komputery cyfrowe” wykonują zmiennoprzecinkowe operacje dodawania i mnożenia na liczbach 64-bitowych lub dłuższych; wyraża się w teraflopsach ważonych (WT), jednostkach wynoszących 10^{12} skorygowanych operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

NB.: Zob. kategoria 4, uwaga techniczna.

„Statek powietrzny” (1, 7, 9) oznacza stałopłat, statek z obrotowymi skrzydłami, wiropłat (helikopter), statek ze zmiennym wirnikiem lub zmiennopłat.

NB.: Zob. również „cywilne statki powietrzne”.

„Pojazd powietrzny” (9) oznacza napędzany mechanicznie pojazd utrzymujący się w powietrzu dzięki korpusowi wypełnionemu gazem (zwykle helem, wcześniej wodorem), który jest lżejszy od powietrza.

„Wszystkie dostępne kompensacje” (2) - oznacza to, że uwzględniono wszystkie wykonalne środki, jakie może zastosować producent w celu zminimalizowania wszystkich systematycznych błędów pozycjonowania określonego modelu obrabiarki lub błędów pomiarowych określonego urządzenia do pomiaru współrzędnych.

„Przydzielone przez ITU” (3, 5) oznacza przydział pasm częstotliwości zgodnie z Przepisami Radiowymi ITU (*International Telecommunication Union* – Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej) dla służb podstawowych, dopuszczonych i pomocniczych.

NB.: Nie obejmuje to przydziałów dodatkowych i alternatywnych.

„Odchylenie położenia kąтового” (2) oznacza maksymalną różnicę pomiędzy położeniem kątowym a rzeczywistym, bardzo dokładnie zmierzonym położeniem kątowym po obróceniu stołu montażowego w stosunku do jego położenia początkowego.

„Kąt błędzenia losowego” (7) oznacza narastanie błędu kąтового w czasie, spowodowane białym szumem w prędkości kątowej. (IEEE STD 528-2001).

„APP” (4) – zob. „Skorygowana wydajność szczytowa”.

„Algorytm asymetryczny” (5) oznacza algorytm kryptograficzny, w którym stosuje się różne, powiązane matematycznie, klucze do szyfrowania i deszyfrowania

NB.: Powszechnym zastosowaniem „algorytmu asymetrycznego” jest zarządzanie kluczami.

„Automatyczne śledzenie celu” (6) oznacza technikę przetwarzania umożliwiającą automatyczne określanie i podawanie na wyjściu w czasie rzeczywistym ekstrapolowanej wartości najbardziej prawdopodobnego położenia celu.

„Przeciętna moc wyjściowa” (6) oznacza całkowitą energię wyjściową „lasera” wyrażoną w dżulach podzieloną przez czas emitowania pojedynczego impulsu lub serii kolejnych impulsów wyrażony w sekundach. Dla serii jednolicie rozmieszczonych impulsów jest ona równa całkowitej energii wyjściowej „lasera” w jednym impulsie wyrażonej w dżulach pomnożonej przez częstotliwość impulsów „lasera” wyrażonej w hercach.

„Opóźnienie sygnału bramki podstawowej” (3) oznacza wartość opóźnienia sygnału odpowiadająca bramce podstawowej, używanej w ‘rodzinie’ „monolitycznych układów scalonych”. Można ją wyznaczyć dla danej ‘rodziny’ „monolitycznych układów scalonych” jako opóźnienie sygnału na bramkę typową w ramach danej ‘rodziny’ lub jako typowe opóźnienie na bramkę w ramach danej ‘rodziny’.

NB. 1: Nie należy mylić „opóźnienia sygnału bramki podstawowej” z opóźnieniem wyjścia/wejścia złożonego „monolitycznego układu scalonego”.

NB. 2: Do ‘rodziny’ zalicza się wszystkie układy scalone, których metody produkcji i specyfikacje techniczne, z wyjątkiem ich odpowiednich funkcji, spełniają wszystkie następujące kryteria:

- a. wspólna architektura sprzętowa i oprogramowania;*
- b. wspólna technologia projektowania i przetwarzania; oraz*
- c. wspólne charakterystyki podstawowe.*

„Podstawowe badania naukowe” (UOdT, UdTJ) oznaczają prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne.

„Wychylenie wstępne akcelerometru” (7) oznacza średnią wartość wskazywaną przez akcelerometr przez określony czas, mierzoną w określonych warunkach eksploatacyjnych i niewykazującą współzależności z przyspieszeniem wejściowym ani z wejściową prędkością obrotową. „Wychylenie wstępne akcelerometru” wyrażone jest w gramach lub w metrach na sekundę do kwadratu (g lub m/s^2). (Norma IEEE 528-2001). (Mikrogram równy jest $1 \times 10^{-6} g$).

„Wychylenie wstępne żyroskopu” (7) oznacza średnią wartość wskazywaną przez żyroskop przez określony czas, mierzoną w określonych warunkach eksploatacyjnych i niewykazującą współzależności z wejściową prędkością obrotową ani z przyspieszeniem wejściowym. „Wychylenie wstępne żyroskopu” wyrażone jest z reguły w stopniach na godzinę (o/h). (Norma IEEE Std 528-2001).

„Bicie osiowe” (2) oznacza przemieszczenie osiowe wrzeciona głównego podczas jednego obrotu, mierzone w płaszczyźnie prostopadłej do czoła wrzeciona, w punkcie sąsiadującym z obwodem czoła wrzeciona (zob. ISO 230 część 1-1986, pkt 5.63).

„Preformy włókien węglowych” (1) oznaczają uporządkowany układ powlekanych lub niepowlekanych włókien przeznaczony do tworzenia struktur składowych przed użyciem „matrycy” do tworzenia „materiału kompozytowego”.

„Krag Równego Prawdopodobieństwa” (CEP) (7) to miara dokładności wyrażana jako promień okręgu ze środkiem w miejscu znajdowania się celu, w który wpada 50 % ładunków użytecznych, przy określonym zasięgu.

„Laser chemiczny” (6) oznacza „laser”, w którym wzbudzenie czynnika następuje za pomocą energii pochodzącej z reakcji chemicznej.

„Mieszanina chemiczna” (1) oznacza produkt stały, płynny lub gazowy składający się z dwóch lub więcej składników, które nie reagują ze sobą w warunkach, w których mieszanina jest przechowywana.

„Cyrkulacyjne układy równoważenia momentu lub cyrkulacyjne układy sterowania kierunkiem” (7) oznaczają układy, w których przepływ powietrza wokół powierzchni aerodynamicznych jest wykorzystywany do zwiększenia powstających na nich sił lub do kierowania nimi.

„Cywilne statki powietrzne” (1, 3, 4, 7) oznaczają „statki powietrzne” wymienione i określone przez organy lotnictwa cywilnego w podawanych do wiadomości publicznej wykazach świadectw zdatności do lotu jako zdadne do użytkowania do komercyjnych celów cywilnych na liniach wewnętrznych i zewnętrznych lub do legalnych celów cywilnych, prywatnych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

NB.: Zob. również „statek powietrzny”.

„Mieszanie” (1) oznacza mieszanie włókien materiałów termoplastycznych z włóknami materiałów wzmacniających w celu wytworzenia mieszkanki włókien wzmacniających z „matrycą”, mającej w całości formę włóknistą.

„Rozdrabnianie” (1) oznacza proces wprowadzania materiału w postać drobnocząstkową przez zginiatanie lub mielenie.

„Sterownik toru telekomunikacyjnego” (4) oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

„Systemy kompensacji” (6) składają się z głównego czujnika skalarnego, co najmniej jednego czujnika odniesienia (np. magnetometru wektorowego) wraz z oprogramowaniem zezwalającym na zmniejszenie szumu ruchu obrotowego korpusu sztywnego platformy.

„Materiał kompozytowy” (1, 2, 6, 8, 9) oznacza „matrycę” oraz dodatkową fazę lub dodatkowe fazy, składające się z cząstek, włókienek, włókien lub dowolnej ich kombinacji, dodawanych w określonym celu lub celach.

„Stół obrotowo-przechyłny” (2) oznacza stół umożliwiający obracanie i przechylanie obrabianego przedmiotu względem dwóch osi nierównoległych, które mogą być równocześnie koordynowane, co umożliwia „sterowanie kształtowe”.

„Związki III/V” (3, 6) oznaczają substancje polikrystaliczne, binarne lub złożone substancje monokrystaliczne składające się z pierwiastków grupy IIIA i VA układu okresowego pierwiastków (np. arsenek galu, arsenek galu i glinu, fosforek indu).

„Sterowanie kształtowe” (2) oznacza co najmniej dwa ruchy „sterowane numerycznie”, realizowane zgodnie z instrukcjami określającymi następną połozenie oraz potrzebne do osiągnięcia tego połozenia prędkości posuwów. Prędkości posuwów nie są jednakowe, wskutek czego powstaje wymagany kształt (zob. ISO/DIS 2806 - 1980).

„Temperatura krytyczna” (1, 3, 5) (nazywana czasami „temperaturą przemiany”) danego materiału „nadprzewodzącego” jest temperaturą, w której materiał całkowicie traci oporność dla przepływu elektrycznego prądu stałego.

„Aktywacja kryptograficzna” (5) oznacza dowolną technikę, która aktywuje lub umożliwia funkcje kryptograficzne za pomocą bezpiecznego mechanizmu zastosowanego przez producenta danego artykułu i jest w sposób niepowtarzalny związana z tym artykułem lub z klientem, na którego potrzeby aktywuje lub umożliwia się funkcje kryptograficzne (np. klucz licencyjny powiązany z numerem seryjnym lub instrumentem uwierzytelniający, jak np. certyfikat z podpisem cyfrowym).

Uwaga techniczna:

Techniki i mechanizmy „aktywacji kryptograficznej” mogą być realizowane w postaci sprzętu, „oprogramowania” lub „technologii”.

„Kryptografia” (5) to dziedzina wiedzy zajmująca się zasadami, narzędziami i metodami przekształcania danych w celu ukrycia zawartych w nich informacji, zapobiegania możliwości niepostrzeżonego ich modyfikowania lub uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. „Kryptografia” ogranicza się do przekształcania informacji za pomocą jednego lub większej liczby ‘tajnych parametrów’ (np. szyfrów) lub związanego z tym zarządzania kluczami.

Uwaga: „Kryptografia” nie obejmuje technik kompresji ani kodowania danych.

Uwaga techniczna:

‘Tajny parametr’: wartość stała lub klucz trzymany w tajemnicy przed osobami postronnymi lub znany wyłącznie pewnej grupie osób.

„Laser o fali ciągłej” (6) oznacza „laser” dający nominalnie stałą energię wyjściową w czasie dłuższym niż 0,25 s.

„Nawigacja na bazie danych z wielu źródeł” („DBRN”) (7) oznacza systemy oparte na danych z wielu źródeł uprzednio zmierzonych danych geograficznych zintegrowanych w celu uzyskania dokładnych informacji nawigacyjnych w warunkach dynamicznych. Do źródeł danych należą mapy batymetryczne, mapy nieba, mapy grawitacji, mapy magnetyczne lub trójwymiarowe cyfrowe mapy terenowe.

„Zwierciadła odkształcalne” (6) (określane również jako zwierciadła piezoelektryczne). Są to zwierciadła mające:

- a. jedną ciągłą odbijającą powierzchnię optyczną, którą można dynamicznie odkształcać za pomocą pojedynczych momentów lub sił, kompensując w ten sposób zniekształcenia fal optycznych padających na zwierciadło; lub
- b. wiele odbijających elementów optycznych, które można oddzielnie i dynamicznie przemieszczać w inne położenie za pomocą działających na nie momentów lub sił, kompensując w ten sposób zniekształcenia fal optycznych padających na zwierciadło.

„Uran zubożony” (0) oznacza uran, w którym zawartość izotopu 235 obniżono do ilości mniejszej niż w warunkach naturalnych.

„Rozwój” (Wszystkie UOdT, UdTJ) odnosi się do wszystkich etapów poprzedzających produkcję seryjną, takich jak: projektowanie, badania projektowe, analiza projektowa, koncepcja projektowania, montaż i testowanie prototypów, plany produkcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w produkt, projektowanie konfiguracji, projektowanie montażu całościowego, rozplanowanie.

„Zgrzewanie dyfuzyjne” (1, 2, 9) oznacza łączenie molekularne w stanie stałym co najmniej dwóch oddzielnych elementów metali w jeden element, przy czym wytrzymałość miejsca połączenia jest równa wytrzymałości najsłabszego z materiałów, a podstawowym mechanizmem jest interdyfuzja atomów na styku obu elementów.

„Komputer cyfrowy” (4, 5) oznacza urządzenie zdolne do wykonywania, w postaci jednej lub kilku zmiennych dyskretnych, wszystkich poniższych funkcji:

- a. przyjmowanie danych;
- b. zapamiętywanie danych lub instrukcji na trwałych lub nietrwałych (zapis usuwalny) urządzeniach pamięciowych;
- c. przetwarzanie danych za pomocą zapamiętanej sekwencji instrukcji, którą można modyfikować; oraz
- d. generowanie danych wyjściowych.

NB.: *Modyfikacje zapamiętanej sekwencji instrukcji dotyczą wymiany trwałych urządzeń pamięciowych, ale nie fizycznych zmian przewodów lub połączeń.*

„Szybkość transmisji danych cyfrowych” (def) oznacza całkowitą szybkość informacji w bitach, przesyłanych bezpośrednio na dowolnym typie nośnika.

NB.: *Zob. także „całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych”.*

„Bezpośrednie wytłaczanie hydrauliczne” (2) oznacza technikę odkształcania, w której stosowana jest napędzona płynem odkształcalna poduszka, działająca bezpośrednio na powierzchnię obrabianego przedmiotu.

„Współczynnik dryftu (żyroskopu)” (7) oznacza składową wyjściową rotacji żyroskopu funkcjonalnie niezależną od rotacji wejściowej. Jest wyrażany jako prędkość kątowa. (IEEE STD 528-2001).

„Gram efektywny” (0, 1) „specjalnego materiału rozszczepialnego” oznacza:

- a. dla izotopów plutonu i uranu-233 – masę izotopu w gramach;
- b. dla uranu wzbogaconego do poziomu 1 % lub więcej izotopu uranu-235 – masę pierwiastka w gramach pomnożoną przez kwadrat jego wzbogacenia wyrażonego w postaci ułamka dziesiętnego udziału wagowego izotopu U-235;
- c. dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-235 do poziomu poniżej 1 procenta – masę pierwiastka w gramach pomnożoną przez 0,0001.

„Zespół elektroniczny” (2, 3, 4, 5) oznacza pewną liczbę elementów elektronicznych (tj. ‘elementów obwodu’, ‘elementów dyskretnych’, układów scalonych itp.) połączonych ze sobą w celu realizacji określonej(-ych) funkcji, wymieniając w całości, która zazwyczaj może być demontowana.

NB. 1: *‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.*

NB. 2: *‘Element dyskretny’: oddzielnie obudowany ‘układ elementarny’ z własnymi końcówkami wyjściowymi.*

„Sterowany elektronicznie układ antenowy fazowany” (5, 6) oznacza antenę kształtującą wiązkę za pomocą sprzężenia fazowego, tj. kierunek wiązki jest utrzymywany za pomocą elementów promieniujących o złożonych współczynnikach wzbudzenia, przy czym kierunek takiej wiązki (azymut lub podniesienie kątowe) można zmieniać za pomocą sygnału elektrycznego, zarówno dla nadawania, jak i odbioru.

„Materiały energetyczne” (1) oznaczają substancje lub mieszanki wchodzące w reakcje chemiczne, by uwolnić energię potrzebną do ich zamierzonego zastosowania. Podklasami materiałów energetycznych są „materiały wybuchowe”, „materiały pirotechniczne” i „paliwa”.

„Manipulatory” (2) obejmują uchwyty, ‘aktywne jednostki oprzyrządowania’ lub wszelkie inne oprzyrządowanie zamontowane na podstawowej (bazowej) płycie na końcu ramienia manipulacyjnego „robota”.

NB.: *‘Aktywne jednostki oprzyrządowania’: urządzenia do przyłożenia mocy napędowej, energii procesowej lub czujnika do przedmiotu obrabianego.*

„Gęstość zastępcza” (6) oznacza masę elementu optycznego na jednostkę pola powierzchni optycznej rzutowanej na powierzchnię optyczną.

„Materiały wybuchowe” (1) oznaczają stałe, ciekłe lub gazowe substancje lub mieszaniny substancji, które mają za zadanie detonować w charakterze ładunku inicjującego, detonatora pośredniego lub ładunku głównego w głowicach bojowych, w robotach rozbiórkowych lub w innych zastosowaniach.

„Systemy FADEC” (7, 9) oznaczają całkowicie autonomiczne systemy cyfrowego sterowania silnikami, czyli cyfrowe elektroniczne systemy sterowania silnikami turbospalinowymi, które są w stanie autonomicznie sterować tymi silnikami w całym zakresie ich pracy, od uruchamiania do wyłączania ich na żądanie, zarówno w warunkach ich normalnej, jak i nieprawidłowej pracy.

„Materiały włókniste lub włókienkowe” (0, 1, 8) obejmują następujące pojęcia:

- a. „włókna elementarne” o strukturze ciągłej;
- b. „przędza” i „rowing” o strukturze ciągłej;
- c. „taśmy”, tkaniny, maty i oploty o strukturze bezładnej;
- d. włókna cięte na drobne kawałki, włókna pocięte na dłuższe odcinki oraz spójne maty z włókien;
- e. wiskery, monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej długości;
- f. pulpa z poliamidu aromatycznego.

„Układ scalony warstwowy” (3) oznacza układ ‘elementów obwodu’ i metalowych łączników, wytworzony techniką osadzania grubej lub cienkiej warstwy na „podłożu” o właściwościach izolujących.

NB.: *‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.*

„Ustalony” (5) oznacza algorytm kodowania lub kompresji, który nie może akceptować parametrów dostarczonych z zewnątrz (np. zmiennych do szyfrowania lub kluczy) i nie może być modyfikowany przez użytkownika.

„Układ czujników optycznych sterowania lotem” (7) oznacza układ rozproszonych czujników optycznych, wykorzystujący promień „lasera” do dostarczania w czasie rzeczywistym danych dotyczących sterowania lotem w celu ich przetwarzania na pokładzie.

„Optymalizacja toru lotu” (7) oznacza procedurę minimalizującą odchylenia od czterowymiarowej (przestrzeń i czas) planowanej trajektorii lotu opartą na zasadzie maksymalizacji osiągnięć lub efektywności realizacji zadania.

„Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej” (6, 8) oznacza płaską warstwę o strukturze liniowej lub dwuwymiarowej lub połączenie takich płaskich warstw, złożonych z oddzielnych elementów detekcyjnych, z elektronicznym urządzeniem odczytującym lub bez, pracująca w płaszczyźnie ogniskowej.

NB.: Definicja ta nie obejmuje stosu pojedynczych elementów detekcyjnych ani detektorów dwu-, trzy- lub czteroelementowych, pod warunkiem że w elemencie nie są realizowane opóźnienie ani integracja.

„Ułamkowa szerokość pasma” (3, 5) oznacza „szerokość chwilową pasma” podzieloną przez częstotliwość środkową, wyrażoną w procentach.

„Rozrzucanie częstotliwości” (frequency hopping) (5) oznacza formę „rozproszenia widma” polegającą na krokowo-dyskretnej zmianie częstotliwości nośnej pojedynczego kanału telekomunikacyjnego, w sposób losowy lub pseudolosowy.

„Metoda wyzwalania maską częstotliwości” (3), w „analizatorach sygnału”, oznacza mechanizm, w którym funkcja wyzwalania jest zdolna do wybrania zakresu częstotliwości, który ma być wyzwalany, jako podzbioru odbieranej szerokości pasma, ignorując inne sygnały, które również mogą być obecne w tej samej odbieranej szerokości pasma. „Metoda wyzwalania maską częstotliwości” może obejmować więcej niż jeden niezależny zbiór wartości granicznych.

„Czas przełączania częstotliwości” (3) oznacza czas (tj. opóźnienie), jakiego potrzebuje sygnał przy przełączaniu się z początkowej zgodnej ze specyfikacjami częstotliwości wyjściowej, by osiągnąć zgodną ze specyfikacjami końcową częstotliwość wyjściową na poziomie zadanym lub w przedziale $\pm 0,05$ % wokół tego poziomu. Produkty, których zgodna ze specyfikacjami częstotliwość mieści się w przedziale węższym niż $\pm 0,05$ % wokół ich częstotliwości środkowej, definiowane są jako niezdolne do przełączania.

„Syntetyzator częstotliwości” (3) oznacza dowolny rodzaj źródła częstotliwości, bez względu na stosowaną technikę, zapewniający uzyskanie wielu równoczesnych lub naprzemiennych częstotliwości wyjściowych z jednego lub kilku wyjść, uzyskanych z mniejszej liczby częstotliwości wzorcowych (lub głównych) lub sterowanych lub regulowanych za ich pomocą.

„Ogniwo paliwowe” (8) oznacza urządzenie elektrochemiczne, które zużywając paliwo ze źródła zewnętrznego, przetwarza energię chemiczną bezpośrednio w prąd stały.

„Topliwy” (1) oznacza taki, który może być dalej sieciowany lub polimeryzowany (utwardzany) przy użyciu ciepła, promieniowania, katalizatora itd. lub stopiony bez pirolizy (zwęglania).

„Atomizacja gazowa” (1) oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej za pomocą strumienia gazu o wysokim ciśnieniu.

„Rozrzucone geograficznie” (6) odnosi się do przypadku, kiedy każdy element znajduje się w odległości większej niż 1 500 m od innego w dowolnym kierunku. Czujniki ruchome są zawsze traktowane jako „rozrzucone geograficznie”.

„Instalacje do naprowadzania” (7) oznaczają systemy scalające proces pomiaru i obliczania położenia pojazdu i jego prędkości (tj. nawigację) z obliczeniami i wysyłaniem poleceń do systemów sterowania lotem pojazdu w celu skorygowania jego toru lotu.

„Izostatyczne zagęszczanie na gorąco” (2) oznacza technikę ciśnieniowania odlewu w temperaturach powyżej 375 K (102°C) w zamkniętej formie za pomocą różnych czynników (gaz, ciecz, cząstki stałe itp.), której celem

jest wytworzenie jednakowej siły we wszystkich kierunkach w celu zmniejszenia lub wyeliminowania jam wewnętrznych w odlewie.

„Hybrydowy układ scalony” (3) oznacza dowolne połączenie układu(-ów) scalonego(-ych) lub układu scalonego z ‘elementami układu’ lub ‘składnikami dyskretnymi’ połączonymi ze sobą w celu realizacji określonej(-ych) funkcji, mające wszystkie wymienione poniżej cechy:

- a. posiada co najmniej jedno urządzenie nieobudowane;
- b. zastosowano w nim typowe metody łączenia stosowane podczas produkcji układów scalonych;
- c. można je wymieniać tylko w całości; oraz
- d. w normalnych warunkach nie można go rozmontować.

NB. 1: ‘Element układu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.

NB. 2: ‘Składnik dyskretny’: ‘element układu’ w oddzielnej obudowie z własnymi końcówkami wyjściowymi.

„Wzmacnianie obrazu” (4) oznacza przetwarzanie obrazów zawierających informacje, uzyskanych ze źródeł zewnętrznych, za pomocą algorytmów, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, ekstrakowanie, selekcja, korelacja, splatanie lub przemieszczanie pomiędzy domenami (np. za pomocą szybkiej transformacji Fouriera lub transformacji Walsha). Nie obejmuje kontrolą algorytmów, w których stosowane są wyłącznie przekształcenia liniowe lub obrotowe pojedynczego obrazu, takie jak przesunięcie, ekstrakowanie jakiejś cechy, rejestracja lub fałszywe barwienie.

„Immunotoksyna” (1) oznacza koniugat jednokomórkowego przeciwciała monoklonalnego i „toksyny” lub „podjednostki toksyny”, który wpływa selektywnie na komórki chorobowo zmienione.

„Będące własnością publiczną” (UOdT UdTJ UOdO), w odniesieniu do niniejszego dokumentu, oznacza „technologię” lub „oprogramowanie” dostępne bez żadnych ograniczeń co do ich dalszego rozpowszechniania (ograniczenia wynikające z praw autorskich nie wykluczają uznania „technologii” lub „oprogramowania” za „będące własnością publiczną”).

„Ochrona informacji” (4, 5) oznacza wszystkie środki i funkcje zapewniające dostęp, poufność lub nienaruszalność informacji lub komunikacji, z wyłączeniem środków i funkcji mających zabezpieczać przed wadliwym działaniem. Obejmuje „kryptografię”, „aktywację kryptograficzną”, „kryptoanalizę”, ochronę przed przypadkowym przekazywaniem sygnałów odnoszących się do tajnych informacji oraz zabezpieczanie komputerów.

NB.: ‘Kryptoanaliza’: analiza systemów kryptograficznych lub ich wejść i wyjść w celu uzyskania tajnych informacji lub danych, włączając w to tajne teksty.

„Chwilowa szerokość pasma” (3, 5, 7) oznacza szerokość pasma, w którym moc wyjściowa pozostaje na stałym poziomie z dokładnością do 3 dB bez regulacji innych parametrów roboczych.

„Zasięg przyrządowy” (6) oznacza jednoznacznie określony zasięg radaru.

„Izolacja” (9) jest pojęciem stosowanym do podzespołów silnika raketowego, tj. osłony, dyszy, wlotów, zamknięć osłon, obejmującym utrwalone lub półutrwalone maty kauczukowe zawierające materiał ogniotrwały lub izolacyjny. Można je również stosować na klatki lub kłapy odprężające.

„Wykładzina wewnętrzna” (9) oznacza warstwę pośrednią pomiędzy paliwem stałym a obudową lub warstwą izolacyjną. Zazwyczaj jest to płynna polimerowa zawieszina materiału ogniotrwałego lub izolacyjnego, np. polibutadien z łańcuchami zakończonymi grupami hydroksylowymi (HTPB) wypełniony węglem lub inny polimer z dodatkiem środków utrwalających, rozpylonych lub rozsmarowanych na wewnętrznej powierzchni osłony.

„Miernik gradientu magnetycznego właściwego” (6) oznacza pojedynczy element do pomiaru gradientu pola magnetycznego oraz związane z nim urządzenia elektroniczne, służące do pomiaru gradientu pola magnetycznego.

NB.: Zob. również „Miernik gradientu magnetycznego”.

„Złośliwe oprogramowanie” (4) oznacza „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu uniknięcia wykrycia przez ‘narzędzia monitorujące’ lub złamania ‘środków zabezpieczających’ komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci, wykonujące następujące działania:

- a. pobieranie danych i informacji z komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci lub modyfikacja systemu lub danych użytkownika; lub
- b. modyfikacja standardowych ścieżek wykonywania programu lub procesu w celu umożliwienia wykonania instrukcji pochodzących z zewnątrz.

Uwagi:

1. „Złośliwe oprogramowanie” nie obejmuje żadnego z poniższych pojęć:
 - a. hiperwizorów, programów do usuwania błędów oraz narzędzi inżynierii wstecznej oprogramowania (Software Reverse Engineering - SRE)
 - b. „oprogramowania” dotyczącego zarządzania prawami cyfrowymi; lub
 - c. „oprogramowania” przeznaczonego do zainstalowania przez producentów, administratorów lub użytkowników do celów śledzenia lub znajdowania towarów;
2. Urządzenia zdolne do pracy w sieci obejmują urządzenia przenośne i inteligentne liczniki.

Uwagi techniczne:

1. ‘Narzędzia monitorujące’: „oprogramowanie” lub sprzęt monitorujące zachowanie systemu lub procesów wykonywanych na urządzeniu. Obejmuje to programy antywirusowe, produkty zapewniające bezpieczeństwo punktów końcowych, produkty bezpieczeństwa osobistego (Personal Security Products - PSP), systemy wykrywania wtargnięcia (Intrusion Detection Systems - IDS), systemy ochrony przed wtargnięciem (Intrusion Detection Systems - IPS) oraz zapory sieciowe.
2. ‘Środki zabezpieczające’: techniki opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania kodu, takie jak Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) lub sandboxing.

„Izolowane żywe kultury” (1) obejmują żywe kultury w postaci uśpionej i w postaci suchych preparatów.

„Prasy izostatyczne” (2) oznaczają urządzenia umożliwiające ciśnieniowanie zamkniętych komór za pomocą różnych czynników roboczych (gazu, cieczy, cząstek stałych itp.) w celu wytwarzania w komorze we wszystkich kierunkach równych ciśnień na obrabiany element lub materiał.

„Laser” (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) oznacza zespół elementów wytwarzający wiązkę światła spójnego zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, wzmocnioną za pomocą stymulowanej emisji promieniowania.

NB.: Zob. również: „Laser chemiczny”;
„Laser o super wysokiej mocy”;
„Laser z przekazaniem energii”.

„Pojazdy lżejsze od powietrza” (9) oznaczają balony i statki powietrzne, które są wypełniane gorącym powietrzem lub innymi gazami lżejszymi od powietrza, takimi jak hel lub wodór.

„Liniiowość” (2) (zazwyczaj określana w kategoriach nieliniowości) stanowi maksymalne odchylenie parametru rzeczywistego (przeciętnej wartości górnego i dolnego odczytu na skali), w kierunku dodatnim lub ujemnym, od linii prostej poprowadzonej w taki sposób, żeby maksymalne odchylenia zostały wyrównane i zminimalizowane.

„Sieć lokalna” (4, 5) oznacza system przesyłania danych mający wszystkie następujące cechy:

- a. umożliwiający bezpośrednie połączenie ze sobą dowolnej liczby niezależnych ‘urządzeń do przetwarzania danych’; oraz

- b. ograniczony w sensie geograficznym do pewnego obszaru o umiarkowanym zasięgu (np. biurowiec, zakład, miasteczko studenckie, magazyn).

NB.: *‘Urządzenie do przetwarzania danych’: urządzenie mające możliwość nadawania lub odbierania ciągów informacji cyfrowych.*

„Mierniki gradientu magnetycznego” (6) oznaczają przyrządy do wykrywania zmian przestrzennych pól magnetycznych ze źródeł zewnętrznych w stosunku do przyrządu pomiarowego. Składają się z wielu „magnetometrów” i przynależnych układów elektronicznych, służących do pomiaru gradientu pola magnetycznego.

NB.: *Zob. również „Miernik gradientu magnetycznego właściwego”.*

„Magnetometry” (6) oznaczają przyrządy do wykrywania pól magnetycznych źródeł zewnętrznych względem przyrządu pomiarowego. Składają się z pojedynczego czujnika pola magnetycznego i odpowiedniego układu elektronicznego, na którego wyjściu jest wartość mierzonego pola magnetycznego.

„Pamięć operacyjna” (4) oznacza podstawową pamięć na dane lub instrukcje szybko dostępną dla jednostki centralnej. Składa się z pamięci wewnętrznej „komputera cyfrowego” oraz jednej z dodatkowych pamięci o strukturze hierarchicznej, takich jak pamięć podręczna (cache) lub pamięć dodatkowa z dostępem niesekwencyjnym.

„Materiały odporne na korozyjne działanie UF_6 ” (0) obejmują miedź, stopy miedzi, stal nierdzewną, glin, tlenek glinu, stopy glinu, nikiel lub stopy zawierające 60 % masy lub więcej niklu oraz fluorowane polimery węglowodorowe.

„Matryca” (1, 2, 8, 9) oznacza fazę o strukturze w zasadzie ciąglej wypełniającą przestrzeń pomiędzy cząstkami, wiskerami lub włóknami.

„Niepewność pomiarowa” (2) oznacza parametr charakterystyczny określający, na poziomie ufności 95 %, w jakiej odległości od wartości prawidłowej leży zmienna pomiarowa. W jego skład wchodzi niedający się skorygować odchylenia systematyczne, niedający się skorygować luz oraz odchylenia losowe (zob. ISO 10360-2).

„Stapianie mechaniczne” (1) oznacza technikę wykonywania stopów polegającą na mechanicznym łączeniu, kruszeniu i ponownym łączeniu sproszkowanych pierwiastków i głównego składnika stopowego. Przez dodawanie odpowiednich proszków można wprowadzać do stopu cząstki niemetaliczne.

„Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej” (1) oznacza technikę ‘gwałtownego krzepnięcia’ i ekstrahowania wyrobu stopowego podobnego do wstęgi, polegającą na zanurzaniu krótkiego odcinka wirującego chłodzonego bloku w wannie stopionego stopu metalowego.

NB.: *‘Gwałtowne krzepnięcie’: krzepnięcie roztopionego materiału podczas chłodzenia z szybkością powyżej 1000 K/s.*

„Formowanie rotacyjne z fazy stopionej” (1) oznacza technikę „gwałtownego krzepnięcia” polegającą na uderzaniu strumienia stopionego metalu w wirujący chłodzony blok, wskutek czego powstaje wyrób w postaci płatków, wstęgi lub pręcików.

NB.: *‘Gwałtowne krzepnięcie’: krzepnięcie roztopionego materiału podczas chłodzenia z szybkością powyżej 1000 K/s.*

„Układ mikrokomputerowy” (3) oznacza „monolityczny układ scalony” lub „wieloukład scalony”, w którego skład wchodzi jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji instrukcji ogólnych, zawartych w pamięci wewnętrznej, na danych znajdujących się w pamięci wewnętrznej.

NB.: *Pamięć wewnętrzna może być wspomagana przez pamięć zewnętrzną.*

„Układ mikroprocesorowy” (3) oznacza „monolityczny układ scalony” lub „wieloukład scalony”, w którego skład wchodzi jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji szeregu instrukcji ogólnych zawartych w pamięci zewnętrznej.

NB. 1: „Układ mikroprocesorowy” zazwyczaj nie jest wyposażony w integralną pamięć dostępną dla użytkownika, ale do realizacji jego funkcji logicznych może być wykorzystywana pamięć istniejąca w mikroukładzie.

NB. 2: Definicja ta obejmuje zespoły układów przeznaczone do pracy razem, w celu realizacji funkcji „układu mikroprocesorowego”.

„Mikroorganizmy” (1, 2) oznaczają bakterie, wirusy, mikoplazmy, riketsje, chlamydie lub grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego żywe organizmy, który rozmyślnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami.

„Pociski rakietowe” (1, 3, 6, 7, 9) oznaczają kompletne systemy rakietowe i systemy bezpilotowych statków powietrznych, zdolne do przenoszenia ładunku użytecznego o masie co najmniej 500 kg na odległość co najmniej 300 km.

„Włókno elementarne” (lub – włókno) (1) oznacza najmniejszy inkrement włókna, zazwyczaj mający średnicę kilku mikrometrów.

„Monolityczny układ scalony” (3) oznacza połączenie ‘elementów obwodu’ czynnych lub biernych lub obu rodzajów, o następujących cechach charakterystycznych:

- a. jest uformowane techniką dyfuzyjną, technikami implantacyjnymi lub technikami osadzania w pojedynczym półprzewodzącym kawałku materiału, tzw. chipie, lub na nim;
- b. można je traktować jak element niepodzielny; oraz
- c. realizuje funkcję(-e) obwodu.

NB.: ‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, taka jak jedna dioda, tranzystor, rezystor, kondensator itp.

„Monospektralne czujniki obrazowe” (6) oznaczają czujniki pozwalające na zbieranie danych obrazowych z pojedynczego pasma widma dyskretnego.

„Wieloukład scalony” (3) oznacza dwa lub więcej „monolityczne układy scalone”, spojone ze wspólnym „podłożem”.

„Wielospektralne analizatory obrazowe” (6) umożliwiają równoczesne lub szeregowe odbieranie danych obrazowych z dwóch lub więcej dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory o więcej niż dwudziestu dyskretnych pasmach spektralnych są czasami nazywane hiperspektralnymi analizatorami obrazowymi.

„Uran naturalny” (0) oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów występujących w naturze.

„Sterownik dostępu do sieci” (4) oznacza interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Używa się w nim wspólnego nośnika działającego z taką samą „szybkością transmisji danych cyfrowych” w systemie transmisji z arbitrażem (np. w sensie znacznika lub nośnika). Niezależnie od innych wybiera on adresowane do niego pakiety z danymi lub grupami danych (np. IEEE 802). Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączu telekomunikacyjnych.

„Komputer neuronowy” (4) oznacza urządzenie obliczeniowe zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do naśladowania działalności neuronu lub zbioru neuronów, tj. urządzenie obliczeniowe wyróżniające się możliwością sprzętowego modulowania znaczenia i liczby połączeń pomiędzy wieloma elementami obliczeniowymi w oparciu o poprzednie dane.

„Reaktor jądrowy” (0) oznacza kompletny reaktor zdolny do pracy w taki sposób, żeby mogła w nim przebiegać kontrolowana, samopodtrzymująca się reakcja łańcuchowa rozszczepiania. „Reaktor jądrowy” obejmuje wszystkie obiekty znajdujące się wewnątrz zbiornika reaktora lub bezpośrednio przymocowane do

nego, wyposażenie sterujące poziomem mocy w rdzeniu oraz elementy, które zazwyczaj zawierają chłodziwo pierwotne rdzenia reaktora lub wchodzi z nim w bezpośrednią styczność lub nim sterują.

„Sterowanie numeryczne” (2) oznacza automatyczne sterowanie procesem wykonywane przez urządzenie korzystające z danych numerycznych zazwyczaj wprowadzanych podczas realizacji operacji (zob. ISO 2382).

„Kod wynikowy” (UOdO) oznacza sprzętowo wykonywalną postać wygodnego wyrażenia jednego lub większej liczby procesów („kod źródłowy” (język źródłowy)), które zostały skompilowane przez system programowania.

„Wzmocnienie optyczne” (5) oznacza w telekomunikacji optycznej technikę wzmacniania polegającą na uzyskiwaniu sygnałów optycznych generowanych przez oddzielne źródło optyczne bez ich przetwarzania na sygnały elektryczne, tj. za pomocą półprzewodnikowych wzmacniaczy optycznych lub światłowodowych wzmacniaczy luminescencyjnych.

„Komputer optyczny” (4) oznacza komputer zaprojektowany lub zmodyfikowany z przeznaczeniem do używania światła jako nośnika danych oraz taki, którego elementy obliczeniowo-logiczne działają bezpośrednio na sprzężonych urządzeniach optycznych.

„Optyczny układ scalony” (3) oznacza „monolityczny układ scalony” lub „hybrydowy układ scalony”, zaopatrzony w co najmniej jedną część przeznaczoną do działania jako fotoczuJNIk lub fotoemiter lub do wykonywania funkcji optycznych lub elektrooptycznych.

„Komutacja optyczna” (5) oznacza przekazywanie lub komutację sygnałów w postaci optycznej bez przetwarzania na sygnały elektryczne.

„Całkowita gęstość prądu” (3) oznacza całkowitą liczbę amperozwojów w cewce (tj. sumę liczby zwojów pomnożoną przez maksymalne natężenie prądu przenoszone przez każdy zwoj) podzieloną przez całkowity przekrój poprzeczny cewki (składającej się z włókienek nadprzewodzących, matrycy metalowej, w której osadzone są włókienka nadprzewodzące, materiału stanowiącego obudowę, kanałów chłodzących itp.).

„Państwo uczestniczące” (7, 9) oznacza każde z państw uczestniczących w Porozumieniu z Wassenaar. (zob. www.wassenaar.org)

„Moc szczytowa” (6) oznacza najwyższy poziom mocy osiągniany w „czasie trwania impulsu”.

„Sieć osobista” (5) oznacza system przesyłania danych mający wszystkie następujące cechy:

- a. umożliwiając bezpośrednie połączenie ze sobą dowolnej liczby niezależnych ‘urządzeń do przetwarzania danych’; oraz
- b. ograniczony do łączności między urządzeniami w bezpośrednim sąsiedztwie osoby fizycznej lub kontrolera urządzeń (np. pojedyncze pomieszczenie, biuro lub samochód oraz ich bezpośrednie otoczenie).

Uwaga techniczna:

‘Urządzenie do przetwarzania danych’: urządzenie mające możliwość nadawania lub odbierania ciągów informacji cyfrowych.

„Sterowanie mocą” (7) oznacza zmianę mocy sygnału nadawanego przez wysokościomierz w taki sposób, żeby moc odbierana w „statku powietrznym” na danej wysokości była zawsze na minimalnym poziomie niezbędnym do określenia wysokości.

„Uprzednio separowany” (0, 1) oznacza oddzielony dowolną techniką, której celem jest zwiększenie zawartości kontrolowanego izotopu.

„Podstawowe sterowanie lotem” (7) oznacza sterowanie stabilnością i manewrowością „statku powietrznego” za pomocą generatorów siły lub momentu, tj. za pomocą aerodynamicznych powierzchni sterujących lub sterowania wektorem ciągu.

„Element o podstawowym znaczeniu” (4) w odniesieniu do kategorii 4 jest „elementem o podstawowym znaczeniu”, jeżeli wartość jego wymiany stanowi ponad 35 % całkowitej wartości systemu, w którego skład wchodzi. Wartość elementu jest ceną płaconą za element przez producenta systemu lub przez firmę montującą system. Wartość całkowita jest zwykłą ceną sprzedaży osobom postronnym w miejscu produkcji lub w miejscu przygotowywania wysyłek towarów.

„Produkcja” (Wszystkie UOdT, UdTJ) oznacza wszystkie etapy związane z produkcją, takie jak: prace konstrukcyjne, technologia produkcji, wytwarzanie, scalanie, montaż (składanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakości.

„Urządzenia produkcyjne” (1, 7, 9) oznaczają oprzyrządowanie, szablony, przyrządy obróbkowe, trzpienie, formy, matryce, uchwyty, mechanizmy synchronizujące, urządzenia testujące, inne maszyny i ich części składowe, z ograniczeniem do urządzeń specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do „rozwoju” lub do jednej lub więcej faz „produkcji”.

„Instalacje produkcyjne” (7, 9) oznaczają „urządzenia produkcyjne” i specjalnie do nich opracowane oprogramowanie, wbudowane w instalacje w celu „rozwoju” lub do jednej lub więcej faz „produkcji”.

„Program” (2, 6) oznacza sekwencję instrukcji do realizacji procesu, mającą postać wykonywalną lub dającą się przekształcić na wykonywalną przez komputer elektroniczny.

„Kompresja impulsów” (6) oznacza kodowanie i przetwarzanie długiego impulsowego sygnału radarowego na krótki, przy zachowaniu korzyści wynikających z wysokiej energii impulsu.

„Czas trwania impulsu” (6) oznacza czas trwania impulsu „lasera” zdefiniowany jako czas upływający między momentami osiągnięcia połowy mocy przez zbocze narastające i zbocze opadające poszczególnego impulsu.

„Laser impulsowy” (6) oznacza „laser”, w którym „czas trwania impulsu” jest równy lub mniejszy niż 0,25 s.

„Kryptografia kwantowa” (5) oznacza grupę technik pozwalających uzyskiwać wspólny klucz do celów „kryptografii” poprzez pomiar własności kwantowych układu fizycznego (w tym własności fizycznych jawnie zależnych od praw optyki kwantowej, kwantowej teorii pola lub elektrodynamiki kwantowej).

„Ruchliwość częstotliwości w radarach” (6) oznacza dowolną technikę zmiany, wg sekwencji pseudolosowej, częstotliwości nośnej impulsowego nadajnika radarowego pomiędzy impulsami lub pomiędzy grupami impulsów, o wartość równą lub większą od szerokości pasma impulsu.

„Rozproszone widmo radarowe” (6) oznacza dowolną technikę modulacji służącą do rozpraszania energii sygnału o stosunkowo wąskim paśmie częstotliwości na dużo szersze pasmo częstotliwości, za pomocą kodowania losowego lub pseudolosowego.

„Czułość promieniowania” (6) oznacza czułość promieniowania $(\text{mA/W}) = 0,807 \times (\text{długość fali w nm}) \times \text{sprawność kwantowa (QE)}$.

Uwaga techniczna:

Sprawność kwantową wyraża się zwykle w postaci procentowej; jednakże do celów niniejszego wzoru sprawność kwantowa wyrażona jest jako liczba dziesiętna mniejsza niż jeden, np. 78 % to 0,78.

„Szerokość pasma czasu rzeczywistego” (3), w „dynamicznych analizatorach sygnałów”, oznacza największy zakres częstotliwości, dla którego analizator może przekształcać w trybie ciągłym dane z domeny czasowej całkowicie w wyniki z domeny częstotliwości za pomocą transformacji Fouriera lub innej dyskretniej w czasie transformacji, która przetwarza każdy przychodzący punkt czasu bez przerwy lub efektów okna (windowing) powodujących zmniejszenie mierzonej amplitudy o więcej niż 3 dB poniżej rzeczywistej amplitudy sygnału, i jednocześnie wydać i wyświetlić przekształcone dane.

„Przetwarzanie w czasie rzeczywistym” (2, 6, 7) oznacza przetwarzanie danych przez system komputerowy, zapewniające żądany poziom realizacji zadań w funkcji dostępnych środków, w gwarantowanym czasie odpowiedzi, bez względu na obciążenie systemu, kiedy jest on stymulowany przez wydarzenia zewnętrzne.

„Powtarzalność” (7) oznacza stopień zgodności powtarzanych pomiarów tej samej zmiennej w tych samych warunkach operacyjnych w sytuacji, gdy pomiędzy pomiarami występują zmiany warunków lub przerwy w działaniu. (Zob. IEEE STD 528-2001 (odchylenie standardowe wielkości 1 sigma)).

„Niezbędne” (UOdT 1-9) - w odniesieniu do „technologii” - dotyczy tylko tej części „technologii”, która jest szczególnie odpowiedzialna za osiągnięcie lub przekroczenie wartości parametrów, właściwości lub funkcji objętych kontrolą. Taka „niezbędna” „technologia” może być wspólna dla różnych produktów.

„Rozdzielczość” (2) oznacza najmniejszą działkę urządzenia pomiarowego; w przyrządach cyfrowych jest to najmniej znaczący bit (zob. ANSI B-89-1.12).

„Środek rozpraszania tłumy” (1) oznacza substancje, które w warunkach użycia dla rozproszenia tłumy szybko wywołują u ludzi podrażnienie receptorów zmysłów lub psychiczny efekt unieszkodliwienia, znikający po krótkim czasie od usunięcia przyczyny.

Uwaga techniczna:

Gazy łzawiące stanowią podzbiór „środków rozpraszania tłumy”.

„Robot” (2, 8) oznacza mechanizm manipulacyjny poruszający się po ścieżce ciągłej lub od punktu do punktu, mogący korzystać z „czujników” i mający wszystkie następujące cechy:

- a. jest wielofunkcyjny;
- b. ma możliwość ustawiania w odpowiednim położeniu lub orientowania przestrzennego materiałów, części, narzędzi lub urządzeń specjalnych poprzez wykonywanie zmiennych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej;
- c. jest wyposażony w trzy lub większą liczbę mechanizmów wspomagających, m.in. silników krokowych, pracujących w obwodzie zamkniętym lub otwartym; oraz
- d. ma „możliwość programowania przez użytkownika” metodą uczenia/odtwarzania lub za pomocą komputera elektronicznego, który może być programowanym sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechanicznej.

NB.: *Niniejsza definicja nie obejmuje kontrolą następujących urządzeń:*

1. *mechanizmów poruszanych wyłącznie ręcznie lub zdalnie przez operatora;*
2. *mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów nie są zmienne ani zmienialne za pomocą środków mechanicznych, elektronicznych lub elektrycznych;*
3. *mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych, choć nastawnych, ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów są zmienne w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub modyfikacji schematu programowego (np. zmiany kolków lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach współrzędnych dokonuje się wyłącznie na drodze działań mechanicznych;*
4. *mechanizmów manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wyłącznie za pomocą sygnału binarnego z elektrycznych urządzeń binarnych o ustalonym mechanicznie położeniu lub nastawnych ograniczników;*
5. *żurawi do stertowania, definiowanych jako systemy manipulatorów działające w kartezjańskim układzie współrzędnych, produkowanych jako integralne części pionowych zespołów do silosów, i służące do uzyskiwania dostępu do zawartości tych silosów w celu składowania lub wyjmowania.*

„Atomizacja rotacyjna” (1) oznacza proces rozpylania strumienia lub jeziora stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 µm lub mniejszej za pomocą siły odśrodkowej.

„Rowing” (1) oznacza wiązkę (zazwyczaj 12-120 szt.) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle ‘skrętek’.

NB.: ‘Skrętka’ oznacza wiązkę „włókien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle.

„Bicie promieniowe” (odchylenie od właściwego ruchu) (2) oznacza promieniowe przemieszczenie głównego wrzeciona w ciągu jednego obrotu, mierzone w płaszczyźnie prostopadłej do osi wrzeciona w punkcie znajdującym się na zewnętrznej lub wewnętrznej badanej powierzchni obrotowej (zob. ISO 230 część 1-1986, pkt 5.61).

„Współczynnik skalowania (żyroskopu lub akcelometru)” (7) oznacza stosunek zmiany wartości wyjściowej do zmiany wartości wejściowej, która ma być mierzona. Współczynnik skalowania jest na ogół szacowany jako nachylenie linii prostej, którą można poprowadzić metodą najmniejszych kwadratów pomiędzy punktami określającymi parametry wejściowe/wyjściowe, uzyskanymi poprzez cykliczną zmianę parametrów wejściowych w przedziale ich wartości.

„Czas ustalania” (3) oznacza czas, jaki podczas przełączania przetwornika z jednego poziomu na drugi potrzebny jest do otrzymania na wyjściu wartości różniącej się o połowę bitu od wartości końcowej.

„SHPL” – zob. „Laser o super wysokiej mocy”.

„Analizatory sygnałów” (3) oznaczają urządzenia do pomiaru i pokazywania podstawowych parametrów sygnałów o jednej częstotliwości, będących składowymi sygnałów wieloczęstotliwościowych.

„Przetwarzanie sygnałów” (3, 4, 5, 6) oznacza przetwarzanie sygnałów zawierających informacje, uzyskanych ze źródeł zewnętrznych, za pomocą algorytmów, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, ekstrakowanie, selekcja, korelacja, splatanie lub przemieszczanie pomiędzy domenami (np. za pomocą szybkiej transformacji Fouriera lub transformacji Walsha).

„Oprogramowanie” (cała UODO) oznacza zbiór jednego lub większej liczby „programów” lub ‘mikroprogramów’, utrwalony na dowolnym materialnym nośniku.

NB.: ‘Mikroprogram’ oznacza sekwencję elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamięci, realizowanych po wprowadzeniu do rejestru instrukcji specjalnej dla niej instrukcji odwołania.

„Kod źródłowy (lub język źródłowy)” (6, 7, 9) oznacza wygodny sposób wyrażenia jednego lub kilku procesów, który może być przekształcony przez system programowania w postać dającą się wykonać na urządzeniu („kod wynikowy” (lub język wynikowy)).

„Statek kosmiczny” (7, 9) oznacza czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.

„Klasy kosmicznej” (3, 6, 7) - odnosi się do produktów zaprojektowanych, wykonanych lub po pomyślnych testach zakwalifikowanych do użycia na wysokości powyżej 100 km nad powierzchnią Ziemi.

NB.: Stwierdzenie na podstawie testu, że konkretny przedmiot jest „klasy kosmicznej”, nie oznacza, że inne przedmioty z tej samej partii produkcyjnej lub serii modelu są „klasy kosmicznej”, jeżeli nie przeszły one indywidualnych testów.

„Specjalny materiał rozszczepialny” (0) oznacza pluton-239, uran-233, „uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233” oraz dowolne zawierające je materiały.

„Moduł właściwy” (0, 1, 9) oznacza moduł Younga w paskalach ($1 \text{ paskal} = 1 \text{ N/m}^2$) podzielony przez ciężar właściwy w N/m^3 , mierzony w temperaturze $(296 \pm 2) \text{ K}$ ($(23 \pm 2) ^\circ \text{C}$) i przy wilgotności względnej $(50 \pm 5) \%$.

„Wytrzymałość właściwa na rozciąganie” (0, 1, 9) oznacza wytrzymałość na rozciąganie w paskalach ($1 \text{ paskal} = 1 \text{ N/m}^2$) podzieloną przez ciężar właściwy w N/m^3 , mierzoną w temperaturze $(296 \pm 2) \text{ K}$ ($(23 \pm 2) ^\circ \text{C}$) i przy wilgotności względnej $(50 \pm 5) \%$.

„Żyroskopy wirujące” (7) to żyroskopy wykorzystujące stale obracającą się masę do wykrywania ruchu obrotowego.

„Chłodzenie ultraszybkie” (1) oznacza technikę ‘gwałtownego krzepnięcia’ polegającą na uderzaniu stopionego strumienia metalu w chłodzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci płatków.

NB.: *‘Gwałtowne krzepnięcie’: krzepnięcie roztopionego materiału podczas chłodzenia z szybkością powyżej 1000 K/s.*

„Widmo rozproszone” (5) oznacza dowolną technikę służącą do rozpraszania energii sygnału ze stosunkowo wąskiego kanału telekomunikacyjnego na dużo szersze widmo energii.

„Radar o rozproszonym widmie” (6) - zob. „Rozproszone widmo radarowe”.

„Stabilność” (7) oznacza odchylenie standardowe (1 sigma) zmienności danego parametru od jego wartości wzorcowej zmierzonej w ustalonych warunkach temperaturowych. Można ją wyrażać w funkcji czasu.

„Państwa (nie)będące stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” (1) są to te państwa, w których Konwencja o zakazie rozwijania, produkcji, składowania i stosowania broni chemicznej (nie) weszła w życie. (zob. www.opcw.org)

„Podłoże” (3) oznacza płytkę materiału głównego z naniesionymi połączeniami lub bez nich, na której lub wewnątrz której można umieszczać ‘składniki dyskretne’ lub układy scalone.

NB. 1: *‘Składnik dyskretny’: ‘element układu’ w oddzielnej obudowie z własnymi końcówkami wyjściowymi.*

NB. 2: *‘Element układu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna część układu elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden kondensator itp.*

„Półprodukt podłoży” (3, 6) oznacza materiał monolityczny o wymiarach umożliwiających wytworzenie z niego elementów optycznych, takich jak zwierciadła lub okienka optyczne.

„Podjednostka toksyny” (1) oznacza strukturalnie i funkcjonalnie oddzielny składnik „toksyny”.

„Nadstopy” (2, 9) oznaczają stopy na osnowie niklu, kobaltu lub żelaza o bardzo wysokiej wytrzymałości w porównaniu z innymi stopami serii AISI 300 w temperaturach powyżej 922 K ($649 ^\circ \text{C}$), w skrajnych warunkach środowiskowych i eksploatacyjnych.

„Nadprzewodniki” (1, 3, 5, 6, 8) oznaczają materiały, tj. metale, stopy lub związki, które mogą całkowicie stracić swoją oporność, tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania ciepła Joule’a.

NB.: *„Nadprzewodzący” stan materiału jest indywidualnie scharakteryzowany „temperaturą krytyczną”, krytycznym polem magnetycznym, będącym funkcją temperatury, oraz krytyczną gęstością prądu, która jest funkcją zarówno pola magnetycznego, jak i temperatury.*

„Laser o super wysokiej mocy” („SHPL”) (6) oznacza „laser”, który może dostarczyć energię wyjściową (całkowitą lub częściową) powyżej 1 kJ w ciągu 50 ms lub taki, którego moc przeciętna lub moc w przypadku fali ciągłej wynosi powyżej 20 kW.

„Formowanie w stanie nadplastycznym” (1, 2) oznacza technikę odkształcania termicznego metali, których wydłużenie całkowite do zerwania, mierzone w temperaturze pokojowej tradycyjnymi technikami badania wytrzymałości na rozciąganie, w normalnych warunkach, jest bardzo małe (poniżej 20 %); jej celem jest co najmniej dwukrotne powiększenie tych wartości podczas obróbki.

„Algorytm symetryczny” (5) oznacza algorytm kryptograficzny, w którym stosuje się identyczne klucze do szyfrowania i deszyfrowania.

NB.: Powszechnym zastosowaniem „algorytmu symetrycznego” jest utajnianie danych.

„Ścieżki systemowe” (6) oznaczają przetworzone, skorelowane (połączenie radiolokacyjnych danych o celu z położeniem lecącego statku powietrznego) i zaktualizowane dane dotyczące położenia lecącego statku powietrznego, przekazane kontrolerom w ośrodku kontroli ruchu powietrznego.

„Komputer z dynamiczną modyfikacją tablic” (4) oznacza komputer, w którym przepływ i modyfikacja danych są dynamicznie sterowane przez użytkownika na poziomie bramek logicznych.

„Taśma” (1) oznacza materiał zbudowany z przeplatanych lub jednakowo ukierunkowanych „włókien elementarnych”, „skrętek”, „rowingów”, „kabli” lub „przędz” itp., zazwyczaj impregnowany żywicą.

NB.: ‘Skrętka’ oznacza wiązkę „włókien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle.

„Technologia” (wszystkie UoDT UdTJ) oznacza specyficzny rodzaj informacji, niezbędny do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postać ‘danych technologicznych’ lub ‘pomocy technicznej’.

NB. 1: ‘Pomoc techniczna’ może przybierać takie formy, jak: przekazanie instrukcji, umiejętności, szkolenie, przekazanie wiedzy na temat eksploatacji oraz usługi konsultacyjne i może obejmować transfer ‘danych technologicznych’.

NB. 2: ‘Dane technologiczne’ mogą mieć formę odbitek, planów, wykresów, modeli, wzorów, tabel, projektów technicznych i opisów, podręczników i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nośnikach lub urządzeniach, takich jak dyski, taśmy, pamięci wyłącznie do odczytu.

„Trójwymiarowy układ scalony” (3) oznacza zbiór płytek półprzewodnikowych zintegrowanych ze sobą i mających otwory przechodzące całkowicie przez co najmniej jedną płytkę w celu utworzenia połączenia między płytkami.

„Wrzeciono wahadłowe” (2) oznacza wrzeciono (uchwyt) do narzędzi, zmieniające podczas procesu obróbki położenie katowe swojej osi względem dowolnej innej osi.

„Stała czasowa” (6) oznacza czas, który upływa od pojawienia się bodźca świetlnego do momentu, kiedy prąd wzrośnie do wartości równej wielkości końcowej pomnożonej przez $1-1/e$ (tj. 63 % wartości końcowej).

„Bandaż” (9) oznacza element składowy pierścienia stacjonarnego (jednolity lub o budowie segmentowej) zamocowany na powierzchni wewnętrznej korpusu turbiny lub element znajdujący się na końcówce łopatk turbiny, który służy przede wszystkim jako uszczelnienie gazodynamiczne między elementami stacjonarnymi a wirującymi.

„Kompleksowe sterowanie lotem” (7) oznacza automatyczne sterowanie zmiennymi stanu „statku powietrznego” i toru lotu dla zrealizowania zadania bojowego odpowiednio do zmian w czasie rzeczywistym danych dotyczących celu, zagrożeń lub innych „statków powietrznych”.

„Całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych” (5) oznacza liczbę bitów, łącznie z bitami kodowymi linii, bitami nieinformacyjnymi i podobnymi, przepływających w jednostce czasu pomiędzy odpowiednimi urządzeniami w cyfrowym systemie transmisji.

NB.: Zob. także „szybkość transmisji danych cyfrowych”.

„Kabel” (1) oznacza wiązkę „włókien elementarnych”, zazwyczaj uporządkowanych w przybliżeniu równolegle.

„Toksyny” (1, 2) oznaczają toksyny w postaci celowo wyizolowanych preparatów lub mieszanek, bez względu na sposób produkcji, różne od toksyn istniejących jako zanieczyszczenia innych materiałów, takich jak próbki patogenne, plony, żywność lub posiewy „mikroorganizmów”.

„Laser z przekazaniem energii” (6) oznacza „Laser”, w którym czynnik emitujący promieniowanie laserowe jest wzbudzany dzięki transferowi energii wskutek zderzeń atomów lub molekuł, niebiorących udziału w akcji laserowej, z atomami lub molekułami czynnika emitującego promieniowanie laserowe.

„Przestrajalność” (6) oznacza zdolność „lasera” do wytwarzania ciągłego sygnału wyjściowego we wszystkich długościach fal w przedziale kilku przejść „laserowych”. „Laser” z selekcją liniową wytwarza dyskretne długości fal w ramach jednego przejścia „laserowego” i nie jest uważany za „przestrajalny”.

„Bezzałogowy statek powietrzny” („UAV”) (9) oznacza każdy statek powietrzny zdolny do wzniesienia się w powietrze i kontynuowania kontrolowanego lotu i nawigacji bez obecności ludzi na pokładzie.

„Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233” (0) oznacza uran zawierający izotopy 235 lub 233 w takich ilościach, że stosunek łącznej zawartości tych izotopów do izotopu 238 jest większy niż stosunek zawartości izotopu 235 do izotopu 238 występujący w naturze (stosunek izotopowy 0,71 procent).

„Użytkowanie” (wszystkie UOdT UdTJ) oznacza eksploatację, instalowanie (łącznie z instalowaniem na miejscu), konserwację (kontrolę), naprawę, remonty i modernizację.

„Możliwość programowania przez użytkownika” (6) oznacza możliwość wprowadzania, modyfikacji lub wymiany „programów” przez użytkownika na innej drodze niż poprzez:

- a. fizyczną modyfikację okablowania lub połączeń; lub
- b. ustawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie parametrów.

„Szczepionka” (1) oznacza produkt leczniczy w postaci wyrobu farmaceutycznego, w odniesieniu do którego władze kraju produkcji lub kraju stosowania wydały zezwolenie na wprowadzanie do obrotu lub na prowadzenie badań klinicznych, a który wprowadzony do ustroju ludzkiego lub zwierzęcego ma za zadanie wytworzenie w nim ochronnej odporności immunologicznej w celu zapobiegania chorobom.

„Atomizacja próżniowa” (1) oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 µm lub mniejszej poprzez szybkie uwolnienie rozpuszczonego gazu w warunkach podciśnienia.

„Profile o zmiennej geometrii” (7) oznaczają profile, w których zastosowano klapy lub inne płaszczyzny na krawędzi spływu lub sloty lub osadzone przegubowo noski na krawędzi natarcia, którymi można sterować w locie.

„Przędza” (1) oznacza wiązkę skręconych ‘skrętek’.

NB.: ‘Skrętka’ oznacza wiązkę „włókien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200) uporządkowanych w przybliżeniu równolegle.

KATEGORIA 0 - MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWE

0A Systemy, urządzenia i części składowe

- 0A001 Następujące „reaktory jądrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia i podzespoły:
- „reaktory jądrowe”;
 - metalowe zbiorniki lub główne prefabrykowane części do nich, w tym górne pokrywy zbiornika ciśnieniowego reaktora, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia „reaktora jądrowego”;
 - urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku i wyładunku elementów paliwowych „reaktorów jądrowych”;
 - pręty regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w „reaktorze jądrowym”, odpowiednie elementy nośne lub zawieszenia, mechanizmy napędu oraz przewodnice rurowe do prętów regulacyjnych;
 - przewody ciśnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem zarówno na elementy paliwowe, jak i chłodziwo w „reaktorze jądrowym”;
 - rury (lub zespoły rur) z cyrkonu metalicznego lub jego stopów specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zastosowania jako okładzina paliwa w „reaktorach jądrowych”, w ilościach przekraczających 10 kg;
- NB.: W przypadku rur ciśnieniowych z cyrkonu zob. 0A001.e, zaś w przypadku rur calandrii zob. 0A001.h.*
- pompy pierwotnego obiegu lub pompy cyrkulacyjne specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chłodziwa w „reaktorach jądrowych”;
 - „zespoły wewnętrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w „reaktorze jądrowym”, w tym elementy nośne rdzenia, kanały paliwowe, rury calandrii, osłony termiczne, przegrody, siatki dystansujące rdzenia i płyty rozpraszające;
- Uwaga techniczna:
W pozycji 0A001.h „zespoły wewnętrzne reaktora” oznaczają dowolną większą strukturę wewnątrz zbiornika reaktora wypełniającą jedną lub więcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłon radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego.*
- wymienniki ciepła, takie jak:
 - wytwornice pary specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do obiegu pierwotnego lub pośredniego „reaktora jądrowego”;
 - inne wymienniki ciepła specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym „reaktora jądrowego”;
- Uwaga: Pozycja 0A001.i nie obejmuje kontroli wymienników ciepła w systemach wspierających reaktora, np. systemie chłodzenia awaryjnego lub systemie odprowadzania ciepła powyłłączeniowego.*
- detektory neutronów specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do określania poziomu strumienia neutronów wewnątrz rdzenia „reaktora jądrowego”;

- k. 'zewewnętrzne tarcze termiczne' specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytku w „reaktorach jądrowych” w celu zmniejszenia strat ciepła oraz ochrony zbiornika.

Uwaga techniczna:

W pozycji 0A001.k „zewewnętrzne tarcze termiczne” oznaczają dużego rozmiaru struktury umieszczone nad zbiornikiem reaktora, służące do ograniczania strat ciepła z reaktora i do zmniejszania temperatury wewnątrz zbiornika.

0B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

0B001 Następujące instalacje do separacji izotopów z „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” i „specjalnych materiałów rozszczepialnych” oraz urządzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

- a. następujące instalacje specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” oraz „specjalnych materiałów rozszczepialnych”:
1. instalacje do rozdzielania gazów metodą wirowania;
 2. instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazów;
 3. instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;
 4. instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;
 5. instalacje do rozdzielania techniką wymiany jonów;
 6. instalacje do rozdzielania izotopów w postaci par metalu za pomocą „laserów” (AVLIS);
 7. instalacje do rozdzielania izotopów w postaci molekularnej za pomocą „laserów” (MLIS);
 8. instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;
 9. instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;
- b. następujące wirówki gazowe oraz zespoły i urządzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w procesach wzbogacania metodą wirowania gazów:

Uwaga techniczna:

W pozycji 0B001.b „material o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości” oznacza którekolwiek z poniższych:

1. *stal maraging o wytrzymałości na rozciąganie równej 1,95 GPa lub większej;*
 2. *stopy glinu o wytrzymałości na rozciąganie równej 0,46 GPa lub większej; lub*
 3. *„materiały włókniste lub włókienkowe” o „module właściwym” powyżej $3,18 \times 10^6 \text{ m}$ i „wytrzymałości właściwej na rozciąganie” powyżej $7,62 \times 10^4 \text{ m}$;*
1. wirówki gazowe;
 2. kompletne zespoły wirników;
 3. cylindryczne zespoły wirników o grubości 12 mm lub mniejszej, średnicy od 75 do 650 mm, wykonane z „materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości”;
 4. pierścienie lub mieszki ze ściankami o grubości 3 mm lub mniejszej i średnicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do lokalnego osadzenia cylindra wirnika lub do połączenia ze sobą wielu cylindrów wirników, wykonane z „materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości”;

5. deflektory o średnicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do instalowania wewnątrz cylindra wirnika odśrodkowego, wykonane z „materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości”;

6. pokrywy górne lub dolne o średnicy od 75 mm do 650 mm pasujące do końców cylindra wirnika, wykonane z „materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości”;
7. następujące łożyska na poduszce magnetycznej:
 - a. zespoły łożysk składające się z pierścieniowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF_6 ” lub chronionej takimi materiałami, zawierającej wewnątrz czynnik tłumiący i posiadające magnes sprzężony z nabiegunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie górnej wirnika;
 - b. aktywne łożyska magnetyczne specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w wirówkach gazowych;
8. specjalnie wykonane łożyska składające się z zespołu czop-panewka osadzonego na amortyzatorze;
9. pompy molekularne zawierające cylindry z wewnętrznymi, obrobionymi techniką skrawania lub wytłoczonymi, spiralnymi rowkami i wewnętrznymi wywierconymi otworami;
10. pierścieniowe stojany do wysokoobrotowych wielofazowych silników histerezy (lub reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w próżni z częstotliwością 600 Hz lub większą i mocą 40 woltoamperów lub większą;
11. obudowy (komory) wirówek, w których znajdują się zespoły wirników cylindrycznych wirówki gazowej, składające się ze sztywnego cylindra ze ściankami o grubości do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi końcami, które są równoległe do siebie i prostopadłe do osi wzdłużnej cylindra w zakresie 0,05 stopnia lub mniej;
12. zbieraki składające się ze specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych rurek, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UF_6 z wirnika na zasadzie rurki Pitota, które mogą być zamocowane w centralnym układzie ekstrakcji gazu;
13. przemienniki częstotliwości (konwertery lub inwertery) specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zasilania stojanów silników wirówek gazowych do wzbogacania, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:
 - a. wyjście wielofazowe o częstotliwości 600 Hz lub większej; oraz
 - b. wysoka stabilność (z regulacją częstotliwości z dokładnością lepszą niż 0,2 %);
14. następujące zawory odcinające i sterujące:
 - a. zawory odcinające specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy z surowcem, produktem lub frakcjami końcowymi ze strumieni zawierających UF_6 poszczególnych wirówek gazowych;
 - b. zawory mieszkowe odcinające lub sterujące o średnicy wewnętrznej od 10 do 160 mm wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF_6 ” lub chronione takimi materiałami, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytku w głównych i pomocniczych układach zakładów wzbogacania stosujących wirówki gazowe;
- c. następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do separacji metodą dyfuzji gazowej;

1. przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych, polimerowych lub ceramicznych „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF_6 ”, posiadające pory o średnicach od 10 do 100 nm, grubość 5 mm lub mniejszą oraz, w przypadku elementów cylindrycznych, średnicę 25 mm lub mniejszą;

2. obudowy dyfuzorów gazowych wykonane lub chronione „materiałami odpornymi na korozyjne działanie UF₆”;
 3. sprężarki lub dmuchawy do gazów o objętościowej pojemności ssania UF₆ wynoszącej 1 m³/min lub więcej, o ciśnieniu wylotowym do 500 kPa oraz stosunku ciśnienia 10:1 lub mniejszym, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF₆” lub chronione takimi materiałami;
 4. uszczelnienia wirujących wałów sprężarek lub dmuchaw wymienionych w pozycji 0B001.c.3, skonstruowane w taki sposób, żeby objętościowe natężenie przepływu gazu buforowego przez nieszczelności wynosiło poniżej 1 000 cm³/min;
 5. wymienniki ciepła wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF₆” lub chronione takimi materiałami, zaprojektowane do pracy z natężeniem przepływu przez nieszczelności na poziomie mniejszym niż 10 Pa na godzinę przy różnicy ciśnień rzędu 100 kPa;
 6. zawory mieszkowe odcinające lub sterujące, obsługiwane ręcznie lub automatycznie, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF₆” lub chronione takimi materiałami;
- d. następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do aerodynamicznego wzbogacania materiałów:
1. dysze separujące składające się ze szczelinowych zakrzywionych kanałów o promieniu krzywizny poniżej 1 mm, odporne na korozyjne działanie UF₆, zawierające w środku ostre krawędzie rozdzielające gaz płynący w dyszach na dwa strumienie;
 2. cylindryczne lub stożkowe rury (rurki wirowe) wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF₆” lub też zabezpieczone takimi materiałami, mające co najmniej jeden wlot styczny;
 3. sprężarki lub dmuchawy do gazów wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF₆” lub zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;
 4. wymienniki ciepła wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF₆” lub zabezpieczone takimi materiałami;
 5. obudowy elementów rozdzielających, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF₆” lub zabezpieczone takimi materiałami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielające;
 6. zawory mieszkowe odcinające lub sterujące, obsługiwane ręcznie lub automatycznie, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF₆” lub chronione takimi materiałami, mające średnicę 40 mm lub większą;
 7. instalacje przetwórcze do oddzielania UF₆ od gazu nośnego (wodoru lub helu) do zawartości 1 ppm UF₆ lub mniejszej, w tym:
 - a. kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120°C) lub niższych;
 - b. zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120°C) lub niższych;
 - c. urządzenia z dyszami rozdzielającymi lub rurkami wirowymi do oddzielania UF₆ od gazu nośnego;

- d. wymrażarki UF_6 zdolne do wymrażania UF_6 ;
- e. następujące urządzenia i podzespoły do nich, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materiałów techniką wymiany chemicznej:

1. cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu urządzenia wynoszącym 30 sekund lub krótszym oraz odporne na stężony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowęglowodorowe lub szkło, lub pokryte takimi materiałami);
 2. cieczowo-cieczowe kontaktory odśrodkowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu urządzenia wynoszącym 30 sekund lub krótszym oraz odporne na stężony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowęglowodorowe lub szkło, lub pokryte takimi materiałami);
 3. elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na działanie roztworów kwasu solnego, do obniżania wartościowości uranu;
 4. urządzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierające U^{+4} ze strumieni substancji organicznych, wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materiałów lub chronione takimi materiałami (na przykład szkło, polimery fluorowęglowe, polisilarszan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany żywicą);
 5. urządzenia do przygotowywania półproduktów do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystości, składające się z zespołów do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu U^{+6} lub U^{+4} do U^{+3} ;
 6. urządzenia do utleniania uranu ze stanu U^{+3} do U^{+4} ;
- f. następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materiałów techniką wymiany jonów:
1. szybko reagujące żywice jonowymienne, żywice błonkowe lub porowate makrosiatkowe, w których grupy chemiczne biorące aktywny udział w wymianie znajdują się wyłącznie w powłoce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury nośnej, oraz inne materiały kompozytowe w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci cząstek lub włókien, ze średnicami wynoszącymi 0,2 mm lub mniej, odporne na stężony kwas solny i wykonane w taki sposób, że ich półczas wymiany wynosi poniżej 10 sekund, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C);
 2. kolumny jonitowe (cyldryczne) o średnicy powyżej 1 000 mm, wykonane z materiałów odpornych na stężony kwas solny lub chronione takimi materiałami (np. tytan lub tworzywa fluorowęglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C) i przy ciśnieniach powyżej 0,7 MPa;
 3. jonitowe urządzenia zwrotne (urządzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do regeneracji substancji do chemicznej redukcji lub utleniania, stosowanych w jonitowych kaskadach do wzbogacania materiałów;

- g. następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zastosowania w technologii opartej na parach metalu:
1. urządzenia do przeprowadzania uranu w stan pary przeznaczone do uzyskiwania docelowej mocy wyjściowej 1 kW lub większej do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocą laserów;
 2. systemy operowania uranem metalicznym w stanie cieczy lub pary, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do operowania stopionym uranem, stopami uranu stopionego lub uranem metalicznym w stanie pary do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocą laserów, jak również specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły;

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2A225.

3. zespoły do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych uranu metalicznego w postaci ciekłej lub stałej, wykonane z materiałów odpornych na działanie cieplne i korozyjne uranu metalicznego w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi materiałami;
4. obudowy modułów urządzeń rozdzielających (zbiorniki cylindryczne lub prostopadłościennne) przeznaczone na źródła par uranu metalicznego, działa elektronowe oraz urządzenia do gromadzenia produktu i frakcji końcowych;
5. „lasery” lub systemy „laserów” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopów uranu, wyposażone w stabilizatory częstotliwości przystosowane do pracy przez dłuższe okresy;

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 6A005 I 6A205.

- h. następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do technologii molekularnych lub systemów laserowych:
1. naddźwiękowe dysze rozprężne do chłodzenia mieszanin UF_6 z gazem nośnym do temperatur 150 K (-123 °C) lub niższych, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF_6 ”;
 2. podzespoły lub urządzenia do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do gromadzenia materiału uranowego i materiału frakcji końcowych uranu po naświetleniu światłem lasera, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF_6 ”;
 3. sprężarki wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF_6 ” lub zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;
 4. urządzenia do fluorowania UF_5 (stałego) do UF_6 (gazowego);
 5. urządzenia przetwórcze do oddzielania UF_6 od gazu nośnego (np. azotu, argonu lub innego gazu), w tym:
 - a. kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120°C) lub niższych;
 - b. zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120°C) lub niższych;
 - c. wymrażarki UF_6 zdolne do wymrażania UF_6 ;

6. „lasery” lub systemy „laserów” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopów uranu, wyposażone w stabilizatory częstotliwości przystosowane do pracy przez dłuższe okresy;

NB.: *ZOB. TAKŻE POZYCJE 6A005 I 6A205.*

- i. następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do plazmowego rozdzielania materiałów:
1. źródła mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonów, o częstotliwości wyjściowej powyżej 30 GHz i średniej mocy wyjściowej powyżej 50 kW;
 2. wysokoczęstotliwościowe cewki do wzbudzania jonów pracujące w zakresie częstotliwości powyżej 100 kHz i zdolne do pracy w warunkach średniej mocy powyżej 40 kW;
 3. urządzenia do wytwarzania plazmy uranowej;
 4. nieużywane;
 5. zespoły do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych uranu metalicznego w postaci stałej, wykonane z materiałów odpornych na działanie cieplne i korozyjne uranu w postaci pary, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi materiałami;
 6. obudowy modułów separatorów (cylindryczne) na źródło plazmy uranowej, cewki na prądy wysokiej częstotliwości oraz kolektory do produktu i frakcji końcowych, wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej);
- j. następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materiałów metodami elektromagnetycznymi:
1. źródła jonów, pojedyncze lub wielokrotne, składające się ze źródła pary, jonizatora oraz akceleratora wiązki wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wiązki jonów o całkowitym natężeniu 50 mA lub większym;
 2. płytkowe kolektory jonów do gromadzenia wzbogaconych lub zubożonych wiązek jonów uranu, składające się z dwóch lub więcej szczelin i kieszeni i wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);
 3. obudowy próżniowe do elektromagnetycznych separatorów uranu wykonane z materiałów niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach 0,1 Pa lub niższych;
 4. elementy biegunów magnesów o średnicy powyżej 2 m;
 5. wysokonapięciowe zasilacze do źródeł jonów, posiadające wszystkie następujące cechy:
 - a. zdolność do pracy w trybie ciągłym;
 - b. napięcie wyjściowe 20 000 V lub większe;
 - c. natężenie prądu na wyjściu 1 A lub większe; oraz
 - d. regulacja napięcia z dokładnością lepszą niż 0,01 % w ciągu 8 godzin;
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 3A227.*
6. zasilacze magnesów (wysokiej mocy, prądu stałego), posiadające wszystkie następujące cechy:
 - a. zdolność do pracy w trybie ciągłym z prądem wyjściowym o natężeniu 500 A lub większym i napięciu 100 V lub większym; oraz

- b. regulacja natężenia lub napięcia prądu z dokładnością lepszą niż 0,01 % w ciągu 8 godzin.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 3A226.

- 0B002 Następujące specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urządzenia i podzespoły do instalacji separacji izotopów wymienionych w pozycji 0B001, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF_6 ” lub chronione materiałami tego typu:
- a. autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF_6 do instalacji do wzbogacania;
 - b. desublimatory lub wymrażarki do odprowadzania UF_6 z instalacji przetwórczych i dalszego jego transportu po ogrzaniu;
 - c. instalacje do produktu lub frakcji końcowych do transportu UF_6 do zbiorników;
 - d. instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF_6 z procesu wzbogacania drogą sprężania, chłodzenia i przetwarzania UF_6 w ciecz lub ciało stałe;
 - e. instalacje rurociąagowe i zbiorniki specjalnie zaprojektowane lub wykonane do transportu i manipulowania UF_6 w procesach rozdzielania izotopów metodą dyfuzji, ultrawierowania lub kaskady aerodynamicznej;
 - f. następujące układy próżniowe i pompy:
 - 1. próżniowe instalacje rur rozgałęźnych lub zbiorników lub pompy próżniowe o wydajności ssania wynoszącej 5 m³ na minutę lub więcej;
 - 2. pompy próżniowe specjalnie zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierającej UF_6 , wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF_6 ” lub zabezpieczone takimi materiałami; lub
 - 3. układy próżniowe składające się z próżniowych instalacji rur rozgałęźnych lub zbiorników i pomp próżniowych, zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierającej UF_6 ;
 - g. spektrometry masowe (źródła jonów) zdolne do bieżącego (on-line) pobierania próbek ze strumieni zawierających UF_6 , posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:
 - 1. zdolność do pomiaru mas jonów o wartości 320 mas atomowych lub większa i rozdzielczość lepsza niż 1 część na 320;
 - 2. źródła jonów wykonane z niklu, stopu niklu i miedzi o zawartości niklu 60 % masy lub większej lub stopów niklu i chromu lub nimi zabezpieczone;
 - 3. elektronowe źródła jonizacyjne; oraz
 - 4. wyposażenie w kolektory umożliwiające analizę izotopową.
- 0B003 Następujące instalacje do przetwarzania uranu i urządzenia specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do nich:
- a. instalacje do przetwarzania koncentratów rudy uranowej na UO_3 ;
 - b. instalacje do przetwarzania UO_3 na UF_6 ;
 - c. instalacje do przetwarzania UO_3 na UO_2 ;
 - d. instalacje do przetwarzania UO_2 na UF_4 ;
 - e. instalacje do przetwarzania UF_4 na UF_6 ;
 - f. instalacje do przetwarzania UF_4 na uran metaliczny;
 - g. instalacje do przetwarzania UF_6 na UO_2 ;
 - h. instalacje do przetwarzania UF_6 na UF_4 ;
 - i. instalacje do przetwarzania UO_2 na UCl_4 .
- 0B004 Następujące instalacje do produkcji lub stężenia ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru oraz specjalnie do nich zaprojektowane i wykonane urządzenia i podzespoły:
- a. następujące instalacje do produkcji ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru:
 - 1. instalacje do produkcji metodą wymiany woda-siarkowodór;
 - 2. instalacje do produkcji metodą wymiany amoniak-wodór;

b. następujące urządzenia i podzespoły:

1. kolumnowe wymienniki typu woda-siarkowodor mające średnicę 1,5 m lub większą i zdolność do pracy przy ciśnieniach równych lub większych niż 2 MPa;
2. jednostopniowe, niskociśnieniowe (np. 0,2 MPa), odśrodkowe dmuchawy lub kompresory wymuszające cyrkulację gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierającego więcej niż 70 % H_2S), o przepustowości równej lub większej niż $56 m^3/s$ podczas pracy przy ciśnieniach zasysania równych lub większych niż 1,8 MPa, posiadające uszczelnienia umożliwiające pracę w środowisku wilgotnego H_2S ;
3. kolumnowe wymienniki typu amoniak-wodór o wysokości równej lub większej niż 35 m i średnicy od 1,5 m do 2,5 m, zdolne do pracy przy ciśnieniach większych niż 15 MPa;
4. konstrukcje wewnętrzne kolumn łącznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi, w tym zanurzeniowymi, do produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór;
5. instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy ciśnieniach równych lub większych niż 3 MPa przy produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór;
6. podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do bieżącej (on-line) analizy stosunku wodoru do deuteru w warunkach, w których stężenia deuteru są równe lub większe niż 90 %;
7. palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w ciężką wodę przy użyciu procesu wymiany amoniak-wodór;
8. kompletne systemy wzbogacania ciężkiej wody lub przeznaczone dla nich kolumny, przeznaczone do zwiększania koncentracji deuteru w ciężkiej wodzie do poziomu reaktorowego.
9. Konwertery do syntezy amoniaku lub urządzenia do syntezy amoniaku specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór.

0B005 Instalacje specjalnie zaprojektowane do wytwarzania elementów paliwowych do „reaktorów jądrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urządzenia.

Uwaga techniczna:

Instalacje do wytwarzania elementów paliwowych do „reaktorów jądrowych” obejmują urządzenia, które:

1. *pozostają w bezpośrednim kontakcie z materiałami jądrowymi lub bezpośrednio je przetwarzają lub sterują procesem ich produkcji;*
2. *uszczelniają materiały jądrowe wewnątrz ich koszulek;*
3. *kontrolują szczelność koszulek;*
4. *kontrolują końcową obróbkę paliwa stałego; lub*
5. *są wykorzystywane do montażu elementów reaktora.*

0B006 Instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) elementów paliwowych „reaktorów jądrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urządzenia i podzespoły.

Uwaga: *Pozycja 0B006 obejmuje:*

- a. *instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) elementów paliwowych „reaktorów jądrowych”, w tym urządzenia i podzespoły, które zazwyczaj wchodzi w bezpośredni kontakt z materiałami jądrowymi, służą do ich bezpośredniego przetwarzania lub sterowania ich przepływem;*
- b. *maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementów paliwowych, tj. zdalnie sterowane urządzenia do cięcia lub krojenia napromieniowanych (wypalonych w*

różnym stopniu) zespołów, wiązek lub prętów paliwowych „reaktorów jądrowych”;

- c. urządzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne (np. zbiorniki o małych średnicach, pierścieniowe lub płaskie), specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) paliwa do „reaktorów jądrowych”, odporne na działanie gorących, silnie żrących płynów oraz przystosowane do zdalnego załadunku i obsługi;
- d. ekstraktory rozpuszczalnikowe, takie jak kolumny z wypełnieniem lub impulsowe, mieszalniki odстойniki lub kontaktory odśrodkowe odporne na żrące działanie kwasu azotowego, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do wykorzystania w instalacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” lub „specjalnego materiału rozszczepialnego”;
- e. zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposób, że są podkrytyczne i odporne na żrące działanie kwasu azotowego;

Uwaga techniczna:

Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogą mieć następujące właściwości:

1. ścianki lub struktury wewnętrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym dla wszystkich składowych pierwiastków w sposób zdefiniowany w uwadze do pozycji 0C004);
 2. maksymalną średnicę 175 mm w przypadku zbiorników cylindrycznych; lub
 3. maksymalną szerokość 75 mm w przypadku zbiorników płytowych lub pierścieniowych;
- f. Neutronowe systemy pomiaru specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zamontowania i zastosowania wraz automatycznymi systemami sterowania procesami w instalacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” lub „specjalnego materiału rozszczepialnego”;

0B007 Instalacje do przetwarzania plutonu oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urządzenia i podzespoły:

- a. instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek plutonu;
- b. instalacje do wytwarzania plutonu metalicznego.

0C Materiały

0C001 „Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub więcej z powyższych materiałów.

Uwaga: Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrolą:

- a. czterech gramów lub mniejszej ilości „uranu naturalnego” lub „uranu zubożonego”, jeżeli znajduje się on w czujnikach instrumentów pomiarowych;
- b. „uranu zubożonego” specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu następujących produktów cywilnych spoza dziedziny jądrowej:
 1. osłony;
 2. wypełnienia;
 3. balasty o masie nieprzekraczającej 100 kg;
 4. przeciwwagi o masie nieprzekraczającej 100 kg;
- c. stopów zawierających mniej niż 5 % toru;
- d. produktów ceramicznych zawierających tor, ale wykonanych do zastosowań poza dziedziną jądrową.

0C002 „Specjalne materiały rozszczepialne”

Uwaga: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolą czterech „gramów efektywnych” lub mniejszej ilości w przypadku ich stosowania w czujnikach instrumentów pomiarowych.

0C003 Deuter, ciężka woda (tlenek deuteru) i inne związki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w których stosunek liczby atomów deuteru do atomów wodoru jest większy niż 1:5 000.

0C004 Grafit o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion „ekwiwalentu boru” oraz gęstości większej niż 1,50 g/cm³ przeznaczony do zastosowania w „reaktorach jądrowych”, w ilościach przekraczających 1 kg.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C107.

Uwaga 1: Dla celów kontroli wywozu właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę, stwierdzają, czy wywóz grafitu spełniającego powyższe specyfikacje ma na celu zastosowanie w „reaktorach jądrowych”.

Uwaga 2: W pozycji 0C004 „ekwiwalent boru” (BE) zdefiniowany jest jako suma BE_Z dla domieszek (z pominięciem BE_{carbon} dla węgla, ponieważ węgiel nie jest uważany za domieszkę) z uwzględnieniem boru, gdzie:

BE_Z (ppm) = CF x stężenie pierwiastka Z określane w ppm (częściach na milion)

$$\text{gdzie CF jest współczynnikiem przeliczeniowym} = \frac{\sigma_Z A_B}{\sigma_B A_Z}$$

zaś σ_B i σ_Z są przekrojami czynnymi na wychwyt neutronów termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z; A_B i A_Z są masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i pierwiastka Z.

0C005 Specjalnie wzbogacone związki lub proszki do wyrobu przegród do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne działanie UF₆ (np. nikiel lub stop zawierający 60 % wagowych lub więcej niklu, tlenek glinu i całkowicie fluorowane polimery węglowodorowe) o procentowym stopniu czystości w proporcji wagowej 99,9 % lub więcej i średniej wielkości cząstek poniżej 10 µm, mierzonej według normy Amerykańskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (ASTM) B330 i wysokim stopniu jednorodności wymiarowej cząstek.

0D Oprogramowanie

0D001 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w tej kategorii.

0E Technologia

0E001 „Technologie” zgodnie z uwagą do technologii jądrowej służące do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w tej kategorii.

KATEGORIA 1 – MATERIAŁY SPECJALNE I ZWIĄZANE Z NIMI URZĄDZENIA

1 A Systemy, urządzenia i części składowe

1A001 Następujące elementy wykonane ze związków fluorowych:

- a. uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniające lub przepony w układach paliwowych, które są specjalnie zaprojektowane do „statków powietrznych” lub raket kosmicznych i w których ponad 50 % zawartości wagowej stanowi jeden z materiałów objętych kontrolą według pozycji 1.C009.b lub 1C009.c;
- b. polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu (CAS 75-38-7), wymienione w pozycji 1C009.a, spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. w postaci arkuszy lub folii; oraz
 2. o grubości większej niż 200 μm ;
- c. uszczelnienia, uszczelki, gniazda zaworów, przepony lub membrany spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. wykonane z elastomerów fluorowych zawierających co najmniej jeden monomer eteru winylowego; oraz
 2. specjalnie opracowane do „statków powietrznych”, raket kosmicznych lub „pocisków raketowych”.

Uwaga: W pozycji 1A001.c „pocisk raketowy” oznacza kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych.

1A002 Wyroby lub laminaty „kompozytowe” spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 1A202, 9A010 i 9A110.

- a. składające się z „matrycy” organicznej i z materiałów objętych kontrolą według pozycji 1C010.c, 1C010.d lub 1C010.e; lub
- b. składające się z „matrycy” metalowej lub węglowej i z któregośkolwiek spośród niżej wymienionych materiałów:
 1. węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:
 - a. ich „moduł właściwy” przekracza $10,15 \times 10^6$ m; oraz
 - b. ich „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” przekracza $17,7 \times 10^4$ m; lub
 2. materiałów wymienionych w pozycji 1C010.c.

Uwaga 1: Pozycja 1A002 nie dotyczy wyrobów kompozytowych ani laminatów wykonanych z żywic epoksydowych impregnowanych węglowymi „materiałami włóknistymi lub włókienkowymi”, przeznaczonych do naprawy elementów lub laminatów „cywilnych statków powietrznych” i spełniających wszystkie z poniższych kryteriów:

- a. mających powierzchnię nieprzekraczającą 1 m^2 ;
- b. mających długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz
- c. mających szerokość nieprzekraczającą 15 mm.

Uwaga 2: Pozycja 1A002 nie obejmuje kontrolą produktów półgotowych, specjalnie zaprojektowanych do następujących, wyłącznie cywilnych, zastosowań:

- a. sprzęt sportowy;
- b. przemysł motoryzacyjny;
- c. przemysł obrabiarkowy;
- d. zastosowania medyczne.

Uwaga 3: Pozycja 1A002.b.1 nie obejmuje kontrolą produktów półgotowych zawierających maksymalnie dwie warstwy plecionych włókien, specjalnie zaprojektowanych do następujących zastosowań:

- a. piec do obróbki cieplnej metali służący do odpuszczania metalu;
- b. urządzenia do produkcji monokryształu krzemu.

Uwaga 4: Pozycja 1A002 nie obejmuje kontrolą produktów gotowych, specjalnie zaprojektowanych do konkretnych zastosowań.

1A003 Wyroby z innych niż „topliwe” poliimidów aromatycznych, w postaci folii, arkuszy, taśm lub wstęg, które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a. o grubości większej niż 0,254 µm; lub
- b. są powlekane lub laminowane węglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.

Uwaga: Pozycja 1A003 nie obejmuje kontrolą wyrobów powlekanych lub laminowanych miedzią, przeznaczonych do produkcji elektronicznych płytek drukowanych.

NB.: „Topliwe” poliimidy aromatyczne w każdej postaci, zob. pozycja 1C008.a.3.

1A004 Następujące urządzenia, wyposażenie i części ochronne i detekcyjne, inne niż specjalnie zaprojektowane do zastosowania wojskowego:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 2B351 I 2B352.

- a. maski przeciwgazowe, pochłaniacze i wyposażenie dekontaminacyjne do nich, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed którymkolwiek z poniższych czynników, a także części specjalnie do nich zaprojektowane:

Uwaga: Pozycja 1A004.a. obejmuje respiratory oczyszczające powietrze z własnym zasilaniem (PARP), zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów ochrony przed środkami i materiałami wymienionymi w pozycji 1A004.a.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1A004.a.:

1. Maski przeciwgazowe są również nazywane maskami gazowymi.
2. Pochłaniacze obejmują również wkłady do filtrów.

1. czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;
2. materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;
3. chemiczne środki bojowe; lub
4. „środki rozpraszania tłumu”, w tym:
 - a. α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);
 - b. dinitryl [(2-chlorofenilo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);
 - c. 2-chloro-1-fenyletanon, chlorek fenylacylu (-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);
 - d. dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);
 - e. 10-chloro-5, 10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);
 - f. N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

- b. ubrania, rękawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed którymkolwiek z poniższych:
 1. czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

2. materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”; lub
 3. chemiczne środki bojowe;
- c. systemy detekcji, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub identyfikacji którychkolwiek z poniższych czynników, a także części specjalnie do nich zaprojektowane:
1. czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;
 2. materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”; lub
 3. chemiczne środki bojowe;

- d. urządzenia elektroniczne zaprojektowane do automatycznego wykrywania lub określania obecności pozostałości „materiałów wybuchowych” przy użyciu technik 'wykrywania substancji śladowych' (np. powierzchniowa fala akustyczna, spektrometria w oparciu o ruchliwość jonów, spektrometria w oparciu o rozkład ruchliwości, spektrometria masowa).

Uwaga techniczna:

'Wykrywanie substancji śladowych' oznacza zdolność do wykrywania poniżej 1 ppm gazu lub 1 mg substancji stałej lub cieczy.

Uwaga 1: Pozycja 1A004.d nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych do użytku laboratoryjnego.

Uwaga 2: Pozycja 1A004.d nie obejmuje kontrolą stacjonarnych bezstykowych bramek bezpieczeństwa.

Uwaga: Pozycja 1A004 nie obejmuje kontrolą:

- a. osobistych monitorujących dozymetrów promieniowania jądrowego;
- b. urządzeń BHP ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do spełniania ochrony przed zagrożeniami typowymi dla bezpieczeństwa mieszkańców i domostw lub przemysłu cywilnego, w tym w:
 1. górnictwie;
 2. eksploatacji kamieniołomów;
 3. rolnictwie;
 4. przemyśle farmaceutycznym;
 5. medycynie;
 6. weterynarii;
 7. ochronie środowiska;
 8. gospodarowaniu odpadami;
 9. przemyśle spożywczym.

Uwagi techniczne:

1. Pozycja 1A004 obejmuje urządzenia i części, które uznano za skuteczne, przetestowano z wynikiem pozytywnym według norm krajowych lub w inny sposób dowiedziono ich skuteczności w zakresie wykrywania materiałów promieniotwórczych „przystosowanych do użycia w działaniach wojennych”, czynników biologicznych „przystosowanych do użycia w działaniach wojennych”, chemicznych środków bojowych, 'nietoksycznych substancji zastępczych' lub „środków rozpraszania tłumy”, a także obrony przed wymienionymi materiałami, czynnikami i środkami, także wtedy, gdy takie wyposażenie lub części stosowane są w cywilnych gałęziach działalności, takich jak: górnictwo, przemysł wydobywczy, rolnictwo, przemysł farmaceutyczny, medycyna, weterynaria, ochrona środowiska, gospodarka odpadami lub przemysł spożywczy.
2. 'Nietoksyczna substancja zastępcza' oznacza substancję lub materiał stosowany zamiast środków toksycznych (chemicznych lub biologicznych) w ramach szkoleń, badań naukowych, testów lub ocen.

1A005 Następujące kamizelki i okrycia kuloodporne oraz elementy do nich:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

- a. miękkie pancerze osobiste lub odzież ochronna, niewyprodukowane zgodnie z normami lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami równoważnymi oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;
- b. twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych dające ochronę balistyczną na poziomie IIIA lub niższym (NIJ 0101.06, lipiec 2008) lub odpowiedniki krajowe.

NB.: W odniesieniu do „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, stosowanych do produkcji kamizelek kuloodpornych zob. 1C010.

- Uwaga 1: Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą indywidualnych okryć kuloodpornych, gdy służą one ich użytkownikowi do osobistej ochrony.
- Uwaga 2: Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych wyłącznie do ochrony czołowej zarówno przed odłamkami, jak i siłą podmuchu z niewojskowych urządzeń wybuchowych.
- Uwaga 3: Pozycja 1A005 nie obejmuje pancerzy osobistych zaprojektowanych wyłącznie do ochrony przed urazami na skutek pchnięcia nożem, szpikulcem, igłą lub tępym narzędziem.

1A006 Wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów unieszkodliwiania następujących improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz specjalnie zaprojektowanych części i akcesoriów do nich:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

- a. pojazdy zdalnie sterowane;
- b. 'neutralizatory'

Uwaga techniczna:

'Neutralizatory' to urządzenia specjalnie zaprojektowane, by uniemożliwić działanie urządzenia wybuchowego przez wyrzucenie pocisku płynnego, stałego lub kruchego.

Uwaga: Pozycja 1A006 nie obejmuje kontrolą wyposażenia obsługiwanego przez operatora.

1A007 Następujące wyposażenie i urządzenia specjalnie zaprojektowane w celu inicjowania ładunków oraz urządzeń zawierających „materiały energetyczne” za pomocą środków elektrycznych:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA, pozycje 3A229 I 3A232.

- a. zestawy zapłonowe do detonatorów, zaprojektowane do detonatorów wymienionych w pozycji 1A007.b;
- b. następujące zapłonniki elektryczne:
 - 1. eksplodujące zapłonniki mostkowe (EB);
 - 2. eksplodujące zapłonniki połączeń mostkowych (EBW);
 - 3. zapłonniki udarowe;
 - 4. eksplodujące zapłonniki foliowe (EFI).

Uwagi techniczne:

- 1. Zamiast słowa detonator używa się czasami słowa inicjator lub zapłonnik.
- 2. Do celów pozycji 1A007.b. wszystkie przedmiotowe detonatory wykorzystują małe przewodniki elektryczne (mostki, połączenia mostkowe lub folie) gwałtownie odparowujące po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokoprądowych impulsów elektrycznych. W przypadku zapłonników nieudarowych wybuchający przewodnik inicjuje eksplozję chemiczną w zetknięciu się z kruszącym materiałem wybuchowym, takim jak PETN (czteroozotan pentaerytrytu). W zapłonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia przeskok bijnika przez szczelinę, a jego uderzenie w materiał wybuchowy inicjuje eksplozję chemiczną. W niektórych przypadkach bijnik napędzany jest siłami magnetycznymi. Termin detonator w postaci folii eksplodującej może odnosić się zarówno do detonatorów typu EB, jak i udarowych.

1A008 Następujące ładunki, urządzenia i części:

- a. 'ładunki kumulacyjne' spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. zawartość materiałów wybuchowych netto (NEQ) większa niż 90 g; oraz
 - 2. zewnętrzna średnica obudowy równa lub większa niż 75 mm;
- b. ładunki tnące o kształcie liniowym spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów i specjalnie zaprojektowane do nich części:
 - 1. zawartość materiałów wybuchowych większa niż 40 g/m; oraz
 - 2. szerokość równa lub większa niż 10 mm;
- c. lont detonujący o zawartości materiałów wybuchowych większej niż 64 g/m;
- d. urządzenia tnące, inne niż wyszczególnione w 1A008.b, oraz narzędzia odcinające o zawartości materiałów wybuchowych netto (NEQ) większej niż 3,5 kg.

Uwaga techniczna:

'Ładunki kumulacyjne' to ładunki wybuchowe ukształtowane tak, by ukierunkować siłę wybuchu.

- 1A102 Elementy z przesyczonego pirolizowanego materiału typu węgiel-węgiel przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.
- 1A202 Elementy kompozytowe, inne niż wymienione w pozycji 1A002, w postaci rur i mające obie z następujących cech:
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A010 I 9A110.
- a. średnicę wewnętrzną od 75 mm do 400 mm; oraz
- b. są wykonane z jednego z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” wymienionych w pozycji 1C010.a, 1C010.b lub 1C210.a lub z materiałów węglowych wyspecyfikowanych w pozycji 1C210.c.
- 1A225 Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru pomiędzy wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody.
- 1A226 Wyspecjalizowane wkłady do oddzielania ciężkiej wody od wody zwykłej, mające obydwie z następujących cech:
- a. są wykonane z siatek z brązu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwiększenia nasiąkliwości; oraz
- b. są przeznaczone do stosowania w próżniowych wieżach destylacyjnych.
- 1A227 Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gęstości (ze szkła ołowiowego lub podobnych materiałów), mające wszystkie z następujących cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane ramy:
- a. powierzchnię w obszarze nieradioaktywnym powyżej 0,09 m²;
- b. gęstość powyżej 3 g/cm³; oraz
- c. grubość 100 mm lub większą.

Uwaga techniczna:

Na użytek poz. 1A227 termin 'obszar nieradioaktywny' oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie najniższym w danym zastosowaniu.

1 B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

- 1B001 Następujące urządzenia do produkcji lub kontroli wyrobów lub laminatów „kompozytowych” wyszczególnionych w pozycji 1A002 lub „materiałów włóknistych lub włókienkowych” wyszczególnionych w pozycji 1C010 oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 1B101 I 1B201.

- a. maszyny nawojowe do włókien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej 'głównych osiach serwo sterowania' ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów „kompozytowych” lub laminatów, z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”;

- b. 'maszyny do układania taśm', z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej pięciu 'głównych osiach serwo sterowania' ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm, specjalnie zaprojektowane do produkcji „kompozytowych” elementów konstrukcyjnych płatowca lub 'pocisku raketowego';

Uwaga: W pozycji 1B001.b 'pocisk raketowy' oznacza kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych.

Uwaga techniczna:

Na użytek poz. 1B001.b 'maszyny do układania taśm' są zdolne do układania jednego lub więcej 'pasm włókien' ograniczonych do szerokości większej niż 25 mm, lecz mniejszej lub równej 305 mm oraz do cięcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych 'pasm włókien' podczas procesu układania.

- c. wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, łącznie z zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, zaprojektowane lub zmodyfikowane specjalnie do tkania, przeplatania lub splatania włókien na potrzeby elementów „kompozytowych”;

Uwaga techniczna:

Na użytek poz. 1B001.c technika przeplatania obejmuje również dzianie.

- d. następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do produkcji włókien wzmocnionych:
 - 1. urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej, paku lub polikarbosilanu) we włókna węglowe lub włókna węgla krzemu, łącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania;
 - 2. urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych w celu wyprodukowania włókien z węgla krzemu;
 - 3. urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek glinu);
 - 4. urządzenia do przetwarzania za pomocą obróbki cieplnej włókien macierzystych zawierających aluminium we włókna tlenku glinu;
- e. urządzenia do produkcji prepregów, wyszczególnionych w pozycji 1C010.e, metodą topienia termicznego (*hot melt*);
- f. następujące urządzenia do badań nieniszczących specjalnie zaprojektowane do materiałów „kompozytowych”:
 - 1. systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech wymiarach;
 - 2. sterowane numerycznie ultradźwiękowe urządzenia badawcze, w których ruchy nadajników lub odbiorników do pozycjonowania są równocześnie sterowane i programowane w co najmniej czterech osiach w celu śledzenia trójwymiarowych kształtów badanych elementów;
- g. 'maszyny do układania kabli' z włókien, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwóch 'głównych osiach serwo sterowania' ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem kabli, specjalnie zaprojektowane do produkcji „kompozytowych” elementów konstrukcyjnych płatowca lub 'pocisku raketowego';

Uwaga techniczna:

Do celów poz. 1B001.g 'maszyny do układania kabli' są zdolne do układania jednego lub więcej 'pasm włókien' o szerokości mniejszej lub równej 25 mm oraz do cięcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych 'pasm włókien' podczas procesu układania.

Uwaga techniczna:

1. *Do celów poz. 1B001 'główne osie serwo sterowania' sterują pod kontrolą programu komputerowego pozycją manipulatora (tj. głowicą) w przestrzeni w odniesieniu do obrabianego elementu, nadając mu właściwe położenie i kierunek, by osiągnąć pożądany wynik.*
2. *Do celów poz. 1B001 'pasma włókna' oznacza pojedynczą ciągłą szerokość taśmy, kabla lub włókna częściowo impregnowanych żywicą.*

- 1B002 Urządzenia do produkcji stopów metali, proszków ze stopów metali lub materiałów stopowych specjalnie zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i specjalnie zaprojektowane do wykorzystania w jednym z procesów wyszczególnionych w pozycji 1C002.c.2.
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B102.*
- 1B003 Narzędzia, matryce, formy lub osprzęt o specjalnej konstrukcji do przetwarzania tytanu, glinu lub ich stopów w „stanie nadplastycznym” lub metodą „zgrzewania dyfuzyjnego” z przeznaczeniem do produkcji którychkolwiek z poniższych:
- konstrukcji lotniczych lub kosmicznych;
 - silników do „statków powietrznych” i rakiet kosmicznych; lub
 - specjalnie zaprojektowanych zespołów do konstrukcji wyszczególnionych w pozycji 1B003.a lub silników wyszczególnionych w pozycji 1B003.b.
- 1B101 Następujące urządzenia, inne niż wyszczególnione w pozycji 1B001, do „produkcji” kompozytów konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B201.*
- Uwaga: Do wyszczególnionych w pozycji 1B101 elementów i akcesoriów należą formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrządowanie do wstępnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementów kompozytowych, laminatów i wytworzonych z nich wyrobów.*
- maszyny nawojowe do włókien lub maszyny do zbrojenia włóknami, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z materiałów włóknistych lub włókienkowych;
 - maszyny do układania taśm z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwóch osiach ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm i arkuszy, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do kompozytowych elementów konstrukcyjnych płatowca lub „pocisku raketowego”;
 - następujące urządzenia zaprojektowane lub przystosowane do „produkcji” „materiałów włóknistych lub włókienkowych”:
 - urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) łącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania;
 - urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych;
 - urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek glinu);
 - urządzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obróbki powierzchniowej włókien lub do wytwarzania prepregów i preform wyszczególnionych w pozycji 9C110.
- Uwaga: Do urządzeń ujętych w pozycji 1B101.d zalicza się rolki, naprężacze, zespoły powlekające, urządzenia do cięcia i formy zatrzaskowe.*

1B102 „Urządzenia produkcyjne” do wytwarzania proszków metali, inne niż wyszczególnione w poz. 1B002, i specjalnie zaprojektowane elementy do nich:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B115.b.

- a. „urządzenia produkcyjne” do wytwarzania proszków metali umożliwiające „produkcję”, w kontrolowanej atmosferze, sferycznych, sferoidalnych lub pylistych materiałów wyszczególnionych w pozycjach: 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 lub w wykazie uzbrojenia;
- b. specjalnie zaprojektowane elementy do „urządzeń produkcyjnych” wyszczególnionych w poz. 1B002 lub 1B102.a.

Uwaga: Pozycja 1B102 obejmuje:

- a. generatory plazmowe (na zasadzie łuku elektrycznego wysokiej częstotliwości) nadające się do otrzymywania pylistych lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon-woda;
- b. urządzenia elektroimpulsowe umożliwiające otrzymywanie pylistych lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon-woda;
- c. urządzenia umożliwiające „produkcję” sferycznych proszków aluminiowych przez rozpylanie roztopionego metalu w atmosferze obojętnej (np. azocie).

1B115 Urządzenia, inne niż wyszczególnione w pozycjach 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i składników paliw oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły:

- a. „urządzenia produkcyjne” do „produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego paliw płynnych i składników paliw wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia;
- b. „urządzenia produkcyjne” do „produkcji”, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wytłaczania lub testowania odbiorczego paliw stałych i składników paliw wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia.

Uwaga: Pozycja 1B115.b nie obejmuje kontrolą mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów zob. pozycje 1B117, 1B118 i 1B119.

Uwaga 1: Urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji wyrobów militarnych wymagają każdorazowo sprawdzenia wykazu uzbrojenia.

Uwaga 2: Pozycja 1B115 nie obejmuje kontrolą urządzeń do „produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego węgliku boru.

1B116 Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materiałów pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podłożu, z gazów macierzystych rozkładających się w zakresie temperatur od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) przy ciśnieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

1B117 Mieszarki okresowe umożliwiające mieszanie próżniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w których można regulować temperaturę w komorze mieszania, spełniające wszystkie poniższe kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

- a. całkowita wydajność objętościowa 110 litrów lub większa; oraz
- b. co najmniej jeden ‘wał mieszający/ugniatający’ osadzony mimośrodowo.

Uwaga: W pozycji 1B117.b ‘wał mieszający/ugniatający’ nie obejmuje rozdrabniaczy i głowic nożowych.

- 1B118 Mieszarki ciągle umożliwiające mieszanie próżniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w których można regulować temperaturę w komorze mieszania i które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy:
- dwa lub więcej wałów mieszających/ugniatających; lub
 - jeden oscylujący wał obrotowy z zębami/kołkami ugniatającymi na nim, jak również wewnątrz obudowy komory mieszalniczej.
- 1B119 Młyny wykorzystujące energię płynów, nadające się do rozdrabniania i mielenia substancji wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.
- 1B201 Następujące maszyny do nawijania włókien i związane z nimi wyposażenie, inne niż wyszczególnione w pozycji 1B001 lub 1B101:
- maszyny do nawijania włókien, mające wszystkie z następujących cech:
 - koordynację i programowanie ruchów związanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, w dwóch lub więcej osiach;
 - są specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”; oraz
 - są zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o średnicy od 75 mm do 650 mm i długości 300 mm lub większej;
 - sterowniki koordynujące i programujące do maszyn do nawijania włókien wyszczególnionych w 1B201.a;
 - trzipienie precyzyjne do maszyn do nawijania włókien wyszczególnionych w 1B201.a.
- 1B225 Ognia elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 250 gramów fluoru na godzinę.
- 1B226 Elektromagnetyczne separatory izotopów, skonstruowane z przeznaczeniem do współpracy z jednym lub wieloma źródłami jonów zdolnymi do uzyskania wiązki jonów o całkowitym natężeniu rzędu 50 mA lub więcej.
- Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje następujące separatory:
- zdolne do wzbogacania izotopów trwałych;
 - ze źródłami i kolektorami jonów zarówno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w których zespoły te znajdują się na zewnątrz pola.
- 1B228 Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:
- zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewnętrznych 35 K (-238 °C) lub niższych;
 - zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach wewnętrznych od 0,5 do 5 MPa;
 - skonstruowane:
 - z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawartości siarki i o wielkości ziarna austenitu 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych); lub
 - z materiałów równoważnych nadających się zarówno do działań w warunkach kriogenicznych, jak i w atmosferze H₂; oraz
 - o średnicach wewnętrznych 30 cm lub większych i 'długościach efektywnych' 4 m lub większych.
- Uwaga techniczna:
W pozycji 1B228 'długość efektywna' oznacza aktywną wysokość materiału wypełniającego w kolumnach z wypełnieniem lub aktywną wysokość płyt kontaktora wewnętrznego w kolumnach płytowych.

- 1B229 Następujące kolumny półkowe do wymiany typu woda-siarkowodór oraz 'kontakторы wewnętrzne' do nich:
- NB.: W przypadku kolumn specjalnie zaprojektowanych lub przygotowanych do produkcji ciężkiej wody zob. 0B004.*
- a. kolumny półkowe do wymiany typu woda-siarkowodór, mające wszystkie z następujących cech:
 1. są przeznaczone do pracy przy ciśnieniu znamionowym 2 MPa lub wyższym;
 2. są wykonane z drobnoziarnistej stali węglowej o wielkości ziarna 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych); oraz
 3. mają średnicę 1,8 m lub większą;
 - b. 'kontakторы wewnętrzne' dla kolumn półkowych do wymiany typu woda-siarkowodór zdefiniowanych w poz. 1B229.a.
- Uwaga techniczna:
'Kontakторы wewnętrzne' w kolumnach są segmentowymi półkami o zespołowej średnicy roboczej 1,8 m lub większej, skonstruowanymi w sposób ułatwiający kontakt czynników w przepływie przeciwnym, wykonanymi ze stali nierdzewnej o zawartości węgla 0,03 % lub mniejszej. Mogą one mieć postać półek sitowych, półek zaworowych, półek dzwonowych lub rusztowych.*
- 1B230 Pompy do przetłaczania roztworów katalizatora z amidku potasu rozcieńczonego lub stężonego w ciekłym amoniaku (KNH_2/NH_3), posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:
- a. szczelność dla powietrza (tj. hermetycznie zamknięte);
 - b. wydajność powyżej 8,5 m³/godz.; oraz
 - c. nadające się do:
 1. stężonych roztworów amidku potasu (1 % lub powyżej) – ciśnienie robocze 1,5–60 MPa; lub
 2. rozcieńczonych roztworów amidku potasu (poniżej 1 %) – ciśnienie robocze 20–60 MPa.
- 1B231 Następujące urządzenia i instalacje do obróbki trytu lub ich podzespoły:
- a. urządzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stężania trytu lub manipulowania trytem;
 - b. następujące urządzenia dla instalacji lub fabryk trytu:
 1. urządzenia do chłodzenia wodoru lub helu zdolne do chłodzenia do temperatury 23 K (-250 °C) lub poniżej, o wydajności odprowadzania ciepła powyżej 150 watów;
 2. instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopów wodoru za pomocą wodorków metali jako środków do magazynowania lub oczyszczania.
- 1B232 Turborozprężarki lub zestawy turborozprężarka-sprężarka mające obie z wymienionych niżej cech:
- a. zaprojektowane do działania przy temperaturze wylotowej poniżej 35 K (-238 °C) lub niższej; oraz
 - b. posiadające przepustowość wodoru większą lub równą 1000 kg/h.

- 1B233 Następujące urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu oraz ich układy i podzespoły do nich:
- a. urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu;
 - b. następujące podzespoły do separacji izotopów litu w oparciu o proces amalgamacji litu i rtęci:
 - 1. kolumny z wypełnieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie zaprojektowane do amalgamatów litu;
 - 2. pompy do pompowania rtęci lub amalgamatu litu;
 - 3. ogniwa do elektrolizy amalgamatu litu;
 - 4. aparaty wyparne do zagęszczonych roztworów wodorotlenku litu;
 - c. układy wymiany jonowej specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy;
 - d. układy wymiany chemicznej (wykorzystujące etery kronowe, kryptandy lub etery lariatowe) specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.
- 1B234 Pojemniki do materiałów wybuchowych, komory, kontenery i inne podobne urządzenia zaprojektowane do testowania materiałów wybuchowych lub urządzeń wybuchowych, mające obie poniższe cechy:
- NB.: *ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.*
- a. są zaprojektowane do całkowitego przyjęcia wybuchu równoważnego 2 kg TNT lub więcej: oraz
 - b. mają elementy konstrukcyjne lub cechy, które umożliwiają przekazywanie danych diagnostycznych lub pomiarowych w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem.

Uwaga techniczna:*Metale i stopy:*

Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, terminy 'metale' i 'stopy' używane w pozycjach od 1C001 do 1C012 dotyczą następujących wyrobów surowych i półfabrykatów:

Wyroby surowe:

Anody, kule, pręty (łącznie z prętami karbowanymi i ciągnionymi), kęsy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, kryształy, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryły, pastylki, surówki, proszki, podkładki, śruty, płyty, owale osadnicze, gąbki i drążki;

Półfabrykaty (zarówno powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i niepoddane żadnej z tych obróbek):

- a. *przerobione plastycznie lub obrobione materiały wyprodukowane poprzez walcowanie, wyciąganie, wytłaczanie, kucie, prasowanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kątowniki, ceowniki, koła, tarcze, pyły, płatki, folie, odkuwki, płyty, proszki, wytłoczki, wypraski, wstęgi, pierścienie, pręty (w tym pręty spawalnicze, walcówki i druty walcowane), kształtowniki, arkusze, taśmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym i tuleje rurowe), druty ciągnione i tłoczone;*
- b. *materiały odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokilach, formach metalowych, gipsowych i innych, w tym przez odlewanie pod ciśnieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkowej.*

Cel kontroli nie powinien być omijany przez eksportowanie form niewymienionych w wykazie jako produktów rzekomo finalnych, ale będących w rzeczywistości formami surowymi lub półfabrykatami.

Następujące materiały specjalnie opracowane z przeznaczeniem na pochłaniacze fal elektromagnetycznych lub polimery przewodzące samoistnie:

NB. ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C101.

- a. materiały pochłaniające fale o częstotliwościach powyżej 2×10^8 Hz, ale poniżej 3×10^{12} Hz;

Uwaga 1: Pozycja 1C001.a nie obejmuje kontrolą:

- a. *pochłaniaczy typu włosowego, wykonanych z włókien naturalnych lub syntetycznych, w których pochłanianie osiąga się innym sposobem niż magnetyczny;*
- b. *pochłaniaczy niewykazujących strat magnetycznych oraz takich, których powierzchnia, na którą pada promieniowanie, nie jest planarna, w tym ostrosłupów, stożków, klinów i powierzchni zwichrowanych;*
- c. *pochłaniaczy planarnych spełniających wszystkie poniższe kryteria:*
 1. *wykonane z któregośkolwiek z poniższych:*
 - a. *ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych lub nieelastycznych) wzmocnianych węglem lub z materiałów organicznych, łącznie z materiałami wiążącymi, dających więcej niż 5 % echa w porównaniu z metalami, w paśmie o szerokości wyższej o ± 15 % od częstotliwości centralnej padającej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczające 450 K (177°C); lub*
 - b. *z materiałów ceramicznych dających o ponad 20 % echa więcej w porównaniu z metalami, w paśmie o szerokości wyższej o ± 15 % od częstotliwości centralnej padającej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczające 800 K (527°C);*

Uwaga techniczna:

Próbki do badania stopnia pochłaniania materiałów wyszczególnionych w uwadze 1.c.1 do pozycji 1C001.a powinny być kwadratami o boku równym co najmniej 5 długościom fali o częstotliwości centralnej i umieszczone w polu dalekim elementu promieniującego fale elektromagnetyczne.

2. wytrzymałość na rozciąganie poniżej $7 \times 10^6 \text{ N/m}^2$; oraz
3. wytrzymałość na ściskanie poniżej $14 \times 10^6 \text{ N/m}^2$;

d. pochłaniacze planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1. gęstość względna powyżej 4,4; oraz
2. maksymalna temperatura robocza na poziomie 548 K (275°C).

Uwaga 2: Żadne sformułowanie w uwadze 1 do pozycji 1C001.a nie zwalnia z kontroli materiałów magnetycznych użytych jako pochłaniacze fal w farbach.

- b. materiały pochłaniające fale o częstotliwościach w zakresie od $1,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ do $3,7 \times 10^{14} \text{ Hz}$ i nieprzezroczyste dla promieniowania widzialnego;

Uwaga: Pozycja 1C001.b nie obejmuje kontrolą materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do któregośkolwiek z poniższych zastosowań:

- a. laserowe znakowanie polimerów; lub
- b. laserowe spawanie polimerów;

- c. materiały polimerowe przewodzące samoistnie, o 'objętościowej przewodności elektrycznej' powyżej 10 000 S/m (simensów na metr) lub 'oporności powierzchniowej' poniżej 100 omów/m², których podstawową częścią składową jest którykolwiek z następujących polimerów:

1. polianilina;
2. polipirol;
3. politiofen;
4. polifenylenowinylen; lub
5. polietylenowinylen;

Uwaga: Pozycja 1C001.c nie obejmuje kontrolą materiałów w postaci ciekłej.

Uwaga techniczna:

'Objętościową przewodność elektryczną' oraz 'oporność powierzchniową' należy określać zgodnie z normą ASTM D-257 lub jej odpowiednikami.

1C002 Następujące stopy metali, proszki stopów metali lub materiały stopowe:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C202.

Uwaga: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolą stopów metali, proszków stopów metali ani materiałów stopowych do powlekania podłoży.

Uwagi techniczne:

1. Do stopów metalu według pozycji 1C002 zalicza się takie, które zawierają wyższy procent wagowy danego metalu niż dowolnego innego pierwiastka.
2. 'Trwałość w próbie pełzania do zerwania' należy określać według normy ASTM E-139 lub jej krajowych odpowiedników.
3. 'Trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych' należy określać według normy ASTM E-606 'Zalecana metoda niskocyklowego badania zmęczeniowego przy stałej amplitudzie' lub jej krajowych odpowiedników. Badania należy prowadzić przy obciążeniu skierowanym osiowo, przy średniej wartości współczynnika asymetrii cyklu 1 oraz wartości współczynnika spiętrzenia naprężeń (K_t) równej 1. Naprężenie średnie definiuje się jako różnicę naprężenia maksymalnego i minimalnego podzieloną przez naprężenie maksymalne.

- a. następujące glinki:
1. glinki niklu zawierające wagowo co najmniej 15 %, a co najwyżej 38 % glinu i przynajmniej jeden dodatek stopowy;
 2. glinki tytanu zawierające wagowo 10 % lub więcej glinu i przynajmniej jeden dodatek stopowy;

- b. następujące stopy metali wykonane z materiałów w postaci proszków lub pyłów wyszczególnionych w pozycji 1C002.c:
1. stopy niklu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. ich 'trwałość w próbie pełzania do zerwania' wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 923 K (650°C) przy naprężeniach 676 MPa; lub
 - b. ich 'trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych' wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 823 K (550 °C) przy maksymalnym naprężeniu 1 095 MPa;
 2. stopy niobu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. ich 'trwałość w próbie pełzania do zerwania' wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 1 073 K (800°C) przy naprężeniu 400 MPa; lub
 - b. ich 'trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych' wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 973 K (700°C) przy maksymalnym naprężeniu 700 MPa;
 3. stopy tytanu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. ich 'trwałość w próbie pełzania do zerwania' wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 723 K (450°C) przy naprężeniu 200 MPa; lub
 - b. ich 'trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych' wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 723 K (450°C) przy maksymalnym naprężeniu 400 MPa;
 4. stopy glinu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 240 MPa lub więcej w temperaturze 473 K (200°C); lub
 - b. ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 415 MPa lub więcej w temperaturze 298 K (25°C);
 5. stopy magnezu spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 345 MPa lub więcej; oraz
 - b. szybkość korozji w 3 % wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzona według normy ASTM G-31 lub jej krajowych odpowiedników, wynosi poniżej 1 mm/rok;
- c. proszki lub pyły stopów metali spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. wykonane z dowolnego materiału o podanych poniżej składach:

Uwaga techniczna:

W podanych poniżej związkach X oznacza jeden lub większą liczbę składników stopu.

- a. stopów niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do wyrobu części lub zespołów silników turbinowych, tj. zawierających mniej niż 3 cząsteczki niemetaliczne (wprowadzone podczas procesu produkcji) o wielkości przekraczającej 100 μm na 10⁹ cząsteczek stopu;
 - b. stopów niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti);
 - c. stopów tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);
 - d. stopów glinu (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub
 - e. stopów magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al);
2. wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedną z następujących metod:

- a. „rozpylania próżniowego”;
- b. „rozpylania gazowego”;
- c. „rozpylania rotacyjnego”;
- d. „chłodzenia ultraszybkiego”;
- e. „formowania rotacyjnego z fazy stopionej” i „rozdrabniania”;
- f. „formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej” i „rozdrabniania”; lub
- g. „stapiania mechanicznego”; oraz

3. nadające się do formowania materiałów wyszczególnionych w poz. 1C002.a lub 1C002.b;

d. materiały stopowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. wykonane z dowolnego materiału o składzie wyszczególnionym w poz. 1C002.c.1;
2. w postaci niesproszkowanych płatków, wstążek lub cienkich pręcików; oraz
3. wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedną z następujących metod:
 - a. „chłodzenia ultraszybkiego”;
 - b. „formowania rotacyjnego z fazy stopionej”; lub
 - c. „formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej”.

1C003 Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a. ich początkowa względna przenikalność magnetyczna wynosi 120 000 lub więcej, a grubość 0,05 mm lub mniej;

Uwaga techniczna:

Początkową względną przenikalność magnetyczną należy mierzyć na materiałach całkowicie wyżarzonych.

- b. stopy magnetostrykcyjne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. magnetostrykcja nasycenia powyżej 5×10^{-4} ; lub
2. współczynnik sprzężenia żyromagnetycznego (k) powyżej 0,8; lub

- c. taśmy ze stopów amorficznych lub „nanokrystalicznych”, spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. skład zawierający co najmniej 75 % wagowych żelaza, kobaltu lub niklu;
2. indukcja magnetyczna nasycenia (B_s) wynosząca 1,6 T lub więcej; oraz
3. spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. grubość taśmy 0,02 mm lub mniejsza; lub
 - b. oporność właściwa 2×10^{-4} omów cm lub większa.

Uwaga techniczna:

Pod pojęciem materiały „nanokrystaliczne” w pozycji 1C003.c rozumie się materiały o rozmiarze ziarna krystalicznego wynoszącym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

1C004 Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na „matrycy” z żelaza, niklu lub miedzi spełniające wszystkie poniższe kryteria:

- a. gęstość powyżej $17,5 \text{ g/cm}^3$;
- b. granica sprężystości powyżej 880 MPa;
- c. wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1 270 MPa; oraz
- d. wydłużenie powyżej 8 %.

1C005 Następujące „nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe” o długości powyżej 100 m lub masie powyżej 100 g:

- a. „nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe”, w których skład wchodzi co najmniej jedno „włókno” niobowo-tytanowe, spełniające oba poniższe kryteria:
 1. osadzone w „matrycy” różnej od miedzianej lub „matrycy” mieszanej na osnowie miedzi; oraz

2. mające pole przekroju poprzecznego poniżej $0,28 \times 10^{-4} \text{ mm}^2$ (o średnicy $6 \text{ }\mu\text{m}$ w przypadku „włókien” o przekroju kołowym);
- b. „nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe”, w których skład wchodzi co najmniej jedno „włókno” „nadprzewodzące” inne niż niobowo-tytanowe, spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. „temperatura krytyczna” przy zerowej indukcji magnetycznej powyżej 9,85 K (-263,31°C); oraz
2. Pozostawanie w stanie „nadprzewodzącym” w temperaturze 4,2 K (-268,96°C) pod działaniem pola magnetycznego działającego w jakimkolwiek kierunku prostopadłym do osi podłużnej przewodnika oraz równoważnego indukcji magnetycznej 12 T o krytycznej gęstości prądu większej niż 1750 A/mm² w całkowitym polu przekroju poprzecznego przewodnika;
- c. „nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe”, w których skład wchodzi co najmniej jedno 'włókien' „nadprzewodzące”, które nadal są „nadprzewodzące” w temperaturze powyżej 115 K (-158,16°C).

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1C005 'włókna' mogą być w postaci drutu, cylindra, folii, taśmy lub wstęgi.

1C006 Następujące płyny i materiały smarne:

- a. płyny hydrauliczne zawierające jako składnik podstawowy którekolwiek z poniższych:
 1. syntetyczne 'oleje krzemowęglowodorowe' spełniające wszystkie poniższe kryteria:

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1C006.a.1 zakłada się, że 'oleje krzemowęglowodorowe' zawierają wyłącznie krzem, wodór i węgiel.

- a. 'temperatura zapłonu' powyżej 477 K (204°C);
- b. 'temperatura krzepnięcia' 239 K (-34 °C) lub niższa;
- c. 'wskaźnik lepkości' 75 lub więcej; oraz
- d. 'stabilność termiczna' w temperaturze 616 K (343°C); lub
2. 'chlorofluoropochodne węglowodorów' spełniające wszystkie poniższe kryteria:

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1C006.a.2 zakłada się, że 'chlorofluoropochodne węglowodorów' zawierają wyłącznie węgiel, fluor i chlor.

- a.
 - brak 'temperatury zapłonu';
 - 'temperatura samozapłonu' powyżej 977 K (704°C);
 - 'temperatura krzepnięcia' 219 K (-54°C) lub niższa;
 - 'wskaźnik lepkości' 80 lub więcej; oraz
 - 'temperatura wrzenia' 473 K (200°C) lub wyższa;
- b. materiały smarne zawierające jako części składowe podstawowe którekolwiek z poniższych:
 1. etery lub tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe lub ich mieszaniny, zawierające powyżej dwóch grup funkcyjnych eteru lub tioeteru lub ich mieszaninę; lub
 2. fluorowe oleje silikonowe o lepkości kinematycznej poniżej 5 000 mm²/s (5 000 centystokesów) mierzonej w temperaturze 298 K (25°C);
- c. płyny zwilżające lub flotacyjne spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. czystość powyżej 99,8 %;
 2. zawierające mniej niż 25 cząstek o średnicy 200 µm lub większej w 100 ml; oraz
 3. wykonane co najmniej w 85 % z którejkolwiek z poniższych:
 - a. dibromotetrafluoroetanu (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
 - b. polichlorotrifluoroetyleny (tylko modyfikowanego olejem lub woskiem); lub
 - c. polibromotrifluoroetyleny;

d. fluorowęglowe elektroniczne płyny chłodzące spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. zawartość wagowa 85 % lub więcej następujących związków lub ich mieszanin:
 - a. monomeryczne postacie perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeterów;
 - b. perfluoroalkiloaminy;
 - c. perfluorocykloalkany; lub
 - d. perfluoroalkany;
2. gęstość przy 298 K (25°C) wynosząca 1,5 g/ml lub więcej;
3. stan ciekły w temperaturze 273 K (0°C); oraz
4. zawartość wagowa fluoru 60 % lub więcej.

Uwaga: Pozycja 1C006.d nie obejmuje kontrolą materiałów określonych i pakowanych jako produkty medyczne.

Uwaga techniczna:

Dla celów pozycji 1C006:

1. 'temperaturę zapłonu' określa się metodą Cleveland Open Cup Method (Otwartego Kubka) opisaną w normie ASTM D-92 lub jej krajowych odpowiednikach;
2. 'temperaturę krzepnięcia' określa się metodą opisaną w normie ASTM D-97 lub jej krajowych odpowiednikach;
3. 'wskaźnik lepkości' określa się metodą opisaną w normie ASTM D-2270 lub jej krajowych odpowiednikach;
4. 'stabilność termiczną' określa się według przedstawionej poniżej procedury lub jej krajowych odpowiedników:

Umieścić dwadzieścia ml badanej cieczy w komorze ze stali nierdzewnej typu 317 o pojemności 46 ml, w której znajdują się trzy kulki o średnicy (znamionowej) 12,5 mm, jedna ze stali narzędziowej M-10, druga ze stali 52100, a trzecia z mosiądzu morskiego dwufazowego (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn).

Następnie napęlić komorę azotem, zamknąć pod ciśnieniem atmosferycznym, podnieść temperaturę do 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) i utrzymać ją na tym poziomie przez sześć godzin. Próbkę uznaje się za stabilną termicznie, jeżeli po zakończeniu badania spełnione są wszystkie następujące warunki:

 - a. spadek wagi każdej z kulek jest mniejszy niż 10 mg/mm² powierzchni kulki;
 - b. zmiana lepkości początkowej określonej w temperaturze 311 K (38°C) jest mniejsza niż 25 %; oraz
 - c. całkowita liczba kwasowa lub zasadowa jest mniejsza niż 0,40;
5. 'temperaturę samozapłonu' wyznacza się metodą opisaną w normie ASTM E-659 lub w jej krajowych odpowiednikach.

1C007 Następujące materiały na osnowie ceramicznej, „niekompozytowe” materiały ceramiczne, „materiały kompozytowe” na „matrycy” ceramicznej oraz materiały macierzyste:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C107.

- a. materiały podłożowe z pojedynczych lub złożonych borków tytanowych, w których łączna ilość zanieczyszczeń metalicznych, z wyłączeniem dodatków zamierzonych, wynosi poniżej 5 000 ppm (części na milion), w których przeciętne wymiary cząstek są równe lub mniejsze niż 5 µm oraz które zawierają nie więcej niż 10 % cząstek o wielkości powyżej 10 µm;
- b. „niekompozytowe” materiały ceramiczne w postaci nieprzerobionej lub półprzetworzonej, złożone z borków tytanowych o gęstości stanowiącej 98 % lub więcej gęstości teoretycznej;
Uwaga: Pozycja 1C007.b nie obejmuje kontrolą materiałów ściernych.
- c. „materiały kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na „matrycy” szklanej lub tlenkowej, wzmacniane włóknami, spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. wykonane z któregośkolwiek z następujących materiałów:
 - a. Si-N;
 - b. Si-C;
 - c. Si-Al-O-N; lub

- d. Si-O-N; oraz
2. mające „wytrzymałość właściwą na rozciąganie” większą niż $12,7 \times 10^3$ m;
- d. „materiały kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne, z fazą metaliczną o strukturze ciągłej lub bez tej fazy, zawierające cząstki, wiskery lub włókna, w których „matrycę” stanowią węgliki lub azotki krzemu, cyrkonu lub boru;
- e. następujące materiały macierzyste (tj. specjalne polimery lub materiały metaloorganiczne) do wytwarzania dowolnej fazy lub faz materiałów ujętych w pozycji 1C007.c:
 1. polidiorganosilany (do produkcji węglika krzemu);
 2. polisilazany (do produkcji azotku krzemu);
 3. polikarbosiłazany (do produkcji materiałów ceramicznych zawierających części składowe krzemowe, węglowe i azotowe);
- f. „materiały kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na „matrycy” szklanej lub tlenkowej, wzmacniane ciągłymi włóknami wykonanymi z jednego z następujących materiałów:
 1. Al_2O_3 (CAS 1344-28-1); lub
 2. Si-C-N.

Uwaga: Pozycja 1C007.f nie obejmuje kontrolą „materiałów kompozytowych” zawierających włókna z wyszczególnionych w niej materiałów, posiadające wytrzymałość na rozciąganie mniejszą niż 700 MPa przy temperaturze 1273 K (1 000°C) lub odporność na pękanie większą niż 1 % odkształcenia przy obciążeniu 100 MPa i temperaturze 1273 K (1 000°C) w czasie 100 godzin.

1C008

Następujące materiały polimerowe niezawierające fluoru:

- a. następujące imidy:
 1. bismaleimidy;
 2. poliamidoimidy aromatyczne (PAI) o 'temperaturze zeszklenia (T_g)' powyżej 563 K (290°C);
 3. poliimidy aromatyczne o 'temperaturze zeszklenia (T_g)' powyżej 505 K (232°C);
 4. polieteroimidy aromatyczne o 'temperaturze zeszklenia (T_g)' powyżej 563 K (290°C);

Uwaga: Pozycja 1C008.a obejmuje kontrolą substancje ciekłe lub stałe w formie „topliwej”, w tym w postaci żywicy, proszku, granulek, folii, arkuszy, taśmy lub wstęgi.

NB.: Wyroby z poliimidów aromatycznych innych niż „topliwe”, w postaci folii, arkuszy, taśm lub wstęg, zob. 1A003.

- b. ciekłe kryształy z kopolimerów termoplastycznych o temperaturze ugięcia pod obciążeniem powyżej 523 K (250 °C) mierzonej według normy ISO 75-2 (2004) lub jej krajowych odpowiedników, przy obciążeniu $1,80 \text{ N/mm}^2$, w których skład wchodzi:
 1. którykolwiek z poniższych związków:
 - a. fenylen, bifenylene lub naftalen; lub
 - b. fenylen, bifenylene lub naftalen z podstawnikiem metylowym, trzeciorzędowym butylowym lub fenylovym; oraz
 2. którykolwiek z poniższych kwasów:
 - a. kwas tereftalowy (CAS 100-21-0);
 - b. kwas 6-hydroksy-2 naftoesowy (CAS 16712-64-4); lub
 - c. kwas 4-hydroksybenzoesowy (CAS 99-96-7);
- c. nieużywane;

- d. poliketony arylenowe;
- e. polisiarczki arylenowe, w których grupą arylenową jest bifenylen, trifenylen lub ich kombinacja;
- f. polisulfon bifenylenoeterowy o 'temperaturze zeszklenia (T_g)' powyżej 563 K (290°C);

Uwaga techniczna:

1. "Temperatura zeszklenia (T_g)" dla materiałów termoplastycznych z pozycji 1C008.a.2 oraz materiałów z pozycji 1C008.a.4 określana jest przy użyciu metody opisanej w normie ISO 11357-2 (1999) lub jej odpowiednikach krajowych.
2. "Temperatura zeszklenia (T_g)" dla materiałów termoutwardzalnych z pozycji 1C008.a.2 oraz materiałów z pozycji 1C008.a.3 określana jest przy użyciu metody trzypunktowego zginania opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub jej odpowiednikach krajowych. Test ten przeprowadza się na suchej próbce, która osiągnęła poziom utwardzenia co najmniej 90 %, jak określono w normie ASTM E 2160-04 lub jej odpowiednikach krajowych, i była utwardzana przy zastosowaniu połączenia procesu utwardzania standardowego i utwardzania dodatkowego, który daje najwyższą wartość T_g .

1C009 Następujące nieprzetworzone związki fluorowe:

- a. kopolimery fluorku winylidenu posiadające w 75 % lub więcej strukturę beta krystaliczną bez rozciągania;
- b. poliimidy fluorowane zawierające 10 % wagowych lub więcej związanego fluoru;
- c. fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30 % wagowych lub więcej związanego fluoru.

1C010 Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe”:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 1C210 ORAZ 9C110.

- a. organiczne „materiały włókniste lub włókienkowe”, spełniające oba poniższe kryteria:
 1. „moduł właściwy” powyżej $12,7 \times 10^6$ m; oraz
 2. „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” powyżej $23,5 \times 10^4$ m;

Uwaga: Pozycja 1C010.a nie obejmuje kontrolą polietylenu.

- b. „włókniste i włókienkowe” materiały węglowe, spełniające oba poniższe kryteria:
 1. „moduł właściwy” powyżej $14,65 \times 10^6$ m; oraz
 2. „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” powyżej $26,82 \times 10^4$ m;

Uwaga: Pozycja 1C010.b nie obejmuje kontrolą:

- a. „materiałów włóknistych lub włókienkowych” przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatów „cywilnych statków powietrznych”, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. mają powierzchnię nieprzekraczającą 1 m^2 ;
 2. mają długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz
 3. mają szerokość nieprzekraczającą 15 mm.
- b. mechanicznie siekanych lub ciętych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” o długości nieprzekraczającej 25 mm.
- c. nieorganiczne „materiały włókniste i włókienkowe”, spełniające oba poniższe kryteria:
 1. „moduł właściwy” powyżej $2,54 \times 10^6$ m; oraz
 2. temperatura topnienia, mięknięcia, rozkładu lub sublimacji powyżej 1 922 K (1 649°C) w środowisku obojętnym;

Uwaga: Pozycja 1C010.c nie obejmuje kontrolą:

- a. nieciągłych, wielofazowych, polikrystalicznych włókien z tlenku glinu w postaci włókien ciętych lub mat o strukturze bezładnej, zawierających wagowo 3 % lub więcej tlenku krzemu i mających „moduł właściwy” poniżej 10×10^6 m;
- b. włókien molibdenowych i ze stopów molibdenowych;
- c. włókien borowych;
- d. nieciągłych włókien ceramicznych o temperaturze topnienia, mięknięcia, rozkładu lub sublimacji poniżej 2 043 K (1 770°C) w środowisku obojętnym.

Uwagi techniczne:

1. Do celów obliczenia „wytrzymałości właściwej na rozciąganie”, „modułu właściwego” lub ciężaru właściwego „materiałów włóknistych i włókienkowych” z pozycji 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c wytrzymałość na rozciąganie i moduł należy określać za pomocą metody A opisanej w normie ISO 10618 (2004) lub jej odpowiednikach krajowych
 2. Ocenę „wytrzymałości właściwej na rozciąganie”, „modułu właściwego” lub ciężaru właściwego niejednokierunkowych „materiałów włóknistych i włókienkowych” (np. tkanin, mat lub opłotów) z pozycji 1C010 należy oprzeć na mechanicznych właściwościach składowych włókien jednakowo ukierunkowanych (np. włókien elementarnych, przędzy, rowingów lub kabli) przed ich przetworzeniem w niejednokierunkowe „materiały włókniste i włókienkowe”.
- d. „materiały włókniste lub włókienkowe” spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. zawierające którekolwiek z poniższych:
 - a. polieteroimidy określone w pozycji 1C008.a; lub
 - b. materiały ujęte w pozycjach od 1C008.b do 1C008.f; lub
 2. złożone z materiałów ujętych w pozycji 1C010.d.1.a lub 1C010.d.1.b i „zmieszane” z innymi materiałami włóknistymi ujętymi w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c;
- e. „materiały włókniste lub włókienkowe” w pełni lub częściowo impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), „materiały włókniste lub włókienkowe” powlekane metalem lub węglem (preformy) lub „preformy włókien węglowych” spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
1. spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. zawierające nieorganiczne „materiały włókniste lub włókienkowe” określone w pozycji 1C010.c; lub
 - b. zawierające organiczne lub węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe” spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. „moduł właściwy” powyżej $10,15 \times 10^6$ m; oraz
 2. „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” powyżej $17,7 \times 10^4$ m; oraz
 2. spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. zawierające żywicę lub pak określone w poz. 1C008 lub 1C009.b;
 - b. mające 'temperaturę zeszklenia wyznaczoną metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tg)' równą lub przekraczającą 453 K (180°C) i zawierające żywice fenolowe; lub
 - c. mające 'temperaturę zeszklenia wyznaczoną metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tg)' równą lub przekraczającą 505 K (232°C) i zawierające żywicę lub pak, które nie są wymienione w poz. 1C008 ani 1C009.b i nie są żywicami fenolowymi.

Uwaga 1: „Materiały włókniste lub włókienkowe” powlekane metalem lub węglem (preformy) lub „preformy włókien węglowych” nieimpregnowane żywicą ani pakiem są wyszczególnione jako „materiały włókniste lub włókienkowe” w poz. 1C010.a, 1C010.b i 1C010.c.

Uwaga 2: Pozycja 1C010.e nie obejmuje kontrolą:

- a. impregnowanych „matrycą” z żywicy epoksydowej węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” (prepregów) przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatów „cywilnych statków powietrznych”, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. mają powierzchnię nieprzekraczającą 1 m²;
 2. mają długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz
 3. mają szerokość nieprzekraczającą 15 mm.
- b. w pełni lub częściowo impregnowanych żywicą lub pakiem mechanicznie siekanych, mielonych lub ciętych węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” o długości nieprzekraczającej 25,0 mm, w przypadku gdy zastosowano żywicę lub pak inne niż określone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.

Uwaga techniczna:

Temperatura zeszklenia wyznaczona metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA T_g) dla materiałów wyszczególnionych w pozycji 1C010.e jest określana za pomocą metody opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub równoważnej normie krajowej przy użyciu suchej próbki. W przypadku materiałów termoutwardzalnych stopień utwardzenia suchej próbki musi wynosić co najmniej 90 % zgodnie z normą ASTM E 2160-04 lub równoważną normą krajową.

1C011

Następujące metale i związki:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJĘ 1C111.

- a. metale o rozmiarach ziarna mniejszych niż 60 µm, zarówno w postaci sferycznej, rozpylanej, sferoidalnej, płatków, jak i zmielonej, wykonane z materiałów zawierających 99 % lub więcej cyrkonu, magnezu lub ich stopów;

Uwaga techniczna:

Naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

Uwaga: Metale lub stopy wyszczególnione w pozycji 1C011.a są objęte kontrolą bez względu na to, czy są zamknięte w kapsułkach z glinu, magnezu lub berylu.

- b. bor lub stopy boru o rozmiarach ziarna 60 µm lub mniejszych, jak następuje:
 1. bor o czystości 85 % wagowo lub większej;
 2. stopy boru o zawartości boru 85 % wagowo lub większej;

Uwaga: Metale lub stopy wyszczególnione w pozycji 1C011.b są objęte kontrolą bez względu na to, czy są zamknięte w kapsułkach z glinu, magnezu lub berylu.

- c. azotan guanidyny (CAS 506-93-4);
- d. nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).

NB.: Zob. także wykaz uzbrojenia – proszki metali zmieszane z innymi substancjami dające w wyniku mieszaninę przeznaczoną do celów wojskowych.

- 1C012 Następujące materiały:
- Uwaga techniczna:
Materiały te są typowo wykorzystywane do jądrowych źródeł ciepła.
- a. pluton w dowolnej postaci zawierający izotop pluton-238 w ilości powyżej 50 % wagowych;
Uwaga: *Pozycja 1C012.a nie obejmuje kontrolą:*
 - a. *dostaw zawierających pluton w ilości 1 grama lub mniejszej;*
 - b. *dostaw zawierających 3 „gramy efektywne” lub mniej, w przypadku gdy pluton jest zawarty w czujnikach instrumentów pomiarowych;*
 - b. „uprzednio separowany” neptun-237 w dowolnej formie.
Uwaga: *Pozycja 1C012.b nie obejmuje kontrolą dostaw zawierających neptun-237 w ilości 1 grama lub mniejszej.*
- 1C101 Materiały i urządzenia do obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego lub podczerwonego i śladów akustycznych, inne niż określone w pozycji 1C001, możliwe do zastosowania w 'pociskach raketowych', podsystemach „pocisków raketowych” lub bezzałogowych statkach powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012.
- Uwaga 1: *Pozycja 1C101 obejmuje:*
- a. *materiały strukturalne i powłoki specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ich echa radarowego;*
 - b. *powłoki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ilości odbijanego lub emitowanego promieniowania z zakresu mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego promieniowania elektromagnetycznego.*
- Uwaga 2: *Pozycja 1C101 nie dotyczy powłok, które są specjalnie używane do regulacji temperatur w satelitach.*
- Uwaga techniczna:
W pozycji 1C101 'pocisk raketowy' oznacza kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.
- 1C102 Przesycane pirolizowane materiały węglowo-węglowe przeznaczone do pojazdów kosmicznych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych (sondujących) wyszczególnionych w poz. 9A104.
- 1C107 Następujące materiały grafitowe i ceramiczne, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C007:
- a. drobnoziarniste materiały grafitowe o gęstości nasypowej co najmniej 1,72 g/cm³ lub większej, mierzonej w temperaturze 288 K (15°C) i o wymiarach ziarna 100 µm lub mniejszych, możliwe do zastosowania w dyszach do rakiet i stożkach czołowych rakiet, umożliwiające uzyskanie w drodze obróbki następujących produktów:
 1. cylindry o średnicy 120 mm lub większej i długości 50 mm lub większej;
 2. rury o średnicy wewnętrznej 65 mm lub większej i grubości ścianki 25 mm lub większej i długości 50 mm lub większej; lub
 3. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub większe;NB.: *Zob. także pozycja 0C004.*
 - b. pirolityczne lub wzmacniane włóknami materiały grafitowe nadające się do zastosowania w dyszach rakiet i stożkach czołowych używanych w „pociskach raketowych”, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;

NB.: *Zob. także pozycja 0C004.*

- c. ceramiczne materiały kompozytowe (o stałej dielektrycznej poniżej 6 przy każdej częstotliwości od 100 MHz do 100 GHz), do użytku w osłonach anten radiolokatora używanych w „pociskach raketowych”, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;

- d. skrawalne, niewypalane materiały ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi, do użytku w stożkach czołowych używanych w „pociskach raketowych”, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w raketach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;
- e. wzmocnione krzemo-węglowe ceramiczne materiały kompozytowe do użytku w stożkach czołowych, raketach ponownie wchodzących w atmosferę i kłapach dysz używanych w „pociskach raketowych”, kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w raketach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104.

1C111 Następujące substancje napędowe i związki chemiczne do nich, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C011:

- a. substancje napędowe:
 - 1. sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy, inny niż wyszczególniony w wykazie uzbrojenia, złożony z cząstek o wielkości poniżej 200 μm , o zawartości glinu wynoszącej 97 % wagowych lub większej, jeżeli co najmniej 10 % ciężaru ogólnego stanowią cząstki o wielkości mniejszej niż 63 μm , zgodnie z ISO 2591:1988 lub równoważnymi normami krajowymi;

Uwaga techniczna:

Wielkość cząstek 63 μm (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce 230 (norma ASTM E-11).

- 2. Następujące proszki metali, inne niż wyszczególnione w wykazie uzbrojenia:
 - a. Proszki cyrkonu, berylu lub magnezu lub stopów tych metali, jeżeli co najmniej 90 % wagi lub objętości wszystkich cząstek stanowią cząstki o wielkości mniejszej niż 60 μm (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, płatków lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierające 97 % wagowych lub więcej któregośkolwiek z poniższych:
 - 1. cyrkonu;
 - 2. berylu; lub
 - 3. magnezu;

Uwaga techniczna:

Naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

- b. Proszki boru lub stopów boru o zawartości boru 85 % wagi lub większej, jeżeli co najmniej 90 % wagi lub objętości wszystkich cząstek stanowią cząstki o wielkości mniejszej niż 60 μm (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, płatków lub silnie rozdrobnionego proszku;

Uwaga: *Pozycje 1C111a.2.a oraz 1C111a.2.b obejmują kontrolą mieszaniny proszków o multimodalnej dystrybucji cząstek (np. mieszaniny różnej wielkości ziaren), jeżeli kontrolą objęta jest co najmniej jedna z form.*

3. następujące utleniacze używane w silnikach rakietowych na paliwo ciekłe:

- a. tritlenek diazotu (CAS 10544-73-7);
- b. ditlenek azotu (CAS 10102-44-0)/tetratlenek diazotu (CAS 10544-72-6);
- c. pentatlenek diazotu (CAS 10102-03-1);
- d. mieszaniny tlenków azotu (MON);

Uwaga techniczna:

Mieszaniny tlenków azotu stanowią roztwory tlenku azotu (NO) w tetratlenku diazotu/ditlenku azotu (N_2O_4/NO_2), które mogą być wykorzystane w systemach rakietowych. Istnieje cała skala mieszanin, które mogą być oznaczone jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j są liczbami całkowitymi przedstawiającymi procentową zawartość tlenku azotu w danej mieszaninie (np. MON3 zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 – 25 % tlenku azotu. Górną granicę stanowi MON40 – 40 % zawartości wagowej).

- e. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA dla inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA);
- f. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA ORAZ POZYCJĘ 1C238 dla związków chemicznych składających się z fluoru oraz jednego lub więcej ilości innych fluorowców, tlenu lub azotu;

4. następujące pochodne hydrazyny:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

- a. trimetylohydrazyna (CAS 1741-01-1);
- b. tetrametylohydrazyna (CAS 6415-12-9);
- c. N,N-dialilohydrazyna;
- d. allilohydrazyna (CAS 7422-78-8);
- e. etylenodihydrazyna;
- f. diazotan monometylohydrazyny;
- g. niesymetryczny diazotan monometylohydrazyny;
- h. azydek hydrazyny (CAS 14546-44-2);
- i. azydek dimetylohydrazyny;
- j. diazotan hydrazyny;
- k. diimido szczawian dihydrazyny (CAS 3457-37-2);
- l. azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN);
- m. zob. wykaz uzbrojenia dla nadchloranu hydrazyny;
- n. dinadchloran hydrazyny (CAS 13812-39-0);
- o. azotan metylohydrazyny (MHN);
- p. azotan dietylohydrazyny (DEHN);
- q. azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny (azotan 1,4-dihydrazyny) (DHTN);

5. materiały o wysokiej gęstości energetycznej inne niż wymienione w wykazie uzbrojenia, które mogą być wykorzystywane w 'pociskach rakietowych' lub bezzałogowych statkach powietrznych wyszczególnionych w poz. 9A012;

- a. paliwa mieszane składające się z paliw stałych i ciekłych, takie jak paliwo borowodorowe, o gęstości energetycznej na jednostkę masy na poziomie 40×10^6 J/kg lub większej;
- b. inne mające wysoką gęstość energetyczną paliwa i dodatki do paliw (np. kuban, roztwory jonowe, JP-10) o gęstości energetycznej na jednostkę objętości na poziomie $37,5 \times 10^9$ J/m³ lub większej zmierzonej w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu jednej atmosfery (101,325 kPa);

Uwaga: *Pozycja 1C111.a.5.b nie obejmuje kontrolą rafinowanych paliw kopalnych ani biopaliw wytworzonych z warzyw, w tym paliw silnikowych dopuszczonych do stosowania w lotnictwie cywilnym,*

chyba że są przeznaczone specjalnie do 'pocisków raketowych' lub bezzałogowych statków powietrznych wyszczególnionych w poz. 9A012.

Uwaga techniczna:

W poz. 1C111.a.5 'pocisk raketowy' oznacza kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

b. substancje polimerowe:

1. polibutadien o łańcuchach zakończonych grupą karboksylową (CTPB);
2. polibutadien o łańcuchach zakończonych grupą hydroksylową (HTPB), inny niż wyszczególniony w wykazie uzbrojenia;
3. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);
4. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN);
5. glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG);

Uwaga techniczna:

Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG) jest kopolimerem blokowym polibutano-1,4-diolu i glikolu polietylenowego (PEG).

c. inne dodatki i środki do materiałów miotających:

1. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA węglodorowodorów, dekadodorowodorów, pentodorowodorów oraz ich pochodnych;
2. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);
3. 2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5);
4. triazotan trimetyloetanu (TMETN) (CAS 3032-55-1);
5. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN) (CAS 693-21-0);
6. pochodne ferrocenu, takie jak:
 - a. zob. wykaz uzbrojenia dla katocenu;
 - b. ferrocen etylu (CAS 1273-89-8);
 - c. ferrocen propylu;
 - d. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu n-butylu;
 - e. ferrocen pentylu (CAS 1274-00-6);
 - f. ferrocen dicyklopentylu;
 - g. ferrocen dicykloheksylu;
 - h. ferrocen dietylu (CAS 1273-97-8);
 - i. ferrocen dipropylu;
 - j. ferrocen dibutylu (CAS 1274-08-4);
 - k. ferrocen diheksylu (CAS 93894-59-8);
 - l. ferrocen acetylu (CAS 1271-55-2)/1,1'-ferrocen diacetylu (CAS 1273-94-5);
 - m. zob. wykaz uzbrojenia dla kwasów karboksylowych ferrocenu;
 - n. zob. wykaz uzbrojenia dla butacenu;
 - o. inne pochodne ferrocenu wykorzystywane jako modyfikatory szybkości spalania paliwa raketowego, różne od wyszczególnionych w wykazie uzbrojenia;

Uwaga: *Pozycja 1C111.c.6.o nie obejmuje kontrolą pochodnych ferrocenu, które zawierają sześciowęglową aromatyczną grupę funkcyjną połączoną z częścią ferrocenu.*

7. 4,5 diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol (izo-DAMTR), inny niż wyszczególniony w wykazie uzbrojenia.

Uwaga: *Dla substancji miotających oraz chemikaliów składowych materiałów miotających, niewyszczególnionych w pozycji 1C111 zob. wykaz uzbrojenia.*

1C116 Stale maraging, stosowane w 'pociskach raketowych', spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C216.

- a. mające wytrzymałość na rozciąganie, mierzoną w temperaturze 293 K (20°C), równą lub większą niż:
 - 1. 0,9 GPa w fazie wyżarzenia roztworu; lub
 - 2. 1,5 GPa w fazie utwardzenia wydzieleniowego; oraz
- b. posiadające którąkolwiek z następujących postaci:
 - 1. blachy, płyty lub rury o grubości ścianek lub płyt mniejszej lub równej 5,0 mm;
 - 2. formy cylindryczne o grubości ścianek mniejszej lub równej 50 mm i średnicy wewnętrznej większej lub równej 270 mm.

Uwaga techniczna 1:

Stale maraging są stopami żelaza:

- 1. charakteryzującymi się ogólnie wysoką zawartością niklu, bardzo niską zawartością węgla i wykorzystaniem składników substytucyjnych lub przyspieszających, które umożliwiają wzmocnienie i utwardzenie wydzieleniowe tego stopu; oraz
- 2. poddawany cyklom obróbki cieplnej w celu ułatwienia procesu transformacji martenzytycznej (faza wyżarzenia roztworu), a następnie utwardzanymi (faza utwardzenia wydzieleniowego).

Uwaga techniczna 2:

W pozycji 1C116 'pocisk raketowy' oznacza kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

1C117 Następujące materiały służące do wytwarzania elementów 'pocisków raketowych':

- a. wolfram i jego stopy w postaci pyłu zawierające wagowo co najmniej 97 % wolframu o wielkości cząstek nie większej niż 50×10^{-6} m (50 μ m);
- b. molibden i jego stopy w postaci pyłu zawierające wagowo co najmniej 97 % molibdenu o wielkości cząstek nie większej niż 50×10^{-6} m (50 μ m);
- c. materiały zawierające wolfram w postaci stałej, spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 - 1. wszelkie materiały o następującym składzie:
 - a. wolfram i jego stopy zawierające wagowo co najmniej 97 % wolframu;
 - b. wolfram nasycony miedzią zawierający wagowo co najmniej 80 % wolframu; lub
 - c. wolfram nasycony srebrem zawierający wagowo co najmniej 80 % wolframu; oraz
 - 2. umożliwiające uzyskanie w drodze obróbki skrawaniem następujących produktów:
 - a. walce o średnicy 120 mm lub większej i długości 50 mm lub większej;
 - b. rury o średnicy wewnętrznej 65 mm lub większej, grubości ścianki 25 mm lub większej i długości 50 mm lub większej; lub
 - c. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub większe;

Uwaga techniczna:

W pozycji 1C117 'pocisk raketowy' oznacza kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

- 1C118 Stabilizowana tytanem stal nierdzewna duplexowa (Ti-DSS) spełniająca wszystkie poniższe kryteria:
- a. spełniająca wszystkie poniższe kryteria:
 1. zawartość wagowa chromu 17,0 – 23,0 % oraz zawartość wagowa niklu 4,5 – 7,0 %;
 2. zawartość wagowa tytanu większa niż 0,10 %; oraz
 3. obecność mikrostruktury ferrytowo-austenitowej (nazywanej także mikrostrukturą dwufazową), w której co najmniej 10 % objętości stanowi austenit (zgodnie z normą ASTM E-1181-87 lub jej odpowiednikiem krajowym); oraz
 - b. posiadająca którąkolwiek z następujących postaci:
 1. sztaby lub pręty o wielkości większej lub równej 100 mm w każdym z wymiarów;
 2. arkusze o szerokości większej lub równej 600 mm i grubości mniejszej lub równej 3 mm; lub
 3. rury o średnicy zewnętrznej większej lub równej 600 mm i grubości ścianek mniejszej lub równej 3 mm.

1C202 Stopy, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C002.b.3 lub b.4, takie jak:

- a. stopy glinu posiadające obydwie wyszczególnione niżej cechy:
 1. 'zdolne do' osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 460 MPa w temperaturze 293 K (20°C); oraz
 2. posiadające postać rur lub litych elementów cylindrycznych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej powyżej 75 mm;
- b. stopy tytanu posiadające obydwie wyszczególnione niżej cechy:
 1. 'zdolne do' osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 900 MPa w temperaturze 293 K (20°C); oraz
 2. posiadające postać rur lub litych elementów cylindrycznych (w tym odkuwek) o średnicy zewnętrznej powyżej 75 mm.

Uwaga techniczna:

Określenie stopy 'zdolne do' obejmuje stopy przed obróbką cieplną lub po obróbce cieplnej.

1C210 'Materiały włókniste lub włókienkowe' lub prepregi, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C010.a, b lub e, takie jak:

- a. węglowe lub aramidowe 'materiały włókniste lub włókienkowe' posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:
 1. „moduł właściwy” większy lub równy $12,7 \times 10^6$ m; lub
 2. „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” większa lub równa $23,5 \times 10^4$ m;

Uwaga: *Pozycja 1C210.a nie obejmuje kontrolą aramidowych 'materiałów włóknistych lub włókienkowych', zawierających wagowo 0,25 % lub więcej dowolnego modyfikatora powierzchni włókien opartego na estrach.*

- b. szklane 'materiały włókniste lub włókienkowe' posiadające obydwie z niżej wyszczególnionych cech:
 1. „moduł właściwy” większy lub równy $3,18 \times 10^6$ m; oraz
 2. „wytrzymałość właściwa na rozciąganie” większa lub równa $7,62 \times 10^4$ m;
- c. termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągle „przędze”, „rowingi”, „kable” lub „taśmy” o szerokości nieprzekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane z węglowych lub szklanych 'materiałów włóknistych lub włókienkowych' wyszczególnionych w pozycji 1C210.a lub b.

Uwaga techniczna:

Żywice tworzą matryce kompozytów.

Uwaga: W pozycji 1C210 pojęcie 'materiały włókniste lub włókienkowe' ogranicza się do ciągłych „włókien elementarnych”, „przędz”, „rowingów”, „kablów” lub „taśm”.

- 1C216 Stal maraging, inna niż wyszczególniona w pozycji 1C116, 'zdolna do' osiągania wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 1 950 MPa, w temperaturze 293 K (20°C).
- Uwaga: *Pozycja 1C216 nie obejmuje kontrolą form, w których wszystkie wymiary liniowe są mniejsze niż lub równe 75 mm.*
- Uwaga techniczna:
Określenie stal maraging 'zdolna do' obejmuje stal maraging przed obróbką cieplną lub po obróbce cieplnej.
- 1C225 Bor wzbogacony izotopem boru-10 (^{10}B) w stopniu większym niż jego naturalna liczebność izotopowa, taki jak: bor pierwiastkowy, związki i mieszaniny zawierające bor, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych.
- Uwaga: *W pozycji 1C225 mieszaniny zawierające bor obejmują materiały obciążone borem.*
- Uwaga techniczna:
Naturalna liczebność izotopowa boru-10 wynosi wagowo ok. 18,5 % (atomowo 20 %).
- 1C226 Wolfram, węgiel wolframu oraz stopy zawierające wagowo powyżej 90 % wolframu, inne niż wymienione w poz. 1C117, posiadające obydwie z niżej wyszczególnionych cech:
- w postaci form wydrążonych o symetrii cylindrycznej (łącznie z segmentami cylindrycznymi) o średnicy wewnętrznej od 100 do 300 mm; oraz
 - masa większa niż 20 kg.
- Uwaga: *Pozycja 1C226 nie obejmuje kontrolą wyrobów specjalnie zaprojektowanych jako odważniki lub kolimatory promieniowania gamma.*
- 1C227 Wapń posiadający obydwie z niżej wyszczególnionych cech:
- zawartość wagowa zanieczyszczeń metalami różnymi od magnezu poniżej 1 000 części na milion; oraz
 - zawartość wagowa boru poniżej 10 części na milion.
- 1C228 Magnez posiadający obydwie z niżej wyszczególnionych cech:
- zawartość wagowa zanieczyszczeń metalami różnymi od wapnia poniżej 200 części na milion; oraz
 - zawartość wagowa boru poniżej 10 części na milion.
- 1C229 Bizmut posiadający obydwie z niżej wyszczególnionych cech:
- czystość wagowa większa niż lub równa 99,99 %; oraz
 - zawartość wagowa srebra poniżej 10 części na milion.
- 1C230 Beryl metaliczny, stopy zawierające wagowo więcej niż 50 % berylu, związki berylu, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych, inne niż wyszczególnione w wykazie uzbrojenia.
- NB.: *ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.*
- Uwaga: *Pozycja 1C230 nie obejmuje kontrolą:*
- metalowych okien do aparatury rentgenowskiej lub do urządzeń wiertniczych;
 - profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub półprzetworzonej, zaprojektowanych specjalnie do elementów zespołów elektronicznych lub jako podłoża do obwodów elektronicznych;
 - berylu (krzemianu berylu i glinu) w postaci szmaragdów lub akwamarynów.

- 1C231 Hafn metaliczny, stopy oraz związki hafnu zawierające wagowo więcej niż 60 % hafnu, wyroby oraz złom i odpady z powstałe z wyżej wymienionych.
- 1C232 Hel-3 (^3He), mieszaniny zawierające hel-3 oraz wyroby lub urządzenia zawierające dowolne z wyżej wymienionych substancji.
- Uwaga: Pozycja 1C232 nie obejmuje kontrolą wyrobów lub urządzeń zawierających mniej niż 1 g helu-3.
- 1C233 Lit wzbogacony izotopem litu-6 (^6Li) w stopniu większym niż naturalna liczebność izotopowa oraz produkty lub urządzenia zawierające wzbogacony lit, takie jak: lit pierwiastkowy, stopy, związki, mieszaniny zawierające lit, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych.
- Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolą dozymetrów termoluminescencyjnych.
- Uwaga techniczna:
Naturalna liczebność izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 % (atomowo 7,5 %).
- 1C234 Cyrkon z zawartością wagową hafnu mniejszą niż 1 część hafnu do 500 części cyrkonu, taki jak: metal, stopy zawierające wagowo ponad 50 % cyrkonu, związki, wyroby oraz złom i odpady powstałe z wyżej wymienionych, inne niż wyszczególnione w pozycji 0A001.f.
- Uwaga: Pozycja 1C234 nie obejmuje kontrolą cyrkonu w postaci folii o grubości mniejszej lub równej 0,10 mm.
- 1C235 Tryt, związki trytu i mieszanki zawierające tryt, w których stosunek atomów trytu do wodoru przewyższa 1 część na 1000, oraz wyroby lub urządzenia zawierające te materiały.
- Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontrolą wyrobów lub urządzeń zawierających mniej niż $1,48 \times 10^3 \text{ GBq}$ (40 Ci) trytu.
- 1C236 Radionuklidy do tworzenia źródeł neutronów w oparciu o reakcję cząstek alfa-neutron, inne niż wyszczególnione w pozycjach 0C001 and 1C012.a, w następujących postaciach:
- pierwiastki;
 - związki o całkowitej aktywności alfa większej lub równej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);
 - mieszaniny o całkowitej aktywności alfa większej lub równej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);
 - wyroby lub urządzenia zawierające wyżej wymienione substancje.
- Uwaga: Pozycja 1C236 nie obejmuje kontrolą wyrobów lub urządzeń o aktywności alfa poniżej $3,7 \text{ GBq}$ (100 mCi).
- Uwaga techniczna:
W pozycji 1C236 'radionuklidy' oznaczają którekolwiek z poniższych:
- aktyn-225 (Ac-225)
 - aktyn-227 (Ac-227)
 - kaliforn-253 (Cf-253)
 - kiur-240 (Cm-240)
 - kiur-241 (Cm-241)
 - kiur-242 (Cm-242)
 - kiur-243 (Cm-243)

- kiur-244 (Cm-244)
- einstein-253 (Es-253)
- einstein-254 (Es-254)
- gadolin-148 (Gd-148)
- pluton-236 (Pu-236)
- pluton-238 (Pu-238)
- polon-208 (Po-208)
- polon-209 (Po-209)
- polon-210 (Po-210)
- rad-223 (Ra-223)
- tor-227 (Th-227)
- tor-228 (Th-228)
- uran-230 (U-230)
- uran-232 (U-232)

1C237 Rad-226 (²²⁶Ra), stopy oraz związki radu-226, mieszaniny zawierające rad-226, powstałe z nich wyroby, oraz produkty i urządzenia powstałe z wyżej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolą:

- a. aplikatorów medycznych;
- b. wyrobów lub urządzeń zawierających mniej niż 0,37 GBq (10 mCi) radu-226.

1C238 Trifluorek chloru (ClF₃).

1C239 Kruszące materiały wybuchowe, inne niż wymienione w wykazie uzbrojenia, substancje lub mieszaniny zawierające wagowo więcej niż 2 % tych materiałów, o gęstości krystalicznej większej niż 1,8 g/cm³ i prędkości detonacji powyżej 8 000 m/s.

1C240 Proszek niklu i porowaty nikiel metaliczny, inny niż wyszczególniony w pozycji 0C005, taki jak:

- a. proszek niklu posiadający obydwie z niżej wymienionych cech:
 1. czystość niklowego składnika wagowego większa niż lub równa 99 %; oraz
 2. średnia wielkość cząstek mniejsza niż 10 µm, mierzona według normy B330 Amerykańskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (ASTM);
- b. porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materiałów wyszczególnionych w pozycji 1C240.a.

Uwaga: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontrolą:

- a. włókiennokowych proszków niklu;
- b. pojedynczych porowatych blach niklowych o polu powierzchni arkusza mniejszym lub równym 1 000 cm².

Uwaga techniczna:

Pozycja 1C240.b odnosi się do porowatego metalu wyrabianego metodą zagęszczania lub spiekania materiałów wyszczególnionych w pozycji 1C240.a, celem otrzymania metalu z drobnymi porami, wzajemnie łączącymi się w całości struktury.

1C241 ren i jego stopy zawierające wagowo co najmniej 90 % renu; oraz stopy renu i wolframu zawierające wagowo powyżej 90 % jakiejkolwiek kombinacji renu i wolframu, posiadające obydwie z niżej wyszczególnionych cech:

- a. w postaci form wydrążonych o symetrii cylindrycznej (łącznie z segmentami cylindrycznymi) o średnicy wewnętrznej od 100 do 300 mm; oraz
- b. o masie większej niż 20 kg.

Następujące substancje chemiczne, które mogą być wykorzystane jako prekursory dla toksycznych środków chemicznych, oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej z niżej wymienionych substancji:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA ORAZ POZYCJĘ 1C450.

1. tiodiglikol (111-48-8);
2. tlenochlorek fosforu (10025-87-3);
3. metylofosfonian dimetylu (756-79-6);
4. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA dla: difluorek metylofosfonowy (676-99-3);
5. dichlorek metylofosfonowy (676-97-1);
6. fosforyn dimetylu (DMP)(868-85-9);
7. trichlorek fosforu (7719-12-2);
8. fosforyn trimetylu (TMP)(121-45-9);
9. chlorek tionylu (7719-09-7);
10. 3-hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3);
11. chlorek N,N-diizopropylu-(beta)-aminoetylu (96-79-7);
12. N,N-diizopropylu-(beta)-tioletoaminy (5842-07-9);
13. 3-chinuklidynol (1619-34-7);
14. fluorek potasu (7789-23-3);
15. 2-chloroetanol (107-07-3);
16. dimetyloamina (124-40-3);
17. etylofosfonian dietylu (78-38-6);
18. N,N-dimetylofosforoamidian dietylu (2404-03-7);
19. fosfonian dietylu (762-04-9);
20. chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2);
21. dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4);
22. dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8);
23. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA dla: difluorek etylofosfonowy (753-98-0);
24. fluorowodor (7664-39-3);
25. benzilan metylu (76-89-1);
26. dichloro(metylo)fosfina (676-83-5);
27. N,N-diizopropylu-(beta)-amino etanol (96-80-0);
28. alkohol pinakolinowy (464-07-3);
29. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA dla: O-etylo-2-diizopropylaminoetylo metylofosfinin (QL) (57856-11-8);
30. fosforyn trietylu (122-52-1);
31. trichlorek arsenu (7784-34-1);
32. kwas benzylowy (76-93-7);
33. metylofosfonin dietylu (15715-41-0);
34. etylofosfonian dimetylu (6163-75-3);
35. etylo-difluorofosfina (430-78-4);
36. metylo-difluorofosfina (753-59-3);
37. 3-chinuklidynon (3731-38-2);
38. pentachlorek fosforu (10026-13-8);
39. pinakolon (75-97-8);
40. cyjanek potasu (151-50-8);
41. wodorofluorek potasu (7789-29-9);
42. wodorofluorek amonu lub bifluorek amonu (1341-49-7);
43. fluorek sodu (7681-49-4);
44. wodorofluorek sodu (1333-83-1);
45. cyjanek sodu (143-33-9);
46. trietanolamina (102-71-6);
47. pentasiarczek fosforawy (1314-80-3);
48. di-izopropylamina (108-18-9);
49. dietyloaminoetanol (100-37-8);
50. siarczek sodu (1313-82-2);
51. monochlorek siarki (10025-67-9);
52. dichlorek siarki (10545-99-0);

53. chlorowodorek trietanolaminy (637-39-8);

54. chlorowodorek chlorku N,N-diizopropylu-(beta)-aminoetylu (4261-68-1);
55. kwas metylofosfonowy (993-13-5);
56. metylofosfonian dietylu (683-08-9);
57. dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy (677-43-0);
58. fosforyn triizopropylu (116-17-6);
59. etylodietanoloamina (139-87-7);
60. O,O-dietylo fosforotionian (2465-65-8);
61. O,O-dietylo fosforoditionian (298-06-6);
62. heksafluorokrzemian sodu (16893-85-9);
63. dichlorek metylotiofosfonowy (676-98-2).

Uwaga 1: Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 i .63, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 10 % mieszaniny.

Uwaga 2: Dla wywozu do „państw będących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 i .63, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 3: Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 i .62, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 4: Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą wyrobów określanych jako towary konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

1C351 Ludzkie i zwierzęce czynniki chorobotwórcze oraz „toksyny”, takie jak:

- a. następujące wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami:
 1. wirus afrykańskiej choroby koni;
 2. wirus afrykańskiego pomoru świń;
 3. wirus Andes;
 4. wirusy grypy ptaków, które są:
 - a. niescharakteryzowane; lub
 - b. określone w załączniku I pkt 2 do unijnej dyrektywy 2005/94/WE (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16) jako posiadające wysokie właściwości chorobotwórcze, w tym:
 1. wirusy typu A o wartości IVPI (wskaźnik dożylniej chorobotwórczości) dla sześciotygodniowych kurcząt powyżej 1,2; lub
 2. wirusy typu A podtypów H5 i H7, z sekwencjami genomu kodującymi liczne aminokwasy zasadowe w miejscu cięcia cząsteczki hemaglutyniny podobnymi do sekwencji obserwowanych w innych wirusach HPAI,

wskazujących na możliwość rozszczepienia cząsteczki hemaglutyniny przez większość proteaz gospodarza;

5. wirus choroby niebieskiego języka;
6. wirus Chapare;
7. wirus gorączki Chikungunya;
8. wirus Choclo;
9. wirus gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej;
10. wirus gorączki denga;

11. wirus Dobrava-Belgrade;
 12. wirus wschodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu;
 13. wirus Ebola;
 14. wirus pryszczycy;
 15. wirus ospy koziej;
 16. wirus Guanarito;
 17. wirus Hantaan;
 18. wirus Hendra;
 19. wirus opryszczki (choroba Aujeszkiego);
 20. wirus klasycznego pomoru świń;
 21. wirus japońskiego zapalenia mózgu;
 22. wirus Junin;
 23. wirus Lasu Kyasanur;
 24. wirus Laguna Negra;
 25. wirus gorączki Lassa;
 26. wirus choroby skokowej owiec;
 27. wirus Lujo;
 28. wirus choroby zgrudowacenia skóry;
 29. wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych;
 30. wirus Machupo;
 31. wirus marburski;
 32. wirus małpiej ospy;
 33. wirus zapalenia mózgu z Murray Valley;
 34. wirus rzekomego pomoru drobiu (wirus z Newcastle);
 35. wirus Nipah;
 36. wirus omskiej gorączki krwotocznej;
 37. wirus Oropouche;
 38. wirus pomoru przeżuwaczy;
 39. enterowirus świński, typ 9 (wirus choroby pęcherzykowej u świń);
 40. wirus Powassan;
 41. wirus wścieklizny i wszystkie inne wirusy należące do rodzaju Lyssa;
 42. wirus gorączki z Rift Valley;
 43. wirus zarazy bydłowej;
 44. wirus Rocio;
 45. wirus Sabia;
 46. wirus Seoul;
 47. wirus ospy owczej;
 48. wirus Sin Nombre;
 49. wirus zapalenia mózgu z St Louis;
 50. wirus choroby cieszyńskiej;
 51. wirus kleszczowego zapalenia mózgu (rosyjski wiosenno-letni wirus zapalenia mózgu);
 52. wirus ospy naturalnej;
 53. wirus wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu;
 54. wirus pęcherzykowego zapalenia jamy gębowej;
 55. wirus zachodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu;
 56. wirus żółtej gorączki;
- b. nieużywane;
- c. następujące bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łączny z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami:
1. łaseczka wąglika (*Bacillus anthracis*);
 2. pałeczka ronienia bydła (*Brucella abortus bovis*);
 3. pałeczka maltańska (*Brucella melitensis*);

4. pałeczka ronienia świń (*Brucella abortus suis*);

5. pałeczka nosacizny *Burkholderia mallei* (*Pseudomonas mallei*);
6. pałeczka melioidozy *Burkholderia pseudomallei* (*Pseudomonas pseudomallei*);
7. zarazek papuzicy *Chlamydophila psittaci* (znany wcześniej jako *Chlamydia psittaci*);
8. laseczka jadu kielbasianego gatunku *Clostridium argentinense* (znana wcześniej jako *Clostridium botulinum* typ G), szczepy wytwarzające neurotoksynę botulinową;
9. *Clostridium baratii*, szczep wytwarzający neurotoksynę botulinową;
10. laseczka jadu kielbasianego (*Clostridium botulinum*);
11. *Clostridium butyricum*, szczep wytwarzający neurotoksynę botulinową;
12. laseczka zgorzeli gazowej wytwarzająca odmiany egzotoksyn (*Clostridium perfringens*);
13. riketsja gorączki Q (*Coxiella burnetii*);
14. pałeczka tularemii (*Francisella tularensis*);
15. *Mycoplasma capricolum* podgatunek *capripneumoniae* (szczep F38);
16. *Mycoplasma mycoides* ssp. *mycoides* SC („mała kolonia”);
17. riketsja duru plamistego (*Rickettsia prowasecki*);
18. pałeczka duru (*Salmonella typhi*);
19. pałeczka okrężnicy (*Escherichia coli*) wytwarzająca toksynę Shiga (STEC) z grup serologicznych O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 oraz innych grup serologicznych wytwarzających toksynę Shiga;
20. pałeczka czerwonej (*Shigella dysenteriae*);
21. przecinkowiec cholery (*Vibrio cholerae*);
22. pałeczka dżumy (*Yersinia pestis*);

d. następujące „toksyny” i ich „podjednostki toksyn”:

1. toksyny botulinowe;
2. toksyny alfa, beta 1, beta 2, epsilon i jota laseczki zgorzeli gazowej;
3. konotoksyna;
4. rycyna;
5. saksytoksyna;
6. toksyna Shiga;
Uwaga techniczna:
Pałeczka Escherichia coli wytwarzająca toksynę Shiga (STEC) występuje również jako szczep enterokrwotoczny (enterohaemorrhagic E. coli – EHEC) lub szczep werotoksyczny (verocytotoxin producing E. coli – VTEC).
7. enterotoksyny gronkowca złocistego, hemolizyna alfa oraz toksyna wywołująca zespół wstrząsu toksycznego (wcześniej znana jako enterotoksyna F gronkowca);
8. tetrodotoksyna;
9. werotoksyna i podobne do toksyny Shiga białka dezaktywujące rybosomy;
10. mikrocytyna (*Cyanginosin*);
11. aflatoksyny;
12. abryna;
13. toksyna cholery;
14. toksyna diacetoksycyrypenolowa;
15. toksyna T-2;
16. toksyna HT-2;
17. modekcyna;
18. wolkenzyna;
19. lektyna 1 jemioly pospolitej (wiskotoksyna);

Uwaga: Pozycja 1C351.d nie obejmuje kontrolą toksyn botulinowych ani konotoksyn w postaci wyrobów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1. są wyrobami farmaceutycznymi przeznaczonymi do podawania ludziom w leczeniu schorzeń;
2. są opakowane do rozprowadzania jako wyroby lecznicze;
3. są dopuszczone przez władze państwowe do obrotu jako wyroby lecznicze.

- e. następujące grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego żywe organizmy, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami:

1. *Coccidioides immitis*;
2. *Coccidioides posadasii*.

Uwaga: Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolą „szczepionek” ani „immunotoksyn”.

1C352 Nieużywane.

1C353 Elementy genetyczne oraz zmodyfikowane genetycznie organizmy:

- a. zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych połączone z czynnikami chorobotwórczymi organizmów wyszczególnionych w pozycjach 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e lub 1C354;
- b. zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych przypisanych do jakiegokolwiek z „toksyn” wyszczególnionych w pozycji 1C351.d lub należących do nich „podjednostek toksyn”.

Uwagi techniczne:

1. Zmodyfikowane genetycznie organizmy obejmują organizmy, w których materiał genetyczny (sekwencje kwasów nukleinowych) został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, oraz organizmy wytworzone w całości lub w części sztucznie.
2. Elementy genetyczne zawierają między innymi chromosomy, genomy, plazmidy, transpozony oraz wektory, bez względu na to, czy są modyfikowane genetycznie lub czy są w całości lub częściowo syntetyzowane chemicznie.
3. Sekwencje kwasów nukleinowych połączone z czynnikami chorobotwórczymi mikroorganizmów wyszczególnionych w pozycjach 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e lub 1C354 oznaczają wszelkie sekwencje właściwe dla określonych mikroorganizmów, które:
 - a. same lub przez swoje produkty transkrybowane lub transponowane stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin; lub
 - b. wiadomo, że zwiększają zdolność określonych mikroorganizmów lub jakichkolwiek innych organizmów, do których mogą zostać wprowadzone lub z którymi mogą zostać w inny sposób zintegrowane, do spowodowania istotnych szkód dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin.

Uwaga: Pozycja 1C353 nie obejmuje kontrolą sekwencji kwasów nukleinowych połączonych z czynnikami chorobotwórczymi pałeczki okrężnicy o odmianie serologicznej O157 oraz innych szczepów wytwarzających werotoksyny, innych niż te przypisane do werotoksyn lub ich podjednostek.

1C354 Roślinne czynniki chorobotwórcze, takie jak:

- a. następujące wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami:
 1. andyjski utajony wirus ziemniaka;
 2. wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka;

- b. następujące bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczipiony lub zakażony takimi kulturami:
1. *Xantomonas albilineans*;
 2. *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* (*Xanthomonas campestris* pv. *citri* A)
[*Xanthomonas campestris* pv. *citri*];

3. *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (*Pseudomonas campestris* pv. *oryzae*);
 4. *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (*Corynebacterium michiganensis* subsp. *sepedonicum* lub *Corynebacterium sepedonicum*);
 5. *Ralstonia solanacearum*, rasa 3, biowar 2;
- c. następujące grzyby pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczerpiony lub zakażony takimi kulturami:
1. *Colletotrichum kahawae* (*Colletotrichum coffeanum* var. *virulans*);
 2. *Cochliobolus miyabeanus* (*Helminthosporium oryzae*);
 3. *Microcyclus ulei* (synonim *Dothidella ulei*);
 4. *Puccinia graminis* ssp. *graminis* var. *graminis* / *Puccinia graminis* ssp. *graminis* var. *stakmanii* (*Puccinia graminis* [syn. *Puccinia graminis* f. sp. *tritici*]);
 5. *Puccinia striiformis* (synonim *Puccinia glumarum*);
 6. *Magnaporthe oryzae* (*Pyricularia oryzae*);
 7. *Peronosclerospora philippinensis* (*Peronosclerospora sacchari*);
 8. *Sclerophthora rayssiae* var. *zeae*;
 9. *Synchytrium endobioticum*;
 10. *Tilletia indica*;
 11. *Thecaphora solani*.

1C450 Toksyczne związki chemiczne, prekursory toksycznych związków chemicznych oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej z tych substancji, takie jak:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 1C350, 1C351.d ORAZ WYKAZ UZBROJENIA.

- a. toksyczne związki chemiczne, takie jak:
1. Amiton: O,O-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylo] fosforotiolan (78-53-5) oraz odpowiednie alkilowane lub protonowane sole;
 2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)-1-propen (382-21-8);
 3. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA dla BZ: 3-chinuklidylo benzytan (6581-06-2);
 4. fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5);
 5. chlorocyjan (506-77-4);
 6. cyjanowodór (74-90-8);
 7. chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2);

Uwaga 1: Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.a.1 oraz .a.2, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 1 % mieszaniny.

Uwaga 2: Dla wywozu do „państw będących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.a.1 oraz .a.2, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 3: Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.a.4, .a.5, .a.6 oraz .a.7, w których żadna z indywidualnie

wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 4: Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą wyrobów określanych jako towary konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

b. prekursory toksycznych związków chemicznych, takie jak:

1. związki chemiczne, inne niż wymienione w wykazie uzbrojenia lub w pozycji 1C350, posiadające atom fosforu, z którym związana jest jedna grupa metylowa, etylowa, propylowa lub izopropylowa, lecz nie więcej atomów węgla;

Uwaga: *Pozycja 1C450.b.1 nie obejmuje kontrolą fonofosu: O-etylo S-fenyl-etylofosfonotiolotionianu (944-22-9).*

2. dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidowe, inne niż dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy;

NB.: *Zob. pozycja 1C350.57 dla dichlorku N,N-dimetylofosforoamidowego.*

3. N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo)-fosforoamidany dialkilo (metylu, etylu, propylu lub izopropylu), inne niż N,N-dimetylofosforoamidany dietylu wyszczególnione w pozycji 1C350;

4. chlorki 2-N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetylu i odpowiednie protonowane sole, inne niż chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu lub chlorowodorek chlorku N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu wyszczególnione w pozycji 1C350;

5. N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetan-2-ole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanol (96-80-0) i N,N-dietyloaminoetanol (100-37-8) wyszczególnione w pozycji 1C350;

Uwaga: *Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolą:*

- a. *N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;*
- b. *protonowanych soli N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8).*

6. N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetano-2-tiole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanotiol wyszczególniony w pozycji 1C350;

7. etylodietanoloamina (139-87-7) – zob. 1C350;

8. metylodietanoloamina (105-59-9).

Uwaga 1: *Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 oraz .b.6, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 10 % mieszaniny.*

Uwaga 2: *Dla wywozu do „państw będących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 oraz .b.6, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.*

Uwaga 3: *Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunkcie*

IC450.b.8, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 4: Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą wyrobów określanych jako towary konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

1D Oprogramowanie

- 1D001 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń wyszczególnionych w pozycjach od 1B001 do 1B003.
- 1D002 „Oprogramowanie” do „rozwoju” „matryc” organicznych, „matryc” metalowych, „matryc” węglowych do laminatów oraz „kompozytów”.
- 1D003 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, aby umożliwić urządzeniom wypełnianie funkcji urządzeń wyszczególnionych w pozycjach 1A004.c lub 1A004.d.
- 1D101 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów obsługi lub konserwacji wyrobów wyszczególnionych w pozycjach 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 lub 1B119.
- 1D103 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do badania obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego/podczerwonego i śladów akustycznych.
- 1D201 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” wyrobów wyszczególnionych w pozycji 1B201.

1E Technologia

- 1E001 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu lub materiałów wyszczególnionych w pozycjach 1A001.b, 1A001.c, 1A002 do 1A005, 1A006.b, 1A007, 1B lub 1C.
- 1E002 Inne „technologie”, takie jak:
- a. „technologia” do „rozwoju” lub „produkcji” polibenzotiazoli lub polibenzoksazoli;
 - b. „technologia” do „rozwoju” lub „produkcji” związków elastomerów fluorowych, zawierających co najmniej jeden monomer eteru winylowego;
 - c. „technologia” do projektowania lub „produkcji” materiałów podstawowych lub innych niż „kompozytowe” materiałów ceramicznych, takich jak:
 1. materiały podstawowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. zawierające którykolwiek z następujących związków:
 1. pojedyncze lub kompleksowe tlenki cyrkonu oraz kompleksowe tlenki krzemu lub glinu;
 2. pojedyncze azotki boru (w postaci regularnych kryształów);
 3. pojedyncze lub kompleksowe węgliki krzemu lub boru; lub
 4. pojedyncze lub kompleksowe azotki krzemu;

b. posiadające całkowitą zawartość zanieczyszczeń metalicznych (z wyłączeniem celowych domieszek) w którejkolwiek z poniższych wysokości:

1. poniżej 1 000 ppm dla pojedynczych tlenków lub węglików; lub
2. poniżej 5 000 ppm dla związków kompleksowych lub pojedynczych azotków; oraz

c. będące którymkolwiek z poniższych:

1. tlenkiem cyrkonu (CAS 1314-23-4) o przeciętnych wymiarach cząsteczek mniejszych lub równych 1 μm , niezawierającym więcej niż 10 % cząsteczek większych niż 5 μm ;
2. innymi materiałami podstawowymi o przeciętnych wymiarach cząsteczek mniejszych lub równych 5 μm , niezawierającymi więcej niż 10 % cząsteczek większych niż 10 μm ; lub
3. spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. postać płytek o stosunku długości do grubości większym niż 5;
 - b. postać wiskerów o stosunku długości do średnicy większym niż 10 przy średnicach poniżej 2 μm ; oraz
 - c. postać ciągłych lub pociętych włókien o średnicy poniżej 10 μm ;

2. nie-„kompozytowe” materiały ceramiczne składające się z materiałów wyszczególnionych w pozycji 1E002.c.1;

Uwaga: Pozycja 1E002.c.2 nie obejmuje kontrolą „technologii” do projektowania lub produkcji materiałów ściernych.

d. „technologia” do „produkcji” włókien z poliamidów aromatycznych;

e. „technologia” do instalacji, obsługiwania lub naprawy materiałów wyszczególnionych w pozycji 1C001;

f. „technologia” do naprawy struktur „kompozytowych”, laminatów lub materiałów wyszczególnionych w pozycji 1A002, 1C007.c lub 1C007.d;

Uwaga: Pozycja 1E002.f nie obejmuje kontrolą „technologii” do naprawy struktur „cywilnych statków powietrznych” za pomocą węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” oraz żywic epoksydowych, zawartych w instrukcjach producenta statku powietrznego.

g. „biblioteki (parametryczne techniczne bazy danych)” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, aby umożliwić urządzeniom wypełnianie funkcji urządzeń wyszczególnionych w pozycjach 1A004.c lub 1A004.d.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1E002.g „biblioteka (parametryczna techniczna baza danych)” oznacza zbiór informacji technicznych, którego wykorzystanie może poprawić wyniki osiągnięte przez odpowiednie systemy lub sprzęt.

1E101 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „użytkowania” wyrobów wyszczególnionych w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 do 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 do 1C118, 1D101 lub 1D103.

1E102 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach 1D001, 1D101 lub 1D103.

1E103 „Technologia” do regulacji temperatur, ciśnień lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w przypadku wykorzystania do „produkcji” „kompozytów” lub „kompozytów” częściowo przetworzonych.

1E104 „Technologia” związana z „produkcją” pirolitycznie wytwarzanych materiałów, formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podłożu z gazów prekursorowych, ulegających rozkładowi w temperaturach od 1 573 K (1 300°C) do 3 173 K (2 900°C) przy ciśnieniach od 130 Pa do 20 kPa.

Uwaga: *Pozycja 1E104 obejmuje „technologię” do łączenia gazów prekursorowych, wartości natężeń przepływu, harmonogramy oraz parametry sterowania procesem.*

1E201 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „użytkowania” wyrobów wyszczególnionych w pozycjach 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 to 1A227, 1B201, 1B225 do 1B234, 1C002.b.3. lub .b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 do 1C241 lub 1D201.

1E202 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” wyrobów wyszczególnionych w pozycjach 1A007, 1A202 lub 1A225 do 1A227.

1E203 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycji 1D201.

KATEGORIA 2 – PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW

2 A Systemy, urządzenia i części składowe

NB.: Dla łożysk bezgłośnych zob. wykaz uzbrojenia.

2A001 Łożyska, zespoły łożysk oraz ich części składowe:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2A101.

Uwaga: Pozycja 2A001 nie obejmuje kontrolą kulek o tolerancji określonej przez producenta zgodnie z normą ISO 3290, klasy 5 lub gorszej.

- a. łożyska kulkowe lub pełne wałeczkowe o tolerancjach, określonych przez producenta zgodnie z normą ISO 492 (lub według innych odpowiedników krajowych), 4 klasy tolerancji lub lepszej, posiadające pierścienie oraz elementy toczne (ISO 5593) wykonane z monelu lub berylu;

Uwaga: Pozycja 2A001.a nie obejmuje kontrolą łożysk z wałeczkami stożkowymi.

- b. nieużywane;
- c. aktywne zespoły łożysk magnetycznych, wykorzystujące którekolwiek z poniższych:
1. materiały o gęstości strumienia 2,0 T lub większej, przenoszące obciążenia większe niż 414 MPa;
 2. całkowicie elektromagnetyczne, trójwymiarowe jednobiegunowe konstrukcje dla silowników; lub
 3. wysokotemperaturowe (450 K (177°C) i więcej) czujniki położenia.

2A101 Łożyska kulkowe promieniowe, inne niż wyszczególnione w pozycji 2A001, o tolerancjach określonych zgodnie z normą ISO 492, 2. klasy tolerancji (lub zgodnie z normą ANSI/ABMA Std 20 – klasa tolerancji ABEC 9 lub według innych odpowiedników krajowych) lub lepszej, mające wszystkie wymienione poniżej cechy:

- a. średnica wewnętrzna 12–50 mm;
- b. średnica zewnętrzna 25–100 mm; oraz
- c. szerokość 10–20 mm.

2A225 Tygle, wykonane z materiałów odpornych na płynne aktynowce, takie jak:

- a. tygle spełniające oba poniższe kryteria:
1. mające pojemność od 150 cm³ do 8 000 cm³; oraz
 2. wykonane z jednego z następujących materiałów lub ich kombinacji lub nimi powlekane, o ogólnym poziomie wagowym domieszek 2 % lub mniejszym:
 - a. fluorek wapnia (CaF₂);
 - b. cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrO₃);
 - c. siarczek ceru (Ce₂S₃);
 - d. tlenek erbowy (erbia) (Er₂O₃);
 - e. tlenek hafnowy (hafnia) (HfO₂);
 - f. tlenek magnezowy (MgO);
 - g. azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (około 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
 - h. tlenek itrowy (itria) (Y₂O₃); lub
 - i. tlenek cyrkonowy (cyrkonian) (ZrO₂);

- b. tygle spełniające oba poniższe kryteria:
 - 1. mające pojemność od 50 cm³ do 2 000 cm³; oraz
 - 2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czystości wagowej tantalu 99,9 % lub większej;
- c. tygle spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - 1. mające pojemność od 50 cm³ do 2 000 cm³;
 - 2. wykonane z tantalu lub nim pokryte, o czystości wagowej tantalu 98 % lub większej; oraz
 - 3. powlekane węglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu lub jakąkolwiek ich kombinacją.

2A226 Zawory posiadające wszystkie z następujących cech:

- a. „wymiar nominalny” 5 mm lub większy;
- b. wyposażone w uszczelnienia mieszkowe; oraz
- c. w całości wykonane z glinu, stopu glinu, niklu lub stopu niklu zawierającego wagowo ponad 60 % niklu lub pokryte nimi.

Uwaga techniczna:

Dla zaworów o różnych średnicach otworu wlotowego i wylotowego pojęcie „wymiar nominalny” w pozycji 2A226 odnosi się do najmniejszej średnicy.

2 B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:

1. *Pomocnicze, równoległe osie konturowe (np. oś „w” w wiertarkach poziomych lub pomocnicza oś obrotowa, której linia centralna biegnie równoległe do głównej osi obrotu) nie są zaliczane do całkowitej liczby osi kształtowych. Osie obrotowe nie muszą obracać się o 360 °. Oś obrotowa może być napędzana za pomocą urządzenia liniowego (np. śruby lub mechanizmu zębatkowego).*
2. *Dla celów pozycji 2B za liczbę osi, które mogą być koordynowane jednocześnie w celu „sterowania kształtowego”, uznaje się liczbę osi, wzdłuż których lub dookoła których w trakcie obrabiania przedmiotu wykonywane są ruchy jednoczesne i wzajemnie powiązane pomiędzy obrabianym przedmiotem a narzędziem. Nie obejmuje to żadnych dodatkowych osi, wzdłuż lub dookoła których wykonywane są inne ruchy względne maszyny, takich jak:*
 - a. *systemów obciążania ściernic w szlifierkach;*
 - b. *równoległych osi obrotowych, przeznaczonych do mocowania oddzielnych przedmiotów obrabianych;*
 - c. *współliniowych osi obrotowych przeznaczonych do manipulowania tym samym przedmiotem poprzez zamocowanie go w uchwytach z oddzielnymi końców.*
3. *Nazewnictwo osi powinno być zgodne z Międzynarodową Normą ISO 841, 'Maszyny sterowane numerycznie – Nazewnictwo osi i ruchów'.*
4. *Na potrzeby pozycji od 2B001 do 2B009 „wrzeczono wahliwe” jest zaliczane do osi obrotowych.*
5. *Jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do indywidualnych testów dla każdego modelu obrabiarki można stosować 'poziomą gwarantowaną dokładność pozycjonowania', ustaloną przy pomiarach wykonanych stosownie do normy ISO 230/2 lub jej odpowiednika krajowego. 'Pozioma gwarantowana dokładność pozycjonowania' oznacza wartość dokładności, przyjętą przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, jako reprezentatywną dokładność określonego modelu maszyny.*

Określanie poziomu 'gwarantowanej dokładności pozycjonowania':

- a. *wybrać pięć egzemplarzy modelu maszyny, który ma być oceniany;*
- b. *zmierzyć liniowe dokładności osi zgodnie z ISO 230/2;*
- c. *określić wartość A dla każdej osi każdej maszyny. Metoda określania wartości A opisana jest w normie ISO;*

- d. określić wartości średnie wartości A dla każdej osi. Średnia wartość $\hat{A}$ staje się gwarantowaną wartością dla każdej osi modelu ($\hat{A}_x, \hat{A}_y, \dots$);
- e. ponieważ wykaz kategorii 2 odnosi się do każdej osi liniowej, wartości gwarantowanych będzie tyle, ile jest osi liniowych;

- f. jeżeli któraś z osi modelu maszyny nieobjętego kontrolą przez podpunkty od 2B001.a do 2B001.c lub 2B201 posiada gwarantowaną dokładność $\bar{A}$ równą wyspecyfikowanej gwarantowanej dokładności każdego z modeli obrabiarek plus $2\text{ }\mu\text{m}$ lub lepszą, od producenta powinno się wymagać potwierdzania poziomu dokładności raz na osiemnaście miesięcy.
6. Dla celów pozycji 2B001.a do 2B001.c nie uwzględnia się niepewności pomiarowej w odniesieniu do dokładności pozycjonowania obrabiarek, jak zdefiniowano w Międzynarodowej Normie ISO 230/2 (2006)¹ lub jej równoważnikach krajowych.

2B001 Obrabiarki oraz ich różne kombinacje, do skrawania (lub cięcia) metali, materiałów ceramicznych lub „kompozytów”, które, według danych technicznych producenta, mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do „sterowania numerycznego”, w tym:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B201.

Uwaga 1: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolą obrabiarek do specjalnych zastosowań ograniczonych do wytwarzania kół zębatach. Dla takich maszyn zob. pozycja 2B003.

Uwaga 2: Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolą obrabiarek do specjalnych zastosowań ograniczonych do wytwarzania którykolwiek z poniższych:

- a. wałów korbowych lub rozrządowych;
- b. narzędzi lub noży do obrabiarek;
- c. ślimaków do wytłaczarek;
- d. grawerowanych lub szlifowanych części biżuterii. lub
- e. protez dentystycznych.

Uwaga 3: Obrabiarki posiadające co najmniej dwie z trzech następujących zdolności: toczenia, frezowania lub szlifowania (np. tokarka ze zdolnością do frezowania), muszą być oszacowane stosownie odpowiednio do każdej pozycji 2B001.a, .b lub .c.

NB.: W odniesieniu do maszyn wykorzystujących optyczną obróbkę wykańczającą – zob. pozycja 2B002.

a. tokarki spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa $3,0\text{ }\mu\text{m}$ lub mniej (lepsza), zgodnie z ISO 230/2 (2006)² lub równoważną normą krajową, mierzona wzdłuż jednej lub więcej osi liniowych; oraz
2. dwie lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”;

Uwaga: Pozycja 2B001.a nie obejmuje kontrolą tokarek specjalnie zaprojektowanych do wytwarzania soczewek kontaktowych i spełniających wszystkie poniższe kryteria:

- a. sterownik obrabiarki jest ograniczony do wykorzystywania oprogramowania służącego do programowania obróbki detali opartego na oprogramowaniu okulistycznym; oraz
- b. brak uchwytów próżniowych.

¹ jak w pozycji 2B001.a.1.

² Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1988) lub (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

b. frezarki spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 - a. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa $3,0\text{ }\mu\text{m}$ lub mniej (lepsz), zgodnie z ISO 230/2 (2006)¹ lub równoważną normą krajową, mierzona wzdłuż jednej lub więcej osi liniowych; oraz
 - b. trzy osie liniowe oraz dodatkowo jedną oś obrotową, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”;
2. pięć lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

NB.: 'Obrabiarki z mechanizmem równoległym' są zdefiniowane w pozycji 2B001.b.2.d.

- a. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa $3,0\text{ }\mu\text{m}$ lub mniej (lepsz), zgodnie z ISO 230/2 (2006)¹ lub równoważną normą krajową, mierzona wzdłuż jednej lub więcej osi liniowych przy długości ruchu mniejszej niż 1 m;
- b. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa $4,5\text{ }\mu\text{m}$ lub mniej (lepsz), zgodnie z ISO 230/2 (2006)¹ lub równoważną normą krajową, mierzona wzdłuż jednej lub więcej osi liniowych przy długości ruchu co najmniej 1 m i mniejszej niż 2 m;
- c. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa $4,5 + 7(L-2)\text{ }\mu\text{m}$ lub mniej (lepsz) (L oznacza długość ruchu w metrach), zgodnie z ISO 230/2 (2006)¹ lub równoważną normą krajową, mierzona wzdłuż jednej lub więcej osi liniowych przy długości ruchu mniejszej niż 2 m; lub
- d. będące obrabiarkami z mechanizmem równoległym¹.

Uwaga techniczna:

'Obrabiarka z mechanizmem równoległym' jest obrabiarką mającą kilka cylindrów, które są połączone z platformą i siłownikami; każdy z siłowników operuje danym cylindrem jednocześnie i niezależnie.

3. dokładność pozycjonowania dla wiertarek współrzędnościowych, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa $3,0\text{ }\mu\text{m}$ lub mniej (lepsz), zgodnie z ISO 230/2 (2006)¹ lub równoważną normą krajową, mierzona wzdłuż jednej lub więcej osi liniowych; lub
4. maszyny do obróbki frezem jednostrzowym spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. wartość „bicia promieniowego” i „bicia osiowego” wrzeczona mniejsza (lepsz) niż $0,0004\text{ mm}$; oraz
 - b. wartość odchylenia kąтового posuwu (odchyłu, skoku i obrotu) mniejsza (lepsz) niż 2 sekundy kątowe, na 300 mm odcinku ruchu;

¹ Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1988) lub (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

c. szlifierki spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 - a. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa $3,0\text{ }\mu\text{m}$ lub mniej (lepszą), zgodnie z ISO 230/2 (2006)¹ lub równoważną normą krajową, mierzona wzdłuż jednej lub więcej osi liniowych; oraz
 - b. trzy lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”; lub
2. pięć lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”;

Uwaga: Pozycja 2B001.c nie obejmuje kontrolą następujących szlifierek:

- a. szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnątrzno-wewnętrznego szlifowania na okrągło, spełniających wszystkie poniższe kryteria:
 1. ograniczenie do szlifowania na okrągło; oraz
 2. ograniczenie do maksymalnych wymiarów przedmiotu obrabianego do 150 mm średnicy zewnętrznej lub długości;
 - b. obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako szlifierki współrzędnościowe, nieposiadających osi z ani osi w, o dokładności pozycjonowania z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji” wynoszącej mniej (lepiej) niż $3,0\text{ }\mu\text{m}$ zgodnie z ISO 230/2 (2006)¹ lub odpowiednikami krajowymi;
 - c. szlifierek powierzchniowych.
- d. obrabiarki elektroiskrowe (EDM), niedrutowe, posiadające dwie lub więcej osi obrotowych, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”;
- e. obrabiarki do obróbki skrawaniem metali, materiałów ceramicznych lub „kompozytowych” spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. usuwające materiał za pomocą któregośkolwiek z niżej wymienionych sposobów:
 - a. wysokociśnieniowym strumieniem wody lub innej cieczy roboczej, w tym zawierającej substancje ściernie;
 - b. wiązką elektronów; lub
 - c. wiązką „laserową”; oraz
 2. posiadające co najmniej dwie osie obrotowe i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. można je jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”; oraz
 - b. posiadają dokładność pozycjonowania mniejszą (lepszą) niż $0,003^\circ$;
- f. wiertarki do głębokich otworów i tokarki zmodyfikowane do wiercenia głębokich otworów posiadające maksymalną zdolność do wiercenia otworów o głębokości przekraczającej 5 m.

¹ Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1988) lub (1997) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

- 2B002 Obrabiarki sterowane numerycznie wykorzystujące optyczną obróbkę wykańczającą przystosowane do selektywnego usuwania materiału w celu uzyskania optycznych powierzchni asferycznych spełniające wszystkie poniższe kryteria:
- obróbka wykańczająca z tolerancją mniejszą (lepszą) niż 1,0 μm ;
 - obróbka wykańczająca pozwalająca na uzyskanie chropowatości mniejszej (lepszey) niż 100 nm (wartość średnia kwadratowa);
 - cztery lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”; oraz
 - przy wykorzystaniu któregośkolwiek z następujących procesów:
 - magnetoreologiczna obróbka wykańczająca ('MRF');
 - elektroreologiczna obróbka wykańczająca ('ERF');
 - 'obróbka wykończeniowa wiązką cząstek wysokoenergetycznych';
 - 'obróbka narzędziami z membranami ciśnieniowymi'; lub
 - 'obróbka strumieniem płynu'.
- Uwagi techniczne:
Do celów pozycji 2B002:
- 'MRF' oznacza proces usuwania materiału, wykorzystujący ścierny płyn magnetyczny, którego lepkość sterowana jest polem magnetycznym.
 - 'ERF' oznacza proces usuwania materiału, wykorzystujący ścierny płyn, którego lepkość sterowana jest polem elektrycznym.
 - 'Obróbka wykończeniowa wiązką cząstek wysokoenergetycznych' wykorzystuje plazmy atomów reaktywnych (RAP) lub wiązki jonowe do selektywnego usuwania materiału.
 - 'Obróbka narzędziami z membranami ciśnieniowymi' oznacza proces wykorzystujący membranę pod ciśnieniem, która ulega deformacji, w celu zetknięcia z obrabianym przedmiotem na małej powierzchni.
 - Podczas 'obróbki strumieniem płynu' do usuwania materiału wykorzystuje się strugę płynu.
- 2B003 Obrabiarki „sterowane numerycznie” lub ręcznie oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły, urządzenia sterujące i oprzyrządowanie, specjalnie opracowane do skrawania, obróbki, wykańczania, szlifowania lub gładzenia hartowanych ($R_c = 40$ lub więcej) kół zębatych o zębach prostych, kół zębatych śrubowych i daszkowych o średnicy toczonej powyżej 1,250 mm i szerokości wieńca wynoszącej 15 % średnicy toczonej lub większej, wykończone do jakości AGMA 14 lub wyższej (równoważnej Klasie 3 normy ISO 1328).
- 2B004 Pracujące na gorąco „prasy izostatyczne” spełniające wszystkie poniższe kryteria oraz specjalnie zaprojektowane do nich podzespoły i oprzyrządowanie, takie jak:
- posiadające możliwość regulacji warunków termicznych w zamkniętej formie oraz wyposażone w komorę formy o średnicy wewnętrznej 406 mm lub większej; oraz
 - spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - maksymalne ciśnienie robocze powyżej 207 MPa;
 - regulacja warunków termicznych powyżej 1 773 K (1 500°C); lub
 - łatwość nasycania węglowodorami i usuwania powstających gazowych produktów rozkładu.

Uwaga techniczna:

Wewnętrzny wymiar komory oznacza wymiar komory, w którym osiąga się zarówno temperaturę roboczą jak i ciśnienie robocze; termin ten nie obejmuje kontrolą osprzętu. Wymiar ten będzie mniejszą ze średnic wewnętrznych komory ciśnieniowej lub izolowanej komory paleniskowej, w zależności od tego, która z tych komór jest umieszczona wewnątrz drugiej.

NB.: W przypadku specjalnie zaprojektowanych matryc, form i oprzyrządowania zob. pozycje 1B003, 9B009 oraz wykaz uzbrojenia.

2B005

Sprzęt specjalnie zaprojektowany do osadzania, przetwarzania i automatycznej kontroli w czasie obróbki pokryw i powłok nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzchniowych, przeznaczony do wytwarzania podłoży nieelektronicznych, technikami wyszczególnionymi w tabeli oraz uwagach umieszczonych po pozycji 2E003.f oraz specjalnie do nich opracowane zautomatyzowane podzespoły do obsługiwaniania, ustalania położenia, manipulowania i sterowania, w tym:

- a. sprzęt produkcyjny do chemicznego osadzania warstw z faz gazowych (CVD) spełniający oba poniższe kryteria:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B105.

1. modyfikacja procesu do wymienionego poniżej:
 - a. CVD pulsujące;
 - b. rozkład termiczny z regulowaną nukleacją (CNTD); lub
 - c. CVD intensyfikowane lub wspomagane plazmowo; oraz
 2. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. zawierający wysokopróżniowe (równe lub mniejsze od 0,01 Pa) uszczelnienia wirujące; lub
 - b. zawierający wbudowane urządzenia do regulowania grubości powłoki;
- b. sprzęt produkcyjny do implantacji jonów o natężeniu wiązki 5 mA lub większym;
- c. sprzęt produkcyjny do elektronowego naparowywania próżniowego (EB-PVD) zaopatrzony w układy zasilania o mocy powyżej 80 kW i posiadający którekolwiek z poniższych:
1. „laserowy” system regulacji poziomu cieczy, umożliwiający precyzyjne sterowanie podawaniem materiału wsadowego; lub
 2. system kontroli wydajności, sterowany komputerowo, działający na zasadzie fotoluminescencji zjonizowanych atomów w strumieniu odparowanego czynnika, umożliwiający sterowanie wydajnością napyłania pokrycia, składającego się z dwóch lub więcej pierwiastków;
- d. sprzęt produkcyjny do napyłania plazmowego spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. możliwość pracy w atmosferze o regulowanym niskim ciśnieniu (równym lub mniejszym od 10 kPa, mierzonym powyżej i w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natryskowej) w komorze próżniowej, w której przed rozpoczęciem napyłania można obniżyć ciśnienie do 0,01 Pa; lub
 2. zawierający wbudowane urządzenia do regulowania grubości powłoki;
- e. sprzęt produkcyjny do napyłania jonowego zdolny do osiągnięcia prądu o gęstości $0,1 \text{ mA/mm}^2$ lub większej przy wydajności napyłania $15 \text{ }\mu\text{m/h}$ lub wyższej;
- f. sprzęt produkcyjny do napyłania łukowo-katodowego zawierający siatki elektromagnesów do sterowania łukiem na katodzie;
- g. sprzęt produkcyjny do powlekania jonowego zdolny do przeprowadzenia na miejscu pomiaru jednego z niżej wymienionych parametrów:
1. grubości powłoki na podłożu i wydajności procesu; lub
 2. właściwości optycznych.

Uwaga: Pozycja 2B005 nie obejmuje kontrolą urządzeń do chemicznego osadzania warstw z faz gazowych, napyłania katodowego, napyłania jonowego, jonowego powlekania lub implantacji jonów, specjalnie zaprojektowanych do narzędzi tnących i skrawających.

2B006 Systemy, sprzęt oraz „zespoły elektroniczne” do kontroli wymiarowej lub pomiarów, takie jak:

- a. sterowane komputerowo lub „sterowane numerycznie” urządzenia do pomiaru współrzędnych (CMM), posiadające maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości ($E_{0, MPE}$), wzdłuż trzech osi (objętościowy), w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. w długości osi) równy lub mniejszy (lepszy) niż $(1,7 + L/1\ 000)\ \mu\text{m}$ (gdzie L jest długością, mierzoną w mm), zgodnie z ISO 10360-2 (2009);

Uwaga techniczna:

Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości ($E_{0, MPE}$) najdokładniejszej konfiguracji urządzenia do pomiaru współrzędnych określonej przez producenta (np. najlepsze: czujnik, długość ramienia, parametry ruchu, warunki środowiskowe) przy „wszystkich dostępnych kompensacjach” porównuje się do progu $1,7 + L/1\ 000\ \mu\text{m}$.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B206.

- b. przyrządy do pomiaru odchylenia liniowego i kąтового:

1. przyrządy do pomiaru „odchylenia liniowego”, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

Uwaga: Interferometry „laserowe” do pomiaru odchylenia są objęte kontrolą tylko w pozycji 2B006.b.1.c.

Uwaga techniczna:

Dla celów pozycji 2B006.b.1 „odchylenie liniowe” oznacza zmianę odległości pomiędzy czujnikiem a obiektem mierzonym.

- a. bezstykowe systemy pomiarowe o „rozdzielczości” równej lub mniejszej (lepszej) niż $0,2\ \mu\text{m}$ w zakresie pomiarowym do $0,2\ \text{mm}$;
- b. systemy transformatorowych różnicowych czujników położenia liniowego (LVDT) spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. mające „liniowość” równą lub mniejszą (lepszą) niż $0,1\ \%$, mierzoną od 0 do 'pełnego zakresu roboczego' dla LVDT o 'pełnym zakresie roboczym' do $\pm 5\ \text{mm}$ włącznie; lub
 - b. mające „liniowość” równą lub mniejszą (lepszą) niż $0,1\ \%$, mierzoną od 0 do $5\ \text{mm}$ dla LVDT o 'pełnym zakresie roboczym' większym niż $\pm 5\ \text{mm}$; oraz
 2. dryf równy lub mniejszy (lepszy) niż $0,1\ \%$ na dzień w standardowej temperaturze pomieszczenia pomiarowego $\pm 1\ \text{K}$;

Uwaga techniczna:

Dla celów pozycji 2B006.b.1.b. 'pełny zakres roboczy' jest równy połowie całego odchylenia liniowego, jakie może zmierzyć LVDT. Przykładowo LVDT o 'pełnym zakresie roboczym' do $\pm 5\ \text{mm}$ włącznie może zmierzyć całkowite możliwe odchylenie liniowe wynoszące $10\ \text{mm}$.

- c. systemy pomiarowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. zawierające „laser”; oraz
 2. utrzymujące, przez co najmniej 12 godzin przy temperaturze 20 ± 1 °C, wszystkie z poniższych parametrów:
 - a. „rozdzielczość” w pełnym zakresie wynoszącą $0,1 \mu\text{m}$ lub mniej (lepszą); oraz
 - b. zdolne do osiągnięcia „niepewności pomiaru” równej lub mniejszej (lepszey) niż $(0,2 + L/2\ 000) \mu\text{m}$ (gdzie L jest długością mierzoną w mm) w każdym miejscu w ramach zakresu pomiaru, przy uwzględnieniu kompensacji ze względu na współczynnik refrakcji powietrza; lub
 - d. „zespoły elektroniczne” specjalnie zaprojektowane do realizacji funkcji sprzężenia zwrotnego w systemach wyszczególnionych w pozycji 2B006.b.1.c;

Uwaga: *Pozycja 2B006.b.1 nie obejmuje kontrolą interferometrycznych systemów pomiarowych z automatycznym systemem sterowania niewykorzystującym technik sprzężenia zwrotnego, zawierających „laser” do pomiaru błędów ruchu posuwistego obrabiarek, urządzeń kontroli wymiarów lub podobnego wyposażenia.*

2. przyrządy do pomiaru przesunięć kątowych o „dokładności” położenia kąтового równej lub mniejszej (lepszey) niż $0,00025^\circ$;

Uwaga: *Pozycja 2B006.b.2 nie obejmuje kontrolą przyrządów optycznych, takich jak autokolimatory, wykorzystujących światło kolimowane (np. światło lasera), w celu wykrycia odchylenia kąтового zwierciadła.*

- c. sprzęt do pomiaru szorstkości powierzchni (w tym wad powierzchni) poprzez pomiar rozproszenia światła, o czułości $0,5 \text{ nm}$ lub mniejszej (lepszey);

Uwaga: *Pozycja 2B006 obejmuje obrabiarki, inne niż wyszczególnione w pozycji 2B001, które można wykorzystać do celów pomiarowych, jeżeli spełniają lub przewyższają kryteria określone dla funkcji maszyny pomiarowej.*

2B007 „Roboty”, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech charakterystycznych, oraz specjalnie zaprojektowane do nich urządzenia sterujące i „manipulatory”, w tym;

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B207.

- a. posiadające możliwość pełnego trójwymiarowego przetwarzania obrazów lub pełnej trójwymiarowej 'analizy obrazów' w czasie rzeczywistym, w celu tworzenia lub modyfikacji „programów” lub tworzenia lub modyfikacji numerycznych danych programowych;

Uwaga techniczna:

Ograniczenie dotyczące 'analizy obrazów' nie obejmuje kontrolą aproksymacji trzeciego wymiaru przez rzutowanie pod zadanym kątem ani stosowanego w ograniczonym zakresie cieniowania według skali szarości, wykorzystywanego do postrzegania głębi lub tekstury dla określonych zadań (2 1/2 D).

- b. specjalnie zaprojektowane w celu spełniania wymagań krajowych norm bezpieczeństwa, stosowanych w środowiskach środków potencjalnie wybuchowych;

Uwaga: Pozycja 2B007.b nie obejmuje kontrolą „robotów” specjalnie zaprojektowanych do komór lakierniczych.

- c. specjalnie zaprojektowane lub odpowiednio wzmocnione przed promieniowaniem w celu przeciwstawienia się dawce promieniowania wynoszącej 5×10^3 Gy (Si) bez pogorszenia parametrów działania; lub

Uwaga techniczna:

Termin Gy (Si) odnosi się do energii w dżulach na kilogram pochłoniętej przez nieekranowaną próbkę krzemu poddaną promieniowaniu jonizującemu.

- d. specjalnie zaprojektowane do działania na wysokościach przekraczających 30 000 m.

2B008 Zespoły lub podzespoły specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, systemów i sprzętu do kontroli wymiarów oraz systemów pomiarowych i sprzętu pomiarowego, takie jak:

- a. podzespoły położenia liniowego ze sprzężeniem zwrotnym, posiadające całkowitą „dokładność” mniejszą (lepszą) niż $(800 + (600 \times L/1\ 000))$ nm (gdzie L równa się efektywnej długości w mm);

NB.: Dla systemów „laserowych” zob. także uwaga do pozycji 2B006.b.1.c i 2B006.b.1.d.

- b. podzespoły położenia obrotowego ze sprzężeniem zwrotnym, posiadające „dokładność” mniejszą (lepszą) niż $0,00025^\circ$;

NB.: Dla systemów „laserowych” zob. także uwaga do pozycji 2B006.b.2.

Uwaga: Pozycje 2B008.a. i 2B008.b. obejmują kontrolą podzespoły, które są zaprojektowane do określania informacji dotyczącej położenia do celów kontroli sprzężenia zwrotnego, takie jak urządzenia typu indukcyjnego, z podziałką stopniową i systemy na podczerwień lub „laserowe”.

- c. „stoły obrotowo-przechyłne” oraz „wrzeciona wychyłne” umożliwiające, według danych technicznych producenta, polepszenie parametrów obrabiarek do poziomów określonych w pozycji 2B lub ponad te poziomy.

2B009 Maszyny do wyoblania i tłoczenia kształtowego, które według danych technicznych producenta mogą być wyposażone w zespoły „sterowania numerycznego” lub komputerowego oraz spełniające oba poniższe kryteria:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 2B109 I 2B209.

- a. trzy lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”; oraz
- b. nacisk wałka większy niż 60 kN.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 2B009 maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowego.

2B104 „Prasy izostatyczne”, inne niż wyszczególnione w pozycji 2B004, spełniające wszystkie poniższe kryteria:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B204.

- a. maksymalne ciśnienie robocze 69 MPa lub większe;
- b. skonstruowane dla osiągnięcia i utrzymania środowiska o regulowanych parametrach termicznych rzędu 873 K (600°C) lub większych; oraz
- c. posiadające komorę o średnicy wewnętrznej 254 mm lub większej.

2B105 Piece do CVD (chemical vapour deposition – chemicznego osadzania warstw z faz gazowych), inne niż wyszczególnione w pozycji 2B005.a, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla zagęszczania kompozytów węglowo-węglowych.

2B109 Maszyny do tłoczenia kształtowego, inne niż wyszczególnione w pozycji 2B009, oraz specjalnie zaprojektowane komponenty, takie jak:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B209.

- a. maszyny do tłoczenia kształtowego spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. mogące być wyposażone, według specyfikacji technicznej producenta, w zespoły „sterowania numerycznego” lub komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie są wyposażone w takie zespoły; oraz
 2. posiadające więcej niż dwie osie, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”;
- b. specjalnie zaprojektowane części składowe do maszyn tłoczenia kształtowego, wyszczególnionych w pozycjach 2B009 i 2B109.a.

Uwaga: *Pozycja 2B109 nie obejmuje kontrolą maszyn nienadających się do produkcji części składowych systemów napędowych i sprzętu napędowego (np. osłon silników) do systemów wyszczególnionych w pozycjach 9A005, 9A007.a lub 9A105.a.*

Uwaga techniczna:

Maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są na potrzeby pozycji 2B109 traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowego.

2B116 Następujące systemy do badań wibracyjnych, sprzęt i części składowe z nimi związane:

- a. systemy do badań wibracyjnych, wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartości

równej lub większej niż 10 g rms między 20 Hz a 2 kHz i przekazujące jednocześnie siły równe lub większe niż 50 kN, mierzone na 'nagim stole';

- b. sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem do badań wibracyjnych, cechujące się 'pasmem sterowania w czasie rzeczywistym' powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w systemach do badań wibracyjnych, wyszczególnionych w pozycji 2B116.a;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B116.b 'pasmo sterowania w czasie rzeczywistym, oznacza maksymalną szybkość, z jaką sterownik może wykonać całkowite cykle próbkowania, przetwarzania danych i przesyłania sygnałów sterowniczych.

- c. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone lub nie wyposażone w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania sił 50 kN lub większych, mierzonych na 'nagim stole', używane w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji 2B116.a;
- d. konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN lub większej, mierzonej na 'nagim stole', używane w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w pozycji 2B116.a.

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B116 pojęcie 'nagi stół' oznacza płaski stół lub powierzchnię, bez osprzętu i wyposażenia.

2B117 Środki do sterowania sprzętem i przebiegiem procesów, inne niż wyszczególnione w pozycjach 2B004, 2B005.a, 2B104 lub 2B105, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla zagęszczania i pirolizy kompozytów strukturalnych do dysz rakietowych oraz głowic powracających do atmosfery.

2B119 Następujące maszyny do wyważania i powiązany z nimi sprzęt:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B219.

- a. maszyny do wyważania, posiadające wszystkie wymienione niżej cechy:
1. nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg;
 2. nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12 500 obr./min;
 3. nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub więcej płaszczyznach; oraz
 4. nadające się do wyważania resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 0,2 gmm/kg masy wirnika;

Uwaga: *Pozycja 2B119.a nie obejmuje kontrolą wyważarek zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego.*

- b. głowice wskaźników zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w pozycji 2B119.a.

Uwaga techniczna:

Głowice wskaźników określone są czasami jako oprzyrządowanie wyważające.

- 2B120 Symulatory ruchu lub stoły obrotowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:
- a. mające dwie lub więcej osi;
 - b. zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by zawierać pierścienie ślizgowe lub zintegrowane urządzenia bezstykowe zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego lub sygnałów sterowniczych; oraz
 - c. spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. spełniające wszystkie poniższe kryteria dla jakiejkolwiek pojedynczej osi:
 - a. zdolność do osiągnięcia prędkości obrotowej równej 400 °/s lub większej lub 30 °/s lub mniejszej; oraz
 - b. rozdzielczość tempa obracania równa 6 °/s lub mniejsza z dokładnością równą 0,6 °/s lub mniejszą;
 2. posiadające stabilność dla najgorszego przypadku równą $\pm 0,05$ % lub lepszą, uśrednioną w zakresie 10 ° lub większym; lub
 3. mające „dokładność” pozycjonowania równą 5 sekund kątowych lub mniej (lepszą).

Uwaga 1: Pozycja 2B120 nie obejmuje kontrolą stołów obrotowych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzętu medycznego. Dla uregulowań dotyczących obrabiarkowych stołów obrotowych zob. pozycja 2B008.

Uwaga 2: Symulatory ruchu lub stoły obrotowe wyszczególnione w pozycji 2B120 są objęte kontrolą niezależnie od tego, czy w momencie wywozu miały już zamontowane pierścienie ślizgowe lub zintegrowane urządzenia bezstykowe.

- 2B121 Stoły pozycjonujące (sprzęt zdolny do precyzyjnego ustawiania położenia kąowego w dowolnej osi), inne niż wyszczególnione w pozycji 2B120, posiadające wszystkie następujące cechy:
- a. mające dwie lub więcej osi; oraz
 - b. mające „dokładność” pozycjonowania równą 5 sekund kątowych lub mniej (lepszą).

Uwaga: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontrolą stołów obrotowych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzętu medycznego. Dla uregulowań dotyczących obrabiarkowych stołów obrotowych zob. pozycja 2B008.

- 2B122 Wirówki umożliwiające nadanie przyspieszenia ponad 100 g i posiadające pierścienie ślizgowe lub zintegrowane urządzenia bezstykowe zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby były zdolne do przekazywania zasilania elektrycznego lub sygnałów sterowniczych.

Uwaga: Wirówki wyszczególnione w pozycji 2B122 są objęte kontrolą niezależnie od tego, czy w momencie wywozu miały już zamontowane pierścienie ślizgowe lub zintegrowane urządzenia bezstykowe.

Obrabiarki i wszelkie ich zestawy poza wyszczególnionymi poniżej w pozycji 2B001, do skrawania lub cięcia metali, materiałów ceramicznych lub „kompozytowych”, które stosownie do specyfikacji technicznej producenta mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do jednoczesnego „sterowania kształtowego” w dwóch lub więcej osiach:

- a. frezarki posiadające którąkolwiek z wymienionych poniżej cech:
 - 1. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa 6 μm lub mniej (lepsz), zgodnie z ISO 230/2 (1988)¹ lub równoważną normą krajową, wzdłuż dowolnej osi liniowej; lub
 - 2. dwie lub więcej konturowe osie obrotu;

Uwaga: Pozycja 2B201.a nie obejmuje kontrolą frezarek posiadających następujące cechy:

- a. robocza długość osi x większa niż 2 m; oraz
- b. ogólna dokładność pozycjonowania wzdłuż osi x większa (gorsza) niż 30 μm ;

- b. szlifierki posiadające którąkolwiek z wymienionych poniżej cech:
 - 1. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich możliwych kompensacji”, równa 4 μm lub mniej (lepsz), zgodnie z ISO 230/2 (1988)¹ lub równoważną normą krajową, wzdłuż dowolnej osi liniowej; lub
 - 2. dwie lub więcej konturowe osie obrotu.

Uwaga: Pozycja 2B201.b nie obejmuje kontrolą następujących szlifierek:

- a. szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnątrzno-wewnętrznego szlifowania na okrągło, posiadających wszystkie niżej wymienione cechy:
 - 1. ograniczenie do maksymalnych wymiarów przedmiotu obrabianego do 150 mm średnicy zewnętrznej lub długości; oraz
 - 2. osie ograniczone do x , z i c ;
- b. szlifierek współrzędnościowych nieposiadających osi z lub osi w przy ogólnej dokładności pozycjonowania mniejszej (lepszej) niż 4 μm zgodnie z ISO 230/2 (1988)¹ lub równoważną normą krajową.

Uwaga 1: Pozycja 2B201 nie obejmuje kontrolą obrabiarek do specjalnych zastosowań ograniczonych do wytwarzania dowolnych z następujących części:

- a. kół zębatych;
- b. wałów korbowych lub rozrządowych;
- c. narzędzi lub noży do obrabiarek;
- d. ślimaków do wytłaczarek;

Uwaga 2: Obrabiarki mogące wykonywać co najmniej dwie z trzech funkcji obejmujących: toczenie, frezowanie lub szlifowanie (np. tokarka z możliwością frezowania), podlegają ocenie na podstawie kryteriów dotyczących każdej stosownej pozycji 2B001.a, 2B201.a lub b.

¹ Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) lub (2006) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

2B204 „Prasy izostatyczne”, inne niż wyszczególnione w pozycjach 2B004 lub 2B104 i sprzęt z nimi związany, w tym:

- a. „prasy izostatyczne” posiadające obydwie niżej wymienione cechy:
 1. zdolność do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia roboczego równego 69 MPa lub większego; oraz
 2. wnękę komorową o średnicy wewnętrznej przekraczającej 152 mm;
- b. matryce, formy i zespoły sterujące specjalnie zaprojektowane do „pras izostatycznych” wyszczególnionych w pozycji 2B204.a.

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B204 wewnętrzny wymiar komory oznacza wymiar, w którym osiąga się zarówno temperaturę roboczą, jak i ciśnienie robocze, a termin ten nie obejmuje osprzętu. Wymiar ten będzie mniejszą ze średnic wewnętrznych komory ciśnieniowej lub izolowanej komory paleniskowej, w zależności od tego, która z tych komór jest umieszczona wewnątrz drugiej.

2B206 Następujące maszyny, przyrządy oraz systemy do kontroli wymiarów, inne niż wyszczególnione w pozycji 2B006:

- a. sterowane komputerowo lub „sterowane numerycznie” urządzenia do pomiaru współrzędnych spełniające jedno z poniższych kryteriów:
 1. mające tylko dwie osie i dające maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości wzdłuż jakiegokolwiek osi (w układzie jednowymiarowym), oznaczony jako kombinacja $E_{0X,MPE}$ $E_{0Y,MPE}$ $E_{0Z,MPE}$, równy lub mniejszy (lepszy) niż $(1,25 + L/1000)$ μm (gdzie L jest długością mierzoną w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. na całej długości osi), zgodnie z ISO 10360-2(2009); lub
 2. mające trzy lub więcej osi i dające maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości ($E_{0,MPE}$) wzdłuż trzech osi (tj. objętościowy) równy lub mniejszy (lepszy) niż $(1,7 + L/800)$ μm (gdzie L jest długością mierzoną w mm) w dowolnym punkcie zakresu roboczego maszyny (tj. na całej długości osi), zgodnie z ISO 10360-2(2009);

Uwaga techniczna:

Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru długości ($E_{0,MPE}$) najdokładniejszej konfiguracji urządzenia do pomiaru współrzędnych określonej zgodnie z ISO 10360-2(2009) przez producenta (np. najlepsze: czujnik, długość ramienia, parametry ruchu, warunki środowiskowe) przy wszystkich dostępnych kompensacjach porównuje się do progu $1,7 + L/800 \mu m$.

- b. systemy do jednoczesnej liniowo-kątowej kontroli półpowłok, posiadające obie z niżej wymienionych cech:
 1. „niepewność pomiarową”, wzdłuż dowolnej osi liniowej, równą lub mniejszą (lepszą) niż 3,5 μm na 5 mm; oraz
 2. „odchylenie położenia kątowego” równe lub mniejsze niż 0,02°.

Uwaga 1: Obrabiarki, które można wykorzystać do celów pomiarowych, są objęte kontrolą, jeżeli spełniają lub przekraczają kryteria określone dla funkcji obrabiarki lub maszyny pomiarowej.

Uwaga 2: Maszyna wyszczególniona w pozycji 2B206 jest objęta kontrolą, jeżeli jej zakres pracy przekracza w jakikolwiek sposób próg objęcia kontrolą.

Uwagi techniczne:

Wszystkie parametry wartości pomiarowych w pozycji 2B206 reprezentują wartości plus/minus, tj. pasmo niepewne.

2B207 „Roboty”, „manipulatory” i jednostki sterujące, inne niż wyszczególnione w pozycji 2B007, takie jak:

- a. „roboty” lub „manipulatory” specjalnie zaprojektowane tak, aby spełniały krajowe normy bezpieczeństwa stosowane przy obchodzeniu się z kruszącymi materiałami wybuchowymi (np. spełniające warunki ujęte w przepisach elektrycznych, stosowanych wobec kruszących materiałów wybuchowych);
- b. jednostki sterujące, specjalnie zaprojektowane do „robotów” i „manipulatorów” wyszczególnionych w pozycji 2B207.a.

2B209 Następujące maszyny do tłoczenia kształtowego, maszyny do wyoblania kształtowego posiadające możliwość realizacji funkcji tłoczenia kształtowego, inne niż wyszczególnione w pozycjach 2B009 lub 2B109, oraz trzpienie:

- a. maszyny spełniające oba poniższe kryteria:
 1. mające trzy lub więcej wałki (aktywne lub prowadzące); oraz
 2. mogące być wyposażone, według specyfikacji technicznej producenta, w zespoły „sterowania numerycznego” lub komputerowego;
- b. trzpienie do formowania wirników zaprojektowane do formowania wirników cylindrycznych o średnicy wewnętrznej pomiędzy 75 mm a 400 mm.

Uwaga: *Pozycja 2B209.a obejmuje maszyny posiadające tylko pojedynczy wałek przeznaczony do odkształcania metalu oraz dwa pomocnicze wałki podtrzymujące trzpień, ale nieuczestniczące bezpośrednio w procesie odkształcania.*

2B219 Następujące odśrodkowe maszyny do wielopłaszczyznowego wyważania, stałe lub przenośne, poziome lub pionowe:

- a. wyważarki odśrodkowe zaprojektowane do wyważania elastycznych wirników o długości 600 mm lub większej, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 1. wychylenie lub średnica czopa powyżej 75 mm;
 2. zdolność do wyważania zespołów o masie od 0,9 do 23 kg; oraz
 3. zdolność do osiągania prędkości obrotowych w czasie wyważania powyżej 5 000 obr./min;
- b. wyważarki odśrodkowe zaprojektowane do wyważania cylindrycznych zespołów wirnika, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 1. średnica czopa powyżej 75 mm;
 2. zdolność do wyważania zespołów o masie od 0,9 do 23 kg;
 3. zdolność wyważania z niewyważeniem szczątkowym rzędu 0,01 kg x mm/kg dla jednej płaszczyzny lub mniejszym; oraz
 4. napęd pasowy.

2B225 Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz w komorach gorących, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

- a. możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej (dla operacji wykonywanych poprzez ścianę); lub
- b. możliwość zmostkowania ponad szczytem ściany komory gorącej o grubości 0,6 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą).

Uwaga techniczna:

Zdalnie sterowane manipulatory przekształcają działanie człowieka operatora na ramię robocze i uchwyt końcowy. Mogą być typu 'master/slave' lub być sterowane joystickiem lub z klawiatury.

2B226 Piece indukcyjne z regulowaną atmosferą (próżniowe lub z gazem obojętnym) i instalacje do ich zasilania, takie jak:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 3B.

- a. piece posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 - 1. zdolność do pracy w temperaturach powyżej 1 123 K (850°C);
 - 2. wyposażone w cewki indukcyjne o średnicy 600 mm lub mniejszej; oraz
 - 3. zaprojektowane do poboru mocy wynoszącego 5 kW lub więcej;
- b. instalacje zasilające, o wydajności znamionowej 5 kW lub większej, specjalnie zaprojektowane do pieców wyszczególnionych w pozycji 2B226.a.

Uwaga: Pozycja 2B226.a nie obejmuje kontrolą pieców przeznaczonych do przetwarzania płytek półprzewodnikowych.

2B227 Próżniowe oraz posiadające inną regulowaną atmosferę, roztopiające i odlewnicze piece metalurgiczne, oraz sprzęt z nimi związany, w tym:

- a. piece łukowe do przetapiania i odlewania, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:
 - 1. wydajność elektrody topliwej pomiędzy 1 000 cm³ a 20 000 cm³; oraz
 - 2. zdolne do pracy w temperaturach topienia powyżej 1 973 K (1 700°C);
- b. piece do topienia wiązką elektronów oraz plazmowe piece do atomizacji i topienia, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:
 - 1. moc 50 kW lub większa; oraz
 - 2. zdolne do pracy w temperaturach topienia powyżej 1 473 K (1 200°C);
- c. komputerowe systemy do sterowania i śledzenia przebiegu procesów, specjalnie skonfigurowane do jakichkolwiek pieców wyszczególnionych w pozycji 2B227.a lub b.

2B228 Sprzęt do wytwarzania, montażu oraz prostowania wirników, trzpienie i matryce do formowania mieszków, w tym:

- a. sprzęt do montażu wirników, przeznaczony do montażu sekcji rurowych wirników odśrodkowych wirówek gazowych, przegród oraz pokryw;

Uwaga: Pozycja 2B228.a obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego.

- b. sprzęt do prostowania wirników, przeznaczony do osiowania sekcji rurowych wirników odśrodkowych wirówek gazowych na wspólnej osi;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B228.b taki sprzęt składa się zazwyczaj z dokładnych czujników pomiarowych, podłączonych do komputera, sterującego następnie pracą np. pneumatycznego bijaka wykorzystywanego do ustawiania sekcji rurowych wirnika.

- c. trzpienie i matryce do formowania mieszków, służące do wytwarzania mieszków jednozwojowych.

Uwaga techniczna:

Mieszki, o których mowa w pozycji 2B228.c, posiadają wszystkie niżej wymienione cechy:

- 1. średnica wewnętrzna pomiędzy 75 mm a 400 mm;
- 2. długość równa lub większa niż 12,7 mm;
- 3. głębokość pojedynczego zwoju większa niż 2 mm; oraz

4. wykonane z wysokowytrzymałych stopów glinu, stali maraging lub wysokowytrzymałych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”.

2B230 Wszystkie rodzaje 'przetworników ciśnienia' zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy

- a. wyposażone w czujniki ciśnień wykonane z glinu, stopów glinu, tlenku glinu (aluminy lub szafiru), niklu, stopów niklu o zawartości wagowej niklu ponad 60 % lub polimerów fluorowęglowodorowych lub też zabezpieczone tymi materiałami;
- b. wyposażone ewentualnie w uszczelnienia, istotne dla uszczelniania czujników ciśnień i stykające się bezpośrednio z przetwarzanym medium, wykonane z glinu, stopów glinu, tlenku glinu (aluminy lub szafiru), niklu, stopów niklu o zawartości wagowej niklu ponad 60 % lub polimerów fluorowęglowodorowych lub też zabezpieczone tymi materiałami; oraz
- c. spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. pełny zakres pomiarowy poniżej 13 kPa oraz „dokładność” lepsza niż ± 1 % (w całym zakresie); lub
 2. pełny zakres pomiarowy wynoszący 13 kPa lub więcej oraz „dokładność” lepsza niż ± 130 Pa przy pomiarze na poziomie 13 kPa.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 2B230 'przetwornik ciśnienia' oznacza urządzenie, które przekształca pomiar ciśnienia na sygnał.
2. Na potrzeby pozycji 2B230 pojęcie „dokładność” obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze otoczenia.

2B231 Pompy próżniowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

- a. gardziel wlotową o średnicy równej lub większej niż 380 mm;
- b. wydajność pompowania równą lub większą niż 15 m³/s; oraz
- c. są zdolne do wytwarzania próżni końcowej o ciśnieniu lepszym niż 13 mPa.

Uwagi techniczne:

1. Wydajność pompowania jest określona w pomiarze z użyciem azotu lub powietrza.
2. Próżnia końcowa jest określana na wlocie do pompy po jego zatkanium.

2B232 Wysokoprędkościowe systemy miotające (napędowe, gazowe, cewkowe, elektromagnetyczne, elektrotermiczne lub inne rozwinięte systemy) zdolne do przyspieszania pocisków do prędkości 1,5 km/s lub większej.

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

2B233 Sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym, spełniające wszystkie poniższe kryteria:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 2B350.i.

- a. objętościowy współczynnik przepływu na wlocie wynoszący 50 m³/h lub więcej;
- b. stopień sprężania 2:1 lub wyższy; oraz
- c. wszystkie ich powierzchnie mające bezpośredni kontakt z medium gazowym są wykonane z jednego z następujących materiałów:
 1. glin lub stop glinu;
 2. tlenek glinu;
 3. stal nierdzewna;
 4. nikiel lub stop niklu;
 5. brąz fosforowy; lub

6. polimery fluorowe.

- a. zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone lub niewyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej $0,1 \text{ m}^3$ (100 litrów) i poniżej 20 m^3 (20 000 litrów), w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jednego z następujących materiałów:
1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 2. polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);
 3. szkła (w tym materiałów powlekanych szklami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
 4. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
 5. tantalu lub 'stopów' tantalu;
 6. tytanu lub 'stopów' tytanu;
 7. cyrkonu lub 'stopów' cyrkonu; lub
 8. niobu lub 'stopów' niobu;
- b. mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, wyszczególnionych w pozycji 2B350.a, oraz wirniki napędzane, łopatki lub wały do takich mieszadeł, w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jednego z następujących materiałów:
1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 2. polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);
 3. szkła (w tym materiałów powlekanych szklami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
 4. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
 5. tantalu lub 'stopów' tantalu;
 6. tytanu lub 'stopów' tytanu;
 7. cyrkonu lub 'stopów' cyrkonu; lub
 8. niobu lub 'stopów' niobu;
- c. zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej $0,1 \text{ m}^3$ (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jednego z następujących materiałów:
1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 2. polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);
 3. szkła (w tym materiałów powlekanych szklami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
 4. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
 5. tantalu lub 'stopów' tantalu;
 6. tytanu lub 'stopów' tytanu;
 7. cyrkonu lub 'stopów' cyrkonu; lub
 8. niobu lub 'stopów' niobu;
- d. wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej $0,15 \text{ m}^2$ oraz poniżej 20 m^2 , w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jednego z następujących materiałów:
1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 2. polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);
 3. szkła (w tym materiałów powlekanych szklami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
 4. grafitu lub 'grafitu węglowego';

5. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
6. tantalu lub 'stopów' tantalu;
7. tytanu lub 'stopów' tytanu;
8. cyrkonu lub 'stopów' cyrkonu;
9. węgla krzemu;
10. węgla tytanu; lub
11. niobu lub 'stopów' niobu;

- e. kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m oraz rozdzielacze cieczy i par, kolektory cieczy, zaprojektowane do takich kolumn destylacyjnych lub absorpcyjnych, w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jednego z następujących materiałów:
 1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 2. polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);
 3. szkła (w tym materiałów powlekanych szklivami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
 4. grafitu lub 'grafitu węglowego';
 5. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
 6. tantalu lub 'stopów' tantalu;
 7. tytanu lub 'stopów' tytanu;
 8. cyrkonu lub 'stopów' cyrkonu; lub
 9. niobu lub 'stopów' niobu;
- f. zdalnie sterowany sprzęt napędzający, w którym wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jednego z następujących materiałów:
 1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu; lub
 2. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
- g. zawory i ich części, takie jak:
 1. zawory spełniające oba poniższe kryteria:
 - a. o 'rozmiarze znamionowym' większym niż 10 mm (3/8"); oraz
 - b. których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z wytwarzaną, przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z 'materiałów odpornych na korozję';
 2. Zawory, inne niż wymienione w pozycji 2B350.g.1, spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. o 'rozmiarze znamionowym' równym lub większym niż 25,4 mm (1") oraz równym lub mniejszym niż 101,6 mm (4");
 - b. mające obudowę (korpus zaworu) lub preformowane wkładki doosłonowe;
 - c. mające część zamykającą, która może być wymieniana; oraz
 - d. których wszystkie powierzchnie obudowy (korpusu zaworu) lub preformowanych wkładek doosłonowych mające bezpośredni kontakt z wytwarzaną, przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z 'materiałów odpornych na korozję';
 3. Następujące części do zaworów wymienionych w pozycjach 2B350.g.1 lub 2B350.g.2, których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z wytwarzaną, przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z 'materiałów odpornych na korozję':
 - a. obudowy (korpusy zaworów);
 - b. preformowane wkładki doosłonowe;

Uwagi techniczne:

1. Dla celów pozycji 2B350.g 'materiały odporne na korozję' oznaczają jeden z poniższych materiałów:
 - a. nikiel lub stopy o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
 - b. stopy o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 - c. polimery fluorowe (materiały polimerowe lub elastomerowe o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);
 - d. szkło lub okładziny szklane (w tym materiały powlekane szklivami lub emaliowane);
 - e. tantal lub stopy tantalu;
 - f. tytan lub stopy tytanu;

- g. *cyrkon lub stopy cyrkonu;*
 - h. *niob lub stopy niobu; lub*
 - i. *następujące materiały ceramiczne:*
 - 1. *węglik krzemu o czystości wagowej co najmniej 80 %;*
 - 2. *tlenek glinu o czystości wagowej co najmniej 99,9 %;*
 - 3. *tlenek cyrkonu (cyrkonia);*
2. *'Rozmiar znamionowy' oznacza mniejszą ze średnic: wlotu lub wylotu.*

- h. rury wielościennie, zawierające okna do wykrywania nieszczelności, w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jednego z następujących materiałów:
1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 2. polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);
 3. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
 4. grafitu lub 'grafitu węglowego';
 5. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
 6. tantalu lub 'stopów' tantalu;
 7. tytanu lub 'stopów' tytanu;
 8. cyrkonu lub 'stopów' cyrkonu; lub
 9. niobu lub 'stopów' niobu;
- i. pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m³/h lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m³/h (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K (0 °C)) oraz ciśnienia (101,3 kPa)), inne niż wyszczególnione w pozycji 2B233, oraz obudowy (korpusy pomp), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki lub dysze do pomp strumieniowych skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi), wykonane są z jednego z następujących materiałów:
1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 2. materiałów ceramicznych;
 3. żelazokrzemu (stopów żelaza o wysokiej zawartości krzemu);
 4. polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);
 5. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
 6. grafitu lub 'grafitu węglowego';
 7. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
 8. tantalu lub 'stopów' tantalu;
 9. tytanu lub 'stopów' tytanu;
 10. cyrkonu lub 'stopów' cyrkonu; lub
 11. niobu lub 'stopów' niobu;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B350.i. termin uszczelnienie odnosi się tylko do uszczelnień, które mają bezpośredni kontakt z przetwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) (lub są do tego zaprojektowane) oraz pełnią funkcję uszczelnacza podczas przesuwu wału napędowego obrotowego lub posuwisto-zwrotnego przez korpus pompy.

- j. piece do unieszkodliwiania termicznego, zaprojektowane do niszczenia chemikaliów wyszczególnionych w pozycji 1C350, posiadające specjalnie zaprojektowane systemy doprowadzania odpadów, specjalne urządzenia obsługujące oraz przeciętną temperaturę w komorze spalania powyżej 1 273 K (1 000 °C), w których wszystkie powierzchnie w systemie doprowadzania odpadów mające bezpośredni kontakt z odpadami są wykonane z jednego z następujących materiałów lub nim pokryte:
1. 'stopów' o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
 2. materiałów ceramicznych; lub
 3. niklu lub 'stopów' o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

Uwaga: Dla celów pozycji 2B350 materiały używane na uszczelki, wypełnienia, uszczelnienia, śruby, podkładki i inne materiały pełniące funkcję uszczelniającą nie decydują o statusie kontroli, pod warunkiem że części te są wymienne.

Uwagi techniczne:

1. 'Grafit węglowy' jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa grafitu wynosi 8 % lub więcej.
2. W przypadku materiałów wymienionych w powyższych pozycjach termin 'stop', jeżeli nie towarzyszy mu szczegółowe określenie stężenia pierwiastków, należy rozumieć jako oznaczający taki stop, w którym wagowa zawartość określonego metalu jest procentowo wyższa niż jakiegokolwiek innego pierwiastka.

2B351 Systemy monitorowania gazów toksycznych i przeznaczone do nich części detekcyjne, inne niż wyszczególnione w pozycji 1A004, oraz detektory, czujniki i wymienne moduły czujnikowe do nich:

- a. zaprojektowane do ciągłej pracy i wykorzystywane do wykrywania bojowych środków chemicznych lub środków chemicznych wyszczególnionych w pozycji 1C350, w stężeniach poniżej 0,3 mg/m³; lub
- b. zaprojektowane do wykrywania aktywności wstrzymującej cholinoesterazę.

2B352 Następujący sprzęt, który może być wykorzystany przy postępowaniu z materiałami biologicznymi:

- a. kompletne biologiczne obudowy zabezpieczające dla poziomu zabezpieczenia P3, P4;

Uwaga techniczna:

Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) są wyszczególnione w instrukcji WHO dotyczącej bezpieczeństwa biologicznego laboratoriów (wydanie trzecie, Genewa 2004 r.).

- b. kadzie fermentacyjne i ich części, takie jak:
 1. kadzie fermentacyjne, pozwalające na namnażanie „mikroorganizmów” chorobotwórczych lub żywych komórek wykorzystywanych do wytwarzania wirusów chorobotwórczych lub toksyn, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające pojemność całkowitą równą 20 litrów lub większą;
 2. części przeznaczone do kadzi fermentacyjnych określonych w pozycji 2B352.b.1., takie jak:
 - a. komory do hodowli przeznaczone do sterylizacji i odkażania na miejscu;
 - b. urządzenia do chwytania w komorach do hodowli;
 - c. jednostki sterowania procesami umożliwiające jednocześnie monitorowanie i kontrolowanie dwóch lub większej liczby parametrów układu fermentacji (np. temperatury, pH, składników odżywczych, stopnia wzbudzenia, rozpuszczonego tlenu, natężenia przepływu powietrza, kontrola piany);

Uwaga techniczna:

Dla celów pozycji 2B352.b. do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, bioreaktory jednorazowego użytku, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym.

- c. separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 1. natężenie przepływu powyżej 100 l/h;
 2. wykonanie elementów z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;
 3. jedno lub więcej złączy uszczelnianych w obszarze występowania pary wodnej; oraz
 4. przystosowane do wysterylizowania w stanie zamkniętym na miejscu;

Uwaga techniczna:

Do separatorów odśrodkowych zalicza się również dekantery.

- d. sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie i jego części składowe, w tym:
 1. sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie, zdolny do ciągłego rozdzielania chorobotwórczych mikroorganizmów, wirusów, toksyn i kultur komórkowych, posiadający wszystkie poniższe cechy:
 - a. całkowite pole powierzchni filtrującej równe lub większe niż 1 m²; oraz
 - b. posiadający którąkolwiek z poniższych cech:
 1. może być wysterylizowany lub odkażony na miejscu; lub
 2. działający przy wykorzystaniu elementów filtrujących jednorazowego użytku;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B352.d.1.b sterylizacja oznacza likwidację wszystkich żyjących mikroorganizmów ze sprzętu poprzez użycie czynnika fizycznego (np. para wodna) lub chemicznego. Odkażenie oznacza zniszczenie potencjalnego zagrożenia mikrobiologicznego sprzętu poprzez użycie czynników chemicznych o właściwościach bakteriobójczych. Odkażenie i sterylizacja różnią się od oczyszczania, które odnosi się do procedur oczyszczenia, zaprojektowanych w celu obniżenia ładunku mikrobiologicznego w sprzęcie bez konieczności dokonania likwidacji wszystkich zagrożeń mikrobiologicznych lub utrzymujących się przy życiu mikroorganizmów.

Uwaga: Pozycja 2B352.d nie obejmuje kontrolą sprzętu do odwrotnej osmozy określonego jako taki przez producenta.

2. elementy do filtracji o poprzecznym (stycznym) przepływie (np. moduły, elementy, kasety, pojemniki, zespoły lub płyty) o powierzchni filtrującej równej lub większej niż 0,2 m² dla każdego komponentu i zaprojektowane do użycia w sprzęcie do filtracji o poprzecznym (stycznym) przepływie wyszczególnionym w pozycji 2B352.d;
- e. sterylizowany parą wodną sprzęt do liofilizacji o wydajności kondensora przekraczającej 10 kg lodu na dobę i mniejszej niż 1 000 kg lodu na dobę;
- f. następujący sprzęt służący do zabezpieczania i fizycznego ograniczania:
 1. pełne lub częściowe obudowy ochronne lub kołpaki uzależnione od dowiązanego zewnętrznego źródła powietrza, pracujące pod nadciśnieniem;

Uwaga: Pozycja 2B352.f.1 nie obejmuje kontrolą kombinezonów zaprojektowanych do noszenia z niezależnym aparatem do oddychania.

2. komory klasy III bezpieczeństwa biologicznego lub izolatory o podobnych znormalizowanych wymaganiach;

Uwaga: W pozycji 2B352.f.2 izolatory obejmują elastyczne pojemniki izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rękawowe (zamknięte z pionowym przepływem).

- g. komory zaprojektowane do testowania tożsamości aerozoli zawierających „mikroorganizmy”, wirusy lub „toksyny” oraz posiadające pojemność 1 m³ lub większą.
- h. Urządzenia do suszenia rozpryskowego umożliwiające odwadnianie toksyn lub mikroorganizmów chorobotwórczych, posiadające wszystkie z następujących cech:
 1. zdolność do odparowywania wody wynoszącą $\geq 0,4$ kg/h i ≤ 400 kg/h;
 2. zdolność do wytwarzania typowych cząstek produktu o średniej wielkości ≤ 10 μ m przy pomocy aktualnego wyposażenia lub po niewielkiej modyfikacji suszarki rozpryskowej przy pomocy dysz atomizujących, które umożliwiają wytwarzanie pożądanej wielkości cząstek; oraz
 3. mogą być wysterylizowane lub odkażone na miejscu;

2C	Materialy
	Żadne.
2D	Oprogramowanie
2D001	„Oprogramowanie”, inne niż wyszczególnione w pozycji 2D002, takie jak: „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń wyszczególnionych w pozycjach 2A001 lub 2B001. „oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „użytkowania” urządzeń wyszczególnionych w pozycjach 2A001.c, 2B001 lub 2B003 do 2B009. <u>Uwaga:</u> <i>Pozycja 2D001 nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” do programowania części służącego do generowania kodów „sterowania numerycznego” do obróbki różnych części.</i>
2D002	„Oprogramowanie” urządzeń elektronicznych, nawet rezydujące w elementach elektronicznych urządzenia lub systemu, pozwalające działać tym urządzeniom lub systemom jako jednostki „sterowania numerycznego”, umożliwiające jednoczesną koordynację więcej niż czterech osi w celu „sterowania kształtowego”. <u>Uwaga 1:</u> <i>Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” specjalnie zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do użytkowania obiektów niewyszczególnionych w kategorii 2.</i> <u>Uwaga 2:</u> <i>Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” do obiektów wyszczególnionych w pozycji 2B002. W odniesieniu do „oprogramowania” do obiektów wyszczególnionych w pozycji 2B002 zob. pozycja 2D001 oraz 2D003.</i> <u>Uwaga 3:</u> <i>Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolą „oprogramowania”, które jest wywożone wraz z obiektami niewyszczególnionymi w kategorii 2 i jest niezbędnym minimum dla ich funkcjonowania.</i>
2D003	„Oprogramowanie” zaprojektowane lub zmodyfikowane do użytkowania urządzeń wyszczególnionych w pozycji 2B002, które przekształca układ optyczny, wymiary obrabianego przedmiotu i funkcje usuwania materiału w polecenia „sterowania numerycznego” służące uzyskiwaniu pożądanej formy obrabianego przedmiotu.
2D101	„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 lub 2B119 do 2B122. <u>NB.:</u> <i>ZOB. TAKŻE POZYCJA 9D004.</i>
2D201	„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 lub 2B227.
2D202	„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 2B201. <u>Uwaga:</u> <i>Pozycja 2D202 nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” do programowania części służącego do generowania kodów „sterowania numerycznego”, ale</i>

nieumożliwiającego bezpośredniego wykorzystania urządzeń do obróbki różnych części.

2D351 „Oprogramowanie”, inne niż wyszczególnione w pozycji 1D003, specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 2B351.

2E Technologia

2E001 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnione w pozycjach 2A, 2B lub 2D.

Uwaga: Pozycja 2E001 obejmuje „technologię” przeznaczoną do montowania systemów czujników w urządzenia do pomiaru współrzędnych wyszczególnione w pozycji 2B006.a.

2E002 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „produkcji” sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 2A lub 2B.

2E003 Inne „technologie”, takie jak:

a. „technologia” do „rozwoju” grafiki interaktywnej jako integralnej części jednostek „sterowanych numerycznie”, przeznaczonych do przygotowania lub modyfikacji programów obróbki części;

b. „technologia” do procesów wytwórczych wykorzystujących obróbkę metali:

1. „technologia” projektowania narzędzi, form lub uchwytów specjalnie zaprojektowanych do jednego z następujących procesów:
 - a. „formowania w stanie nadplastycznym”;
 - b. „zgrzewania dyfuzyjnego”; lub
 - c. „bezpośredniego wytłaczania hydraulicznego”;
2. dane techniczne, zawierające metody lub parametry procesu, wykorzystywane do sterowania, takie jak:
 - a. „formowanie w stanie nadplastycznym” stopów glinu, stopów tytanu lub „nadstopów”:
 1. przygotowanie powierzchni;
 2. właściwości plastyczne;
 3. temperatura;
 4. ciśnienie;
 - b. „zgrzewanie dyfuzyjne” „nadstopów” lub stopów tytanu:
 1. przygotowanie powierzchni;
 2. temperatura;
 3. ciśnienie;
 - c. „bezpośrednie wytłaczanie hydrauliczne” stopów glinu lub tytanu:
 1. ciśnienie;
 2. czas cyklu;
 - d. „izostatyczne zagęszczanie na gorąco” stopów tytanu, glinu lub „nadstopów”:
 1. temperatura;
 2. ciśnienie;
 3. czas cyklu;

- c. „technologia” do „rozwoju” lub „produkcji” obciążarek hydraulicznych i form do nich, wykorzystywanych do wytwarzania struktur płatowca;
- d. „technologia” do „rozwoju” generatorów instrukcji dla obrabiarek (np. programów do obróbki części) na podstawie danych konstrukcyjnych rezydujących w urządzeniach „sterowanych numerycznie”;
- e. „technologia” do „rozwoju” zintegrowanego „oprogramowania” do wprowadzania systemów eksperckich do wspomagania procesu decyzyjnego pracy warsztatowej, przeznaczonego do urządzeń „sterowanych numerycznie”;
- f. „technologia” do nakładania powłok nieorganicznych lub powłok nieorganicznych modyfikowanych powierzchniowo (wyszczególnionych w kolumnie 3 poniższej tabeli) na podłoża nieelektroniczne (wyszczególnione w kolumnie 2 poniższej tabeli) za pomocą procesów wyszczególnionych w kolumnie 1 poniższej tabeli i zdefiniowanych w uwadze technicznej;

Uwaga: Tabela i uwaga techniczna znajdują się za pozycją 2E301.

NB. Z tabeli należy korzystać w celu określenia konkretnej techniki powlekania tylko w przypadku, gdy powłoka wynikowa w kolumnie 3 znajduje się w polu bezpośrednio obok odnośnego podłoża w kolumnie 2. Na przykład dane techniczne procesu powlekania za pomocą osadzania z pary lotnej są podane w przypadku powlekania krzemkami podłoży z „materiałów kompozytowych” na „matrycy” węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej, lecz nie są podane w przypadku powlekania krzemkami podłoży będących 'spiekanyymi węglkami wolframu' (16) lub 'węglkami krzemu' (18). W drugim przypadku powłoka wynikowa nie jest wymieniona w kolumnie 3 w polu bezpośrednio przylegającym do pola, w którym w kolumnie 2 znajdują się 'spiekane węgliki wolframu' (16) i 'węgliki krzemu' (18).

- 2E101 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, przeznaczona do „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 do 2B122 lub 2D101.
- 2E201 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, przeznaczona do „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 do 2B233, 2D201 lub 2D202.
- 2E301 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, przeznaczona do „użytkowania” towarów wyszczególnionych w pozycjach 2B350 do 2B352.

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA

1. <u>Technika powlekania</u> (1) *	2. <u>Podłoże</u>	3. <u>Powłoka wynikowa</u>
A. Osadzanie z pary lotnej (CVD)	„Nadstopy”	Glinki na kanały wewnętrzne
	Podłoża ceramiczne (19) i szkło o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)	Krzemki Węgliki Warstwy dielektryczne (15) Diamant Węgiel diamentopodobny (17)
	„Materiały kompozytowe” na „matrycy” węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej	Krzemki Węgliki Metale ognioodporne Mieszaniny powyższych (4) Warstwy dielektryczne (15) Glinki Glinki stopowe (2) Azotek boru
	Spiekany węgiel wolframu (16), węgiel krzemu (18)	Węgliki Wolfram Mieszaniny powyższych (4) Warstwy dielektryczne (15)
	Molibden i stopy molibdenu	Warstwy dielektryczne (15)
	Beryl i stopy berylu	Warstwy dielektryczne (15) Diamant Węgiel diamentopodobny (17)
	Materiały na okienka wziernikowe (9)	Warstwy dielektryczne (15) Diamant Węgiel diamentopodobny (17)

* Indeksy w nawiasach odnoszą się do uwag zamieszczonych pod tabelą.

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA

1. <u>Technika powlekania</u> (1)	2. <u>Podłoże</u>	3. <u>Powłoka wynikowa</u>
B. Termiczne naparowywanie próżniowe (TE-PVD)		
B.1. Naparowywanie próżniowe (PVD) wiązką elektronów (EB-PVD)	„Nadstopy”	Krzemki stopowe. Glinki stopowe (2) MCrAlX (5) Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12) Krzemki Glinki Mieszaniny powyższych (4)
	Podłoża ceramiczne (19) i szkło o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)	Warstwy dielektryczne (15)
	Stale odporne na korozję (7)	MCrAlX (5) Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12) Mieszaniny powyższych (4)
	„Materiały kompozytowe” na „matrycy” węgiel- węgiel, ceramicznej i metalowej	Krzemki Węgliki Metale ognioodporne Mieszaniny powyższych (4) Warstwy dielektryczne (15) Azotek boru
	Spiekany węgiel wolframu (16), węgiel krzemu (18)	Węgliki Wolfram Mieszaniny powyższych (4) Warstwy dielektryczne (15)
	Molibden i stopy molibdenu	Warstwy dielektryczne (15)
	Beryl i stopy berylu	Warstwy dielektryczne (15) Borki Beryl
	Materiały na okienka wziernikowe (9)	Warstwy dielektryczne (15)
	Stopy tytanu (13)	Borki Azotki

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA

1. <u>Technika powlekania</u> (1)	2. <u>Podłoże</u>	3. <u>Powłoka wynikowa</u>
B.2. Napyłanie techniką ogrzewania oporowego wspomaganego (PVD) (Pokrywanie jonowe)	Podłoża ceramiczne (19) i szkło o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)	Warstwy dielektryczne (15) Węgiel diamentopodobny (17)
	„Materiały kompozytowe” na „matrycy” węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej	Warstwy dielektryczne (15)
	Spiekany węgiel wolframu (16), węgiel krzemu	Warstwy dielektryczne (15)
	Molibden i stopy molibdenu	Warstwy dielektryczne (15)
	Beryl i stopy berylu	Warstwy dielektryczne (15)
	Materiały na okienka wzornikowe (9)	Warstwy dielektryczne (15) Węgiel diamentopodobny (17)
B.3. Napyłanie próżniowe (PVD): odparowywanie „laserowe”	Podłoża ceramiczne (19) i szkło o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)	Krzemki Warstwy dielektryczne (15) Węgiel diamentopodobny (17)
	„Materiały kompozytowe” na „matrycy” węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej	Warstwy dielektryczne (15)
	Spiekany węgiel wolframu (16), węgiel krzemu	Warstwy dielektryczne (15)
	Molibden i stopy molibdenu	Warstwy dielektryczne (15)
	Beryl i stopy berylu	Warstwy dielektryczne (15)
	Materiały na okienka wzornikowe (9)	Warstwy dielektryczne (15) Węgiel diamentopodobny

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA

1. <u>Technika powlekania</u> (1)	2. <u>Podłoże</u>	3. <u>Powłoka wynikowa</u>
B.4. Naparowywanie próżniowe (PVD): za pomocą łuku katodowego	„Nadstopy” „Polimery” (11) oraz „materiały kompozytowe” na „matrycy” organicznej	Krzemki stopowe. Glinki stopowe (2) MCrAlX (5) Borki Węgliki Azotki Węgiel diamentopodobny (17)
C. Osadzanie fluidyzacyjne (zob. A powyżej dla innych technik) (10)	„Materiały kompozytowe” na „matrycy” węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej	Krzemki Węgliki Mieszaniny powyższych (4)
	Stopy tytanu (13)	Krzemki Glinki Glinki stopowe (2)
	Metale i stopy ognioodporne (8)	Krzemki Tlenki
D. Napylanie plazmowe	„Nadstopy” Stopy glinu (6) Metale i stopy ognioodporne (8)	MCrAlX (5) Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12) Mieszaniny powyższych (4) Materiał ścierny nikiel-grafit Materiał ścierny Ni-Cr-Al Materiał ścierny Al-Si-poliester Glinki stopowe (2) MCrAlX (5) Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12) Krzemki Mieszaniny powyższych (4) Glinki Krzemki Węgliki

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA

1. <u>Technika powlekania</u> (1)	2. <u>Podłoże</u>	3. <u>Powłoka wynikowa</u>
	Stale odporne na korozję (7)	MCrAlX (5) Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12) Mieszaniny powyższych (4)
	Stopy tytanu (13)	Węglik Glinki Krzemki Glinki stopowe (2) Materiał ścierny nikiel-grafit Materiał ścierny Ni-Cr-Al Materiał ścierny Al-Si- -poliester
E. Powlekanie zawieszinowe	Metale i stopy ognioodporne (8)	Krzemki stopione Glinki stopione z wyjątkiem elementów do nagrzewania oporowego
	„Materiały kompozytowe” na „matrycy” węgiel-węgiel, ceramicznej i metalowej	Krzemki Węglik Mieszaniny powyższych (4)
F. Rozpylanie jonowe	„Nadstopy”	Krzemki stopowe. Glinki stopowe (2) Glinki zmodyfikowane metalem szlachetnym (3) MCrAlX (5) Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12) Platyna Mieszaniny powyższych (4)
	Podłoża ceramiczne i szkło o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej (14)	Krzemki Platyna Mieszaniny powyższych (4) Warstwy dielektryczne (15) Węgiel diamentopodobny (17)

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA

1. <u>Technika powlekania</u> (1)	2. <u>Podłoże</u>	3. <u>Powłoka wynikowa</u>
	Stopy tytanu (13)	Borki Azotki Tlenki Krzemki Glinki Glinki stopowe (2) Węgliki
	„Materiały kompozytowe” na „matrycy” węgiel- węgiel, ceramicznej i metalowej	Krzemki Węgliki Metale ognioodporne Mieszaniny powyższych (4) Warstwy dielektryczne (15) Azotek boru
	Spiekany węgiel wolframu (16), węgiel krzemu (18)	Węgliki Wolfram Mieszaniny powyższych (4) Warstwy dielektryczne (15) Azotek boru
	Molibden i stopy molibdenu	Warstwy dielektryczne (15)
	Beryl i stopy berylu	Borki Warstwy dielektryczne (15) Beryl
	Materiały na okienka wziernikowe (9)	Warstwy dielektryczne (15) Węgiel diamentopodobny (17)
	Metale i stopy ognioodporne (8)	Glinki Krzemki Tlenki Węgliki

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA

1. <u>Technika powlekania</u> (1)	2. <u>Podłoże</u>	3. <u>Powłoka wynikowa</u>
G. Implantacja jonów	Żarowytrzymałe stale łożyskowe	Dodatki chromu, tantalu lub niobu
	Stopy tytanu (13)	Borki Azotki
	Beryl i stopy berylu	Borki
	Spiekany węglik wolframu (16)	Węgliki Azotki

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA – UWAGI

1. Termin 'technika powlekania' obejmuje zarówno naprawę i odnawianie powłok, jak i powłoki pierwotne.
2. Termin 'powłoka z gliniku stopowego' obejmuje powłoki uzyskane w procesie jedno- lub wieloetapowym, w którym każdy pierwiastek lub pierwiastki są nakładane przed lub podczas nakładania powłoki glinkowej, nawet jeżeli pierwiastki te są nakładane podczas innego procesu powlekania. Nie obejmuje to jednak przypadku wieloetapowego stosowania jednostopniowych procesów osadzania fluidyzacyjnego, mającego na celu uzyskanie glinków stopowych.
3. Termin powłoka z 'gliniku modyfikowanego metalem szlachetnym' obejmuje powłoki wytwarzane w procesie wieloetapowym, podczas którego przed położeniem powłoki z gliniku na podłoże nakładany jest, w innym procesie powlekania, jeden lub kilka metali szlachetnych.
4. Termin 'mieszaniny powyższych' obejmuje przesycony materiał powłoki podłoża, części składowe pośrednie, materiał współosadzony oraz wielowarstwowy materiał osadzony uzyskane jedną lub kilkoma technikami powlekania wyszczególnionymi w tabeli.
5. Przez termin 'MCrAlX' należy rozumieć powłokę stopową, w której M oznacza kobalt, żelazo, nikiel lub ich kombinację, a X oznacza hafn, itr, krzem, tantal w dowolnych ilościach lub inne zamierzone dodatki w ilościach powyżej 0,01 % wagowo, w różnych proporcjach i kombinacjach, z wyjątkiem:
 - a. powłok CoCrAlY, w których znajduje się poniżej 22 % wagowo chromu, poniżej 7 % wagowo glinu i poniżej 2 % wagowo itru;
 - b. powłok CoCrAlY, w których znajduje się 22 do 24 % wagowo chromu, 10 do 12 % wagowo glinu i 0,5 do 0,7 % wagowo itru; lub
 - c. powłok NiCrAlY, w których znajduje się 21 do 23 % wagowo chromu, 10 do 12 % wagowo glinu i 0,9 do 1,1 % wagowo itru;
6. Termin 'stopy glinu' dotyczy stopów, których wytrzymałość na rozciąganie, mierzona w temperaturze 293 K (20°C), wynosi 190 MPa lub więcej.
7. Termin 'stale odporne na korozję' odnosi się do stali serii 300 według AISI (*American Iron and Steel Institute*) lub równoważnych norm krajowych.
8. Termin 'metale i stopy ognioodporne' obejmuje następujące metale i ich stopy: niob, molibden, wolfram i tantal.
9. 'Materiały na okienka wziernikowe', takie jak: tlenek glinu, krzem, german, siarczek cynku, selenek cynku, arsenek galu, diament, fosforek galu, szafir oraz następujące halogenki metali: materiały na okienka wziernikowe o średnicy powyżej 40 mm z fluorku cyrkonu i fluorku hafnu.
10. Kategoria 2 nie obejmuje kontrolą „technologii” jednostopniowych procesów osadzania fluidyzacyjnego w przypadku litych profili aerodynamicznych.

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA

11. 'Polimery', takie jak: poliiimidy, poliestry, polisiarczki, poliwęglany i poliuretany.
12. Termin 'zmodyfikowany tlenek cyrkonowy' odnosi się do tlenku cyrkonowego z dodatkami innych tlenków metali (np. tlenku wapnia, tlenku magnezu, tlenku itru, tlenku hafnu, tlenków metali ziem rzadkich) dodanymi w celu stabilizacji pewnych faz krystalicznych i składników faz. Powłoki przeciwtermiczne wykonane z tlenku cyrkonowego modyfikowanego poprzez mieszanie lub stapianie z tlenkiem wapnia lub magnezu nie są objęte kontrolą.
13. Termin 'stopy tytanu' odnosi się jedynie do stopów stosowanych w technice kosmicznej i lotniczej, których wytrzymałość na rozciąganie, mierzona w temperaturze 293 K (20°C), wynosi 900 MPa lub więcej.
14. Termin 'szkło o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej' odnosi się do szkła, dla których wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej, mierzona w temperaturze 293 K (20°C), wynosi 1×10^{-7} K⁻¹ lub mniej.
15. Termin 'warstwy dielektryczne' odnosi się do powłok wielowarstwowych z materiałów izolacyjnych, w których interferencyjne właściwości konstrukcji złożonej z materiałów o różnych współczynnikach załamania są wykorzystywane do odbijania, przepuszczania lub pochłaniania fal o różnych długościach. Warstwy dielektryczne odnoszą się do materiałów składających się z więcej niż czterech warstw dielektrycznych lub warstw „kompozytów” dielektryk/metal.
16. 'Spiekany węgiel wolframu' nie obejmuje kontrolą materiałów na narzędzia skrawające i formujące wykonane z węgla wolframu/(kobaltu, niklu), węgla tytanu/(kobaltu, niklu), węgla chromu/niklu-chromu i węgla chromu/niklu.
17. Nie jest objęta kontrolą „technologia” specjalnie zaprojektowana do nakładania węgla diamentopodobnego na którykolwiek z niżej wymienionych produktów:
dyski i głowice magnetyczne, urządzenia do wytwarzania produktów jednorazowych, zawory do kranów, membrany do głośników, części silników samochodowych, narzędzia tnące, matryce do tłoczenia-wykrawania, sprzęt do automatyzacji prac biurowych, mikrofony lub urządzenia lub formy medyczne służące do odlewu lub formowania tworzyw sztucznych, wykonane ze stopów zawierających mniej niż 5% berylu.
18. 'Węgiel krzemu' nie obejmuje kontrolą materiałów na narzędzia do cięcia i formowania.
19. Podłoża ceramiczne, w rozumieniu tej pozycji, nie obejmują materiałów ceramicznych zawierających wagowo 5 % lub więcej gliny lub cementu, zarówno w postaci oddzielnych składników, jak i ich kombinacji.

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA TECHNICZNA

Definicje procesów wyszczególnionych w kolumnie 1 tabeli:

- a. Osadzanie z pary lotnej (CVD) jest procesem nakładania powłoki lub modyfikacji powierzchni podłoża, polegającym na osadzaniu na rozgrzanym podłożu metalu, stopu, „kompozytu”, dielektryka lub materiału ceramicznego. W sąsiedztwie podłoża następuje rozkład lub łączenie gazowych substratów reakcji, wskutek czego osadza się na nim pożądany pierwiastek, stop lub związek. Potrzebna do rozkładu związków lub do reakcji chemicznych energia może być dostarczana przez rozgrzane podłoże, plazmę z wyładowań jarzeniowych lub za pomocą promieniowania „lasera”.

NB.1: CVD obejmuje następujące procesy: osadzanie w ukierunkowanym przepływie gazów bez zanurzania w proszku, CVD pulsujące, rozkład termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD), CVD intensyfikowane lub wspomagane za pomocą plazmy.

NB.2: Zanurzanie w proszku polega na zanurzeniu podłoża w mieszaninie sproszkowanych substancji.

NB.3: Gazowe substraty reakcji, wykorzystywane w technice, w której nie stosuje się zanurzania w proszku, są wytwarzane podczas takich samych reakcji podstawowych i przy takich samych parametrach, jak w przypadku osadzania fluidyzacyjnego: z tym wyjątkiem, że powlekane podłoże nie styka się z mieszaniną proszku.

- b. Naparowywanie termiczne – fizyczne osadzanie par (TE-PVD) – jest procesem powlekania w próżni przy ciśnieniach poniżej 0,1 Pa, w którym do odparowania materiału powlekającego używa się energii termicznej. Rezultatem tego procesu jest kondensacja lub osadzenie odparowanych składników na odpowiednio usytuowanych powierzchniach.

Zwykle proces ten jest modyfikowany poprzez wpuszczanie dodatkowych gazów do komory próżniowej podczas powlekania, co umożliwia wytwarzanie powłok o złożonym składzie.

Innym powszechnie stosowanym sposobem jego modyfikacji jest używanie wiązki jonów lub elektronów lub plazmy do intensyfikacji lub wspomagania osadzania powłoki. W technice tej można stosować monitory do bieżącego pomiaru parametrów optycznych i grubości powłoki.

Wyróżnia się poszczególne procesy TE-PVD, takie jak:

1. PVD z zastosowaniem wiązki elektronów – do rozgrzania i odparowania materiału, który ma stanowić powłokę, używa się wiązki elektronów;
2. PVD z ogrzewaniem oporowym – do wytwarzania odpowiedniego i równomiernego strumienia odparowanych składników powłokowych wykorzystywane są źródła elektrycznego ogrzewania oporowego w kombinacji z uderzającą wiązką jonów;
3. odparowanie „laserowe” wykorzystujące ciągłą lub impulsową wiązkę „laserową” do ogrzania materiału przeznaczonego na powłokę;

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA TECHNICZNA

- b. 4. metoda osadzania za pomocą łuku katodowego wykorzystująca zużywającą się katodę wykonaną z materiału mającego stanowić powłokę; łuk wywoływany jest na powierzchni tego materiału poprzez chwilowy kontakt inicjujący. Kontrolowany ruch łuku powoduje erozję powierzchni katody, wytwarzając wysoko zjonizowaną plazmę. Anodę może stanowić stożek osadzony w izolatorze na obwodzie katody lub sama komora. Osadzanie w miejscach nieleżących na linii biegu wiązki uzyskuje się dzięki odpowiedniej polaryzacji podłoża.

NB. *Definicja ta nie obejmuje bezładnego osadzania wspomaganego łukiem katodowym w przypadku powierzchni niepolaryzowanych.*

5. Powlekanie jonowe stanowi specjalną modyfikację procesu TE-PVD, w której do jonizacji osadzanych składników jest wykorzystywane źródło plazmy lub jonów, natomiast podłoże jest polaryzowane ujemnie, co ułatwia wychwytywanie z plazmy tych składników, które mają być osadzone. Do często spotykanych odmian tej techniki należą: wprowadzanie składników aktywnych, odparowywanie substancji stałych wewnątrz komory roboczej oraz bieżący pomiar parametrów optycznych i grubości powłok za pomocą monitorów.
- c. Osadzanie fluidyzacyjne jest procesem powlekania lub modyfikacji powierzchni podłoża, w której podłoże jest zanurzane w mieszaninie proszków, składającej się z:
1. proszków metalicznych, które mają być osadzone (zazwyczaj glin, chrom, krzem lub ich kombinacje);
 2. aktywatora (zazwyczaj sól halogenkowa); oraz
 3. proszku obojętnego, najczęściej tlenku glinu.

Podłoże wraz z mieszaniną proszków znajduje się w retorcie, która jest podgrzewana do temperatury od 1 030 K (757°C) do 1 375 K (1 102°C) przez okres wystarczający do osadzenia powłoki.

- d. Napyłanie plazmowe jest procesem powlekania, w którym do pistoletu (palnika natryskowego) służącego do wytwarzania strumienia plazmy i sterowania nim jest doprowadzany materiał do powlekania w postaci proszku lub pręta. Pistolet topi materiał i wyrzuca go na podłoże, na którym powstaje silnie z nim związana powłoka. Odmianami tego procesu jest napyłanie plazmowe niskociśnieniowe oraz napyłanie plazmowe z wysoką prędkością.

NB.1: *Niskociśnieniowe oznacza pod ciśnieniem niższym od ciśnienia atmosferycznego otoczenia.*

NB.2: *Wysoka prędkość odnosi się do prędkości gazów na wylocie z dyszy przekraczającej wartość 750 m/s w temperaturze 293 K (20°C) i ciśnieniu 0,1 MPa.*

- e. Osadzanie zawieszinowe jest procesem powlekania lub modyfikacji powierzchni, w której stosowana jest zawieszina proszku metalicznego lub ceramicznego ze

spoiwem organicznym w cieczy, nakładana na podłoże techniką natryskiwania, zanurzania lub malowania. Następnym etapem jest suszenie w powietrzu lub w piecu i obróbka cieplna, w wyniku czego powstaje powłoka o odpowiedniej charakterystyce.

TABELA – TECHNIKI OSADZANIA - UWAGA TECHNICZNA

- f. Rozpylanie jonowe jest procesem powlekania, opartym na zjawisku przenoszenia pędu, w której naładowane dodatnio jony są przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (materiał powłokowy). Energia kinetyczna padających jonów jest wystarczająca do wyrwania atomów z powierzchni materiału powłokowego i osadzenia ich na odpowiednio usytuowanej powierzchni podłoża.

NB.1: *Tabela dotyczy tylko rozpylania jonowego za pomocą triody, magnetronowego i reakcyjnego, które jest wykorzystywane do zwiększania przyczepności powłoki i wydajności osadzania oraz do rozpylania jonowego wspomaganego prądami wysokiej częstotliwości, wykorzystywanego do intensyfikacji odparowania niemetalicznych materiałów powłokowych.*

NB.2: *Do aktywacji osadzania można zastosować wiązki jonów o niskiej energii (poniżej 5 keV).*

- g. Implantacja jonowa jest procesem modyfikacji powierzchni polegającym na jonizacji pierwiastka, który ma być stopiony, przyspieszaniu go za pomocą różnicy potencjałów i wstrzeliwaniu w odpowiedni obszar powierzchni podłoża. Technika ta może być stosowana równocześnie z napyłaniem jonowym wspomaganym za pomocą wiązki elektronów lub rozpylaniem jonowym.

KATEGORIA 3 - ELEKTRONIKA

3A Systemy, urządzenia i części składowe

Uwaga 1: Poziom kontroli sprzętu i części składowych opisanych w pozycjach 3A001 lub 3A002, innych niż opisane w pozycji 3A001.a.3 do 3A001.a.10, 3A001.a.12 lub 3A001.a.13, specjalnie do nich zaprojektowanych lub posiadających te same cechy funkcjonalne co inny sprzęt, jest taki sam jak poziom kontroli innego sprzętu.

Uwaga 2: Poziom kontroli układów scalonych opisanych w pozycjach 3A001.a.3 do 3A001.a.9, 3A001.a.12 lub 3A001.a.13, zaprogramowanych na stałe bez możliwości wprowadzenia zmian lub zaprojektowanych do specjalnych funkcji dla innego sprzętu jest taki sam jak poziom kontroli innego sprzętu.

NB.: W razie, gdy producent lub wnioskodawca nie jest w stanie określić poziomu kontroli innego sprzętu, poziom kontroli danych układów scalonych jest określony w pozycjach 3A001.a.3 do 3A001.a.9, 3A001.a.12 i 3A001.a.13.

3A001 Następujące elementy elektroniczne i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a. następujące układy scalone ogólnego przeznaczenia:

Uwaga 1: Poziom kontroli płytek (gotowych lub niegotowych) posiadających wyznaczoną funkcję należy określać na podstawie parametrów podanych w pozycji 3A001.a.

Uwaga 2: Wśród układów scalonych rozróżnia się następujące typy:

- „monolityczne układy scalone”,
- „hybrydowe układy scalone”,
- „wieloukłady scalone”,
- „układy scalone warstwowe”, łącznie z układami scalonymi typu krzem na szafirze,
- „optyczne układy scalone”,
- „trójwymiarowe układy scalone”.

1. układy scalone zaprojektowane lub oznaczone znamionowo jako zabezpieczone przed promieniowaniem jonizującym, wytrzymujące którekolwiek z poniższych:
 - a. dawkę całkowitą 5×10^3 Gy (Si) lub wyższą;
 - b. wzrost dawki o 5×10^6 Gy (Si)/s lub większy; lub
 - c. fluencję (zintegrowany strumień) neutronów (ekwiwalent 1 MeV) o wartości 5×10^{13} n/cm² lub większej na krzemie, lub jej ekwiwalent na innym materiale;

Uwaga: Pozycja 3A001.a.1.c nie obejmuje kontrolą struktur metal-izolator-półprzewodnik (MIS).

2. „układy mikroprocesorowe”, „układy mikrokomputerowe” i układy do mikrosterowników, układy scalone pamięci wykonane z półprzewodników złożonych, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, układy elektrooptyczne lub „optyczne układy scalone” do „przetwarzania sygnałów”, sieci bramek programowalne przez użytkownika, robione na zamówienie układy scalone o nieznanym ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli urządzenia, w którym miałyby być zainstalowane, procesory do Szybkiej Transformacji Fouriera (FFT), wymazywalne elektrycznie programowalne pamięci stałe (EEPROM), pamięci błyskowe lub statyczne pamięci o dostępie swobodnym (SRAM), spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyżej 398 K (125 °C),
 - b. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia poniżej 218 K (-55 °C),
lub
 - c. przystosowane do pracy w całym przedziale wartości temperatur od 218 K (-55 °C) do 398 K (125 °C).

Uwaga: Pozycja 3A001.a.2 nie obejmuje kontrolą układów scalonych do silników pojazdów cywilnych ani kolejowych.

3. „układy mikroprocesorowe”, „układy mikrokomputerowe” i układy do mikrosterowników wykonane z półprzewodników złożonych, pracujące z częstotliwością zegara przekraczającą 40 MHz;

Uwaga: Pozycja 3A001.a.3 obejmuje cyfrowe procesory sygnałowe, cyfrowe procesory tablicowe i koprocесory cyfrowe.

4. nieużywane;
5. następujące przetworniki analogowo-cyfrowe (przetworniki AC) i cyfrowo-analogowe (przetworniki DA) na układach scalonych:
 - a. przetworniki analogowo-cyfrowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

NB. ZOB. TAKŻE POZYCJA 3A101.

1. rozdzielczość 8 bitów lub więcej, lecz poniżej 10 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 1 000 mln słów/sek;
2. rozdzielczość 10 bitów lub więcej, lecz poniżej 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 300 mln słów/sek;
3. rozdzielczość 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 200 mln słów/sek;
4. rozdzielczość powyżej 12 bitów lecz równa lub mniejsza niż 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 125 mln słów/sek; lub
5. rozdzielczość powyżej 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 20 mln słów/sek;

Uwagi techniczne:

1. Rozdzielczość n bitów odpowiada kwantowaniu na 2^n poziomach.
2. Liczba bitów w słowie wyjściowym jest równa rozdzielczości przetwornika analogowo-cyfrowego.
3. Wielkość wyjściowa jest to maksymalna wielkość wyjściowa przetwornika, bez względu na architekturę czy oversampling.
4. W przypadku 'wielokanałowych przetworników AC' wielkości wyjściowe nie są agregowane i wielkość wyjściowa jest maksymalną wielkością wyjściową pojedynczego kanału.

5. W przypadku 'przetworników AC' z przeplotem lub w przypadku 'wielokanałowych przetworników AC', których specyfikacje przewidują tryb pracy z przeplotem, wielkości wyjściowe są agregowane i wielkość wyjściowa jest maksymalną łączną całkowitą wielkością wyjściową wszystkich kanałów.

Uwagi techniczne

6. Sprzedawcy mogą także określać wielkość wyjściową jako wielkość próbkową, wielkość przetwarzania, lub przepustowość. Jest ona określana często w megahercach (MHz) lub megapróbkach na sekundę (MSPS).
7. Dla celów pomiarów wielkości wyjściowej jedno słowo wyjściowe na sekundę odpowiada jednemu hercowi lub jednej próbce na sekundę.
8. 'Wielokanałowe przetworniki analogowo-cyfrowe' definiuje się jako urządzenia zawierające więcej niż jeden przetwornik AC, zaprojektowane tak, by każdy AC miał odrębne wejście analogowe.
9. 'Przetworniki AC z przeplotem' definiuje się jako urządzenia mające wiele jednostek AC próbkujących ten sam wejściowy sygnał analogowy w różnych momentach, tak że po zagregowaniu sygnałów wyjściowych analogowy sygnał wejściowy został skutecznie spróbkowany i przekształcony z większą częstotliwością próbkowania.
- b. przetworniki cyfrowo-analogowe (przetworniki CA) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. rozdzielczość 10 bitów lub większa, przy „skorygowanej prędkości aktualizacji” wynoszącej 3 500 MSPS lub więcej; lub
 2. rozdzielczość 12 bitów lub większa przy „skorygowanej prędkości aktualizacji” wynoszącej 1 250 MSPS lub więcej i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. czas ustalania krótszy niż 9 ns do 0,024 % pełnej skali od pełnego stopnia skali; lub
 - b. 'zakres dynamiki wolny od zafałszowań' (SFDR) większy niż 68 dBc (nośna) przy syntetyzowaniu pełnoskalowego sygnału analogowego o częstotliwości 100 MHz lub najwyższej częstotliwości pełnoskalowego sygnału analogowego wyspecyfikowanej poniżej 100 MHz;

Uwagi techniczne:

1. 'Zakres dynamiki wolny od zafałszowań' (SFDR) jest definiowany jako stosunek średniej kwadratowej częstotliwości nośnej (maksymalny element składowy sygnału) na wejściu przetwornika CA do średniej kwadratowej najbliższego dużego składnika szumu lub zniekształcenia harmonicznego na jego wyjściu.
2. SFDR określa się bezpośrednio z tabel specyfikacji lub z wykresów przedstawiających charakterystyki SFDR w funkcji częstotliwości.
3. Sygnał definiuje się jako pełnoskalowy, gdy jego amplituda jest większa niż -3 dBfs (pełna skala).
4. 'Skorygowana prędkość aktualizacji' dla przetwornika CA:
 - a. w przypadku konwencjonalnych (nieinterpolujących) przetworników CA 'skorygowana prędkość aktualizacji' jest to prędkość, z jaką sygnał cyfrowy jest przekształcany na sygnał analogowy i analogowe wartości wyjściowe są zmieniane przez przetwornik CA. Przetworniki cyfrowo-analogowe, w których można obejść tryb interpolacji (współczynnik interpolacji wynoszący jeden), należy uznać za konwencjonalne przetworniki CA (nieinterpolujące);
 - b. w przypadku przetworników CA interpolujących (przetworniki CA z oversamplingiem) 'skorygowana prędkość aktualizacji' jest definiowana jako prędkość aktualizacji przetwornika CA podzielona

przez najmniejszy współczynnik interpolacji. W przypadku interpolujących przetworników CA 'skorygowana prędkość aktualizacji' bywa stosowana zamiennie z innymi terminami, w tym:

- *prędkość przesyłania danych na wejściu,*
- *prędkość transmisji słów na wejściu,*
- *częstotliwość próbkowania na wejściu,*
- *maksymalna całkowita prędkość magistrali na wejściu,*
- *maksymalna częstotliwość cyklu zegara DAC dla danych wejściowych zegara DAC.*

6. elektrooptyczne układy scalone lub „optyczne układy scalone” zaprojektowane do „przetwarzania sygnałów” i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. jedna lub więcej wewnętrzna dioda „laserowa”;
 - b. jeden lub więcej wewnętrzny element wykrywający światło; oraz
 - c. przewodnica światłowodowa;
7. ‘programowalne przez użytkownika urządzenia logiczne’ spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. maksymalna liczba asynchronicznych cyfrowych wejść/wyjść wynosząca 500 lub więcej; lub
 - b. ‘łączna jednokierunkowa szczytowa prędkość przesyłu danych nadajnika-odbiornika szeregowego’ wynosząca 200 Gb/s lub więcej;

Uwaga: *Pozycja 3A001.a.7 zawiera:*

- *proste programowalne urządzenia logiczne (SPLD),*
- *złożone programowalne urządzenia logiczne (CPLD),*
- *tablice bramek programowalne przez użytkownika (FPGA),*
- *tablice logiczne programowalne przez użytkownika (FPLA),*
- *połączenia wewnętrzne programowalne przez użytkownika (FPIC).*

Uwagi techniczne:

1. ‘Programowalne przez użytkownika urządzenia logiczne’ znane są również jako bramki programowalne przez użytkownika lub tablice logiczne programowalne przez użytkownika.
2. Maksymalna liczba cyfrowych wejść/wyjść w pozycji 3A001.a.7.a jest również nazywana maksymalną liczbą wejść/wyjść użytkowników lub maksymalną liczbą dostępnych wejść/wyjść niezależnie od tego, czy obwód scalony jest obudowany czy surowy.
3. ‘łączna jednokierunkowa szczytowa prędkość przesyłu danych nadajnika-odbiornika szeregowego’ oznacza iloczyn jednokierunkowej szczytowej prędkości przesyłu danych nadajnika-odbiornika i liczby nadajników-odbiorników na tablicach bramek programowalnych przez użytkownika (FPGA).
8. nieużywane;
9. obwody scalone do sieci neuronowych;
10. wykonywane na zamówienie układy scalone o nieznanym ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli sprzętu, w którym będzie zastosowany dany układ scalony, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. ponad 1 500 końcówek;
 - b. typowe „podstawowe opóźnienie przechodzenia sygnału przez bramkę” mniejsze niż 0,02 ns; lub
 - c. częstotliwość robocza powyżej 3 GHz;
11. cyfrowe układy scalone, różne od przedstawionych w pozycji 3A001.a.3 do 3A001.a.10 lub 3A001.a.12, oparte na dowolnym układzie półprzewodników złożonych oraz spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a. zastępczą liczbę bramek powyżej 3 000 (bramki dwuwejściowe); lub
 - b. częstotliwość przełączania powyżej 1,2 GHz;
12. procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadające nominalny czas realizacji dla N-punktowej zespolonej transformaty FFT poniżej $(N \log_2 N)/20$ 480 ms, gdzie N jest liczbą punktów;

Uwaga techniczna:

Gdy N jest równe 1 024 punkty, wynik formuły w pozycji 3A001.a.12, określającej czas realizacji, wynosi 500 μ s.

13. obwody scalone bezpośredniego syntezer cyfrowego (DDS) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
- częstotliwość zegara przetwornika cyfrowo-analogowego (przetwornika DAC) wynosząca co najmniej 3,5 GHz i rozdzielczość przetwornika DAC wynosząca co najmniej 10 bit, ale mniej niż 12 bitów; lub
 - częstotliwość zegara przetwornika DAC wynosząca co najmniej 1,25 GHz i rozdzielczość przetwornika DAC wynosząca co najmniej 12 bitów;

Uwaga techniczna:

Częstotliwość zegara przetwornika DAC można określić jako częstotliwość zegara głównego lub częstotliwość zegara wejścia

- b. następujące elementy mikrofalowe lub pracujące na falach milimetrowych:

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 3A001.b. parametr mocy wyjściowej na granicy nasycenia może być również określany w arkuszu danych produktu jako moc wyjściowa, nasycona moc wyjściowa, maksymalna moc wyjściowa, szczytowa moc wyjściowa lub szczytowa wartość obwiedni mocy.

1. następujące elektronowe lampy próżniowe i katodowe:

Uwaga 1: Pozycja 3A001.b.1 nie obejmuje kontrolą lamp zaprojektowanych lub przystosowanych do działania w jakimkolwiek paśmie częstotliwości i spełniających wszystkie poniższe kryteria:

- szerokość pasma nie przekracza 31,8 GHz; oraz
- jest „rozdzielone przez ITU” dla służb radiokomunikacyjnych, ale nie w celu namierzania radiowego.

Uwaga 2: Pozycja 3A001.b.1 nie obejmuje kontrolą lamp innych niż „klasy kosmicznej”, spełniających wszystkie poniższe kryteria:

- średnia moc wyjściowa równa lub mniejsza niż 50 W; oraz
- zaprojektowanych lub przystosowane do działania w jakimkolwiek paśmie częstotliwości i spełniających wszystkie poniższe kryteria:
 - szerokość przekracza 31,8 Ghz, lecz nie przekracza 43,5 GHz; oraz
 - jest „rozdzielone przez ITU” dla służb radiokomunikacyjnych, ale nie w celu namierzania radiowego.

- następujące lampy o fali bieżącej, fali impulsowej lub ciągłej:
 - lampy pracujące na częstotliwościach powyżej 31,8 GHz;
 - lampy posiadające element podgrzewający katodę, z czasem uzyskania mocy znamionowej w zakresie fal radiowych wynoszącym poniżej 3 sekund;
 - sprężone lampy wnękowe lub ich pochodne o „ułamkowej szerokości pasma” powyżej 7 % lub mocy szczytowej powyżej 2,5 kW;
 - lampy spiralne lub ich pochodne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - „chwilowa szerokość pasma” powyżej jednej oktawy oraz iloczyn mocy przeciętnej (wyrażonej w kW) i częstotliwości (wyrażonej w GHz) powyżej 0,5;
 - „chwilowa szerokość pasma” poniżej jednej oktawy oraz iloczyn mocy przeciętnej (wyrażonej w kW) i częstotliwości (wyrażonej w GHz) powyżej 1; lub
 - są „klasy kosmicznej”;

- b. wzmacniacze lampowe o skrzyżowanych polach o wzmocnieniu powyżej 17 dB;
- c. impregnowane katody zaprojektowane do lamp elektronicznych, wytwarzające ciągły prąd emisyjny w znamionowych warunkach pracy o gęstości powyżej 5 A/cm^2 ;

2. mikrofalowe „monolityczne układy scalone” (MMIC) wzmacniaczy mocy spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
- a. przystosowane do pracy na częstotliwościach przewyższających 2,7 GHz, do 6,8 GHz włącznie, o „ułamkowej szerokości pasma” powyżej 15% i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 75 W (48,75 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,7 GHz do 2,9 GHz włącznie;
 - 2. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 55 W (47,4 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,9 GHz do 3,2 GHz włącznie;
 - 3. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 40 W (46 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,2 GHz do 3,7 GHz włącznie; lub
 - 4. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 20 W (43 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,7 GHz do 6,8 GHz włącznie;
 - b. przystosowane do pracy na częstotliwościach przekraczających 6,8 GHz, do 16 GHz włącznie, o „ułamkowej szerokości pasma” powyżej 10 % i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 10 W (40 dBm) przy dowolnej częstotliwości przewyższającej 6,8 GHz, do 8,5 GHz włącznie; lub
 - 2. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 5 W (37 dBm) przy dowolnej częstotliwości przewyższającej 8,5 GHz, do 16 GHz włącznie;
 - c. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 3 W (34,77 dBm) na częstotliwościach przewyższających 16 GHz, do 31,8 GHz włącznie, i przy „ułamkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 10%;
 - d. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,1 nW (-70 dBm) na częstotliwościach przewyższających 31,8 GHz, do 37 GHz włącznie;
 - e. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 1 W (30 dBm) na częstotliwościach przewyższających 37 GHz, do 43,5 GHz włącznie, i przy „ułamkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 10%;
 - f. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 31,62 mW (15 dBm) na częstotliwościach przewyższających 43,5 GHz, do 75 GHz włącznie, i przy „ułamkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 10%;
 - g. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 10 mW (10 dBm) na częstotliwościach przewyższających 75 GHz, do 90 GHz włącznie, i przy „ułamkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 5 %; lub
 - h. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,1 nW (-70 dBm) na częstotliwościach przewyższających 90 GHz;

Uwaga 1: nieużywane.

Uwaga 2: Poziom kontroli MMIC, których znamionowa częstotliwość robocza obejmuje częstotliwości zawarte w więcej niż jednym paśmie, zgodnie z definicjami w pozycjach 3A001.b.2.a do 3A001.b.2.h, jest określony przez najniższy próg mocy wyjściowej na granicy nasycenia.

Uwaga 3: Uwagi 1 i 2 w kategorii 3A oznaczają, że pozycja 3A001.b.2 nie obejmuje kontrolą MMIC, jeśli są one specjalnie zaprojektowane do innych zastosowań, np. telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych, motoryzacyjnych.

3. dyskretne tranzystory mikrofalowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. przystosowane do działania w zakresie częstotliwości powyżej 2,7 GHz i do 6,8 GHz włącznie i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 400 W (56 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,7 GHz do 2,9 GHz włącznie;
 2. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 205 W (53,12 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,9 GHz do 3,2 GHz włącznie;
 3. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 115 W (50,61 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,2 GHz do 3,7 GHz włącznie; lub
 4. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 60 W (47,78 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,7 GHz do 6,8 GHz włącznie;
 - b. przystosowane do działania w zakresie częstotliwości powyżej 6,8 GHz i do 31,8 GHz włącznie i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 50 W (47 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 6,8 GHz do 8,5 GHz włącznie;
 2. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 15 W (41,76 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 8,5 GHz do 12 GHz włącznie;
 3. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 40 W (46 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 12 GHz do 16 GHz włącznie; lub
 4. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 7 W (38,45 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 16 GHz do 31,8 GHz włącznie;
 - c. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,5 W (27 dBm) na częstotliwościach przewyższających 31,8 GHz, do 37 GHz włącznie;
 - d. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 1 W (30 dBm) na częstotliwościach przewyższających 37 GHz, do 43,5 GHz włącznie;
 - e. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,1 nW (-70 dBm) na częstotliwościach przewyższających 43,5 GHz;

Uwaga 1 : Poziom kontroli tranzystora, którego znamionowa częstotliwość robocza obejmuje częstotliwości zawarte w więcej niż jednym paśmie, zgodnie z definicjami w pozycjach 3A001.b.3.a do 3A001.b.3.e, jest określony przez najniższy próg mocy wyjściowej na granicy nasycenia.

Uwaga 2: Pozycja 3A001.b.3. obejmuje surowe płytki półprzewodnikowe, płytki zamontowane na nośnikach oraz płytki zamontowane w zestawach. Niektóre dyskretne tranzystory mogą być również określane jako wzmacniacze mocy, jednak status tych dyskretnych tranzystorów jest podany w pozycji 3A001.b.3.

4. mikrofalowe wzmacniacze półprzewodnikowe oraz mikrofalowe zespoły/moduły zawierające mikrofalowe wzmacniacze półprzewodnikowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a. przystosowane do działania w zakresie częstotliwości powyżej 2,7 GHz i do 6,8 GHz włącznie, o „ułamkowej szerokości pasma” powyżej 15% i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 500 W (57 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,7 GHz do 2,9 GHz włącznie;
 2. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 270 W (54,3 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,9 GHz do 3,2 GHz włącznie;
 3. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 200 W (53 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,2 GHz do 3,7 GHz włącznie; lub
 4. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 90 W (49,54 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,7 GHz do 6,8 GHz włącznie;

- b. przystosowane do działania w zakresie częstotliwości powyżej 6,8 GHz i do 31,8 GHz włącznie, o „uławkowej szerokości pasma” powyżej 10 % i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 70 W (48,54 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 6,8 GHz do 8,5 GHz włącznie;
 - 2. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 50 W (47 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 8,5 GHz do 12 GHz włącznie;
 - 3. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 30 W (44,77 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 12 GHz do 16 GHz włącznie; lub
 - 4. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 20 W (43 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 16 GHz do 31,8 GHz włącznie;
- c. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,5 W (27 dBm) na częstotliwościach przewyższających 31,8 GHz, do 37 GHz włącznie;
- d. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 2 W (33 dBm) na częstotliwościach przewyższających 37 GHz, do 43,5 GHz włącznie, i przy „uławkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 10%;
- e. przystosowane do pracy na częstotliwościach powyżej 43,5 GHz oraz spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 0,2 W (23 dBm) na częstotliwościach przewyższających 43,5 GHz, do 75 GHz włącznie, i przy „uławkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 10%;
 - 2. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 20 mW (13 dBm) na częstotliwościach przewyższających 75 GHz, do 90 GHz włącznie, i przy „uławkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 5 %; lub
 - 3. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 0,1 nW (-70 dBm) na częstotliwościach przewyższających 90 GHz; lub
- f. przystosowane do pracy na częstotliwościach powyżej 2,7 GHz oraz spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - 1. Moc wyjściowa na granicy nasycenia (w watach), P_{sat} , większa niż 400 dzielone przez maksymalną częstotliwość pracy (w GHz) podniesione do potęgi drugiej $[P_{\text{sat}} > 400 \text{ W} \cdot \text{GHz}^2 / f_{\text{GHz}}^2]$;
 - 2. „uławkowa szerokość pasma” wynosząca 5 % lub więcej; oraz
 - 3. jakiegokolwiek dwustronne, wzajemnie prostopadłe d siebie, o długości d (w cm) mniejszej niż 15 lub równej 15 podzielone przez najniższą częstotliwość roboczą (w GHz) $[d \leq 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} / f_{\text{GHz}}]$;

Uwaga techniczna:

Częstotliwość 2.7 GHz należy przyjąć jako najniższą częstotliwość roboczą (f_{GHz}) we wzorze w pozycji 3A001.b.4.f.3 dla wzmacniaczy, których dolna granica znamionowej częstotliwości roboczej osiąga wartość 2,7 GHz lub niższą $[d \leq 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} / 2,7 \text{ GHz}]$.

NB.: Mikrofalowe „monolityczne układy scalone” (MMIC) wzmacniaczy mocy należy oceniać wg kryteriów zawartych w pozycji 3A001.b.2.

Uwaga 1: nieużywane.

Uwaga 2: Poziom kontroli elementu, którego znamionowa częstotliwość robocza obejmuje częstotliwości zawarte w więcej niż jednym paśmie, zgodnie z definicjami w pozycjach 3A001.b.4.a do 3A001.b.4.e, jest określony przez najniższy próg mocy wyjściowej na granicy nasycenia.

Uwaga 3: Pozycja 3A001.b.4. obejmuje moduły nadawcze/odbiorcze i moduły nadawcze.

5. filtry środkowo-przepustowe i środkowo-zaporowe, przestrajalne elektronicznie lub magnetycznie, posiadające więcej niż 5 przestrajalnych rezonatorów umożliwiających strojenie w zakresie pasma częstotliwości 1,5:1 ($f_{\max}/f_{\min}$) w czasie poniżej 10 μ s i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. szerokość pasma środkowo-przepustowego powyżej 0,5 % częstotliwości nośnej; lub
 - b. szerokość pasma środkowo-zaporowego poniżej 0,5 % częstotliwości nośnej;
6. nieużywane;
7. konwertery i mieszacze harmoniczne przeznaczone do rozszerzania przedziału częstotliwości sprzętu opisanego w pozycjach 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e lub 3A002.f powyżej podanych tam wartości granicznych;
8. mikrofalowe wzmacniacze mocy zawierające lampy wyszczególnione w pozycji 3A001.b.1 i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. częstotliwości robocze powyżej 3 GHz;
 - b. średni stosunek mocy wyjściowej do masy większy niż 80 W/kg; oraz
 - c. objętość mniejsza niż 400 cm³;

Uwaga: Pozycja 3A001.b.8 nie obejmuje kontrolą sprzętu zaprojektowanego lub przystosowanego do działania w jakimkolwiek paśmie częstotliwości, które jest „przydzielane przez ITU” dla służb radiokomunikacyjnych, ale nie w celu namierzania radiowego.

9. mikrofalowe moduły mocy (MPM) składające się co najmniej z lampy o fali bieżącej, mikrofalowego „monolitycznego układu scalonego” i zintegrowanego elektronicznego kondycjonera mocy i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. ‘czas włączania’ od stanu wyłączenia do stanu całkowitej gotowości krótszy niż 10 sekund;
 - b. objętość mniejszą niż iloczyn maksymalnej mocy znamionowej w watach i 10cm³/W; oraz
 - c. „Chwilową szerokość pasma” większą niż 1 oktawa ($f_{\max} > 2f_{\min}$) oraz spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. dla częstotliwości równych lub mniejszych niż 18 GHz – moc wyjściowa w zakresie fal radiowych większą niż 100 W; lub
 2. częstotliwość większa niż 18 GHz;

Uwagi techniczne:

1. Do obliczenia objętości w pozycji 3A001.b.9.b podaje się następujący przykład: dla maksymalnej mocy znamionowej wynoszącej 20 W objętość wyniosłaby: 20 W x 10 cm³/W = 200 cm³.
 2. ‘Czas włączania’, o którym mowa w pozycji 3A001.b.9.a, odnosi się do czasu upływającego od stanu całkowitego wyłączenia do osiągnięcia całkowitej gotowości do pracy, a zatem obejmuje on również czas rozgrzewania MPM.
10. Oscylatory lub zespoły oscylatorów przewidziane do działania z jednoczesnym spełnieniem wszystkich poniższych kryteriów:

- a. zakłócenie fazowe pojedynczej wstęgi bocznej (SSB) w dBc/Hz lepsze niż $(126+20\log_{10}F-20\log_{10}f)$ w dowolnym punkcie w zakresie $10\text{ Hz} < F < 10\text{ kHz}$; oraz
- b. zakłócenie fazowe pojedynczej wstęgi bocznej (SSB) w dBc/Hz lepsze niż $(114+20\log_{10}F-20\log_{10}f)$ w dowolnym punkcie w zakresie $10\text{ kHz} \leq F < 500\text{ kHz}$;

Uwaga techniczna:

W pozycji 3A001.b.10 F oznacza przesunięcie w stosunku do częstotliwości roboczej w Hz, a f oznacza częstotliwość roboczą w MHz.

11. „zespoły elektroniczne” będące „syntezatorami częstotliwości”, których „czas przełączania częstotliwości” określony jest przez którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. krótszy niż 156 ps;
 - b. krótszy niż 100 μ s dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 1,6 GHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 4,8 GHz, ale nieprzekraczającym 10,6 GHz;
 - c. krótszy niż 250 μ s dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 10,6 GHz, ale nieprzekraczającym 31,8 GHz;
 - d. krótszy niż 500 μ s dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 31,8 GHz, ale nieprzekraczającym 43,5 GHz;
 - e. krótszy niż 1 ms dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 43,5 GHz, ale nieprzekraczającym 56 GHz;
 - f. krótszy niż 1 ms dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 2,2 GHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 56 GHz, ale nieprzekraczającym 75 GHz; lub
 - g. krótszy niż 1 ms w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 75 GHz;

NB.: *Używane do zastosowań ogólnych: „analizatory sygnału” – zob. poz. 3A002.c, generatory sygnałowe – 3A002.d, analizatory sieci – 3A002.e, kontrolne odbiorniki mikrofalowe – 3A002.f.*

- c. następujące urządzenia wykorzystujące fale akustyczne oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty:
 1. urządzenia wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne oraz szumiące powierzchniowo (płytkie) fale akustyczne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. częstotliwość nośną powyżej 6 GHz;
 - b. częstotliwość nośną większą niż 1 GHz, ale nieprzekraczającą 6 GHz oraz spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. ‘tłumienie pasma bocznego częstotliwości’ powyżej 65 dB;
 2. iloczyn maksymalnego czasu zwłoki i szerokości pasma (czas w μ s, a szerokość pasma w MHz) powyżej 100;
 3. szerokość pasma większa, niż 250 MHz; lub
 4. opóźnienie dyspersyjne powyżej 10 μ s; lub
 - c. częstotliwość nośną wynoszącą 1 GHz lub mniejszą oraz spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. iloczyn maksymalnego czasu zwłoki i szerokości pasma (czas w μ s, a szerokość pasma w MHz) powyżej 100;
 2. opóźnienie dyspersyjne powyżej 10 μ s; lub
 3. ‘tłumienie pasma bocznego częstotliwości’ powyżej 65 dB i szerokość pasma większa niż 100 MHz;

Uwaga techniczna:

‘Tłumienie pasma bocznego częstotliwości’ oznacza maksymalną wartość tłumienia wyszczególnioną na arkuszu danych.

2. urządzenia wykorzystujące przestrzenne fale akustyczne, umożliwiające bezpośrednie przetwarzanie sygnałów z częstotliwościami powyżej 6 GHz;
3. urządzenia do „przetwarzania sygnałów” optyczno-akustycznych wykorzystujące oddziaływania pomiędzy falami akustycznymi (przestrzennymi lub

powierzchniowymi) a falami świetlnymi do bezpośredniego przetwarzania sygnałów lub obrazów, łącznie z analizą widmową, korelacją lub splataniem;

Uwaga: Pozycja 3A001.c nie obejmuje kontrolą urządzeń wykorzystujących fale akustyczne ograniczone do pojedynczego filtra środkowoprzepustowego, filtra dolnoprzepustowego, filtra górnoprzepustowego, filtra antysprężeniowego lub funkcji rezonancyjnej.

- d. urządzenia i układy elektroniczne, zawierające części składowe wykonane z materiałów „nadprzewodzących”, specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z elementów „nadprzewodzących” i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. przełączanie prądowe dla obwodów cyfrowych za pomocą bramek „nadprzewodzących”, dla którego iloczyn czasu zwłoki na bramkę (w sekundach) i rozproszenia mocy na bramkę (w watach) wynosi poniżej 10^{-14} J; lub
 - 2. selekcję częstotliwości dla wszystkich częstotliwości za pomocą obwodów rezonansowych o wartościach Q przekraczających 10 000;
- e. następujące urządzenia wysokoenergetyczne:
 - 1. ‘ogniwa’, takie jak:
 - a. ‘ogniwa pierwotne’ o ‘gęstości energii’ powyżej 550 Wh/kg w temperaturze 20 °C;
 - b. ‘ogniwa wtórne’ o ‘gęstości energii’ powyżej 300 Wh/kg w temperaturze 20 °C;

Uwagi techniczne:

- 1. Do celów pozycji 3A001.e.1 ‘gęstość energii’ (Wh/kg) otrzymuje się, mnożąc napięcie znamionowe przez pojemność znamionową w amperogodzinach (Ah) i dzieląc powyższe przez masę w kilogramach. Jeżeli pojemność znamionowa nie jest podana, gęstość energii otrzymuje się przez podniesienie napięcia znamionowego do kwadratu, a następnie pomnożenie przez czas rozładowania wyrażony w godzinach oraz podzielenie przez obciążenie rozładowania wyrażone w omach i całkowitą masę ogniwa wyrażoną w kilogramach.
- 2. Do celów pozycji 3A001.e.1 ‘ogniwo’ definiuje się jako urządzenie elektrochemiczne zawierające elektrody dodatnie i ujemne, elektrolit i będące źródłem energii elektrycznej. Jest to podstawowy element składowy baterii.
- 3. Do celów pozycji 3A001.e.1.a ‘ogniwo pierwotne’ jest ‘ogniwem’, które nie jest przeznaczone do ładowania z jakiegokolwiek innego źródła.
- 4. Do celów pozycji 3A001.e.1.b ‘ogniwo wtórne’ jest ‘ogniwem’, które jest przeznaczone do ładowania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

Uwaga: Pozycja 3A001.e.1 nie obejmuje kontrolą baterii, w tym również baterii pojedynczych.

- 2. wysokoenergetyczne kondensatory magazynujące, takie jak:

NB.: ZOB. TAKŻE 3A201.a. i Wykaz uzbrojenia.

- a. kondensatory o częstotliwości powtarzania poniżej 10 Hz (kondensatory jednokrotne) i spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. napięcie znamionowe równe lub wyższe niż 5 kV;
 2. gęstość energii równa lub wyższa niż 250 J/kg; oraz
 3. energia całkowita równa lub wyższa niż 25 kJ;
- b. kondensatory o częstotliwości powtarzania 10 Hz lub wyższej (kondensatory powtarzalne) i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. napięcie znamionowe równe lub wyższe niż 5 kV;
 2. gęstość energii równa lub wyższa niż 50 J/kg;
 3. energia całkowita równa lub wyższa niż 100 J; oraz
 4. żywotność mierzona liczbą cykli ładowanie/rozładowanie wynosząca więcej niż 10 000;

3. „nadprzewodzące” elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełne ładowanie i rozładowanie w czasie mniejszym niż 1 s i spełniające wszystkie poniższe kryteria:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 3A201.b.

Uwaga: Pozycja 3A001.e.3 nie obejmuje kontrolą elektromagnesów ani cewek „nadprzewodzących” specjalnie zaprojektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzystywanej w medycynie.

- a. energia dostarczona podczas wyładowania jest większa od 10 kJ w pierwszej sekundzie;
 - b. średnica wewnętrzna uzwojenia prądowego cewki wynosi powyżej 250 mm; oraz
 - c. zostały dostosowane do indukcji magnetycznej powyżej 8 T lub posiadają „całkowitą gęstość prądu” w uzwojeniu powyżej 300 A/mm²;
4. ogniwa słoneczne, zespoły ogniwo-łącznik-szkło osłonowe (CIC), panele słoneczne i baterie słoneczne klasy kosmicznej, mające minimalną średnią sprawność wyższą niż 20 % w temperaturze roboczej 301 K (28 °C) w symulowanym oświetleniu ‘AM0’ o irradiancji 1 367 watów na metr kwadratowy (W/m²);

Uwaga techniczna:

‘AM0’ lub ‘masa powietrza 0’ odpowiada irradiancji widmowej światła słonecznego w zewnętrznej atmosferze Ziemi przy odległości Ziemi od Słońca wynoszącej 1 jednostkę astronomiczną (AU).

- f. urządzenia kodujące bezwzględne położenie o dokładności równej $\pm 1,0$ sekunda kątowna lub mniejszej (lepszej);
- g. półprzewodnikowe impulsowe tyrystorowe wyłączniki zasilania i ‘moduły tyrystorowe’ oparte na metodach wyłączania sterowanych elektrycznie, optycznie lub promieniowaniem elektronowym spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. maksymalna szybkość narastania prądu włączenia (di/dt) większa niż 30 000 A/μs i napięcie w stanie wyłączenia większe niż 1 100 V; lub
 2. maksymalna szybkość narastania prądu włączenia (di/dt) większa niż 2 000 A/μs i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. napięcie szczytowe w stanie wyłączonym równe lub większe niż 3 000 V; oraz
 - b. prąd szczytowy (udarowy) równy lub większy niż 3 000 A.

Uwaga 1: Pozycja 3A001.g obejmuje:

- krzemowe prostowniki sterowane (SCR),
- tyrystory wyzwalane elektrycznie (ETT),
- tyrystory wyzwalane optycznie (LTT),
- tyrystory o komutowanej bramce (IGCT),
- tyrystory sterowane MOS (MCT),
- tyrystory wyłączalne prądem bramki (GTO),
- urządzenia typu Solidtron.

Uwaga 2: Pozycja 3A001.g nie obejmuje kontrolą urządzeń tyrystorowych i ‘modułów tyrystorowych’ wbudowanych w urządzenia przeznaczone do zastosowań w kolejniectwie cywilnym lub „cywilnych statkach powietrznych”.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 3A001.g 'moduł tyrystorowy' zawiera co najmniej jedno urządzenie tyrystorowe.

- h. półprzewodnikowe przełączniki mocy, diody mocy lub 'moduły' mocy spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. nominalna maksymalna temperatura robocza złącza wyższa niż 488 K (215 °C);
 2. szczytowe powtarzalne napięcie w stanie wyłączonym (napięcie blokujące) przekraczające 300 V; oraz
 3. prąd ciągły większy niż 1 A.

Uwaga 1: Szczytowe powtarzalne napięcie w stanie wyłączonym w pozycji 3A001.h obejmuje napięcie dren-źródło, napięcie kolektor-emiter, szczytowe powtarzalne napięcie wsteczne i szczytowe powtarzalne napięcie blokujące w stanie wyłączonym.

Uwaga 2: Pozycja 3A001.h obejmuje:

- tranzystory polowe złączowe (JFET),
- pionowe tranzystory polowe złączowe (VJFET),
- tranzystory polowe o strukturze metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET),
- podwójny dyfuzyjny tranzystor polowy o strukturze metal-tlenek-półprzewodnik (DMOSFET),
- tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT),
- tranzystory z wysoką ruchliwością elektronów (HEMT),
- tranzystory bipolarne złączowe (BJT),
- tyrystory i krzemowe prostowniki sterowane (SCR),
- tyrystory wyłączalne prądem bramki (GTO),
- tyrystory wyłączalne emiterem (ETO),
- diody PiN,
- diody Schottky'ego.
-

Uwaga 3: Pozycja 3A001.h nie obejmuje kontrolą przełączników, diod ani 'modułów' znajdujących się w urządzeniach przeznaczonych do zastosowania w cywilnych pojazdach drogowych, cywilnych pojazdach kolejowych lub „cywilnych statkach powietrznych”.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 3A001.h 'moduły' zawierają jeden lub więcej półprzewodnikowych przełączników lub diod.

3A002 Następujący sprzęt elektroniczny ogólnego przeznaczenia:

- a. następujący sprzęt do rejestracji i oscyloskopy:
1. nieużywane;
 2. nieużywane;
 3. nieużywane;
 4. nieużywane;
 5. przetworniki falowe oraz rejestratory stanów przejściowych spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. szybkość przetwarzania cyfrowego równa lub większa niż 200 milionów próbek na sekundę i rozdzielczość 10 bitów lub większa; oraz

- b. 'przepustowość ciągła' 2 Gbit/s lub większa;

Uwagi techniczne:

1. W przypadku urządzeń o równoległej architekturze szyn, 'przepustowość ciągła' określa się jako iloczyn największej prędkości transmisji słów i liczby bitów w słowie.
 2. 'Przepustowość ciągła' oznacza największą prędkość przesyłania danych przez urządzenie do pamięci masowej, bez utraty informacji, z utrzymaniem prędkości próbkowania i przetwarzania analogowo-cyfrowego;
6. cyfrowe oprzyrządowanie do rejestracji danych wykorzystujące techniki składowania na dyskach magnetycznych i spełniające wszystkie poniższe kryteria oraz zaprojektowane specjalnie do tego celu rejestratory cyfrowe:
- a. szybkość przesyłu danych oprzyrządowania cyfrowego równa lub większa niż 100 milionów próbek na sekundę przy rozdzielczości 8 bitów lub większej; oraz
 - b. 'przepustowość ciągła' 1 Gbit/s lub większa;

Uwaga techniczna:

cyfrowe oprzyrządowanie do rejestracji danych może być konfigurowane przy pomocy przetwornika cyfrowego zintegrowanego z rejestratorem cyfrowym lub zewnętrznego.

7. Oscyloskopy pracujące w trybie próbkowania w czasie rzeczywistym, w których napięcie szumów ma pionową wartość średniokwadratową (rms) mniejszą niż 2% pełnej skali na skali pionowej, na której najmniejsza wartość szumów dla każdej wejściowej szerokości pasma 3dB wynosi 60 GHz lub więcej na kanał;

Uwaga: Pozycja 3A002.a.7. nie obejmuje kontrolą oscyloskopów pracujących w trybie próbkowania ekwiwalentnego (ETS).

- b. nieużywane;
- c. „analizatory sygnałów” o częstotliwościach radiowych, takie jak:
1. „analizatory sygnałów”, w których szerokość pasma o rozdzielczości 3 dB przekracza 10 MHz w dowolnym punkcie zakresu częstotliwości przekraczających 31,8 GHz, lecz nieprzekraczających 37,5 GHz;
 2. „analizatory sygnałów”, w których średni wyświetlany poziom szumu (DANL) jest mniejszy/a (lepszy/a) niż -150 dBm/Hz w dowolnym punkcie zakresu częstotliwości przekraczających 43,5 GHz, lecz nieprzekraczających 75 GHz;
 3. „analizatory sygnałów” o częstotliwości powyżej 75 GHz;
 4. „analizatory sygnałów” spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. szerokość pasma przekraczająca 85 MHz; oraz
 - b. 100% prawdopodobieństwa odkrycia przy mniejszej niż 3 dB redukcji w stosunku do pełnej amplitudy w związku z przerwami lub okienkowaniem sygnałów o długości trwania wynoszącej 15 μ s lub mniej;

Uwagi techniczne:

1. Prawdopodobieństwo odkrycia, o którym mowa w pozycji 3A002.c.4.b., określane jest również jako prawdopodobieństwo przechwycenia.
2. Do celów pozycji 3A002.c.4.b., czas trwania dla 100% prawdopodobieństwa odkrycia równy jest minimalnej długości trwania sygnału niezbędnej dla określonej niepewności pomiaru poziomu.

Uwaga: Pozycja 3A002.c.4 nie obejmuje kontrolą „analizatorów sygnałów”, w których zastosowano jedynie filtry o stałoprocentowej szerokości

pasma (znanych również jako filtry oktafowe lub ułamkowo-oktafowe).

5. „analizatory sygnałów” posiadające funkcję „wyzwalania maską częstotliwości” ze 100% prawdopodobieństwem wyzwolenia (przechwycenia) dla sygnałów o czasie trwania nie dłuższym niż 15 μ s;

- d. generatory sygnałowe z syntezą częstotliwości, wytwarzające częstotliwości wyjściowe, których dokładność oraz stabilność krótko- i długoterminowa pochodzi z wewnętrznego podstawowego oscylatora referencyjnego lub jest za jego pomocą sterowana lub regulowana, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. przewidziane według specyfikacji do generowania sygnałów modulowanych impulsowo spełniające wszystkie następujące kryteria, w dowolnym punkcie zakresu częstotliwości syntetyzowanej przekraczającego 31,8 GHz, lecz nieprzekraczającego 75 GHz:
 - a. 'czas trwania impulsu' krótszy niż 100 ns; oraz
 - b. stosunek on/off równy lub większy niż 65 dB;
 2. moc wyjściowa przekraczająca 100 mW (20 dBm) w dowolnym punkcie zakresu częstotliwości syntetyzowanej przekraczającego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczającego 75 GHz;
 3. „czas przełączania częstotliwości” określony przez jeden z poniższych parametrów:
 - a. nieużywane;
 - b. krótszy niż 100 μ s dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 1,6 GHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 4,8 GHz, ale nieprzekraczającym 10,6 GHz;
 - c. krótszy niż 250 μ s dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 10,6 GHz, ale nieprzekraczającym 31,8 GHz;
 - d. krótszy niż 500 μ s dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 31,8 GHz, ale nieprzekraczającym 43,5 GHz;
 - e. krótszy niż 1 ms dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 550 MHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 43,5 GHz, ale nieprzekraczającym 56 GHz; lub
 - f. krótszy niż 1 ms dla każdej zmiany częstotliwości przewyższającej 2,2 GHz w zakresie syntetyzowanych częstotliwości przekraczającym 56 GHz, ale nieprzekraczającym 75 GHz;
 4. zakłócenie fazowe pojedynczej wstęgi bocznej (SSB) w dBc/Hz, spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. mniejsze (lepiej) niż $-(126 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$ w dowolnym punkcie w zakresie $10 \text{ Hz} < F < 10 \text{ kHz}$ w dowolnym punkcie zakresu częstotliwości syntetyzowanej przekraczającego 3,2 GHz lecz nieprzekraczającego 75 GHz; oraz
 - b. mniejsze (lepiej) niż $-(114 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$ w dowolnym punkcie w zakresie $10 \text{ kHz} \leq F < 500 \text{ kHz}$ w dowolnym punkcie zakresu częstotliwości syntetyzowanej przekraczającego 3,2 GHz lecz nieprzekraczającego 75 GHz; lub

Uwaga techniczna:

W pozycji 3A002.d.4 F oznacza przesunięcie w stosunku do częstotliwości roboczej w Hz, a f oznacza częstotliwość roboczą w MHz.

5. maksymalna częstotliwość syntetyzowana przekraczająca 75 GHz;

Uwaga 1: Do celów pozycji 3A002.d generatory sygnałowe z syntezą częstotliwości obejmują także generatory funkcji i przebiegów arbitralnych.

Uwaga 2: Pozycja 3A002.d nie obejmuje kontrolą sprzętu, w którym częstotliwość wyjściowa jest wytwarzana poprzez dodawanie lub odejmowanie dwóch lub więcej częstotliwości oscylatorów kwarcowych, lub poprzez dodawanie lub odejmowanie, a następnie mnożenie uzyskanego wyniku.

Uwagi techniczne:

1. Maksymalna częstotliwość syntetyzowana generatora funkcji i przebiegów arbitralnych obliczana jest przez podzielenie częstotliwości próbkowania, w liczbie próbek na sekundę, przez współczynnik 2,5.
2. Do celów pozycji 3A002.d.1 'czas trwania impulsu' definiuje się jako czas upływający między momentem osiągnięcia przez zbocze narastające impulsu wartości 50% amplitudy impulsu a momentem osiągnięcia przez zbocze opadające wartości 50% amplitudy impulsu.

- e. analizatory sieci spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. moc wyjściowa przekraczająca 31,62 mW (15 dBm) w dowolnym punkcie zakresu częstotliwości roboczej przekraczającego 43,5 GHz, lecz nieprzekraczającego 75 GHz;
 2. moc wyjściowa przekraczająca 1 mW (0 dBm) w dowolnym punkcie zakresu częstotliwości roboczej przekraczającego 75 GHz, lecz nieprzekraczającego 110 GHz;
 3. 'funkcja pomiaru wektora nieliniowego' przy częstotliwościach przekraczających 50 GHz, ale nieprzekraczających 110 GHz; lub

Uwaga techniczna

'Funkcja pomiaru wektora nieliniowego' to zdolność instrumentu do analizowania wyników testów urządzeń stosowanych w modelach wielkosygnałowych lub w zakresie zakłóceń nieliniowych.

- 4 . maksymalna częstotliwość robocza przewyższająca 110 GHz;

- f. kontrolne odbiorniki mikrofalowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. maksymalna częstotliwość robocza przewyższająca 110 GHz; oraz
 2. posiadające możliwość jednoczesnego pomiaru amplitudy i fazy;
- g. atomowe wzorce częstotliwości, które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. są „klasy kosmicznej”;
 2. są nierubidowe, a ich stabilność długookresowa jest mniejsza (lepsza) niż 1×10^{-11} /miesiąc; lub
 3. nie są „klasy kosmicznej” i spełniają wszystkie poniższe kryteria:
 - a. są rubidowymi wzorcami częstotliwości;
 - b. ich stabilność długookresowa jest mniejsza (lepsza) niż 1×10^{-11} /miesiąc; oraz
 - c. ich całkowite zużycie energii jest niższe niż 1 W.

3A003

Systemy sterowania temperaturą z chłodzeniem natryskowym, wykorzystujące umieszczone w uszczelnionych obudowach urządzenia z zamkniętym obiegiem do transportu i regenerowania płynu, w których płyn dielektryczny jest przy użyciu specjalnie zaprojektowanych dysz rozpylany na elementy elektroniczne w celu utrzymania ich w

dopuszczalnym przedziale temperatur pracy, a także specjalnie zaprojektowane do nich części składowe.

3A101 Sprzęt, przyrządy i elementy elektroniczne, inne niż wyszczególnione w pozycji 3A001, takie jak:

- a. przetworniki analogowo-cyfrowe, wykorzystywane w „pociskach raketowych”, spełniające wymagania wojskowe dla urządzeń odpornych na wstrząsy;
- b. akceleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego, wytwarzanego w wyniku hamowania elektronów o energii 2 MeV lub większej oraz systemy zawierające takie akceleratory.

Uwaga :Pozycja 3A101.b nie określa sprzętu specjalnie zaprojektowanego do zastosowań medycznych.

3A102 ‘Baterie termiczne’ zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ‘pocisków raketowych’

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 3A102 ‘baterie termiczne’ oznaczają baterie jednorazowego użycia zawierające jako elektrolit nieprzewodzący sól nieorganiczną w stanie stałym. Baterie te zawierają materiał pirolityczny, który po zapaleniu topi elektrolit i uruchamia baterię.
2. W pozycji 3A102 ‘pociski raketowe’ oznaczają kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych, o zasięgu przekraczającym 300 km.

3A201 Podzespoły elektroniczne, inne niż wyszczególnione w pozycji 3A001, takie jak:

- a. kondensatory posiadające jeden z następujących zestawów cech:
 1. a. napięcie znamionowe większe niż 1,4 kV;
 - b. zgromadzona energia większa niż 10 J;
 - c. reaktancja pojemnościowa większa niż 0,5 μ F; oraz
 - d. indukcyjność szeregową mniejszą niż 50 nH; lub
 2. a. napięcie znamionowe większe niż 750 V;
 - b. reaktancja pojemnościowa większa niż 0,25 μ F; oraz
 - c. indukcyjność szeregową mniejszą niż 10 nH;
- b. nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 1. zdolne do wytwarzania pól magnetycznych o natężeniu większym niż 2 T;
 2. o stosunku długości do średnicy wewnętrznej większym niż 2;
 3. o średnicy wewnętrznej większej niż 300 mm; oraz
 4. wytwarzające pole magnetyczne o równomierności rozkładu lepszej niż 1 % w zakresie środkowych 50 % objętości wewnętrznej.

Uwaga: Pozycja 3A201.b nie obejmuje kontrolą magnesów specjalnie zaprojektowanych i eksportowanych ‘jako części’ medycznych systemów do obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Sformułowanie ‘jako części’ niekoniecznie oznacza fizyczną część wchodzącą w skład tej samej partii wysyłanego wyrobu; dopuszcza się możliwość oddzielnych wysyłek z różnych źródeł, pod warunkiem że w towarzyszącej im dokumentacji eksportowej wyraźnie określa się, że wysyłane wyroby są dostarczane ‘jako część’ systemu obrazowania.

- c. generatory błyskowe promieniowania rentgenowskiego lub impulsowe akceleratory elektronów posiadające jeden z następujących zestawów cech:
 1. a. energia szczytowa akceleratora elektronów równa 500 keV lub większa, ale mniejsza niż 25 MeV; oraz
 - b. ‘współczynnik dobroci’ (K) równy 0,25 lub większy; lub

2.
 - a. energia szczytowa akceleratora elektronów równa 25 MeV lub większa;
oraz
 - b. 'moc szczytowa' powyżej 50 MW.

Uwaga: Pozycja 3A201.c nie obejmuje kontrolą akceleratorów stanowiących elementy składowe urządzeń zaprojektowanych do innych celów niż wytwarzanie wiązek elektronów lub promieniowania rentgenowskiego (np. mikroskopy elektronowe) ani urządzeń zaprojektowanych do zastosowań medycznych.

Uwagi techniczne:

1. 'Współczynnik dobroci' K jest zdefiniowany jako:

$$K = 1,7 \times 10^3 V^{2,65} Q$$

gdzie V jest szczytową energią elektronów w milionach elektronowoltów.

Jeżeli czas trwania impulsu wiązki akceleratora jest równy $1 \mu s$ lub krótszy, to Q jest całkowitym ładunkiem przyspieszanym, wyrażonym w kulombach. Jeżeli czas trwania impulsu wiązki akceleratora jest większy niż $1 \mu s$, to Q jest maksymalnym ładunkiem przyspieszanym w $1 \mu s$.

Q równa się całce z i po t , w przedziale o długości równym mniejszej z dwóch wartości: $1 \mu s$ lub czasu trwania impulsu wiązki ($Q = \int i dt$), gdzie i jest prądem wiązki w amperach, a t jest czasem w sekundach;

2. 'Moc szczytowa' = (napiecie szczytowe w voltach) x (szczytowy prąd wiązki w amperach).
3. W maszynach bazujących na mikrofalowych akceleratorach rezonatorowych czas trwania impulsu wiązki jest mniejszą z następujących dwóch wartości: $1 \mu s$ lub czas emisji pakietu wiązek wynikających z jednego impulsu modulatora mikrofalowego.
4. W maszynach bazujących na mikrofalowych akceleratorach rezonatorowych szczytowa wartość prądu wiązki jest wartością średnią prądu podczas emisji pakietu wiązek.

3A225

Przeмиenniki częstotliwości lub generatory, inne niż wyszczególnione w pozycji 0B001.b.13, które mogą być używane jako napęd silnikowy zmiennej lub stałej częstotliwości, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

NB. 1: „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania wydajności przeмиennika częstotliwości lub generatora, tak by odpowiadały cechom pozycji 3A225 jest wymienione w pozycji 3D225.

NB. 2: „Technologia” w postaci kodów lub kluczy, służąca do poprawy lub wykorzystania wydajności przeмиennika częstotliwości lub generatora, tak by odpowiadały cechom pozycji 3A225 jest wymieniona w pozycji 3E225.

- a. wyjście wielofazowe zapewniające moc równą 40 W lub większą;
- b. pracujące w zakresie częstotliwości równym lub większym niż 600 Hz; oraz
- c. dokładność regulacji częstotliwości lepsza (mniejsza) niż 0,2 %.

Uwaga: Pozycja 3A225 nie obejmuje kontrolą przeмиenników częstotliwości lub generatorów, jeśli posiadają osprzęt, „oprogramowanie” lub „technologię”, których pewne cechy ograniczają skuteczność bądź wydajność do poziomu niższego niż określony powyżej, pod warunkiem, że spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. w celu dokonania w nich ulepszeń lub zmniejszenia ograniczeń muszą zostać odesłane do pierwotnego producenta;
2. w celu poprawy lub wykorzystania wydajności, pozwalających na spełnienie wymogów wymienionych w pozycji 3A225 wymagają „oprogramowania” określonego w pozycji 3D225; lub
3. w celu poprawy lub wykorzystania wydajności, pozwalających na spełnienie wymogów wymienionych w pozycji 3A225 wymagają „technologii” w postaci kluczy lub kodów określonej w pozycji 3E225;

Uwagi techniczne:

1. Przeмиenniki częstotliwości w pozycji 3A225 nazywane są również konwerterami lub inwerterami.
2. Przeмиenniki częstotliwości w pozycji 3A225 mogą być wprowadzane na rynek jako generatory, elektroniczne urządzenia testowe, zasilacze prądu zmiennego, napędy silnikowe zmiennej prędkości, napędy zmiennej prędkości (VSD), falowniki, napędy z regulowaną częstotliwością (AFD) lub napędy z regulowaną prędkością (ASD).

3A226 Wysokoenergetyczne zasilacze prądu stałego, inne niż wyszczególnione w pozycji 0B001.j.6, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

- a. zdolność do ciągłego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napięcia 100 V lub większego z wyjściem prądowym 500 A lub większym; oraz
- b. stabilność prądu lub napięcia, przez okres 8 godzin, lepsza niż 0,1 %.

3A227 Wysokoenergetyczne zasilacze prądu stałego, inne niż wyszczególnione w pozycji 0B001.j.5, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

- a. zdolność do ciągłego wytwarzania, przez okres 8 godzin, napięcia 20 kV lub większego z wyjściem prądowym 1 A lub większym; oraz
- b. stabilność prądu lub napięcia, przez okres 8 godzin, lepsza niż 0,1 %.

3A228 Następujące urządzenia przełączające:

- a. lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez względu na to, czy są napełnione gazem, czy też nie, pracujące podobnie do iskiernika i posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 1. składające się z trzech lub więcej elektrod;
 2. szczytową wartość napięcia anody 2,5 kV lub więcej;
 3. szczytowa wartość natężenia prądu anodowego równa 100 A lub więcej; oraz
 4. czas zwłoki dla anody równy 10 µs lub mniej;

Uwaga: Pozycja 3A228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i próżniowe lampy sprytronowe.

- b. iskierniki wyzwalane, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:
 1. czas zwłoki dla anody równy 15 µs lub mniej; oraz
 2. przystosowane do znamionowych prądów szczytowych równych 500 A lub większych;
- c. moduły lub zespoły do szybkiego przełączania funkcji, inne niż wyszczególnione w pozycji 3A001.g lub 3A001.h, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 1. szczytowa wartość napięcia anody równa 2 kV lub więcej;
 2. szczytowa wartość natężenia prądu anodowego równa 500 A lub więcej; oraz
 3. czas włączania równy 1 µs lub mniej.

3A229 Generatory impulsów wysokoprądowych, takie jak:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

- a. Zestawy zapłonowe do detonatorów (zapalniki, zapłonniki), w tym zestawy zapłonowe uruchamiane elektronicznie, eksplozją i optycznie, inne niż te wymienione w pozycji 1A007.a., zaprojektowane do uruchamiania kontrolowanych detonatorów wielokrotnych wymienionych w 1A007.b.;
- b. modułowe generatory impulsów elektrycznych (impulsatory) posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:
 1. zaprojektowane do urządzeń przenośnych, przewoźnych lub innych narażonych na wstrząsy;

2. zdolne do dostarczenia swojej energii w czasie krótszym niż 15 μ s przy obciążeniu poniżej 40 Ω ;
3. posiadające wyjście prądowe powyżej 100 A;
4. żaden z wymiarów nie przekracza 30 cm;
5. masa mniejsza niż 30 kg; oraz
6. zaprojektowane do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur 223 K (-50°C) do 373 K (100°C) lub nadające się do stosowania w przestrzeni powietrznej.

Uwaga: Pozycja 3A229.b obejmuje wzbudnice ksenonowych lamp błyskowych.

- c. jednostki mikrowyładowcze posiadające wszystkie z następujących cech:
1. żaden z wymiarów nie przekracza 35 mm;
 2. napięcie znamionowe równe lub większe niż 1 kV; oraz
 3. reaktancja pojemnościowa równa lub większa niż 100 nF;

3A230 Szybkie generatory impulsowe oraz ich 'główce impulsowe', posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

- a. a. napięcie wyjściowe większe niż 6 V, przy obciążeniu rezystancyjnym mniejszym niż 55 Ω ; oraz
- b. 'czas narastania impulsów' mniejszy niż 500 ps.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 3A230 'czas narastania impulsów' definiuje się jako przedział czasowy pomiędzy 10 % a 90 % amplitudy napięcia.
2. 'Główce impulsowe' oznaczają sieci formowania impulsów zaprojektowane do przyjmowania funkcji skokowej napięcia i kształtowania różnych przebiegów, np. prostokątnych, trójkątowych, skokowych, impulsowych lub wykładniczych. 'Główce impulsowe' mogą stanowić integralną część generatora impulsów, moduł podłączany do urządzenia lub też zewnętrznie podłączane urządzenie.

3A231 Generatory neutronów, w tym lampy, mające obie następujące właściwości:

- a. zaprojektowane do pracy bez zewnętrznych instalacji próżniowych; oraz
- b. wykorzystujące którekolwiek z poniższych:
 1. przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jądrowej trytu z deuterem. lub
 2. przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jądrowej deuteru z deuterem i pozwalające uzyskać wynik 3×10^9 neutronów/s lub większy.

3A232 Następujące wielopunktowe instalacje inicjujące, inne niż wymienione w pozycji 1A007:

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

NB.: Zob. pozycja 1A007.b w odniesieniu do detonatorów.

- a. nieużywane;
- b. instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi, przeznaczone do prawie równoczesnego inicjowania wybuchów na obszarze większym niż 5 000 mm² za pomocą pojedynczego sygnału zapłonowego przy opóźnieniu synchronizacji na całej powierzchni mniejszym niż 2,5 μ s.

Uwaga Pozycja 3A232 nie obejmuje kontrolą zapłonników wykorzystujących wyłącznie inicjujące materiały wybuchowe, takie jak azydek ołowiawy.

- 3A233 Następujące spektrometry masowe, inne niż wyszczególnione w pozycji 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 230 mas atomowych lub większej oraz posiadające rozdzielczość lepszą niż 2 części na 230, oraz źródła jonów do tych urządzeń:
- a. plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS);
 - b. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
 - c. termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);
 - d. spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami posiadające obydwie poniższe cechy:
 1. układ wlotowy wiązki molekularnej, który wprowadza skolimowaną wiązkę molekuł do celów analitycznych w rejon źródła jonów, gdzie molekuły są jonizowane przez wiązkę elektronów; oraz
 2. co najmniej jedną 'wymrażarkę', którą można schłodzić do temperatury 193 K (-80 °C);
 - e. nieużywane;
 - f. spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecności aktynowców lub fluorków aktynowców.

Uwagi techniczne:

1. *spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami wymienione w pozycji 3A233.d. znane są również jako spektrometry masowe z jonizacją strumieniem elektronów lub spektrometry masowe z jonizacją elektronową.*
2. *W pozycji 3A233.d.2., 'wymrażarka' jest urządzeniem, które przechwytuje molekuły gazu kondensując je lub zamrażając na zimnych powierzchniach. Do celów pozycji 3A233.d.2., kriogeniczna pompa próżniowa z zamkniętym obwodem helu w stanie gazowym nie jest 'wymrażarką'.*

- 3A234 linie paskowe zapewniające ścieżkę o małej indukcyjności do detonatorów, posiadające następujące cechy:
- a. napięcie znamionowe większe niż 2 kV; oraz
 - b. indukcyjność mniejsza niż 20 nH.

3B**Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne**

3B001

Sprzęt do wytwarzania urządzeń lub materiałów półprzewodnikowych oraz specjalnie zaprojektowane do niego części składowe i akcesoria, w tym:

- a. następujący sprzęt zaprojektowany do osadzania warstwy epitaksjalnej:
 1. sprzęt zdolny do wytwarzania powłok o równomiernej grubości z materiałów różnych od krzemu, wykonanych z dokładnością poniżej $\pm 2,5\%$ na odcinku o długości 75 mm lub większym;

Uwaga: Pozycja 3B001.a.1 obejmuje urządzenia do epitaksji warstw atomowych.
 2. reaktory do osadzania z par lotnych związków metaloorganicznych (MOCVD), specjalnie zaprojektowane do wytwarzania warstw epitaksjalnych półprzewodników z materiałów posiadających co najmniej dwa następujące elementy: glin, gal, ind, arsen, fosfor, antymon lub azot;
 3. sprzęt wykorzystujący wiązkę molekularną do wytwarzania warstw epitaksjalnych z surowca gazowego lub stałego;
- b. sprzęt zaprojektowany do implantacji jonów i spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. nieużywane;
 2. zaprojektowany i optymalizowany do działania z energią wiązki wynoszącą 20 keV lub więcej i prądem wiązki o wartości 10 mA lub więcej w celu implantacji wodoru, deuteru lub helu;
 3. zdolność bezpośredniego zapisu;
 4. posiadający energię wiązki wynoszącą 65 keV lub większą oraz natężenie wiązki równe 45 mA lub większe, w celu wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzany półprzewodnikowy materiał „podłoża”; lub
 5. zaprojektowany i optymalizowany do działania z energią wiązki wynoszącą 20 keV lub więcej i prądem wiązki o wartości 10 mA lub więcej w celu implantacji krzemu w półprzewodnikowy materiał „podłoża” podgrzany do temperatury 600°C lub wyższej;
- c. sprzęt do suchego trawienia za pomocą plazmy anizotropowej spełniający wszystkie poniższe kryteria:
 1. zaprojektowany lub optymalizowany do produkcji z wymiarem krytycznym 65 nm lub mniejszym; oraz
 2. niejednorodność wewnątrz płytek nieprzekraczająca 10 % 3σ mierzona z wyłączeniem krawędzi do 2 mm włącznie;
- d. nieużywane;
- e. automatycznie ładujące się, wielokomorowe, centryczne systemy do wytwarzania płytek elektronicznych spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. interfejsy wejściowe i wyjściowe do płytek, zaprojektowane z myślą o podłączeniu więcej niż dwóch pełniących różne funkcje ‘urządzeń do produkcji półprzewodników’ wymienionych w poz. 3B001.a, 3B001.b lub 3B001.c; oraz
 2. zaprojektowane do tworzenia zintegrowanego systemu, działającego w warunkach próżni, do ‘sekwencyjnego wytwarzania płytek metodą powielania’;

Uwaga: Pozycja 3B001.e nie obejmuje kontrolą automatycznych zrobotyzowanych systemów wytwarzania płytek elektronicznych, specjalnie zaprojektowanych do równoległego wytwarzania płytek.

Uwagi techniczne:

1. *Do celów poz. 3B001.e 'urządzenia do produkcji półprzewodników' to urządzenia modularne umożliwiające zachodzenie procesów fizycznych wymaganych do wytwarzania półprzewodników; pełnią one różne funkcje, takie jak: osadzanie, trawienie, implantacja lub obróbka cieplna.*
2. *Do celów poz. 3B001.e 'sekwencyjne wytwarzanie płytek metodą powielania' oznacza zdolność do obrabiania każdej płytki w innym 'urządzeniu wytwarzającym półprzewodniki', np. przez przeniesienie każdej płytki z jednego urządzenia do drugiego i do kolejnego przy pomocy automatycznego wielokomorowego centralnego systemu podawania płytek.*

- f. następujący sprzęt litograficzny:
1. sprzęt do wytwarzania płytek elektronicznych poprzez pozycjonowanie, naświetlanie oraz powielanie (bezpośredni krok na płytkę) lub skanowanie (skaner), z wykorzystaniem metody fotooptycznej lub promieni rentgenowskich, spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. źródło światła o długości fali krótszej niż 245 nm; lub
 - b. zdolny do wytwarzania wzorów o 'rozmiarze minimalnej rozdzielczości wymiarowej' (MRF) 95 nm lub mniejszej;

Uwaga techniczna:

'Rozmiar minimalnej rozdzielczości wymiarowej' (MRF) obliczany jest według poniższego wzoru:

$$MRF = \frac{(\text{długość fali źródła światła napromieniowującego w nm}) \times (\text{współczynnik K})}{\text{apertura liczbowa}}$$

gdzie współczynnik $K = 0,35$

2. urządzenia do litografii nanodrukowej zdolne do drukowania elementów o wielkości 95 nm lub mniejszych;

Uwaga: pozycja 3B001.f.2 obejmuje:

- narzędzia do mikrodruku kontaktowego,
- narzędzia do wytłaczania na gorąco,
- narzędzia do litografii nanodrukowej,
- narzędzia do litografii „step-and-flash” (S-FIL).

3. sprzęt specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek lub przyrządów półprzewodnikowych wykorzystujący metody bezpośredniego nadruku i spełniający wszystkie poniższe kryteria:
 - a. wykorzystujący odchylaną, zogniskowaną wiązkę elektronów, jonów lub wiązkę „laserową”; oraz
 - b. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. apertura plamki poniżej 0,2 μm;
 2. zdolność wytwarzania obrazów o wielkości charakterystycznej poniżej 1 μm; lub
 3. dokładność nakładania warstw lepsza niż $\pm 0,20 \mu\text{m}$ (3 sigma);

- g. maski i siatki optyczne zaprojektowane do układów scalonych wyszczególnionych w pozycji 3A001;

- h. maski wielowarstwowe z warstwą z przesunięciem fazowym niewyszczególnione w pozycji 3B001.g. i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. wykonany na masce „półprodukt podłoża” ze szkła, którego dwójłomność zgodnie ze specyfikacją wynosi poniżej 7 nm/cm; lub
 2. zaprojektowane do stosowania w urządzeniach litograficznych, w których długość fali źródła światła jest mniejsza niż 245 nm;

Uwaga: Pozycja 3B001.h nie obejmuje kontrolą wielowarstwowych masek z warstwą z przesunięciem fazowym, zaprojektowanych do wytwarzania urządzeń pamięciowych, nieobjętych kontrolą przez pozycję 3A001.

- i. szablony do litografii nanodrukowej układów scalonych wyszczególnionych w pozycji 3A001.

- 3B002 Następujący sprzęt testujący specjalnie zaprojektowany do testowania gotowych i niegotowych elementów półprzewodnikowych oraz specjalnie zaprojektowane do niego części składowe i akcesoria:
- a. do testowania S-parametrów urządzeń tranzystorowych przy częstotliwościach powyżej 31,8 GHz;
 - b. nieużywane;
 - c. do testowania mikrofalowych układów scalonych wyszczególnionych w pozycji 3A001.b.2.

3C**Materiały**

3C001 Materiały heteroepitaksjalne składające się z „podłoża” i wielu nałożonych epitaksjalnie warstw z któregośkolwiek z poniższych:

- a. krzemu (Si);
- b. germanu (Ge);
- c. węgla krzemu (SiC); lub
- d. „związków III/V” galu lub indu.

Uwaga: Pozycja 3C001.d. nie obejmuje kontrolą „podłoża” posiadającego co najmniej jedną warstwę epitaksjalną typu P z GaN, InGaN, AlGaIn, InAlN, InAlGaIn, GaP, InGaP, AlInP lub InGaAlP, bez względu na kolejność pierwiastków, z wyjątkiem sytuacji, gdy warstwa epitaksjalna typu P znajduje się między warstwami typu N.

3C002 Następujące materiały fotorezystywne i „podłoża” powlekane następującymi materiałami ochronnymi:

- a. następujące materiały fotorezystywne zaprojektowane do litografii półprzewodnikowej:
 1. materiały fotorezystywne pozytywowe wyregulowane (zoptymalizowane) do stosowania w zakresie długości fali poniżej 245 nm, ale nie mniejszym niż 15 nm;
 2. materiały fotorezystywne wyregulowane (zoptymalizowane) do stosowania w zakresie długości fali poniżej 15 nm, ale większym niż 1 nm;
- b. wszystkie materiały fotorezystywne zaprojektowane do użytku z wiązkami elektronowymi lub jonowymi, o czułości 0,01 $\mu\text{C}/\text{mm}^2$ lub lepszej;
- c. nieużywane;
- d. wszystkie materiały fotorezystywne zoptymalizowane do technologii tworzenia obrazów powierzchniowych;
- e. wszystkie materiały fotorezystywne zaprojektowane lub zoptymalizowane do użytku z urządzeniami do litografii nanodrukowej wyszczególnionymi w pozycji 3B001.f.2 wykorzystującymi proces termiczny lub proces fotoutwardzania.

3C003 Związki organiczno-nieorganiczne, takie jak:

- a. związki metaloorganiczne glinu, galu lub indu o czystości (na bazie metalu) powyżej 99,999 %;
- b. związki arsenoorganiczne, antymonoorganiczne i fosforoorganiczne o czystości (na bazie składnika nieorganicznego) powyżej 99,999 %.

Uwaga: Pozycja 3C003 obejmuje kontrolą wyłącznie związki, w których składnik metalowy, częściowo metalowy lub składnik niemetalowy jest bezpośrednio związany z węglem w organicznym składniku molekuly.

3C004 Wodorki fosforu, arsenu lub antymonu o czystości powyżej 99,999 %, nawet rozpuszczone w gazach obojętnych lub w wodorze.

Uwaga: Pozycja 3C004 nie obejmuje kontrolą wodorków zawierających molowo 20 %, lub więcej, gazów obojętnych lub wodoru.

3C005 „Podłoża” półprzewodnikowe z węgla krzemu (SiC), azotku galu (GaN), azotku glinu (AlN) lub z azotku galu i glinu (AlGaIn), lub wlewki, monokryształy lub inne preformy tych materiałów o rezystywności powyżej 10 000 Ω/cm w temperaturze 20 °C.

3C006 „Podłoża” wyszczególnione w pozycji 3C005 z co najmniej jedną warstwą epitaksjalną z węgla krzemu, azotku galu, azotku glinu lub azotku galu i glinu.

3D Oprogramowanie

- 3D001 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu objętego kontrolą, wymienionego w pozycji 3A001.b do 3A002.g, lub 3B.
- 3D002 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” sprzętu wymienionego w pozycjach 3B001.a do 3B001.f, w pozycji 3B002 lub w pozycji 3A225.
- 3D003 „Oprogramowanie” symulacyjne, ‘bazujące na fizyce’, specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” procesów litografii, wytrawiania lub osadzania w celu przekształcenia maskujących kształtów w konkretną topografię obszarów przewodzących, dielektrycznych lub półprzewodnikowych.
- Uwaga techniczna:
‘Bazujące na fizyce’ w 3D003 oznacza wykorzystanie obliczeń do określenia sekwencji przyczyn fizycznych oraz skutków zdarzeń, opierających się na właściwościach fizycznych (np. temperatura, ciśnienie, stałe dyfuzji oraz właściwości materiałów półprzewodnikowych).
- Uwaga: *Biblioteki, związane z nimi atrybuty i inne dane służące do projektowania urządzeń półprzewodnikowych lub układów scalonych są postrzegane jako „technologia”.*
- 3D004 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” sprzętu wymienionego w pozycji 3A003.
- 3D101 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” sprzętu wymienionego w pozycji 3A101.b.
- 3D225 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania wydajności przemienników częstotliwości lub generatorów, tak by odpowiadały cechom wymienionym w pozycji 3A225.

3E**Technologia**

3E001 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu lub materiałów wyszczególnionych w pozycji 3A, 3B lub 3C.

Uwaga 1: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolą „technologii” do „produkcji” sprzętu lub części składowych objętych kontrolą przez pozycję 3A003.

Uwaga 2: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolą „technologii” do „rozwoju” lub „produkcji” układów scalonych wyszczególnionych w pozycji 3A001.a.3 do 3A001.a.12 spełniające wszystkie poniższe kryteria:

- a. wykorzystujące „technologię” 0,130 μm lub więcej; oraz
- b. posiadające strukturę wielowarstwową z nie więcej niż trzema warstwami metalu.

3E002 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, inna niż wyszczególnione w pozycji 3E001, do „rozwoju” lub „produkcji” „układu mikroprocesorowego”, „układu mikrokomputerowego” lub rdzenia układu mikrosterowników posiadającego jednostkę arytmetyczno-logiczną z szyną dostępu na 32 bity lub więcej i którąkolwiek z poniższych właściwości:

- a. ‘procesor wektorowy’ zaprojektowany do jednoczesnego wykonywania więcej niż dwu operacji na wektorach zmiennoprzecinkowych (jednowymiarowych tablicach złożonych z liczb 32-bitowych lub dłuższych);

Uwaga techniczna:

‘Procesor wektorowy’ jest zdefiniowany jako procesor wyposażony w wewnętrzne instrukcje pozwalające równocześnie wykonywać wielokrotne operacje na wektorach zmiennoprzecinkowych (jednowymiarowych tablicach złożonych z liczb 32-bitowych lub dłuższych), posiadający co najmniej jedną jednostkę wektorową arytmetyczno-logiczną.

- b. zaprojektowany do wykonywania w jednym cyklu więcej niż czterech wyników operacji zmiennoprzecinkowych na liczbach 64-bitowych lub dłuższych; lub
- c. zaprojektowany do wykonywania w jednym cyklu więcej niż czterech wyników operacji stałoprzecinkowych typu multiply-accumulate na liczbach 16-bitowych (np. obróbka cyfrowa informacji analogowych, które uprzednio zostały przekształcone na postać cyfrową, znana również jako cyfrowe „przetwarzanie sygnału”).

Uwaga: Pozycja 3E002.c nie obejmuje kontrolą „technologii” do rozszerzeń multimedialnych.

Uwaga 1: Pozycja 3E002 nie obejmuje kontrolą „technologii” do „rozwoju” lub „produkcji” rdzeni mikroprocesorów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

- a. zastosowanie „technologii” na poziomie 0,130 μm lub powyżej; oraz
- b. wykorzystywanie struktur wielowarstwowych o co najwyżej pięciu warstwach metalu.

Uwaga 2: Pozycja 3E002 obejmuje „technologię” dla procesorów sygnałowych i procesorów macierzowych.

- 3E003 Inna „technologia” do „rozwoju” lub „produkcji” następujących produktów:
- a. próżniowych urządzeń mikroelektronicznych;
 - b. heterostrukuralnych elektronicznych urządzeń półprzewodnikowych, takich jak tranzystory o wysokiej ruchliwości elektronów (HEMT), tranzystory heterobipolarne (HBT), urządzenia nadstrukuralne oraz ze studnią kwantową;
- Uwaga: Pozycja 3E003.b nie obejmuje kontrolą „technologii” dla tranzystorów o wysokiej ruchliwości elektronów (HEMT), pracujących na częstotliwościach niższych od 31,8 GHz oraz tranzystorów heterobipolarnych (HBT), pracujących na częstotliwościach niższych od 31,8 GHz.*
- c. urządzeń elektronicznych opartych na „Nadprzewodnikach”;
 - d. podłoży folii diamentowych do podzespołów elektronicznych;
 - e. podłoży do układów scalonych, typu „krzem na izolatorze” (SOI), gdzie izolatorem jest dwutlenek krzemu;
 - f. podłoży z węgla krzemu do części elektronicznych;
 - g. elektronicznych lamp próżniowych, pracujących na częstotliwościach równych 31,8 GHz lub wyższych.
- 3E101 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wymienionego w pozycji 3A001.a.1 lub 3A001.a.2, 3A101, 3A102 lub 3D101.
- 3E102 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” „oprogramowania” wymienionego w pozycji 3D101.
- 3E201 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „użytkowania” sprzętu wymienionego w pozycji 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225 do 3A234.
- 3E225 „Technologia” w postaci kodów lub kluczy, służąca do poprawy lub wykorzystania wydajności przemienników częstotliwości lub generatorów, tak by odpowiadały cechom wymienionym w pozycji 3A225.

KATEGORIA 4 - KOMPUTERY

Uwaga 1: Komputery, towarzyszące im sprzęt i „oprogramowanie” wypełniające funkcje telekomunikacyjne lub działające w ramach „lokalnej sieci komputerowej”, muszą również być analizowane pod kątem spełniania charakterystyk, przynależnych do kategorii 5 część 1 – Telekomunikacja.

Uwaga 2: Jednostki sterujące podłączone bezpośrednio do szyn lub łączą jednostek centralnych, „pamięci operacyjnych” lub sterowników dysków nie są uważane za urządzenia telekomunikacyjne ujęte w kategorii 5 część 1 – Telekomunikacja.

NB.: Dla ustalenia poziomu kontroli „oprogramowania” specjalnie zaprojektowanego do komutacji pakietów, zob. pozycja 5D001.

Uwaga 3: Komputery, towarzyszące im urządzenia i „oprogramowanie” spełniające funkcje szyfrowania, rozszyfrowywania, systemu zabezpieczeń wymagającego potwierdzania wielopoziomowego lub w wymagających potwierdzania systemach wyodrębnienia użytkownika lub które ograniczają zgodność elektromagnetyczną (EMC), należy również analizować pod kątem spełniania charakterystyk, przynależnych do kategorii 5 część 2 – Ochrona informacji.

4A Systemy, urządzenia i części składowe

4A001 Komputery elektroniczne i towarzyszący im sprzęt spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów i „zespoły elektroniczne” oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 4A101.

- a. specjalnie zaprojektowane, aby spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. możliwość działania w temperaturze otoczenia poniżej 228 K (-45°C) lub powyżej 358 K (85°C); lub

Uwaga: Pozycja 4A001.a.1 nie obejmuje kontrolą komputerów specjalnie zaprojektowanych do zastosowania w samochodach cywilnych, kolejnictwie lub „cywilnych statkach powietrznych”.

2. zabezpieczone przed promieniowaniem jonizującym, o następujących parametrach minimalnych:

- a. dawka całkowita 5×10^3 Gy (Si);
- b. narastanie natężenia dawki 5×10^6 Gy (Si)/s; lub
- c. pojedyncze przypadkowe zakłócenie 1×10^{-8} błędów/bit/dzień;

Uwaga: Pozycja 4A001.a.2 nie obejmuje kontrolą komputerów specjalnie zaprojektowanych do zastosowania w „cywilnych statkach powietrznych”.

- b. nieużywane.

4A003 Następujące „komputery cyfrowe”, „zespoły elektroniczne” i sprzęt im towarzyszący oraz specjalnie zaprojektowane dla nich części składowe:

Uwaga 1: Pozycja 4A003 obejmuje:

- procesory wektorowe,
- procesory tablicowe,
- cyfrowe procesory sygnałowe,
- procesory logiczne,
- sprzęt zaprojektowany do „wzmacniania obrazów”,
- sprzęt zaprojektowany do „przetwarzania sygnałów”.

Uwaga 2: Poziom kontroli „komputerów cyfrowych” i towarzyszącego im sprzętu opisany w pozycji 4A003 wynika z poziomu kontroli innego sprzętu lub systemów, pod warunkiem że:

- a. „komputery cyfrowe” lub towarzyszący im sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla działania innego sprzętu lub systemów;
- b. „komputery cyfrowe” lub towarzyszący im sprzęt nie są „elementem o podstawowym znaczeniu” innego sprzętu lub systemów; oraz

NB. 1: Poziom kontroli sprzętu do „przetwarzania sygnałów” lub „wzmacniania obrazów”, specjalnie zaprojektowanych do innego sprzętu i ograniczonych funkcjonalnie do wymogów pracy tego sprzętu wynika z poziomu kontroli innego sprzętu, nawet, gdy wykracza to poza kryterium „elementu o podstawowym znaczeniu”.

NB. 2: W przypadku poziomu kontroli „komputerów cyfrowych” lub towarzyszącego im sprzętu, do sprzętu telekomunikacyjnego zob. kategoria 5 część 1 – Telekomunikacja.

- c. „technologia” do „komputerów cyfrowych” i towarzyszącego im sprzętu jest określona przez pozycję 4E.

- a. nieużywane;
- b. „komputery cyfrowe” posiadające „skorygowaną wydajność szczytową” („APP”) powyżej 8,0 teraflopsa ważonego (WT);
- c. „zespoły elektroniczne”, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu polepszenia mocy obliczeniowej poprzez agregację procesorów, w taki sposób, że „APP” agregatu przekracza wartość graniczną określoną w pozycji 4A003.b;

Uwaga 1: Pozycja 4A003.c obejmuje kontrolą wyłącznie „zespoły elektroniczne” i programowane połączenia, których moc obliczeniowa nie wykracza poza wartości graniczne określone w pozycji 4A003.b, w przypadku dostarczania ich jako „zespoły elektroniczne” w stanie rozłożonym. Pozycja ta nie obejmuje kontrolą „zespołów elektronicznych”, które ze względu na charakter swojej konstrukcji nie mogą z natury rzeczy być wykorzystywane jako urządzenia towarzyszące, wyszczególnione w pozycji 4A003.e.

Uwaga 2: Pozycja 4A003.c nie obejmuje kontrolą „zespołów elektronicznych”, specjalnie zaprojektowanych do wyrobu lub rodziny wyrobów, których maksymalna konfiguracja nie wykracza poza ograniczenia wyszczególnione w pozycji 4A003.b.

- d. nieużywane;

- e. sprzęt do przetwarzania analogowo-cyfrowego o parametrach wykraczających poza wartości graniczne określone w pozycji 3A001.a.5;
- f. nieużywane;

- g. sprzęt specjalnie zaprojektowany w celu łączenia wydajności „komputerów cyfrowych” przez nawiązywanie połączeń zewnętrznych pozwalających na wymianę danych z szybkościami przekraczającymi 2,0 Gb/s w jednym kierunku dla każdego połączenia.

Uwaga: Pozycja 4A003.g nie obejmuje kontrolą sprzętu zapewniającego połączenia wewnętrzne (np. tablice połączeń, szyny), urządzeń łączących o charakterze pasywnym, „sterowników dostępu do sieci” ani „sterowników torów telekomunikacyjnych”.

4A004 Następujące komputery i specjalnie do nich zaprojektowany sprzęt towarzyszący, „zespoły elektroniczne” i ich części składowe:

- a. „komputery z dynamiczną modyfikacją zestawu procesorów”;
- b. „komputery neuronowe”;
- c. „komputery optyczne”.

4A005 Systemy, wyposażenie i ich części składowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do tworzenia, obsługi lub dostarczania „złośliwego oprogramowania” lub komunikacji z nim.

4A101 Komputery analogowe, „komputery cyfrowe” lub cyfrowe analizatory różniczkowe, inne niż wyszczególnione w pozycji 4A001.a.1, zabezpieczone przed narażeniami mechanicznymi lub podobnymi i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do użycia w kosmicznych pojazdach nośnych, wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104.

4A102 „Komputery hybrydowe”, specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub rakiet meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104.

Uwaga: Kontrola dotyczy wyłącznie takich sytuacji, w których sprzęt jest dostarczany z „oprogramowaniem” wymienionym w pozycji 7D103 lub 9D103.

4B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

Żadne.

4C Materiały

Żadne.

4D Oprogramowanie

Uwaga: Poziom kontroli „oprogramowania” do urządzeń opisanych w innych kategoriach wynika z odpowiedniej kategorii.

4D001 Następujące „oprogramowanie”:

- a. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionych w pozycji 4A001 do 4A004 lub 4D;
- b. „oprogramowanie”, inne niż wyszczególnione w pozycji 4D001.a, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” lub „produkcji” następującego sprzętu:
 1. „komputery cyfrowe” posiadające „skorygowaną wydajność szczytową” („APP”) powyżej 0,60 teraflopsa ważonego (WT);
 2. „zespoły elektroniczne”, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu polepszenia mocy obliczeniowej poprzez agregację procesorów, w taki sposób, że „APP” agregatu przekracza wartość graniczną określoną w pozycji 4D001.b.1.

4D002 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wspomagania „technologii” wyszczególnionych w pozycji 4E.

4D003 nieużywane.

4D004 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do tworzenia, obsługi lub dostarczania „złośliwego oprogramowania” lub komunikacji z nim.

4E Technologia

- 4E001
- a. „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionych w pozycji 4A lub 4D;
 - b. „technologia”, inna niż wyszczególniona w pozycji 4E001.a, specjalnie zaprojektowana lub zmodyfikowana do „rozwoju” lub „produkcji” następującego sprzętu:
 1. „komputery cyfrowe” posiadające „skorygowaną wydajność szczytową” („APP”) powyżej 0,60 teraflopsa ważonego (WT);
 2. „zespoły elektroniczne”, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu polepszenia mocy obliczeniowej poprzez agregację procesorów, w taki sposób, że „APP” agregatu przekracza wartość graniczną określoną w pozycji 4E001.b.1.
 - c. „Technologia” służąca do „opracowywania” „złośliwego oprogramowania”.

UWAGA TECHNICZNA DOTYCZĄCA „SKORYGOWANEJ WYDAJNOŚCI SZCZYTOWEJ”
(„APP”)

„APP” oznacza skorygowaną największą prędkość, z jaką „komputery cyfrowe” wykonują zmiennoprzecinkowe operacje dodawania i mnożenia na liczbach 64-bitowych lub dłuższych.

„APP” wyraża się w teraflopsach ważonych (WT), w jednostkach wynoszących 10^{12} skorygowanych operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

Skróty stosowane w niniejszej uwadze technicznej

n	liczba procesorów w „komputerze cyfrowym”
i	numer procesora ($i, \dots, n$)
t_i	czas cyklu procesora ($t_i = 1/F_i$)
F_i	częstotliwość procesora
R_i	szczytowa szybkość obliczeniowa dla operacji zmiennoprzecinkowych
W_i	współczynnik korygujący związany z architekturą systemu

Omówienie sposobu obliczania „APP”

1. Dla każdego procesora i określić szczytową liczbę operacji zmiennoprzecinkowych (FPO_i) na liczbach 64-bitowych lub dłuższych wykonywanych w jednym cyklu przez każdy procesor „komputera cyfrowego”.

Uwaga Określając FPO , należy brać pod uwagę wyłącznie zmiennoprzecinkowe operacje dodawania lub mnożenia na liczbach 64-bitowych lub dłuższych. Wszystkie operacje zmiennoprzecinkowe muszą być wyrażone w operacjach na cykl procesora; operacje wymagające wielu cykli można wyrażać w postaci wyniku ułamkowego na jeden cykl. W przypadku procesorów niezdolnych do wykonywania operacji na argumentach zmiennoprzecinkowych o długości 64 bitów lub dłuższych, efektywna szybkość obliczeniowa R wynosi zero.

2. Obliczyć szybkość operacji zmiennoprzecinkowych R dla każdego procesora, $R_i = FPO_i/t_i$.
3. Obliczyć „APP” z wzoru „APP” = $W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \dots + W_n \times R_n$.
4. Dla ‘procesorów wektorowych’, $W_i = 0,9$. Dla procesorów niebędących ‘procesorami wektorowymi’, $W_i = 0,3$.

Uwaga 1: W przypadku procesorów wykonujących w jednym cyklu operacje złożone, takie jak dodawanie i mnożenie, liczy się każda operacja.

Uwaga 2: W przypadku procesora działającego w trybie potokowym, jako efektywną szybkość obliczeniową R przyjmuje się większą z następujących prędkości: prędkość w trybie potokowym przy pełnym wykorzystaniu potoku i prędkości w trybie niepotokowym.

Uwaga 3: Do celów obliczenia „APP” całego zespołu przyjmuje się dla każdego procesora składowego jego maksymalną teoretycznie możliwą szybkość obliczeniową R . Przyjmuje się, że zachodzi równoczesne wykonywanie operacji, jeżeli producent komputera stwierdza w broszurze lub podręczniku użytkownika, że komputer przetwarza dane w sposób współbieżny, równoległy lub równoczesny.

Uwaga 4: *Przy obliczaniu „APP” nie uwzględnia się procesorów, których rola ogranicza się do funkcji wejścia/wyjścia i peryferyjnych (np. w napędzie dysków, urządzeniach komunikacyjnych i wyświetlaczu wideo).*

Uwaga 5: *Nie oblicza się wartości „APP” dla zespołów procesorów połączonych ze sobą i z innymi w ramach „lokalnych sieci komputerowych”, rozległych sieci komputerowych (WAN), dzielonych wspólnych połączeń lub urządzeń wejścia/wyjścia, kontrolerów wejścia/wyjścia oraz we wszelkich połączeniach komunikacyjnych implementowanych przez „oprogramowanie”.*

UWAGA TECHNICZNA DOTYCZĄCA „SKORYGOWANEJ WYDAJNOŚCI SZCZYTOWEJ” („APP”)

- Uwaga 6: *Konieczne jest obliczenie wartości „APP” dla:*
- 1. zespołów procesorów zawierających procesory specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności poprzez agregację, równoczesne działanie i współdzielenie pamięci; lub*
 - 2. większej liczby zespołów pamięć/procesor działających równocześnie z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego sprzętu.*

Uwaga techniczna:

łącznie wszystkie procesory i akceleratory działające równocześnie i znajdujące się na tej samej płycie.

- Uwaga 7: *‘Procesor wektorowy’ jest zdefiniowany jako procesor wyposażony w wewnętrzne instrukcje pozwalające równocześnie wykonywać wielokrotne operacje na wektorach zmiennoprzecinkowych (jednowymiarowych tablicach złożonych z liczb 64-bitowych lub dłuższych), posiadający co najmniej dwie funkcjonalne jednostki wektorowe i co najmniej 8 rejestrów wektorowych, każdy o pojemności co najmniej 64 elementów.*

KATEGORIA 5 - TELEKOMUNIKACJA I „OCHRONA INFORMACJI”

Cześć 1 - TELEKOMUNIKACJA

Uwaga 1: W pozycjach kategorii 5 część 1, ujęto poziom kontroli części składowych, sprzętu „laserowego”, testującego i „produkcyjnego”, oraz „oprogramowania” do nich, specjalnie zaprojektowanych do sprzętu lub systemów telekomunikacyjnych.

NB.1: „Lasery” specjalnie zaprojektowane do urządzeń i systemów telekomunikacyjnych – zob. poz. 6A005.

NB.2: Urządzenia, części składowe i „oprogramowanie” realizujące lub mające funkcje „ochrony informacji” – zob. również kategoria 5 część 2.

Uwaga 2: „Komputery cyfrowe”, towarzyszący im sprzęt lub „oprogramowanie”, mające zasadniczy wpływ na działanie i wspomaganie działań sprzętu telekomunikacyjnego przedstawionych w pozycjach dotyczących telekomunikacji w niniejszej kategorii, są traktowane jako specjalnie opracowane komponenty, pod warunkiem że są to modele standardowe, dostarczane przez producenta na zamówienie klienta. Dotyczy to komputerowych systemów obsługi, zarządzania, konserwacji, technicznych lub księgowych.

5A1 Systemy, urządzenia i części składowe

5A001 Następujące systemy telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, części składowe i osprzęt:

- a. dowolny typ sprzętu telekomunikacyjnego, posiadający jedną z niżej wymienionych cech lub właściwości lub realizujący jedną z wymienionych funkcji:
 1. specjalnie zabezpieczone przed skutkami przejściowych zjawisk elektronicznych lub impulsu elektromagnetycznego, powstających w wyniku wybuchu jądrowego;
 2. specjalnie zabezpieczone przed promieniowaniem gamma, neutronowym lub jonizacyjnym; lub
 3. specjalnie zaprojektowane do eksploatacji w zakresie temperatur poza przedziałem od 218 K (- 55 °C) do 397 K (+ 124 °C);

Uwaga: Pozycja 5A001.a.3 odnosi się wyłącznie do sprzętu elektronicznego.

Uwaga: Pozycje 5A001.a.2 i 5A001.a.3 nie obejmują kontrolę sprzętu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do stosowania w satelitach.

- b. systemy i urządzenia telekomunikacyjne oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe i osprzęt, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:
 1. będące bezprzewodowymi systemami komunikacji podwodnej spełniającymi którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. akustyczna częstotliwość nośna poza przedziałem 20 kHz do 60 kHz;
 - b. działające w zakresie elektromagnetycznej częstotliwości nośnej poniżej 30 kHz;

- c. działające z wykorzystaniem technik sterowania za pomocą wiązki elektronów; lub
- d. działające z wykorzystaniem „laserów” lub diod elektroluminescencyjnych (LED) o fali wyjściowej, której długość przekracza 400 nm, lecz nie osiąga 700 nm, w „lokalnej sieci komputerowej”;

2. będące sprzętem radiowym działającym w paśmie od 1,5 do 87,5 MHz i spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
- a. automatyczne przewidywanie i wybieranie częstotliwości oraz „całkowite szybkości transmisji danych cyfrowych” na kanał, umożliwiające optymalizację transmisji; oraz
 - b. zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz mocy umożliwiający równoczesną obróbkę wielu sygnałów przy mocy wyjściowej 1 kW lub wyższej, w zakresie częstotliwości od 1,5 do 30 MHz, lub 250 W lub wyższej w zakresie częstotliwości od 30 do 87,5 MHz, w zakresie „pasma chwilowego” o szerokości jednej oktawy lub większej oraz z wyjściem o zniekształceniach harmonicznych lub innych lepszych niż -80 dB;
3. będące sprzętem radiowym, w którym zastosowano techniki „widma rozproszonego” w tym „rozrzucanie częstotliwości”, poza wyszczególnionymi w pozycji 5A001.b.4, i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
- a. programowane przez użytkownika kody rozpraszania; lub
 - b. całkowita szerokość przesyłanego pasma 100 lub więcej razy większa od szerokości pasma dowolnego z kanałów informacyjnych w nadmiarze 50 kHz;

Uwaga: Pozycja 5A001.b.3.b nie obejmuje kontrolą sprzętu radiowego specjalnie zaprojektowanego do stosowania w którychkolwiek z poniższych:

- a. sieci telekomunikacyjnych w układzie terytorialnym (komórkowym) działających w zakresie pasm cywilnych; lub
- b. Stałe lub ruchome naziemne stacje satelitarne do zastosowań w komercyjnych cywilnych systemach telekomunikacji.

Uwaga: Pozycja 5A001.b.3 nie obejmuje kontrolą urządzeń o mocy wyjściowej 1 W lub mniejszej.

4. będące sprzętem radiowym, w którym zastosowano ultraszerokopasmowe techniki modulacji, posiadające programowane przez użytkownika kody przydzielania kanałów, szyfrowania (scrambling) lub identyfikacji sieci i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
- a. szerokość pasma przekraczająca 500 MHz; lub
 - b. „ułamkowa szerokość pasma” wynosząca 20 % lub więcej;
5. będące sterowanymi cyfrowo odbiornikami radiowymi, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- a. posiadają ponad 1 000 kanałów;
 - b. charakteryzują się ‘czasem przełączania kanałów’ niższym od 1 ms;
 - c. umożliwiają automatyczne przeszukiwanie lub skanowanie części widma fal elektromagnetycznych; oraz
 - d. umożliwiają identyfikację odbieranych sygnałów lub typu nadajnika; lub

Uwaga: Pozycja 5A001.b.5 nie obejmuje kontrolą sprzętu specjalnie zaprojektowanego do komórkowych radiowych sieci telekomunikacyjnych, działających w zakresie pasm cywilnych.

Uwagi techniczne:

‘Czas przełączania kanałów’ oznacza czas (tj. opóźnienie) do zmiany z jednej częstotliwości odbiorczej na inną, by osiągnąć zgodną ze specyfikacjami końcową częstotliwość odbiorczą na poziomie zadanym lub w przedziale $\pm 0,05$ % wokół tego poziomu. Produkty, których zgodna ze specyfikacjami częstotliwość mieści się w przedziale węższym niż $\pm 0,05$ % wokół ich częstotliwości środkowej, definiowane są jako niezdolne do przełączania częstotliwości kanałów.

6. będące urządzeniami wykorzystującymi funkcje cyfrowego „przetwarzania sygnałów” dla realizacji ‘kodowania mowy’ z szybkością poniżej 2 400 bitów/s;

Uwagi techniczne:

1. Dla zmiennych współczynników ‘kodowania mowy’, pozycja 5A001.b.6 dotyczy ‘kodowania mowy’ w odniesieniu do wyjścia ciągłego sygnału głosowego.
 2. Do celów pozycji 5A001.b.6 ‘kodowanie mowy’ określa się jako technikę próbkowania głosu ludzkiego, a następnie przetwarzania próbek na sygnał cyfrowy, z uwzględnieniem cech szczególnych mowy ludzkiej.
- c. światłowody o długości ponad 500 m i określone przez producenta, jako mogące się oprzeć podczas ‘testu kontrolnego’ naprężeniom rozciągającym wynoszącym 2×10^9 N/m² lub większe;

NB.: Dla kabli startowych (pępowinowych) zob. także pozycja 8A002.a.3.

Uwaga techniczna:

‘Test kontrolny’: prowadzona na bieżąco (on line) lub poza linią produkcyjną (off-line) kontrola zupełna, podczas której wszystkie włókna są obciążane dynamicznie z góry określonymi naprężeniami rozciągającymi, działającymi na odcinek światłowodu o długości od 0,5 do 3 m, przeciągany z szybkością 2 do 5 m/s pomiędzy bębnami nawijającymi o średnicy około 150 mm. Temperatura otoczenia powinna wynosić 293 K (20°C), a wilgotność względna 40 %. Testy kontrolne można przeprowadzić według równoważnych norm krajowych.

- d. „elektronicznie sterowane fazowane układy antenowe” pracujące w zakresie częstotliwości powyżej 31,8 GHz;

Uwaga: Pozycja 5A001.d nie obejmuje kontrolą „elektronicznie sterowanych fazowanych układów antenowych” do systemów kontroli lądowania oprzyrządowanych według wymagań norm ICAO obejmujących mikrofalowe systemy kontroli lądowania (MLS).

- e. sprzęt radiowy do namierzania kierunku działający na częstotliwościach powyżej 30 MHz i spełniający wszystkie poniższe kryteria, jak również specjalnie zaprojektowane podzespoły do tego sprzętu:
1. „chwilowa szerokość pasma” wynosząca 10 MHz lub więcej; oraz
 2. zdolność określania namiaru na niewspółpracujące nadajniki radiowe emitujące sygnał o czasie trwania krótszym niż 1 ms;
- f. następujące urządzenia przechwytyjące lub zakłócające telekomunikacji mobilnej i urządzenia monitorujące do nich oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

1. urządzenia przechwytyjące zaprojektowane do ekstrahowania głosu lub danych, transmitowanych przez interfejs radiowy;
2. urządzenia przechwytyjące niewymienione w pozycji 5A001.f.1., zaprojektowane do ekstrahowania identyfikatorów urządzeń klientów lub abonentów (np. IMSI, TIMSI lub IMEI), sygnałów lub innych metadanych transmitowanych przez interfejs radiowy;
3. sprzęt zakłócający zaprojektowany lub zmodyfikowany specjalnie na potrzeby celowego i selektywnego zakłócania, blokowania, utrudniania, pogarszania jakości lub wprowadzania w błąd systemów usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych i wypełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. zdolność symulowania funkcji sprzętu sieci dostępu radiowego (RAN);
 - b. wykrywanie i wykorzystywanie cech szczególnych stosowanego protokołu telekomunikacji ruchomej (np. GSM); lub
 - c. wykorzystywanie cech szczególnych stosowanego protokołu telekomunikacji ruchomej (np. GSM);
4. urządzenia do monitorowania częstotliwości radiowych zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykrywania działania podzespołów określonych w pozycjach 5A001.f.1., 5A001.f.2. lub 5A001.f.3.;

Uwaga: Pozycje 5A001.f.1 i 5A001.f.2 nie obejmują kontrolą żadnych z poniższych:

- a. urządzeń zaprojektowanych specjalnie do przechwytywania analogowych prywatnych systemów radiowej łączności ruchomej (PMR), IEEE 802.11 WLAN;
- b. urządzeń zaprojektowanych dla potrzeb operatorów sieci telekomunikacji mobilnej; lub
- c. urządzeń zaprojektowanych do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń lub systemów telekomunikacji mobilnej.

NB.1: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

NB.2: Odbiorniki radiowe - zob. pozycja 5A001.b.5.

- g. systemy lub urządzenia do pasywnej koherentnej lokacji (PCL) specjalnie zaprojektowane do wykrywania i śledzenia obiektów ruchomych za pomocą pomiaru odbić emisji częstotliwości radiowych z otoczenia, pochodzących od nadajników nieradarowych;

Uwaga techniczna:

Nadajniki nieradarowe mogą obejmować stacje bazowe radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej.

Uwaga: Pozycja 5A001.g nie obejmuje kontrolą żadnych z poniższych:

- a. urządzeń radioastronomicznych; lub
- b. systemów lub urządzeń wymagających, aby cel nadawał jakiegokolwiek sygnał radiowy.

- h. następujące urządzenia do unieszkodliwiania improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) i powiązany sprzęt:
1. urządzenia do transmisji w częstotliwości radiowej (RF), niewyszczególnione w pozycji 5A001.f., zaprojektowane lub zmodyfikowane do przedwczesnej aktywacji lub zapobiegania inicjacji improwizowanych urządzeń wybuchowych;
 2. urządzenia wykorzystujące techniki zaprojektowane w celu umożliwienia komunikacji radiowej na tych samych kanałach częstotliwości, na których transmitują urządzenia towarzyszące określone w pozycji 5A001.h.1.

NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

- i. nieużywane;
- j. Systemy lub urządzenia do nadzorowania komunikacji w sieci z wykorzystaniem protokołu IP oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. wykonujące wszystkie poniższe działania w sieci IP klasy operatorskiej (np. krajowa sieć szkieletowa IP):
 - a. analiza w warstwie aplikacji (np. warstwa 7 modelu OSI (Open Systems Interconnection) (ISO/IEC 7498-1));
 - b. ekstrakcja wybranych metadanych i zawartości aplikacji (np. głos, obraz wideo, wiadomości, załączniki); oraz
 - c. indeksowanie wyekstrahowanych danych; oraz
 2. specjalnie zaprojektowane do wykonywania wszystkich następujących czynności:
 - a. przeprowadzania wyszukiwania w oparciu o ‘twarde parametry’ oraz
 - b. mapowanie sieci powiązań pojedynczej osoby lub grupy ludzi.

Uwaga: Pozycja 5A001.j nie obejmuje kontrolą systemów lub sprzętu specjalnie zaprojektowanego do którychkolwiek z poniższych:

- a. cel rynkowy;
- b. sieciowa jakość usługi (QoS); lub
- c. postrzegalna jakość usług (QoE);

Uwaga techniczna:

‘Twarde parametry’ oznaczają dane lub zestaw danych powiązanych z daną osobą (np. nazwisko, imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu lub powiązania grupowe).

5A101 Sprzęt do zdalnego przekazywania wyników pomiarów i do zdalnego sterowania, w tym sprzęt naziemny, zaprojektowany lub zmodyfikowany do użycia w ‘pociskach raketowych’.

Uwaga techniczna:

W pozycji 5A101 ‘pocisk raketowy’ oznacza kompletne systemy raketowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych, zdolnych do pokonania odległości przekraczającej 300 km.

Uwaga: Pozycja 5A101 nie obejmuje kontrolą:

- a. sprzętu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do załogowych statków powietrznych lub satelitów;
- b. sprzętu naziemnego, zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do zastosowań lądowych lub morskich;
- c. sprzętu zaprojektowanego do celów usług GNSS (np. integralności danych, bezpieczeństwa lotów) o charakterze komercyjnym, cywilnym lub dla ‘ratowania życia’.

5B1 Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

5B001 Następujące telekomunikacyjne urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne, części składowe i osprzęt:

- a. sprzęt i specjalnie zaprojektowane do niego elementy i akcesoria, specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń, materiałów, funkcji lub właściwości ujętych w pozycji 5A001;

Uwaga: *Pozycja 5B001.a nie obejmuje kontrolą sprzętu do cechowania światłowodów.*

- b. sprzęt i specjalnie zaprojektowane do niego części składowe i osprzęt, specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” następujących telekomunikacyjnych urządzeń przesyłowych lub przełączających:

1. nieużywane;
2. sprzęt wykorzystujący „laser” i spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. długość fali nadawczej przekraczająca 1750 nm;
 - b. dający „wzmocnienie optyczne” przy wykorzystaniu wzmacniaczy światłowodowych fluorkowych domieszkowanych prazeodymem (PDFFA);
 - c. wykorzystujący techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej; lub

Uwaga: *Pozycja 5B001.b.2.c. obejmuje kontrolą urządzenia specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” systemów wykorzystujących optyczny lokalny generator drgań po stronie odbiorczej do synchronizowania z „laserem” będącym nośnikiem.*

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 5B001.b.2.c. techniki te obejmują techniki heterodyny optycznej, homodynowe i intradykowe.

- d. stosujący techniki analogowe i posiadający szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz; lub

Uwaga: *Pozycja 5B001.b.2.d nie obejmuje kontrolą sprzętu specjalnie zaprojektowanego do „rozwoju” komercyjnych systemów telewizji.*

3. nieużywane;
4. sprzęt radiowy wykorzystujący technikę modulacji kwadraturowej (QAM), powyżej poziomu 256;
5. nieużywane.

5C1 Materiały

Żadne.

5D1 Oprogramowanie

5D001 Następujące „oprogramowanie”:

- a. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu, funkcji lub właściwości wyszczególnionych w pozycji 5A001;
- b. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wspierania „technologii” wymienionej w pozycji 5E001;
- c. specyficzne „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu umożliwienia sprzętowi osiągnięcia cech charakterystycznych, funkcji lub właściwości wyszczególnionych w pozycji 5A001 lub 5B001;
- d. „oprogramowanie”, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju”, następującego sprzętu telekomunikacyjnych oraz przełączającego:
 1. nieużywane;
 2. sprzęt wykorzystujący „laser” i spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. długość fali nadawczej przekraczająca 1 750 nm; lub
 - b. stosujący techniki analogowe i posiadający szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz; lub

Uwaga: Pozycja 5D001.d.2.b nie obejmuje kontrolą „oprogramowania” specjalnie zaprojektowanego do „rozwoju” komercyjnych systemów telewizji.
 3. nieużywane;
 4. sprzęt radiowy wykorzystujący technikę modulacji kwadraturowej (QAM), powyżej poziomu 256;

5D101 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” sprzętu wymienionego w pozycji 5A101.

5E1 Technologia

5E001 Następujące „technologie”:

- a. „technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” lub „użytkowania” (wyluczając obsługiwane) sprzętu, funkcji lub właściwości wyszczególnionych w pozycji 5A001 lub „oprogramowania” wymienionego w pozycji 5D001.a;
- b. „technologie” specjalne, takie jak:
 1. „technologie” „niezbędne” do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu telekomunikacyjnego zaprojektowanego specjalnie do instalowania w satelitach;
 2. „technologie” służące do „rozwoju” lub „użytkowania” „laserowych” technik komunikacyjnych z możliwością automatycznego wykrywania, ustalania pochodzenia i śledzenia sygnałów oraz utrzymywania komunikacji w egzoatmosferze lub w środowisku podpowierzchniowym (podwodnym);
 3. „technologie” służące do „rozwoju” komórkowych cyfrowych systemów radiowych, których możliwości odbiorcze pozwalają na multi-pasmowe, multi-kanalowe, multi-trybowe, multi-kodowe algorytmy lub multi-protokołowe użytkowanie, które może być modyfikowane poprzez zmiany w „oprogramowaniu”;
 4. „technologie” służące do „rozwoju” technik „widma rozproszonego”, łącznie z technikami „rozzrucania częstotliwości”;

Uwaga: Pozycja 5E001.b.4 nie obejmuje kontrolą „technologii” „rozwoju” któregośkolwiek z poniższych:

- a. sieci telekomunikacyjnych w układzie terytorialnym (komórkowym) działających w zakresie pasm cywilnych; lub
- b. Stałe lub ruchome naziemne stacje satelitarne do zastosowań w komercyjnych cywilnych systemach telekomunikacji.

- c. „technologia” stosownie do uwagi ogólnej do technologii w odniesieniu do „rozwoju” lub „produkcji” któregośkolwiek z poniższych:

1. sprzęt wykorzystujący techniki cyfrowe, zaprojektowane do pracy z „całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych” przekraczającą 120 Gbit/s;

Uwaga techniczna:

Dla telekomunikacyjnego sprzętu przełączającego „całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych” jest szybkością przekazu danych w jednym kierunku przez jedno łącze mierzona dla największej szybkości portu lub linii.

2. sprzęt wykorzystujący „laser” i spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. długość fali nadawczej przekraczająca 1 750 nm;
 - b. dający „wzmocnienie optyczne” przy wykorzystaniu wzmacniaczy światłowodowych fluorkowych domieszkowanych praeodymem (PDFFA);
 - c. wykorzystujący techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej;

Uwaga: Pozycja 5E001.c.2.c. obejmuje kontrolą „technologię” służącą do „rozwoju” lub „produkcji” systemów wykorzystujących

optyczny lokalny generator drgań po stronie odbiorczej do synchronizowania z „laserem” będącym nośnikiem.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 5E001.c.2.c. techniki te obejmują techniki heterodyny optycznej, homodynowe i intradyne.

- d. wykorzystujący techniki zwielokrotniania poprzez rozdzielanie fal nośników optycznych w odstępie mniejszym niż 100 GHz; lub
- e. stosujący techniki analogowe i posiadający szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz;

Uwaga: *Pozycja 5E001.c.2.e nie obejmuje kontrolą „technologii” służącej do „rozwoju” lub „produkcji” komercyjnych systemów telewizji.*

NB.: *Jeżeli chodzi o „technologię” służącą do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń nitelekomunikacyjnych wykorzystujących laser, zob. pozycja 6E.*

- 3. sprzęt wykorzystujący „komutację optyczną”, którego czas komutacji jest krótszy niż 1 ms;
- 4. sprzęt radiowy spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. wykorzystujący technikę modulacji kwadraturowej (QAM) powyżej poziomu 256;
 - b. pracujący z częstotliwościami, wejściową lub wyjściową, powyżej 31,8 GHz; lub

Uwaga: *Pozycja 5E001.c.4.b nie obejmuje kontrolą „technologii” do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do pracy w pasmach przydzielonych przez ITU dla służb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.*

- c. pracujący w paśmie 1,5 MHz do 87,5 MHz i stosujący techniki adaptacyjne zapewniające tłumienie sygnałów zakłócających na poziomie większym niż 15 dB; lub
- 5. nieużywane;
- 6. sprzęt mobilny spełniający wszystkie poniższe kryteria:
 - a. działający na fali optycznej dłuższej niż lub równej 200 nm i krótszej lub równej 400 nm; oraz
 - b. działający jako „sieć lokalna”;
- d. „technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” mikrofalowych „monolitycznych układów scalonych” (MMIC) wzmacniaczy mocy specjalnie zaprojektowanych dla telekomunikacji i spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 5E001.d. parametr mocy wyjściowej na granicy nasycenia może być również określany w arkuszu danych produktu jako moc wyjściowa, nasycona moc wyjściowa, maksymalna moc wyjściowa, szczytowa moc wyjściowa lub szczytowa wartość obwiedni mocy.

1. przystosowane do działania w zakresie częstotliwości powyżej 2,7 GHz i do 6,8 GHz włącznie, o „ułamkowej szerokości pasma” powyżej 15% i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 75 W (48,75 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,7 GHz do 2,9 GHz włącznie;
 - b. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 55 W (47,4 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 2,9 GHz do 3,2 GHz włącznie;
 - c. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 40 W (46 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,2 GHz do 3,7 GHz włącznie; lub
 - d. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 20 W (43 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 3,7 GHz do 6,8 GHz włącznie;
 2. przystosowane do działania w zakresie częstotliwości powyżej 6,8 GHz i do 16 GHz włącznie, o „ułamkowej szerokości pasma” powyżej 10 % i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 10 W (40 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 6,8 GHz do 8,5 GHz włącznie; lub
 - b. moc wyjściowa na granicy nasycenia powyżej 5 W (37 dBm) przy dowolnej częstotliwości w zakresie powyżej 8,5 GHz do 16 GHz włącznie;
 3. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 3 W (34,77 dBm) na częstotliwościach przewyższających 16 GHz, do 31,8 GHz włącznie, i przy „ułamkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 10%;
 4. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,1 nW (-70 dBm) na częstotliwościach przewyższających 31,8 GHz, do 37 GHz włącznie;
przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 1 W (30 dBm) na częstotliwościach przewyższających 37 GHz, do 43,5 GHz włącznie, i przy „ułamkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 10%;
 6. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 31,62 mW (15 dBm) na dowolnej częstotliwości przekraczającej 43,5 GHz i do 75 GHz włącznie, i przy „ułamkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 10%;
 7. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 10 mW (10 dBm) na częstotliwościach przewyższających 75 GHz, do 90 GHz włącznie, i przy „ułamkowej szerokości pasma” wynoszącej powyżej 5 %; lub
 8. przystosowane do pracy z mocą wyjściową na granicy nasycenia powyżej 0,1 nW (-70 dBm) na częstotliwościach przewyższających 90 GHz;
- e. „technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń lub układów elektronicznych specjalnie zaprojektowanych dla telekomunikacji, zawierających części składowe wykonane z materiałów „nadprzewodzących”, specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej „temperatury krytycznej” co najmniej jednego z elementów „nadprzewodzących” i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. przełączanie prądowe dla obwodów cyfrowych za pomocą bramek „nadprzewodzących”, dla którego iloczyn czasu zwłoki na bramkę (w sekundach) i rozproszenia mocy na bramkę (w watach) wynosi poniżej 10^{-14} J; lub
 2. wybór częstotliwości dla wszystkich częstotliwości za pomocą obwodów rezonansowych o wartościach Q przekraczających 10 000.

5E101 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wymienionego w pozycji 5A101.

Część 2 - „OCHRONA INFORMACJI”

Uwaga 1: W kategorii 5 część 2 określono poziom kontroli sprzętu, „oprogramowania”, systemów, specyficznych dla poszczególnych zastosowań „zespołów elektronicznych”, modułów, układów scalonych, części składowych lub funkcji służących do „ochrony informacji”, nawet jeśli stanowią one części składowe lub „zespoły elektroniczne” innego sprzętu.

Uwaga 2: Kategoria 5 – część 2 nie obejmuje kontrolą wyrobów, towarzyszących użytkownikowi dla jego osobistego użytku.

Uwaga 3: Uwaga kryptograficzna

Pozycje 5A002 i 5D002 nie obejmują kontrolą następujących produktów:

- a. Produktów spełniających wszystkie następujące kryteria:
 1. są ogólnie dostępne dla klientów poprzez ich sprzedaż bez ograniczeń z magazynów punktów sprzedaży detalicznej w jakikolwiek z wymienionych niżej sposobów:
 - a. bezpośrednie transakcje sprzedaży;
 - b. transakcje realizowane na zamówienie pocztowe;
 - c. transakcje zawierane drogą elektroniczną; lub
 - d. transakcje realizowane na zamówienie telefoniczne;
 2. ich funkcjonalność kryptograficzna nie może być łatwo zmieniona przez użytkownika;
 3. są przeznaczone do zainstalowania przez użytkownika bez dalszej, znaczącej pomocy ze strony dostawcy; oraz
 4. w przypadku konieczności, szczegóły techniczne tych towarów są dostępne i zostaną dostarczone, na żądanie właściwych organów państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, w celu potwierdzenia zgodności z warunkami określonymi w punktach od 1. do 3. powyżej;
- b. części składowych osprzętu lub ‘wykonywalnego oprogramowania’ istniejących towarów opisanych w pkt a. niniejszej uwagi, które zostały zaprojektowane do tych istniejących towarów, spełniające wszystkie następujące kryteria:
 1. ‘bezpieczeństwo informacji’ nie jest główną funkcją lub zestawem funkcji części składowej lub ‘wykonywalnego oprogramowania’;
 2. część składowa ani ‘wykonywalne oprogramowanie’ nie zmienia żadnego elementu funkcjonalności kryptograficznej istniejących towarów ani nie dodaje elementów funkcjonalności kryptograficznej do istniejących towarów;
 3. budowa części składowej lub ‘wykonywalnego oprogramowania’ jest stała i nie jest projektowana lub zmieniana wg specyfikacji klienta; oraz
 4. tam, gdzie jest to konieczne, jeśli zostanie to ustalone przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba eksportera, szczegółowe dane części składowej lub ‘wykonywalnego oprogramowania’ oraz szczegółowe dane odpowiednich produktów końcowych są dostępne i zostaną przekazane właściwym organom na ich wniosek w celu potwierdzenia zgodności z opisanymi powyżej warunkami.

Uwaga techniczna:

Do celów uwagi kryptograficznej, ‘wykonywalne oprogramowanie’ oznacza „oprogramowanie” w formie wykonywalnej z istniejącej części składowej osprzętu wykluczonej z pozycji 5A002 przez uwagę kryptograficzną.

Uwaga: *‘wykonywalne oprogramowanie’ nie obejmuje kompletnych binarnych obrazów „oprogramowania” pracującego w produkcie końcowym;*

Uwaga do uwagi kryptograficznej:

1. Aby spełnione zostały warunki określone w pkt a. uwagi 3, zastosowanie muszą znaleźć wszystkie poniższe kryteria:
 - a. towar może cieszyć się zainteresowaniem szerokiego kręgu osób fizycznych i przedsiębiorstw; oraz
 - b. cena oraz informacje na temat głównej funkcjonalności towaru można uzyskać przed zakupem bez potrzeby konsultowania się ze sprzedawcą lub dostawcą.
2. Podczas ustalania kwalifikowalności pkt a. uwagi 3 właściwe organy mogą wziąć pod uwagę odpowiednie czynniki, takie jak ilość, cena, wymagane umiejętności techniczne, istniejące kanały sprzedaży, typowi klienci, typowe zastosowanie lub wszelkie nietypowe praktyki dostawcy.

Uwaga 4: Kategoria 5 – część 2 nie obejmuje kontrolą towarów zawierających lub wykorzystujących „kryptografię” oraz spełniających wszystkie z poniższych kryteriów:

- a. ich podstawową funkcją lub zestawem funkcji nie jest żadne z poniższych:
 1. „ochrona informacji”
 2. komputer, w tym systemy operacyjne, części i komponenty do komputerów;
 3. wysyłanie, otrzymywanie lub przechowywanie informacji (z wyjątkiem okoliczności, kiedy jest to na potrzeby rozrywki, publicznych kampanii reklamowych, cyfrowego zarządzania prawami lub zarządzania danymi medycznymi pacjentów); lub
 4. obsługa sieci (w tym obsługa operacyjna, administrowanie, zarządzanie i udostępnianie);
- b. element kryptograficzny jest ograniczony do wspierania podstawowej funkcji lub zestawu funkcji; oraz
- c. w razie konieczności szczegółowe informacje na temat tych towarów są dostępne i na żądanie zostaną udostępnione właściwym organom w państwie eksportera w celu sprawdzenia zgodności z warunkami opisanymi w lit. a i b powyżej.

5A2 Systemy, urządzenia i części składowe

5A002 Następujące systemy i urządzenia związane z „ochroną informacji” oraz ich części składowe:

- a. następujące systemy, urządzenia, specyficzne dla poszczególnych zastosowań „zespoły elektroniczne”, moduły i układy scalone związane z „ochroną informacji” oraz inne ich części składowe specjalnie zaprojektowane do celów „ochrony informacji”:

NB.: Sterowanie urządzeniami odbiorczymi globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS) zawierającymi lub wykorzystującymi funkcję deszyfrowania – zob. 7A005. Powiązane deszyfrujące „oprogramowanie” i „technologia” – zob. 7D005 i 7E001.

1. zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu zastosowania „kryptografii” z wykorzystaniem technik cyfrowych realizujących jakiekolwiek funkcje kryptograficzne inne niż uwierzytelnienie, podpis cyfrowy lub wykonanie „oprogramowania” zabezpieczonego przed kopiowaniem i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwagi techniczne:

1. Funkcje identyfikacji, podpisu cyfrowego i wykonywania „oprogramowania” zabezpieczonego przed kopiowaniem obejmują ich powiązaną funkcję zarządzania kluczem.
2. Uwierzytelnienie obejmuje kontrolą wszystkie aspekty kontroli dostępu, gdzie nie występuje szyfrowanie plików lub fragmentów tekstów, z wyjątkiem tych bezpośrednio związanych z ochroną haseł, Numerów Personalnej Identyfikacji (PIN) lub podobnych danych stosowanych do ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

- a. „algorytm symetryczny” wykorzystujący długość klucza przekraczającą 56 bitów; lub

Uwaga techniczna:

W ramach kategorii 5 – część 2 bity parzystości nie są wliczane do długości klucza.

- b. „algorytm asymetryczny”, w którym bezpieczeństwo stosowania algorytmu bazuje na jakiegokolwiek z poniższych właściwości:
 1. faktoryzacji liczb całkowitych powyżej 512 bitów (np. RSA);
 2. zliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie pola o skończonej wielkości większej niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z Z/pZ); lub
 3. dyskretnych logarytmach w grupie innej niż wspomniana w pozycji 5A002.a.1.b.2 większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej);

2. zaprojektowane lub zmodyfikowane dla realizacji funkcji kryptoanalitycznych;

Uwaga: Pozycja 5A002.a.2. obejmuje systemy lub wyposażenie zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by przeprowadzało kryptoanalizę z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej.

3. nieużywane;
4. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do redukcji przypadkowego przekazywania sygnałów noszących informację poza tym, co jest niezbędne ze

względów zdrowotnych, bezpieczeństwa pracy i ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi;

5. zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania technik kryptograficznych w celu generowania kodu rozpraszającego dla „widma rozproszonego”, poza określonymi w pozycji 5A002.a.6, wraz z kodem rozrzucającym dla systemów z „rozzucaniem częstotliwości”;

6. zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania technik kryptograficznych w celu generowania kodów przydzielania kanałów, szyfrowania (scrambling) lub identyfikacji sieci w systemach stosujących modulację ultraszerokopasmową i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. szerokość pasma przekraczająca 500 MHz; lub
 - b. „ułamkowa szerokość pasma” wynosząca 20 % lub więcej;
7. niekryptograficzne systemy i urządzenia ochrony technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), które zostały ocenione i certyfikowane przez organ krajowy do poziomu uzasadnionego zaufania wykraczającego poza klasę EAL-6 (poziom uzasadnionego zaufania) wspólnych kryteriów lub kryteriów równorzędnych;
8. kablowe systemy telekomunikacyjne zaprojektowane lub zmodyfikowane z zastosowaniem środków mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w celu wykrywania włamań do sieci teleinformatycznych;

Uwaga: *Pozycja 5A002.a.8. obejmuje kontrolą jedynie bezpieczeństwo warstwy fizycznej.*

9. zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania „kryptografii kwantowej”;

Uwaga techniczna:
„Kryptografia kwantowa” bywa również określana jako kwantowa wymiana klucza (QKD).

- b. systemy, urządzenia, specyficzne dla konkretnych zastosowań użytkowych „zespoły elektroniczne”, moduły i obwody scalone, zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby dany produkt mógł osiągnąć lub przekroczyć kontrolowane poziomy osiągnięć w odniesieniu do funkcji wyszczególnionych w pozycji 5A002.a, które w innym przypadku nie zostałyby osiągnięte.

Uwaga: *Pozycja 5A002 nie obejmuje kontrolą żadnego z poniższych:*

- a. następujących kart elektronicznych i ‘urządzeń do odczytu/zapisu’ do kart elektronicznych:
 1. karta elektroniczna lub dokument osobisty do odczytu elektronicznego (np. żeton, paszport biometryczny), spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. wykorzystanie funkcji kryptograficznych ograniczone jest do urządzeń lub systemów wyłączonych z pozycji 5A002 na podstawie uwagi 4 w części 2 kategorii 5 lub na podstawie lit. b – i niniejszej uwagi oraz nie ma możliwości ich przeprogramowania do innego zastosowania; lub
 - b. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. specjalnie zaprojektowane i ograniczone do ochrony przechowywanych na nich ‘danych osobowych’;
 2. zawierające dane służące do celów transakcji publicznych lub handlowych lub do ustalenia tożsamości lub umożliwiające umieszczenie na nich wyłącznie takich danych; oraz
 3. nieumożliwiające użytkownikowi dostępu do funkcji kryptograficznych.

Uwaga techniczna:

'Dane osobowe' obejmują wszelkie dane charakteryzujące daną osobę lub podmiot, takie jak kwota przechowywanych pieniędzy i dane niezbędne do uwierzytelnienia.

2. *'urządzenia do odczytu/zapisu' specjalnie zaprojektowane lub przekształcone i ograniczone do stosowania w przedmiotach wymienionych w pkt a.1 niniejszej uwagi;*

Uwaga techniczna:

'Urządzenia do odczytu/zapisu' obejmują sprzęt, który łączy się z kartami elektronicznymi lub dokumentami do odczytu elektronicznego za pośrednictwem sieci.

- b. *nieużywane;*
- c. *nieużywane;*
- d. *sprzętu kryptograficznego specjalnie zaprojektowanego i ograniczonego do zastosowań bankowych lub 'transakcji pieniężnych';*

Uwaga techniczna:

'Transakcje pieniężne' w ramach uwagi d do pozycji 5A002 obejmują pobieranie i rozliczanie opłat za przejazd lub funkcje kredytowe.

- e. *przewoźnych lub przenośnych radiotelefonów do zastosowań cywilnych (np. do zastosowania w cywilnych systemach radiokomunikacji komórkowej), w których nie ma możliwości przekazywania zaszyfrowanych danych bezpośrednio do innego radiotelefonu lub sprzętu (innych niż sprzęt sieci dostępu radiowego – RAN) ani przekazywania zaszyfrowanych danych przez sprzęt sieci dostępu radiowego (np. sterownik sieci radiowej – RNC, sterownik stacji bazowej – BSC);*
- f. *sprzętu telefonii bezprzewodowej niezdolnego do szyfrowania typu „end-to-end”, w którym, zgodnie z danymi producenta, maksymalny skuteczny zasięg działania bezprzewodowego bez dodatkowego wzmocnienia (tj. pojedyncza, bez pośrednictwa przekaźnika, odległość między terminalem a domową stacją bazową) wynosi mniej niż 400 m;*
- g. *przewoźnych lub przenośnych radiotelefonów i podobnych bezprzewodowych urządzeń typu klient do zastosowań cywilnych, które wykorzystują wyłącznie opublikowane lub znajdujące się w sprzedaży standardy kryptograficzne (z wyjątkiem funkcji mających na celu zwalczanie piractwa, które nie muszą być publikowane) i spełniają przepisy pkt a.2 do a.4 uwagi kryptograficznej (kategoria 5 część 2, uwaga 3), które z myślą o konkretnym zastosowaniu w przemyśle cywilnym zostały na zamówienie wyposażone w funkcje niemające wpływu na funkcjonalność kryptograficzną oryginalnych urządzeń niewyposażonych w te funkcje;*
- h. *nieużywane;*
- i. *Urządzenia bezprzewodowej „sieci osobistej”, które wykorzystują wyłącznie publiczne lub komercyjne standardy kryptograficzne i w których funkcje kryptograficzne są ograniczone do nominalnego zasięgu działania nieprzekraczającego 30 metrów zgodnie ze specyfikacją producenta lub nieprzekraczającego 100 metrów zgodnie ze specyfikacjami producenta w odniesieniu do urządzeń, które nie mogą łączyć się z więcej niż siedmioma urządzeniami;*

- j. *urządzenia, których funkcje nie są wyszczególnione w pozycjach 5A002.a.2, 5A002.a.4, 5A002.a.7 ani 5A002.a.8, a których wszystkie funkcje kryptograficzne wyszczególnione w pozycji 5A002.a spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:*

1. *nie można z nich korzystać; lub*
2. *można je uczynić użytecznymi wyłącznie za pomocą „aktywacji kryptograficznej”; lub*

NB.: Urządzenia, które zostały poddane „aktywacji kryptograficznej” – zob. pozycja 5A002.a.

- k. *Urządzenia sieci radiowej wykorzystywane w telekomunikacji mobilnej przeznaczone do zastosowań cywilnych, które spełniają również warunki określone w pkt a.2. do a.4. uwagi kryptograficznej (uwaga 3 w kategorii 5, część 2), posiadające moc wyjściową RF ograniczoną do 0,1W (20 dBm) lub mniej i obsługujące nie więcej niż 16 bieżących użytkowników.*

5B2 Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

5B002 Następujące urządzenia testujące, kontrolne i „produkcyjne” związane z „ochroną informacji”:

- a. sprzęt specjalnie zaprojektowany do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 5A002 lub 5B002.b;
- b. sprzęt pomiarowy specjalnie zaprojektowany do oceny i analizy funkcji „ochrony informacji” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 5A002 lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycjach 5D002.a lub 5D002.c.

5C2 Materiały

Żadne.

5D2 Oprogramowanie

5D002 Następujące „oprogramowanie”:

- a. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 5A002 lub „oprogramowania” wyszczególnionego w pozycji 5D002.c;
- b. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wspierania „technologii” wymienionej w pozycji 5E002;
- c. następujące konkretne „oprogramowanie”:
 1. „oprogramowanie” posiadające takie same właściwości lub realizujące lub symulujące funkcje takie same jak sprzęt wymieniony w pozycji 5A002;
 2. „oprogramowanie” do prowadzenia procesu certyfikacji „oprogramowania” wymienionego w pozycji 5D002.c.1;
- d. „oprogramowanie” zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby dany produkt mógł osiągnąć lub przekroczyć kontrolowane poziomy osiągnięć w odniesieniu do funkcji wyszczególnionych w pozycji 5A002.a, które w innym przypadku nie zostałyby osiągnięte.

5E2 Technologia

5E002 Następujące „technologie”:

- a. „technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” lub „użytkowania” sprzętu wymienionego w pozycji 5A002, 5B002 lub „oprogramowania” wymienionego w pozycji 5D002.a lub 5D002.c;
- b. „technologia” umożliwiająca danemu produktowi osiągnięcie lub przekroczenie kontrolowanych poziomów osiągnięć w odniesieniu do funkcji wyszczególnionych w pozycji 5A002.a, które w innym przypadku nie zostałyby osiągnięte.

Uwaga: *Pozycja 5E002 obejmuje dane techniczne „bezpieczeństwa informacji” wynikające z procedur przeprowadzonych w celu oceny lub ustalenia wdrożenia funkcji, właściwości lub technik wymienionych w kategorii 5-część 2.*

KATEGORIA 6 - CZUJNIKI I LASERY

6 A Systemy, urządzenia i części składowe

6A001 Następujące systemy, urządzenia i części akustyczne:

- a. następujące okrętowe systemy akustyczne, urządzenia lub specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:
 1. następujące systemy aktywne (nadajniki lub nadajniki-odbiorniki), urządzenia i specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:

Uwaga: Pozycja 6A001.a.1 nie obejmuje kontrolą następujących urządzeń:

- a. sond do pomiaru głębokości pracujących w pionie pod aparaturą, niemających możliwości przeszukiwania w zakresie szerszym niż $\pm 20^\circ$, których działanie jest ograniczone do pomiaru głębokości wody, odległości do zanurzonych lub zagrzebanych obiektów lub do wykrywania ławic ryb;
 - b. następujących pław lub staw akustycznych:
 1. akustycznych pław lub staw ostrzegawczych;
 2. sonarów impulsowych specjalnie zaprojektowanych do przemieszczenia się lub powrotu do położenia podwodnego.
- a. następujące urządzenia do akustycznego badania dna morskiego:
 1. urządzenia dla statków nawodnych zaprojektowane do sporządzania map topograficznych dna morskiego i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. przeznaczenie do dokonywania pomiarów pod kątem większym niż 20° w stosunku do pionu;
 - b. przeznaczenie do pomiarów topografii dna morskiego położonego na głębokościach większych niż 600 m;
 - c. 'rozdzielczość sondowania' mniejsza niż 2; oraz
 - d. 'zwiększenie' dokładności określania głębokości poprzez kompensację w odniesieniu do wszystkich poniższych:
 1. ruch czujnika akustycznego;
 2. rozchodzenie się fali w wodzie w kierunku od czujnika do dna morskiego i z powrotem;
 3. prędkość dźwięku przy czujniku;

Uwagi techniczne

1. 'Rozdzielczość sondowania' oznacza szerokość pola oświetlania (w stopniach) podzieloną przez liczbę sondowań na jedno omięcie.
2. 'Zwiększenie' obejmuje zdolność kompensowania z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

2. podwodne urządzenia zaprojektowane do sporządzania map topograficznych dna morskiego i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga techniczna:

Wartość ciśnienia czujnika akustycznego określa wartość głębokości urządzeń wymienionych w pozycji 6A001.a.1.a.2.

- a. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. zaprojektowany lub zmodyfikowany do pracy na głębokościach przekraczających 300 m; oraz
 2. 'wskaźnik sondowania' większy niż 3 800; lub

Uwaga techniczna:

'Wskaźnik sondowania' jest iloczynem maksymalnej prędkości (w m/s), z jaką może pracować czujnik i maksymalnej liczby sondowań na jedno omiecenie, przy założeniu 100 % pokrycia.

- b. urządzenia zaprojektowane do sporządzania map topograficznych, niewymienione w pozycji 6A001.a.1.a.2.a., spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. zaprojektowany lub zmodyfikowany do pracy na głębokościach przekraczających 100 m;
 2. przeznaczenie do dokonywania pomiarów pod kątem większym niż 20° w stosunku do pionu;
 3. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. częstotliwość robocza poniżej 350 kHz; lub
 - b. zaprojektowane do dokonywania pomiarów topografii dna morskiego w zasięgu przekraczającym 200 m przy pomocy czujnika akustycznego; oraz
 4. 'zwiększenie' dokładności określania głębokości poprzez kompensację w odniesieniu do wszystkich poniższych:
 - a. ruch czujnika akustycznego;
 - b. rozchodzenie się fali w wodzie w kierunku od czujnika do dna morskiego i z powrotem; oraz
 - c. prędkość dźwięku przy czujniku;
3. boczny sonar skanujący (SSS) lub sonar z syntezą apertury (SAS) zaprojektowany do obrazowania dna morskiego i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. zaprojektowany lub zmodyfikowany do pracy na głębokościach przekraczających 500 m;
 - b. 'wskaźnik pokrycia obszaru' większy niż $570 \text{ m}^2/\text{s}$ podczas pracy przy maksymalnym zasięgu, z jakim może pracować, z 'rozdzielczością wzdłużną' mniejszą niż 15 cm; oraz
 - c. 'rozdzielczość poprzeczna' mniejsza niż 15 cm;

Uwagi techniczne:

1. *'Wskaźnik pokrycia powierzchni' (w m^2/s) stanowi dwukrotność iloczynu zakresu sonaru (w m) oraz maksymalnej prędkości (w m/s), z jaką może pracować czujnik przy tym zakresie.*
2. *'Rozdzielczość wzdłużna' (w cm) – wyłącznie w odniesieniu do SSS, jest iloczynem azymutowej (poziomej) szerokości wiązki (w stopniach), zakresu sonaru (w m) i liczby 0,873.*
3. *'Rozdzielczość poprzeczna' (w cm) jest ilorazem liczby 75 i szerokości pasma sygnału (w kHz).*

- b. Systemy lub matryce nadawcze lub odbiorcze, zaprojektowane do wykrywania lub lokalizacji obiektów, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. częstotliwość nośna poniżej 10 kHz;
 2. poziom ciśnienia akustycznego powyżej 224 dB (poziom odniesienia $1 \mu\text{Pa}$ na 1 m) w odniesieniu do urządzeń z częstotliwością roboczą w paśmie od 10 kHz do 24 kHz włącznie;
 3. poziom ciśnienia akustycznego powyżej 235 dB (poziom odniesienia $1 \mu\text{Pa}$ na 1 m) w odniesieniu do urządzeń z częstotliwością roboczą w paśmie od 24 kHz do 30 kHz;
 4. kształtujące wiązki o kącie rozproszenia poniżej 1° względem dowolnej osi i posiadające częstotliwość roboczą poniżej 100 kHz;

5. umożliwiające jednoznaczny pomiar odległości do obiektów w zakresie powyżej 5 120 m; lub

6. skonstruowane w ten sposób, że w normalnych warunkach pracy są wytrzymałe na ciśnienia na głębokości większej niż 1 000 m i są zaopatrzone w przetworniki spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. z dynamiczną kompensacją ciśnienia; lub
 - b. w których elementem przetwarzającym nie jest cyrkonian/tytanian ołowiu;
- c. reflektory akustyczne, łącznie z przetwornikami, wyposażone w elementy piezoelektryczne, magnetostrykcyjne, elektrostrykcyjne, elektrodynamiczne lub hydrauliczne, działające indywidualnie lub w odpowiedniej kombinacji zespołowej i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga 1: Poziom kontroli reflektorów akustycznych, łącznie z przetwornikami, specjalnie zaprojektowanych do innych urządzeń, wynika z poziomu kontroli tych innych urządzeń.

Uwaga 2: Pozycja 6A001.a.1.c nie obejmuje kontrolą elektronicznych źródeł kierujących dźwięk tylko w pionie ani źródeł mechanicznych (np. pistolety powietrzne lub parowe) lub chemicznych (np. materiały wybuchowe).

Uwaga 3: Elementy piezoelektryczne wymienione w pozycji 6A001.a.1.c. obejmują elementy wykonane z pojedynczych kryształów piezoelektrycznych niobianu ołowiu i magnezu/tytanianu ołowiu ($\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$, or PMN-PT) wytworzonych z roztworu stałego lub pojedynczych kryształów piezoelektrycznych niobianu ołowiu i indu/niobianu ołowiu i magnezu/tytanianu ołowiu ($\text{Pb}(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3\text{-Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$, or PIN-PMN-PT) wytworzonych z roztworu stałego.

1. ‘gęstość mocy akustycznej’ w impulsie powyżej $0,01 \text{ mW/mm}^2/\text{Hz}$ dla urządzeń pracujących w paśmie częstotliwości poniżej 10 kHz;
2. ‘gęstość mocy akustycznej’ ciągłej powyżej $0,001 \text{ mW/mm}^2/\text{Hz}$ dla urządzeń pracujących w paśmie częstotliwości poniżej 10 kHz; lub

Uwaga techniczna:

‘Gęstość mocy akustycznej’ oblicza się, dzieląc wyjściową moc akustyczną przez iloczyn pola powierzchni wypromieniowanej wiązki i częstotliwości roboczej.

3. tłumienie pasma bocznego częstotliwości powyżej 22 dB;
- d. systemy akustyczne i urządzenia do określania położenia statków nawodnych lub pojazdów podwodnych spełniające wszystkie poniższe kryteria oraz elementy zaprojektowane specjalnie do nich:
 1. zasięg wykrywania powyżej 1 000 m; oraz
 2. wyznaczanie położenia z dokładnością poniżej 10 m (wartość średnia kwadratowa) w przypadku pomiaru w zasięgu do 1 000 m;

Uwaga: Pozycja 6A001.a.1.d obejmuje:

- a. urządzenia, w których zastosowano koherentne „przetwarzanie sygnałów” pomiędzy dwiema lub większą liczbą boi kierunkowych a hydrofonem na statku nawodnym lub w pojeździe podwodnym;

- b. *urządzenia mające możliwość automatycznego korygowania błędów prędkości rozchodzenia się dźwięku w celu obliczenia położenia obiektu.*
- e. aktywne pojedyncze sonary, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu wykrywania, ustalania położenia i automatycznej klasyfikacji pływaków lub nurków, spełniające wszystkie poniższe kryteria oraz specjalnie do nich zaprojektowane nadawcze i odbiorcze akustyczne zestawy matrycowe:
1. zasięg wykrywania powyżej 530 m;
 2. wyznaczanie położenia z dokładnością poniżej 15 m (wartość średnia kwadratowa) w przypadku pomiaru w zasięgu do 530 m; oraz
 3. szerokość pasma przekazywanego impulsu powyżej 3 kHz;

NB.: *Systemy wykrywania nurków specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych – zob. wykaz uzbrojenia.*

Uwaga: *W przypadku pozycji 6A001.a.1.e, jeśli określono wiele zasięgów wykrywania w zależności od środowiska, zastosowanie ma największy zasięg.*

2. następujące pasywne urządzenia i systemy oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

- a. hydrofony spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga: Poziom kontroli hydrofonów specjalnie zaprojektowanych do innych urządzeń wynika z poziomu kontroli tych innych urządzeń.

Uwaga techniczna:

Hydrofony składają się z co najmniej jednego elementu czujnikowego wytwarzającego pojedynczy akustyczny kanał wyjścia. Te, które zawierają kilka elementów mogą być określane jako grupa hydrofonów.

1. wyposażone w ciągłe, elastyczne zespoły czujnikowe;
2. złożone z dyskretnych elementów czujnikowych o średnicy lub długości poniżej 20 mm znajdujących się od siebie w odległości mniejszej niż 20 mm;
3. wyposażone w jeden z następujących elementów czujnikowych:
 - a. światłowodowy;
 - b. 'piezoelektryczne powłoki polimerowe' inne niż polifluorek winylidenu (PVDF) i jego kopolimery {P(VDF-TrFE) i P(VDF-TFE)};
 - c. 'elastyczne kompozyty piezoelektryczne';
 - d. Pojedyncze kryształy piezoelektryczne niobianu ołowiu i magnezu/tytanianu ołowiu (tj. $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$, lub PMN-PT) wytworzone z roztworu stałego; lub
 - e. Pojedyncze kryształy piezoelektryczne niobianu ołowiu i indu/niobianu ołowiu i magnezu/tytanianu ołowiu (tj. $\text{Pb}(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3\text{-Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$, lub PIN-PMN-PT) wytworzone z roztworu stałego;
4. 'czułość hydrofonów' lepsza niż -180 dB na każdej głębokości bez kompensacji przyspieszeniowej;
5. zaprojektowane do pracy na głębokościach większych niż 35 m z kompensacją przyspieszeniową; lub
6. zaprojektowane do działania na głębokościach większych niż 1 000 m;

Uwagi techniczne:

1. Elementy czujnikowe typu 'piezoelektryczne powłoki polimerowe' składają się ze spolaryzowanej powłoki polimerowej, rozpiętej i przymocowanej do ramy lub szpuli (trzcienia).
2. Elementy czujnikowe typu 'elastyczne kompozyty piezoelektryczne' składają się z piezoelektrycznych cząstek lub włókien ceramicznych połączonych z elektrycznie izolującym, akustycznie przejrzystym tworzywem gumowym, polimerowym lub epoksydowym, przy czym tworzywo to jest integralną częścią elementów czujnikowych.
3. 'Czułość hydrofonu' definiuje się jako dwadzieścia logarytmów przy podstawie 10 ze stosunku napięcia skutecznego po sprowadzeniu do napięcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych fal płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 μPa . Na przykład hydrofon o czułości -160 dB (poziom odniesienia 1 V na μPa) daje w takim polu napięcie wyjściowe 10^{-8} V, natomiast hydrofon o czułości -180 dB daje w takim samym polu napięcie wyjściowe tylko 10^{-9} V. Zatem hydrofon o czułości -160 dB jest lepszy od hydrofonu o czułości -180 dB.

- b. holowane zestawy matrycowe hydrofonów akustycznych spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga techniczna:

Zespoły hydrofonów składają się z kilku hydrofonów zapewniających szereg akustycznych kanałów wyjścia.

1. odległość pomiędzy grupami hydrofonów wynosi poniżej 12,5 m; lub 'umożliwia modyfikację tak, żeby odległość pomiędzy grupami hydrofonów była mniejsza niż 12,5 m;
2. zaprojektowane lub 'umożliwiające modyfikację' do działania na głębokościach większych niż 35 m;

Uwaga techniczna:

Wspomniana w pozycji 6A001.a.2.b.1 i 2 'możliwość modyfikowania' oznacza, że są zaopatrzone w elementy umożliwiające zmianę przewodów lub połączeń w celu zmiany odległości pomiędzy grupami hydrofonów lub granicznych głębokości roboczych. Do elementów takich zalicza się: zapasowe przewody w ilości przewyższającej o 10 % liczbę przewodów używanych, bloki umożliwiające zmianę odległości pomiędzy grupami hydrofonów lub wewnętrzne regulowane urządzenia limitujące głębokość lub urządzenia sterujące umożliwiające sterowanie więcej niż jedną grupą hydrofonów.

3. czujniki kursowe objęte kontrolą według pozycji 6A001.a.2.d;
 4. sieci węży ze wzmocnieniem podłużnym;
 5. wyposażenie w układ zespołowy o średnicy mniejszej niż 40 mm;
 6. nieużywane;
 7. wyposażenie w hydrofony o właściwościach określonych w pozycji 6A001.a.2.a; lub
 8. wykorzystujące akcelerometr czujniki hydroakustyczne określone w pozycji 6A001.a.2.g.;
- c. urządzenia przetwarzające, specjalnie zaprojektowane do holowanych zestawów (matryc) hydrofonów akustycznych posiadające „możliwość programowania przez użytkownika” oraz możliwość przetwarzania i korelacji w funkcji czasu lub częstotliwości, łącznie z analizą spektralną, filtrowaniem cyfrowym i kształtowaniem wiązki za pomocą szybkiej transformaty Fouriera lub innych transformat lub procesów;
- d. czujniki kursowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. dokładność powyżej $\pm 0,5^\circ$; oraz
 2. zaprojektowane do pracy na głębokościach większych niż 35 m lub wyposażone w regulowane lub możliwe do demontażu czujniki głębokości z przeznaczeniem do pracy na głębokościach większych niż 35 m;
- e. holowane zestawy matrycowe hydrofonów akustycznych z dennymi lub międzywręgowymi układami kablowymi spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. wykorzystujące hydrofony z pozycji 6A001.a.2.a;
 2. zawierające moduły multipleksowe sygnałów grup hydrofonów, spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. zaprojektowane do pracy na głębokościach większych niż 35 m lub wyposażone w regulowane lub możliwe do demontażu czujniki głębokości z przeznaczeniem do pracy na głębokościach większych niż 35 m; oraz

- b. mogące pracować wymiennie z modułami holowanych zestawów hydrofonów akustycznych; lub
- 3. wyposażone w wykorzystujące akcelerometr czujniki hydroakustyczne określone w pozycji 6A001.a.2.g.;

- f. urządzenia przetwarzające, specjalnie zaprojektowane do kablowych układów dennych lub międzywzględowych, posiadające „możliwość programowania przez użytkownika” oraz umożliwiające przetwarzanie i korelację w dziedzinie czasu lub częstotliwości, w tym analizę widmową, filtrowanie cyfrowe oraz cyfrowe kształtowanie wiązki za pomocą szybkiej transformaty Fouriera lub innych transformat lub procesów;
- g. wykorzystujące akcelerometr czujniki hydroakustyczne spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. składające się z trzech akcelerometrów rozmieszczonych wzdłuż trzech różnych osi;
 2. posiadające ogólną ‘wrażliwość na przyspieszenie’ powyżej 48 dB (odniesienie 1 000 mV rms/g);
 3. zaprojektowane do działania na głębokościach większych niż 35 m; oraz
 4. częstotliwość robocza poniżej 20 kHz.

Uwaga: Pozycja 6A001.a.2.g. nie obejmuje kontrolą czujników prędkości cząsteczek ani geofonów.

Uwagi techniczne:

1. Wykorzystujące akcelerometr czujniki hydroakustyczne określane są również jako czujniki wektorowe.
2. ‘Wrażliwość na przyspieszenie’ definiuje się jako dwadzieścia logarytmów przy podstawie 10 ze stosunku napięcia skutecznego po sprowadzeniu do napięcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydroakustycznego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych fal płaskich o przyspieszeniu 1 g (i.e., 9,81 m/s²).

Uwaga: Pozycja 6A001.a.2 obejmuje kontrolą również urządzenia odbiorcze powiązane lub niepowiązane w warunkach normalnego użytkowania z odrębnymi urządzeniami aktywnymi oraz i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.

- b. Następujące urządzenia sonarowe posługujące się logami korelacyjnymi i dopplerowskimi przeznaczone do pomiaru prędkości poziomej obiektu, na którym się znajdują, względem dna morza:
 1. urządzenia sonarowe posługujące się logami korelacyjnymi i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. przeznaczenie do pracy w przypadku odległości obiektu od dna przekraczającej 500 m; lub
 - b. dokładność pomiaru prędkości większa niż 1 %;
 2. urządzenia sonarowe posługujące się logami dopplerowskimi umożliwiające określenie prędkości z dokładnością lepszą niż 1 %;

Uwaga 1: Pozycja 6A001.b nie obejmuje kontrolą sond do pomiaru głębokości, które ograniczone są do którejkolwiek z poniższych funkcji:

- a. pomiar głębokości wody;
- b. pomiar odległości do zanurzonych lub zagrzebanych obiektów; lub
- c. wykrywanie ławic ryb.

Uwaga 2: Pozycja 6A001.b nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych do zainstalowania na statkach nawodnych.

- c. nieużywane.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 6A102.

a. następujące detektory optyczne:

1. następujące detektory półprzewodnikowe „klasy kosmicznej”:

Uwaga: Do celów pozycji 6A002.a.1 detektory półprzewodnikowe obejmują „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej”.

a. detektory półprzewodnikowe „klasy kosmicznej” spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. a. reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 10 nm, ale nie więcej niż 300 nm; oraz
2. w zakresie fal o długości powyżej 400 nm reakcja słabsza niż 0,1 % reakcji szczytowej;
- b. detektory półprzewodnikowe „klasy kosmicznej” spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 900 nm, ale nie więcej niż 1 200 nm; oraz
 2. „stała czasowa” reakcji 95 ns lub poniżej;
- c. detektory półprzewodnikowe „klasy kosmicznej” posiadające reakcję szczytową w zakresie długości fal powyżej 1 200 nm, ale nieprzekraczającej 30 000 nm;
- d. „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” „klasy kosmicznej” mające więcej niż 2 048 elementów na zespół i reakcję szczytową w paśmie fal o długości powyżej 300 nm, ale nieprzekraczającej 900 nm;

2. następujące lampowe wzmacniacze obrazu i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

Uwaga: Pozycja 6A002.a.2 nie obejmuje kontrolą nieobrazowych lamp fotonowolnych wyposażonych w znajdujący się w próżni czujnik elektronowy ograniczony wyłącznie do jakiegokolwiek z poniższych:

- a. pojedyncza anoda metalowa; lub
- b. anody metalowe o odległości między środkami otworków większej niż 500 μm .

Uwaga techniczna:

‘Powielanie ładunków’ oznacza formę wzmacniania obrazów elektronicznych i zdefiniowane jest jako wytwarzanie nośników ładunków w wyniku procesu jonizacji strumieniem. Czujniki ‘powielania ładunków’ mogą mieć postać lampowego wzmacniacza obrazu, detektora półprzewodnikowego lub „matrycy detektorowej płaszczyzny ogniskowej”.

a. lampowe wzmacniacze obrazu spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 400 nm, ale nie więcej niż 1 050 nm;
2. wzmacnianie obrazów elektronicznych z wykorzystaniem którychkolwiek z poniższych:
 - a. elektrody mikrokanalikowej z otworkami w odstępach (odległość pomiędzy środkami otworków) 12 μm lub mniejszych; lub
 - b. czujników elektronowych o rozmiarach pojedynczego niełączonego piksela 500 μm lub mniej specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych, by uzyskać ‘powielanie ładunków’ w sposób inny niż za pomocą elektrody mikrokanalikowej; oraz

3. dowolnej z poniższych fotokatod:
- a. fotokatody alkaliczne wielopierwiastkowe (np. S-20 i S-25) o czułości świetlnej przekraczającej $350 \mu\text{A/lm}$;
 - b. fotokatody GaAs lub GaInAs; lub
 - c. inne fotokatody półprzewodnikowe oparte na „związkach III/V” o maksymalnej „czułości promieniowania” powyżej 10 mA/W ;

- b. lampowe wzmacniacze obrazu spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 050 nm, ale nie więcej niż 1 800 nm;
 2. wzmacnianie obrazów elektronicznych z wykorzystaniem którychkolwiek z poniższych:
 - a. elektrody mikrokanalikowej z otworkami w odstępach (odległość pomiędzy środkami otworków) 12 μm lub mniejszych; lub
 - b. czujników elektronowych o rozmiarach pojedynczego niełączonego piksela 500 μm lub mniej specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych, by uzyskać 'powielanie ładunków' w sposób inny niż za pomocą elektrody mikrokanalikowej; oraz
 3. fotokatody półprzewodnikowe (np. GaAs lub GaInAs) oparte na „związkach III/V” oraz fotokatody o elektronach przeniesionych, o maksymalnej „czułości promieniowania” powyżej 15 mA/W;
- c. następujące specjalnie opracowane elementy:
 1. elektrody mikrokanalikowe do wzmacniania obrazów z otworkami w odstępach (odległość pomiędzy środkami otworków) nie większych niż 12 μm ;
 2. czujników elektronowych o rozmiarach pojedynczego niełączonego piksela 500 μm lub mniej specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych, by uzyskać 'powielanie ładunków' w sposób inny niż za pomocą elektrody mikrokanalikowej;
 3. fotokatody półprzewodnikowe (np. GaAs lub GaInAs) oparte na „związkach III/V” oraz fotokatody o elektronach przeniesionych;

Uwaga: *Pozycja 6A002.a.2.c.3 nie obejmuje kontrolą fotokatod półprzewodnikowych związkowych zaprojektowanych tak, by osiągały maksymalnie którąkolwiek z poniższych „czułości promieniowania”:*

- a. *10 mA/W lub mniej przy reakcji szczytowej w zakresie długości fal z przedziału powyżej 400 nm, ale nie więcej niż 1 050 nm; lub*
- b. *15 mA/W lub mniej przy reakcji szczytowej w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 050 nm, ale nie więcej niż 1 800 nm;*

3. następujące, inne niż „klasy kosmicznej” „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej”:

NB.: *‘Mikrobolometryczne’ „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej”, inne niż „klasy kosmicznej” są wymienione jedynie w pozycji 6A002.a.3.f.*

Uwaga techniczna:

„Matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” to liniowe lub dwuwymiarowe wieloelementowe zespoły detektorów.

Uwaga 1: *Pozycja 6A002.a.3 obejmuje kontrolą zespoły fotoprzewodzące i fotowoltaiczne.*

Uwaga 2: *Pozycja 6A002.a.3. nie obejmuje kontrolą:*

- a. *wieloelementowych (nie więcej niż 16 elementów) komórek fotoelektrycznych w obudowie, zawierających siarczek lub selenek ołowiu;*
- b. *detektorów piroelektrycznych, w których zastosowano którekolwiek z poniższych:*
 1. *siarczan triglicyny i jego odmiany;*
 2. *tytania ołowiu-lantanu-cyrkonu i odmiany;*
 3. *tantalan litu;*
 4. *polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub*
 5. *niobian strontu-baru i jego odmiany;*
- c. *„matryc detektorowych płaszczyzny ogniskowej” specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych tak, by uzyskać ‘powielanie ładunków’ oraz ograniczonych projektowo tak, by ich maksymalna „czułość promieniowania” wynosiła 10 mA/W lub mniej przy długości fal powyżej 760 nm, spełniających wszystkie poniższe kryteria:*
 1. *wyposażonych w mechanizm ograniczenia reakcji, zaprojektowany w sposób nieprzewidujący jego usuwania ani modyfikowania; oraz*
 2. *spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:*
 - a. *mechanizm ograniczenia reakcji jest zintegrowany z elementem detekcyjnym lub połączony z nim; lub*
 - b. *„matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej” działa wyłącznie wtedy, gdy zainstalowany jest mechanizm ograniczenia reakcji.*

Uwaga techniczna:

Mechanizm ograniczenia reakcji, w jaki wyposażony jest element detekcyjny, jest zaprojektowany tak, by w przypadku jego usunięcia lub modyfikacji detektor przestawał działać.

Uwaga techniczna:

‘Powielanie ładunków’ oznacza formę wzmacniania obrazów elektronicznych i zdefiniowane jest jako wytwarzanie nośników ładunków w wyniku procesu jonizacji strumieniem. Czujniki ‘powielania ładunków’ mogą mieć postać lampowego wzmacniacza obrazu, detektora półprzewodnikowego lub „matrycy detektorowej płaszczyzny ogniskowej”.

- a. *inne niż „klasy kosmicznej” „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” spełniające wszystkie poniższe kryteria:*

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie długości fal z przedziału powyżej 900 nm, ale nieprzekraczającej 1 050 nm; oraz
2. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „stała czasowa” reakcji poniżej 0,5 ns; lub
 - b. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskać ‘powielanie ładunków’, i mające maksymalną „czułość promieniowania” powyżej 10 mA/W;

- b. inne niż „klasy kosmicznej” „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - 1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 050 nm, ale nie więcej niż 1 200 nm; oraz
 - 2. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „stała czasowa” reakcji 95 ns lub poniżej; lub
 - b. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskać ‘powielanie ładunków’, i mające maksymalną „czułość promieniowania” powyżej 10 mA/W;
- c. inne niż „klasy kosmicznej” nieliniowe (2 wymiarowe) „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” posiadające reakcję szczytową poszczególnych elementów w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 200 nm, ale nieprzekraczającej 30 000 nm;

NB.: *‘Mikrobolometryczne’ „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej”, inne niż „klasy kosmicznej”, wykonane na bazie krzemu lub innych materiałów są wymienione jedynie w pozycji 6A002.a.3.f.*

- d. inne niż „klasy kosmicznej” liniowe (1 wymiarowe) „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - 1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 200 nm, ale nie więcej niż 3 000 nm; oraz
 - 2. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. stosunek wymiaru ‘kierunku przeszukiwania’ elementu detekcyjnego do wymiaru ‘poprzecznego kierunku przeszukiwania’ elementu detekcyjnego poniżej 3,8; lub
 - b. przetwarzanie sygnałów w elementach detekcyjnych;

Uwaga: *Pozycja 6A002.a.3.d nie obejmuje kontrolą „matryc detektorowych płaszczyzny ogniskowej” (nieprzekraczających 32 elementów), w których elementy detekcyjne są wykonane wyłącznie z germanu.*

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 6A002.a.3.d ‘poprzeczny kierunek przeszukiwania’ jest określany jako oś równoległa do liniowego układu elementów detekcyjnych, a ‘kierunek przeszukiwania’ jest określany jako oś prostopadła do liniowego układu elementów detekcyjnych.

- e. inne niż „klasy kosmicznej” liniowe (1 wymiarowe) „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” posiadające reakcję szczytową poszczególnych elementów w zakresie długości fal z przedziału powyżej 3 000 nm, ale nieprzekraczającej 30 000 nm;
- f. inne niż „klasy kosmicznej” nieliniowe (2 wymiarowe) „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” w zakresie promieniowania podczerwonego oparte na materiale ‘mikrobolometrycznym’ posiadające niefiltrowaną reakcję poszczególnych elementów w zakresie długości fal z przedziału powyżej 8 000 nm, ale nieprzekraczającej 14 000 nm;

Uwaga techniczna:

Do celów 6A002.a.3.f ‘mikrobolometr’ jest określany jako obrazowy detektor termalny, który, w wyniku zmiany temperatury w detektorze spowodowanej przez absorpcję promieniowania podczerwonego, generuje nadające się do wykorzystania sygnały.

- g. inne niż „klasy kosmicznej” „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. oddzielne elementy detekcyjne o reakcji szczytowej w zakresie długości fal z przedziału powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 900 nm;
 2. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by uzyskać ‘powielanie ładunków’ i mające maksymalną „czułość promieniowania” powyżej 10 mA/W przy długości fal powyżej 760 nm; oraz
 3. mające powyżej 32 elementów;

- b. „monospektralne czujniki obrazowe” i „wielospektralne czujniki obrazowe” przeznaczone do zdalnego wykrywania obiektów i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. chwilowe pole widzenia (IFOV) poniżej 200 μ rad (mikroradianów); lub
 2. przeznaczenie do działania w zakresie fal o długości powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 30 000 nm oraz mające wszystkie następujące własności:
 - a. dostarczanie wyjściowych danych obrazowych w postaci cyfrowej; oraz
 - b. spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. są „klasy kosmicznej”; lub
 2. przeznaczenie do zastosowań lotniczych i zaopatrzenie w czujniki inne niż krzemowe oraz posiadające IFOV poniżej 2,5 miliradianów;

Uwaga: Pozycja 6A002.b.1 nie obejmuje kontrolą „monospektralnych czujników obrazowych” o reakcji szczytowej w paśmie fal o długości powyżej 300 nm, ale nieprzekraczającej 900 nm i obejmujących wyłącznie którekolwiek z poniższych detektorów innych niż „klasy kosmicznej” lub „matryce detektorowych płaszczyzny ogniskowej” innych niż „klasy kosmicznej”:

1. matryce CCD, niezaprojektowane ani niezmodyfikowane do osiągnięcia ‘powielania ładunków’; lub
2. matryce CMOS, niezaprojektowane ani niezmodyfikowane do osiągnięcia ‘powielania ładunków’.

- c. urządzenia do ‘bezpośredniego widzenia’ wyposażone w którekolwiek z poniższych:
 1. lampowe wzmacniacze obrazu wyszczególnione w pozycji 6A002.a.2.a lub 6A002.a.2.b;
 2. „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” wyszczególnione w pozycji 6A002.a.3; lub
 3. detektory półprzewodnikowe wyszczególnione w pozycji 6A002.a.1;

Uwaga techniczna:

Termin ‘bezpośrednie widzenie’ odnosi się do urządzeń tworzących obrazy przedstawiające widzialny dla człowieka obraz bez jego przetwarzania na sygnał elektroniczny przekazywany na ekran telewizyjny, niemogących zarejestrować ani utrwalić obrazu na drodze fotograficznej, elektronicznej ani żadnej innej.

Uwaga: Pozycja 6A002.c nie obejmuje kontrolą poniższych urządzeń, jeżeli są wyposażone w fotokatody inne niż z GaAs lub GaInAs:

- a. przemysłowych lub cywilnych systemów alarmowych, systemów kontroli ruchu drogowego lub przemysłowego ani systemów zliczających;
- b. urządzeń medycznych;
- c. urządzeń przemysłowych stosowanych do kontroli, sortowania lub analizy właściwości materiałów;
- d. wykrywaczy płomieni do pieców przemysłowych;
- e. urządzeń specjalnie zaprojektowanych do celów laboratoryjnych.

- d. następujące specjalne elementy pomocnicze do czujników optycznych:
 1. chłodnice kriogeniczne „klasy kosmicznej”;
 2. następujące chłodnice kriogeniczne inne niż „klasy kosmicznej”, posiadające źródło chłodzenia o temperaturze poniżej 218 K (-55 °C):
 - a. pracujące w obiegu zamkniętym i charakteryzujące się średnim czasem do awarii (MTTF) lub średnim czasem międzyawaryjnym (MTBF) powyżej 2 500 godzin;
 - b. samoregulujące się minichłodnice Joula-Thomsona (JT) z otworkami o średnicy (na zewnątrz) poniżej 8 mm;
 3. czujnikowe włókna optyczne o specjalnym składzie lub konstrukcji lub zmodyfikowane techniką powlekania, w celu nadania im właściwości

umożliwiających reagowanie na fale akustyczne, promieniowanie termiczne, siły bezwładności, promieniowanie elektromagnetyczne lub jądrowe;

Uwaga: *Pozycja 6A002.d.3 nie obejmuje kontrolą czujnikowych włókien optycznych w obudowie specjalnie zaprojektowanych do stosowania jako czujniki w odwiertach.*

e. nieużywane.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 6A203.

NB.: Kamery telewizyjne i aparaty fotograficzne na błony światłoczułe specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do zastosowań podwodnych – zob. także pozycje 8A002.d.1 i 8A002.e.

a. następujące kamery rejestrujące i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

Uwaga: Kamery rejestrujące, określone w poz. 6A003.a.3 do 6A003.a.5, o budowie modułowej powinny być oceniane wg ich maksymalnych możliwości przy wykorzystaniu „zespołów wtykanych” zgodnie ze specyfikacją producenta kamery.

1. bardzo szybkie kamery filmowe rejestrujące na błonie dowolnego formatu od 8 mm do 16 mm włącznie, w których błona jest podczas rejestracji przesuwana w sposób ciągły, umożliwiające rejestrowanie obrazów z szybkościami powyżej 13 150 klatek na sekundę;

Uwaga: Pozycja 6A003.a.1 nie obejmuje kontrolą filmowych kamer rejestrujących przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. bardzo szybkie kamery z napędem mechanicznym, bez przesuwu filmu, umożliwiające rejestrację z szybkościami powyżej 1 000 000 klatek na sekundę na całej szerokości błony 35 mm, lub z szybkościami proporcjonalnie większymi na błonach o mniejszych formatach lub z szybkościami proporcjonalnie mniejszymi na błonach o formatach większych;
3. mechaniczne lub elektryczne kamery smugowe o szybkości zapisu powyżej 10 mm/μs;
4. elektroniczne kamery obrazowe o szybkości powyżej 1 000 000 klatek na sekundę;
5. kamery elektroniczne spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. szybkość działania migawki elektronicznej (bramkowania) poniżej 1 mikrosekundy na pełną klatkę; oraz
 - b. czas odczytu umożliwiający szybkość powyżej 125 pełnych klatek na sekundę;
6. „zespoły wtykane” spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujących, które mają strukturę modułową i które zostały wyszczególnione w pozycji 6A003.a; oraz
 - b. umożliwiające tym kamerom realizowanie właściwości wymienionych w pozycjach 6A003.a.3, 6A003.a.4 lub 6A003.a.5, zgodnie z danymi technicznymi producenta;

b. następujące kamery obrazowe:

Uwaga: Pozycja 6A003.b nie obejmuje kontrolą kamer telewizyjnych ani wideokamer przeznaczonych specjalnie dla stacji telewizyjnych.

1. wideokamery z czujnikami półprzewodnikowymi posiadające reakcję szczytową w przedziale długości fal powyżej 10 nm, ale nie więcej niż 30 000 nm, oraz spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. powyżej 4×10^6 „aktywnych pikseli” na półprzewodnikową siatkę dla kamer monochromatycznych (czarno-białych);
 2. powyżej 4×10^6 „aktywnych pikseli” na półprzewodnikową siatkę dla kamer kolorowych z trzema siatkami półprzewodnikowymi; lub

3. powyżej 12×10^6 „aktywnych pikseli” na półprzewodnikową siatkę dla kamer kolorowych z jedną siatką półprzewodnikową; oraz
- b. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. zwierciadła optyczne wyszczególnione w pozycji 6A004.a;
 2. urządzenia do sterowania optyką wyszczególnione w pozycji 6A004.d; lub
 3. zdolność do nanoszenia wytwarzanych wewnętrznie ‘ścieżek danych o kamerze’;

Uwaga techniczna:

1. *Na użytek niniejszego punktu wideokamery cyfrowe powinny być oceniane na podstawie maksymalnej liczby „aktywnych pikseli” wykorzystywanych do rejestrowania obrazów ruchomych.*
2. *Na użytek niniejszego punktu ‘ścieżki danych o kamerze’ stanowią informacje niezbędne do określenia orientacji widzenia kamery względem ziemi. Należą do nich: 1) kąt poziomy osi widzenia kamery względem kierunku pola magnetycznego ziemi; oraz 2) kąt pionowy pomiędzy osią widzenia kamery a horyzontem ziemi.*
2. kamery skanujące i systemy kamer skanujących spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 10 nm, ale nieprzekraczającej 30 000 nm;
 - b. liniowe siatki detekcyjne posiadające powyżej 8 192 elementów na siatkę; oraz
 - c. mechaniczne przeszukiwanie w jednym kierunku;

Uwaga: *Pozycja 6A003.b.2 nie obejmuje kontrolą kamer skanujących ani systemów kamer skanujących specjalnie zaprojektowanych do któregośkolwiek z poniższych:*

- a. *fotokopiarki przemysłowe lub cywilne;*
 - b. *skanery specjalnie zaprojektowane do skanowania w zastosowaniach cywilnych, stacjonarnych, z małych odległości (np. powielanie obrazów lub druku zawartych w dokumentach, dziełach sztuki lub fotografiach); lub*
 - c. *sprzęt medyczny.*
3. kamery obrazowe wyposażone we wzmacniacze obrazów wyszczególnione w pozycji 6A002.a.2.a lub 6A002.a.2.b;
 4. kamery obrazowe zawierające „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” wyposażone w którekolwiek z poniższych:
 - a. „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” wymienione w pozycjach 6A002.a.3.a do 6A002.a.3.e;
 - b. „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” wyszczególnione w pozycji 6A002.a.3.f; lub
 - c. „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” wyszczególnione w pozycji 6A002.a.3.g;

Uwaga 1: *Kamery obrazowe wyszczególnione w pozycji 6A003.b.4 zawierają „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” połączone z odpowiednią elektroniką „przetwarzania sygnałów”, poza układem odczytującym, w celu umożliwienia przynajmniej wyjścia sygnału analogowego lub cyfrowego po podłączeniu zasilania.*

- Uwaga 2: Pozycja 6A003.b.4.a nie obejmuje kontrolą kamer obrazowych wykorzystujących liniowe „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” o 12 elementach lub mniejszej ich liczbie, nierealizujących w elementach funkcji opóźnienia czasowego ani integracji i przeznaczonych do któregokolwiek z poniższych:
- a. przemysłowe lub cywilne alarmy włamaniowe, kontrola ruchu na drogach lub w przemyśle lub systemy zliczające;
 - b. urządzenia przemysłowe stosowane do nadzoru lub monitorowania wypływu ciepła w budynkach, urządzeniach lub procesach przemysłowych;
 - c. urządzenia przemysłowe stosowane do nadzoru, sortowania lub analizy właściwości materiałów;
 - d. urządzenia specjalnie zaprojektowane do zastosowań laboratoryjnych; lub
 - e. sprzęt medyczny.

Uwaga 3: Pozycja 6A003.b.4.b nie obejmuje kontrolą kamer obrazowych spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a. szybkość analizy obrazów równa lub wyższa niż 9 Hz;
- b. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. poziome lub pionowe minimalne 'chwilowe pole widzenia (IFOV)' wynoszące przynajmniej 10 mrad/piksel (miliradianów/piksel);
 2. wyposażone w stałą soczewkę ogniskującą, która została zaprojektowana w sposób uniemożliwiający jej usunięcie;
 3. brak wizjera 'bezpośredniego widzenia', oraz
 4. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. brak możliwości uzyskania widzialnego obrazu wykrytego pola widzenia; lub
 - b. zaprojektowanie kamery dla jednego rodzaju zastosowania, bez możliwości modyfikowania jej funkcji przez użytkownika; lub
- c. kamery specjalne zaprojektowane do instalacji w cywilnych pasażerskich pojazdach lądowych o ciężarze mniejszym niż 3 tony (ciężar brutto pojazdu) i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. działające wyłącznie wtedy, gdy kamera jest zainstalowana w którymkolwiek z poniższych:
 - a. cywilne pasażerskie pojazdy lądowe, do których była przeznaczona; lub
 - b. specjalnie zaprojektowane, autoryzowane urządzenie do testów konserwacyjnych; oraz
 2. posiada aktywny mechanizm, który powoduje zaprzestanie działania kamery, gdy jest ona zdjęta z pojazdu, do którego została przeznaczona.

Uwagi techniczne:

1. 'Chwilowe pole widzenia (IFOV)' określone w pozycji 6.A003.b.4 uwaga 3.b jest mniejszą z wartości 'poziomego IFOV' lub 'pionowego IFOV'.
'Poziome IFOV' = poziome pole widzenia (FOV)/liczba poziomych elementów detekcyjnych
'Pionowe IFOV' = pionowe pole widzenia (FOV)/liczba pionowych elementów detekcyjnych
2. Termin 'widzenie bezpośrednie' określony w pozycji 6A003.b.4. Uwaga 3.b odnosi się do kamery obrazowej działającej w zakresie fal podczerwonych, która wytwarza obraz widzialny dla człowieka będącego obserwatorem, wykorzystując mikrowyświetlacz bliski oku wyposażony w dowolny mechanizm zabezpieczenia przed światłem.

Uwaga 4: Pozycja 6A003.b.4.c nie obejmuje kontrolą kamer obrazowych spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 - 1. specjalnie zaprojektowanych do zainstalowania jako zintegrowany element systemów i urządzeń wewnętrznych i korzystających z zasilania z zewnętrznej sieci energetycznej, które zostały zaprojektowane w sposób ograniczający ich zastosowanie do jednego z poniższych:
 - a. monitorowanie procesów przemysłowych, kontrola jakości lub analiza właściwości materiałów;
 - b. sprzęt laboratoryjny zaprojektowany specjalnie do badań naukowych;
 - c. urządzeń medycznych;
 - d. sprzęt służący do wykrywania nadużyć finansowych; oraz
 - 2. działające wyłącznie wtedy, gdy kamera jest zainstalowana w którymkolwiek z poniższych:
 - a. w układach lub sprzęcie, do których są przeznaczone; lub
 - b. specjalnie zaprojektowanych i dopuszczonych do obrotu systemach obsługowych; oraz
 - 3. wyposażonych w aktywny mechanizm, który powoduje, że kamera nie działa, gdy zostaje usunięta z systemu, systemów lub urządzeń, do których jest przeznaczona;
- b. specjalnie zaprojektowanych do instalacji w cywilnych pasażerskich pojazdach lądowych o ciężarze mniejszym niż 3 tony (ciężar brutto pojazdu) lub promach, które przewożą osoby i pojazdy i mają długość całkowitą (LOA) 65 m lub większą, oraz spełniających wszystkie poniższe kryteria:
 - 1. działające wyłącznie wtedy, gdy kamera jest zainstalowana w którymkolwiek z poniższych:
 - a. w cywilnym pasażerskim pojeździe lądowym lub promie, które przewożą osoby i pojazdy, do jakich są przeznaczone; lub
 - b. w specjalnie zaprojektowanym urządzeniu do testów konserwacyjnych; oraz
 - 2. wyposażonych w aktywny mechanizm, który powoduje, że kamera nie działa, gdy zostaje usunięta z pojazdu, do którego jest przeznaczona;
- c. zaprojektowanych tak, by ich maksymalna „czułość promieniowania” wynosiła 10 mA/W lub mniej przy długości fal powyżej 760 nm, spełniających wszystkie poniższe kryteria:
 - 1. wyposażonych w mechanizm ograniczenia reakcji, zaprojektowany w sposób nieprzewidujący jego usuwania ani modyfikowania;
 - 2. wyposażonych w aktywny mechanizm, który powoduje, że kamera nie działa, gdy zostaje usunięty mechanizm ograniczenia odpowiedzi; oraz
 - 3. niezaprojektowanych ani zmodyfikowanych specjalnie do stosowania pod wodą; lub
- d. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 - 1. niewyposażonych w ‘widzenie bezpośrednie’ ani elektroniczny wyświetlacz obrazu;
 - 2. niewyposażonych w urządzenie umożliwiające uzyskanie widzialnego obrazu wykrytego pola widzenia;

3. „matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej” działa wyłącznie wtedy, gdy zainstalowany jest w kamerze, do której jest przeznaczony; oraz
4. „matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej” wyposażona jest w aktywny mechanizm, który na stałe uniemożliwia działanie tego zespołu, jeżeli zostanie on usunięty z kamery, do której jest przeznaczony;

5. kamery obrazowe wyposażone w detektory półprzewodnikowe wyszczególnione w pozycji 6A002.a.1.

6A004 Następujące urządzenia optyczne i elementy:

- a. następujące zwierciadła optyczne (reflektory):

NB.: *Zwierciadła optyczne specjalnie zaprojektowane do urządzeń litograficznych – zob. pozycja 3B001.*

1. „zwierciadła odkształcalne” o powierzchni ciągłej lub wieloelementowej oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, mające możliwość dynamicznej zmiany położenia części powierzchni zwierciadła z szybkością powyżej 100 Hz;
 2. lekkie zwierciadła monolityczne o przeciętnej „gęstości zastępczej” poniżej 30 kg/m^2 i masie całkowitej powyżej 10 kg;
 3. lekkie konstrukcje zwierciadlane z materiałów „kompozytowych” lub spienionych o przeciętnej „gęstości zastępczej” poniżej 30 kg/m^2 i masie całkowitej powyżej 2 kg;
 4. zwierciadła do kierowania wiązką, mające średnicę lub długość osi głównej powyżej 100 mm, zachowujące płaskość rzędu $\lambda/2$ lub lepszą (λ jest równe 633 nm) i sterowane wiązką o szerokości pasma powyżej 100 Hz;
- b. elementy optyczne z selenku cynku (ZnSe) lub siarczku cynku (ZnS) z możliwością transmisji w zakresie długości fal powyżej 3 000 nm, ale nie większej niż 25 000 nm i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. objętość powyżej 100 cm^3 ; lub
 2. średnicę lub długość osi głównej powyżej 80 mm oraz grubość (głębokość) powyżej 20 mm;
- c. następujące elementy „klasy kosmicznej” do systemów optycznych:
 1. o „gęstości zastępczej” elementów obniżonej o 20 % w porównaniu z maszynowym wyrobem o takiej samej aperturze i grubości;
 2. podłoża surowe, podłoża powlekane powierzchniowo (z powłoką jednowarstwową lub wielowarstwową, metaliczną lub dielektryczną, przewodzącą, półprzewodzącą lub izolującą) lub pokryte błoną ochronną;
 3. segmenty lub zespoły zwierciadeł przeznaczone do montażu z nich w przestrzeni kosmicznej systemów optycznych, mające sumaryczną aperturę równoważną lub większą niż pojedynczy element optyczny o średnicy 1 metra;
 4. elementy wykonane z materiałów „kompozytowych” o współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej w kierunku dowolnej współrzędnej równym lub mniejszym niż 5×10^{-6} ;
- d. następujące urządzenia do sterowania elementami optycznymi:
 1. urządzenia specjalnie zaprojektowane do utrzymywania kształtu lub orientacji powierzchni elementów „klasy kosmicznej” objętych kontrolą według pozycji 6A004.c.1 lub 6A004.c.3;
 2. urządzenia posiadające pasmo sterowania, śledzenia, stabilizacji lub strojenia rezonatora o szerokości równej lub większej niż 100 Hz oraz dokładność 10 μrad (mikroradianów) lub lepszą;

3. zawieszenia kardanowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. maksymalny kąt wychylenia powyżej 5° ;
 - b. szerokość pasma równą lub większą niż 100 Hz;
 - c. możliwość ustawiania kątownego z dokładnością równą lub lepszą niż 200 μ rad (mikroradianów); oraz
 - d. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. średnicę lub długość osi głównej powyżej 0,15 m, ale nie większą niż 1 m i możliwość zmiany położenia kątownego z przyspieszeniami powyżej 2 rad (radianów)/s²; lub
 2. średnicę lub długość osi głównej powyżej 1 m i możliwość zmiany położenia kątownego z przyspieszeniami powyżej 0,5 rad (radianów)/s²;
4. urządzenia specjalnie zaprojektowane do utrzymywania w odpowiednim położeniu systemów układów fazowanych lub systemów fazowanych zwierciadeł segmentowych o średnicy segmentów lub długości osi głównej równej lub większej od 1 m;
- e. 'asferyczne elementy optyczne' spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. największy wymiar apertury optycznej jest większy niż 400 mm;
 2. nierówność powierzchni jest mniejsza niż 1 nm (średnia wartość kwadratowa) dla długości próbkowania równej lub większej niż 1 mm; oraz
 3. wartość absolutna współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej przy 25 °C jest mniejsza niż $3 \times 10^{-6}/K$.

Uwagi techniczne:

1. 'Asferycznym elementem optycznym' jest taki element, stosowany w systemach optycznych, którego powierzchnia lub powierzchnie czynne są zaprojektowane jako odbiegające od kształtu idealnej kuli.
2. Od producentów nie jest wymagany pomiar nierówności, o którym mowa w 6A004.e.2, jeżeli element optyczny nie został zaprojektowany lub wykonany z zamiarem dotrzymania lub przekroczenia parametru kontrolnego.

- Uwaga Pozycja 6A004.e. nie obejmuje kontrolą 'asferycznych elementów optycznych' spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:
- a. największy wymiar apertury optycznej mniejszy niż 1 m i stosunek długości ogniskowej do apertury równy lub większy niż 4,5:1;
 - b. największy wymiar apertury optycznej równy lub większy niż 1 m i stosunek długości ogniskowej do apertury równy lub większy niż 7:1;
 - c. zaprojektowany jako element Fresnela, oko muchy, pasek, pryzmat lub element dyfrakcyjny;
 - d. wykonany ze szkła borokrzemowego mającego współczynnik rozszerzalności liniowej większy niż $2,5 \times 10^{-6}/K$ przy 25 °C; lub
 - e. będący elementem optyki rentgenowskiej, mającym właściwości zwierciadła wewnętrznego (np. zwierciadła typu rurowego).

NB. Jeżeli chodzi o 'asferyczne elementy optyczne' specjalnie zaprojektowane dla urządzeń litograficznych, zob. 3B001.

6A005 Następujące „lasery”, ich elementy i urządzenia optyczne do nich, inne niż wymienione w pozycjach 0B001.g.5 lub 0B001.h.6:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 6A205.

Uwaga 1: Do „laserów” impulsowych zalicza się lasery z falą ciągłą (CW), z nakładanymi na nią impulsami.

Uwaga 2: „Lasery” ekscymerowe, półprzewodnikowe, chemiczne, CO, CO₂ i neodymowo-szklane o ‘niepowtarzających się impulsach’ wymienione są wyłącznie w pozycji 6A005.d.

Uwaga techniczna:

‘O niepowtarzających się impulsach’ dotyczy „laserów” wytwarzających jeden impuls wyjściowy lub „laserów”, w których odcinek czasowy między impulsami wynosi powyżej jednej minuty.

Uwaga 3: Pozycja 6A005 obejmuje „lasery” włóknowe.

Uwaga 4: Poziom kontroli „laserów” wykorzystujących przetworzenie częstotliwości (tzn. zmianę długości fali) w inny sposób niż przez „pompowanie” jednego lasera innym „laserem” określony jest przez zastosowanie parametrów kontroli zarówno do wyjścia „lasera” źródłowego, jak i do wyjścia optycznego o przekształconej częstotliwości.

Uwaga 5: Pozycja 6A005 nie obejmuje kontrolą następujących „laserów”:

- a. rubinowy o energii wyjściowej poniżej 20 J;
- b. azotowy;
- c. kryptonowy.

Uwaga techniczna:

W pozycji 6A005 ‘sprawność całkowita’ definiuje się jako stosunek mocy wyjściowej „lasera” (lub „średniej mocy wyjściowej”) do całkowitej mocy wejściowej wymaganej do funkcjonowania „lasera”, w tym zasilania/kondycjonowania mocy oraz kondycjonowania termicznego/wymiennika ciepła.

a. „nieprzestrajalne” „lasery” z falą ciągłą spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. długość fali wyjściowej poniżej 150 nm i moc wyjściowa powyżej 1 W;
2. długość fali wyjściowej równa lub większa niż 150 nm, ale nie większa niż 510 nm i moc wyjściowa powyżej 30 W;
Uwaga: Pozycja 6A005.a.2 nie obejmuje kontrolą „laserów” argonowych o mocy wyjściowej równej lub mniejszej niż 50 W.
3. długość fali wyjściowej powyżej 510 nm, ale nie większa niż 540 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i moc wyjściowa przekraczająca 50 W; lub
 - b. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i moc wyjściowa przekraczająca 150 W;
4. długość fali wyjściowej większa niż 540 nm, ale nie większa niż 800 nm i moc wyjściowa powyżej 30 W;
5. długość fali wyjściowej powyżej 800 nm, ale nie większa niż 975 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i moc wyjściowa przekraczająca 50 W; lub

- b. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i moc wyjściowa przekraczająca 80 W;

6. długość fali wyjściowej powyżej 975 nm, ale nie większa niż 1 150 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i moc wyjściowa przekraczająca 200 W; lub
 - b. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i którykolwiek z poniższych kryteriów:
 1. 'sprawność całkowita' powyżej 18 % i moc wyjściowa powyżej 500 W; lub
 2. moc wyjściowa powyżej 2 kW;

Uwaga 1: Pozycja 6A005.a.6.b nie obejmuje kontrolą „laserów” przemysłowych działających w trybie z pojedynczym przejściem poprzecznym o mocy wyjściowej powyżej 2 kW a nieprzekraczającej 6 kW i o masie całkowitej większej niż 1 200 kg. Do celów niniejszej uwagi masa całkowita obejmuje wszystkie części składowe wymagane do funkcjonowania „lasera”, tzn. „laser”, zasilacz, wymiennik ciepła, natomiast nie obejmuje kontrolą zewnętrznych urządzeń optycznych do kondycjonowania lub wysyłania wiązki.

Uwaga 2: Pozycja 6A005.a.6.b nie obejmuje kontrolą „laserów” przemysłowych działających w trybie z pojedynczym przejściem poprzecznym spełniających którykolwiek z poniższych kryteriów:

- a. Moc wyjściowa większa niż 500 W, ale nieprzekraczająca 1 kW oraz spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. Iloczyn parametrów wiązki (BPP) przekraczający 0,7 mm•mrad; oraz
 2. 'Jasność' nieprzekraczającą $1024 \text{ W}/(\text{mm} \cdot \text{mrad})^2$;
- b. Moc wyjściowa większa niż 1 kW, ale nieprzekraczająca 1,6 kW oraz których wartość BPP przekracza 1,25 mm•mrad;
- c. Moc wyjściowa większa niż 1,6 kW, ale nieprzekraczająca 2,5 kW oraz których wartość BPP przekracza 1,7 mm•mrad;
- d. Moc wyjściowa większa niż 2,5 kW, ale nieprzekraczająca 3,3 kW oraz których wartość BPP przekracza 2,5 mm•mrad;
- e. Moc wyjściowa większa niż 3,3 kW, ale nieprzekraczająca 4 kW oraz których wartość BPP przekracza 3,5 mm•mrad;
- f. Moc wyjściowa większa niż 4 kW, ale nieprzekraczająca 5 kW oraz których wartość BPP przekracza 5 mm•mrad;
- g. Moc wyjściowa większa niż 5 kW, ale nieprzekraczająca 6 kW oraz których wartość BPP przekracza 7,2 mm•mrad;
- h. Moc wyjściowa większa niż 6 kW, ale nieprzekraczająca 8 kW oraz których wartość BPP przekracza 12 mm•mrad; lub
- i. Moc wyjściowa większa niż 8 kW, ale nieprzekraczająca 10 kW oraz których wartość BPP przekracza 24 mm•mrad.

Uwaga techniczna:

Dla celów pozycji 6A005.a.6.b. uwaga 2.a., 'jasność' definiowana jest jako moc wyjściowa „lasera” podzielona przez iloczyn parametrów wiązki (BPP) do kwadratu, tj. $(\text{moc wyjściowa})/\text{BPP}^2$.

7. długość fali wyjściowej powyżej 1 150 nm, ale nie większa niż 1 555 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:

- a. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i moc wyjściowa przekraczająca 50 W; lub
 - b. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i moc wyjściowa przekraczająca 80 W; lub
8. długość fali wyjściowej poniżej 1 555 nm i moc wyjściowa powyżej 1 W;

- b. „nieprzestrzajalne” „lasery” impulsowe, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. długość fali wyjściowej poniżej 150 nm i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. energia wyjściowa powyżej 50 mJ na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 1 W; lub
 - b. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 1 W;
 2. długość fali wyjściowej równa lub większa niż 150 nm, ale nie większa niż 510 nm i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. energia wyjściowa powyżej 1,5 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 30 W; lub
 - b. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 30 W;
Uwaga: Pozycja 6A005.b.2.b nie obejmuje kontrolą „laserów” argonowych mających „przeciętną moc wyjściową” równą lub większą 50 W.
 3. długość fali wyjściowej powyżej 510 nm, ale nie większa niż 540 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 1,5 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 50 W; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 50 W; lub
 - b. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 1,5 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 150 W; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 150 W;
 4. długość fali wyjściowej powyżej 540 nm, ale nie większa niż 800 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. „czas trwania impulsu” poniżej 1 ps i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 0,005 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 5 GW; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 20 W; lub
 - b. „czas trwania impulsu” równy lub przekraczający 1 ps i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 1,5 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 30 W; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 30 W;
 5. długość fali wyjściowej powyżej 800 nm, ale nie większa niż 975 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. „czas trwania impulsu” poniżej 1 ps i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 0 005 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 5 GW; lub
 2. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 20 W;
 - b. „czas trwania impulsu” równy lub przekraczający 1 ps i nieprzekraczający 1 μs i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 0,5 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 50 W;
 2. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 20 W; lub

3. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 50 W; lub

- c. „czas trwania impulsu” przekraczający 1 μ s i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 2 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 50 W;
 2. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 50 W; lub
 3. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 80 W;
6. długość fali wyjściowej powyżej 975 nm, ale nie większa niż 1 150 nm oraz którekolwiek z poniższych parametrów:
 - a. „czas trwania impulsu” poniżej 1 ps i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. wyjściowa „moc szczytowa” powyżej 2 GW na impuls;
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 10 W; lub
 3. energia wyjściowa większa niż 0,002 J na impuls;
 - b. „czas trwania impulsu” równy lub przekraczający 1 ps i krótszy niż 1 ns i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. wyjściowa „moc szczytowa” powyżej 5 GW na impuls;
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 10 W; lub
 3. energia wyjściowa większa niż 0,1 J na impuls;
 - c. „czas trwania impulsu” równy lub przekraczający 1 ns, ale nieprzekraczający 1 μ s i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „moc szczytowa” przekraczająca 100 MW;
 - b. „przeciętna moc wyjściowa” przekraczająca 20 W, ograniczona projektowo do maksymalnej częstotliwości powtarzania impulsów mniejszej niż lub równej 1 kHz;
 - c. ‘sprawność całkowita’ przekraczająca 12 %, „przeciętna moc wyjściowa” przekraczająca 100 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz;
 - d. „przeciętna moc wyjściowa” przekraczająca 150 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub
 - e. energia wyjściowa większa niż 2 J na impuls; lub
 2. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „moc szczytowa” przekraczająca 400 MW;
 - b. ‘sprawność całkowita’ przekraczająca 18 % i „przeciętna moc wyjściowa” przekraczająca 500 W;
 - c. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 2 kW; lub
 - d. energia wyjściowa większa niż 4 J na impuls; lub
 - d. „czas trwania impulsu” przekraczający 1 μ s i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „moc szczytowa” przekraczająca 500 kW;
 - b. ‘sprawność całkowita’ przekraczająca 12 % i „przeciętna moc wyjściowa” przekraczająca 100 W; lub
 - c. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 150 W; lub
 2. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „moc szczytowa” przekraczająca 1 MW;
 - b. ‘sprawność całkowita’ przekraczająca 18 % i „przeciętna moc wyjściowa” przekraczająca 500 W; lub
 - c. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 2 kW;

7. długość fali wyjściowej powyżej 1 150 nm, ale nieprzekraczająca 1 555 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. „czas trwania impulsu” nieprzekraczający 1 μ s i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 0,5 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 50 W;
 2. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 20 W; lub
 3. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 50 W; lub
 - b. „czas trwania impulsu” przekraczający 1 μ s i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa powyżej 2 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 50 W;
 2. sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 50 W; lub
 3. sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 80 W; lub
8. długość fali wyjściowej przekraczająca 1 555 nm i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. energia wyjściowa powyżej 100 mJ na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 1 W; lub
 - b. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 1 W;
- c. „lasery” przestrajalne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga: Pozycja 6A005.c obejmuje „lasery” tytanowo-szafirowe (Ti: Al₂O₃), tul – YAG (Tm: YAG), tul – YSGG (Tm: YSGG), aleksandrytowe (CR: BeAl₂O₄), na centrach barwnych, „lasery” barwnikowe oraz „lasery” cieczowe.

1. długość fali wyjściowej poniżej 600 nm i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. energia wyjściowa powyżej 50 mJ na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 1 W; lub
 - b. przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 1 W;

Uwaga: Pozycja 6A005.c.1 nie obejmuje kontrolą laserów barwnikowych ani innych laserów cieczowych z wielomodalnym sygnałem wyjściowym i o długości fali wynoszącej 150 nm lub więcej, ale nieprzekraczającej 600 nm, i spełniających wszystkie z poniższych kryteriów:

1. energia wyjściowa poniżej 1,5 J na impuls i „moc szczytowa” poniżej 20 W; oraz
 2. przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa poniżej 20 W.
2. długość fali wyjściowej 600 nm lub większa, ale nieprzekraczająca 1 400 nm i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. energia wyjściowa powyżej 1 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 20 W; lub
 - b. przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 20 W; lub
 3. długość fali wyjściowej przekraczająca 1 400 nm i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. energia wyjściowa powyżej 50 mJ na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 1 W; lub
 - b. przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 1 W;

- d. następujące inne „lasery”, niewymienione w pozycjach 6A005.a, 6A005.b, lub 6A005.c:

1. następujące „lasery” półprzewodnikowe:

Uwaga 1: Pozycja 6A005.d.1 obejmuje „lasery” półprzewodnikowe wyposażone w optyczne złącza wyjściowe (np. kable z włókien światłowodowych).

Uwaga 2: Poziom kontroli „laserów” półprzewodnikowych zaprojektowanych specjalnie do innych urządzeń wynika z poziomu kontroli tych innych urządzeń.

- a. indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z pojedynczym przejściem poprzecznym spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. długość fali równa lub mniejsza niż 1 510 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 1,5 W; lub
 2. długość fali większa niż 1 510 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 500 mW;
- b. indywidualne „lasery” półprzewodnikowe działające w trybie z wielokrotnym przejściem poprzecznym spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. długość fali poniżej 1 400 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 15 W;
 2. długość fali równa lub większa niż 1 400 nm, a mniejsza niż 1 900 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 2,5 W; lub
 3. długość fali równa lub większa niż 1 900 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 1 W;
- c. indywidualne „szeregi” „laserów” półprzewodnikowych spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. długość fali poniżej 1 400 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 100 W;
 2. długość fali równa lub większa niż 1 400 nm, a mniejsza niż 1 900 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 25 W; lub
 3. długość fali równa lub większa niż 1 900 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 10 W;
- d. „macierze” „laserów” półprzewodnikowych (układy dwuwymiarowe) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. mające długość fali mniejszą niż 1 400 nm i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa mniejsza niż 3 kW oraz przeciętna lub ciągła (CW) wyjściowa „gęstość mocy” powyżej 500 W/cm²;
 - b. przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa nie mniejsza niż 3 kW, lecz nie większa niż 5 kW oraz przeciętna lub ciągła (CW) wyjściowa „gęstość mocy” powyżej 350 W/cm²;
 - c. przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa powyżej 5 kW;
 - d. szczytowa „gęstość mocy” impulsu powyżej 2 500 W/cm²; lub
 - e. przestrzennie koherentna przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa powyżej 150 W;
 2. mające długość fali nie mniejszą niż 1 400 nm, lecz mniejszą niż 1 900 nm i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a. przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa mniejsza niż 250 W oraz przeciętna lub ciągła (CW) wyjściowa 'gęstość mocy' powyżej 150 W/cm²;
- b. przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa nie mniejsza niż 250 W, lecz nie większa niż 500 W oraz przeciętna lub ciągła (CW) wyjściowa 'gęstość mocy' powyżej 50 W/cm²;
- c. przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa powyżej 500 W;

- d. szczytowa 'gęstość mocy' impulsu powyżej 500 W/cm²; lub
- e. przestrzennie koherentna przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa powyżej 15 W;
- 3. mające długość fali nie mniejszą niż 1 900 nm i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. przeciętna lub ciągła (CW) wyjściowa 'gęstość mocy' powyżej 50 W/cm²;
 - b. przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 10 W; lub
 - c. przestrzennie koherentna przeciętna lub ciągła (CW) całkowita moc wyjściowa powyżej 1,5 W; lub
- 4. posiadające przynajmniej jeden 'szereg' „laserów” określony w poz. 6A005.d.1.c;

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 6A005.d.1.d 'gęstość mocy' oznacza całkowitą moc wyjściową „lasera” podzieloną przez powierzchnię emitera 'macierzy'.

- e. 'macierze' „laserów” półprzewodnikowych inne niż wymienione w poz. 6A005.d.1.d spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 - 1. specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z myślą o łączeniu ich z innymi 'macierz' w celu utworzenia większej 'macierzy'; oraz
 - 2. mające zintegrowane połączenia, wspólne zarówno dla układów elektronicznych, jak i układów chłodzenia;

Uwaga 1: 'Macierze' utworzone przez połączenie 'macierzy' „laserów” półprzewodnikowych opisanych w poz. 6A005.d.1.e, które nie są zaprojektowane z myślą o dalszym łączeniu lub modyfikacji są wyszczególnione w poz. 6A005.d.1.d.

Uwaga 2: 'Macierze' utworzone przez połączenie 'macierzy' „laserów” półprzewodnikowych opisanych w poz. 6A005.d.1.e, które są zaprojektowane z myślą o dalszym łączeniu lub modyfikacji są wyszczególnione w poz. 6A005.d.1.e.

Uwaga 3: Pozycja 6A005.d.1.e nie obejmuje kontrolą modularnych zespołów pojedynczych 'szeregów' zaprojektowanych do montowania jako liniowe układy szeregów.

Uwagi techniczne:

- 1. „Lasery” półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami „laserowymi”.
- 2. 'Szereg' (zwany także 'szeregiem' „laserów” półprzewodnikowych, 'szeregiem' diod „laserowych” lub 'szeregiem' diod) składa się z wielu półprzewodnikowych „laserów” w układzie jednowymiarowym.
- 3. 'Macierz' składa się z wielu 'szeregów' tworzących dwuwymiarowy układ „laserów” półprzewodnikowych.
- 2. „lasery” na tlenku węgla (CO) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. energia wyjściowa powyżej 2 J na impuls i „szczytowa moc” impulsu powyżej 5 kW; lub
 - b. przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 5 kW;
- 3. „lasery” na dwutlenku węgla (CO₂) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 15 kW;
 - b. wyjście impulsowe z „czasem trwania impulsu” powyżej 10 μs oraz którykolwiek z poniższych parametrów:

1. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 10 kW; lub
2. „moc szczytowa” przekraczająca 100 kW; lub
- c. wyjście impulsowe o „szerokości impulsu” równej lub mniejszej niż 10 μ s oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 1. energia impulsu powyżej 5 J na impuls; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 2,5 kW;

4. „lasery” ekscymerowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. długość fali wyjściowej nieprzekraczająca 150 nm oraz którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa większa niż 50 mJ na impuls; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 1 W;
 - b. długość fali wyjściowej przekraczająca 150 nm, ale nie większa niż 190 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 1. energia wyjściowa większa niż 1,5 J na impuls; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 120 W;
 - c. długość fali wyjściowej przekraczająca 190 nm, ale nie większa niż 360 nm oraz którykolwiek z poniższych parametrów:
 1. energia wyjściowa większa niż 10 J na impuls; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 500 W; lub
 - d. długość fali wyjściowej powyżej 360 nm i którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. energia wyjściowa większa niż 1,5 J na impuls; lub
 2. „przeciętna moc wyjściowa” powyżej 30 W;

NB.: *W przypadku „laserów” ekscymerowych specjalnie zaprojektowanych dla urządzeń litograficznych zob. 3B001.*

5. następujące „lasery chemiczne”:
 - a. „lasery” fluorowodorowe (HF);
 - b. „lasery” na fluorku deuteru (DF);
 - c. „lasery z przekazaniem energii”:
 1. „lasery” tlenowo-jodowe (O₂-I);
 2. „lasery” na mieszaninie fluorku deuteru i dwutlenku węgla (DF-CO₂);
6. „lasery” neodymowo-szklane ‘o niepowtarzających się impulsach’ spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „czas trwania impulsu” nieprzekraczający 1 μs oraz energia wyjściowa powyżej 50 J na impuls; lub
 - b. „czas trwania impulsu” przekraczający 1 μs oraz energia wyjściowa powyżej 100 J na impuls;

Uwaga: *‘O niepowtarzających się impulsach’ dotyczy „laserów” wytwarzających jeden impuls wyjściowy lub „laserów”, w których odcinek czasowy między impulsami wynosi powyżej jednej minuty.*

e. następujące części składowe:

1. zwierciadła 'chłodzone czynnie' lub za pomocą termicznej chłodnicy rurkowej;

Uwaga techniczna:

'Chłodzenie czynne' jest techniką chłodzenia elementów optycznych za pomocą cieczy przepływającej pomiędzy powierzchnią optyczną a dodatkową (zazwyczaj znajdującą się w odległości poniżej 1 mm od powierzchni optycznej), wskutek czego następuje odprowadzenie ciepła z powierzchni optycznej.

2. zwierciadła optyczne lub przepuszczalne lub częściowo przepuszczalne elementy optyczne lub elektrooptyczne specjalnie zaprojektowane do wymienionych „laserów”;

f. następujące urządzenia optyczne:

NB.: *Odnosnie do elementów optycznych z dzieloną aperturą, zdolnych do pracy w „laserach super wysokiej mocy” („SHPL”) zob. także wykaz uzbrojenia.*

1. dynamiczne urządzenia pomiarowe do czoła fali (faza) umożliwiające mapowanie co najmniej 50 położeń na czole wiązki falowej i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. szybkość analizy obrazów równa lub wyższa niż 100 Hz oraz dyskryminacja fazy na co najmniej 5 % długości fali wiązki; lub
 - b. szybkość analizy obrazów równa lub wyższa niż 1 000 Hz oraz dyskryminacja fazy na co najmniej 20 % długości fali wiązki;
2. „laserowe” urządzenia diagnostyczne umożliwiające pomiar błędów sterowania położeniem kątowym „systemów laserowych super wysokiej mocy” (SHPL) z dokładnością równą lub lepszą niż 10 μ rad (mikroradianów);
3. urządzenia optyczne i elementy specjalnie zaprojektowane do systemów „SHPL” w formie zespołów fazowanych w celu sterowania wiązkami koherentnymi z dokładnością $\lambda/10$ dla określonej długości fali, lub 0,1 μ m, w zależności od tego, która z tych wielkości jest mniejsza;
4. teleskopy projekcyjne specjalnie zaprojektowane do systemów SHPL;

g. 'laserowe urządzenia do detekcji akustycznej' spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

1. ciągła moc wyjściowa lasera równa lub przewyższająca 20 mW;
2. stabilność częstotliwości lasera równa lub lepsza (mniejsza) niż 10 MHz;
3. długość fali lasera równa lub przewyższająca 1 000 nm, ale nie przewyższająca 2 000 nm;
4. rozdzielczość układu optycznego lepsza (mniejsza) niż 1 nm; oraz
5. stosunek sygnału optycznego do szumu równe lub przewyższające 10^3 .

Uwaga techniczna:

„Laserowe urządzenia do detekcji akustycznej” są czasami określane nazwą mikrofonu laserowego lub mikrofonu wykrywającego przepływ cząstek.

6A006 Następujące „magnetometry”, „mierniki gradientu magnetycznego”, „mierniki gradientu magnetycznego właściwego”, podwodne czujniki pola elektrycznego, „systemy kompensacji” i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 7A103.d.

Uwaga: Pozycja 6A006 nie obejmuje kontrolą instrumentów specjalnie zaprojektowanych do pomiarów biomagnetycznych do celów zastosowań w rybołówstwie lub diagnostyce medycznej.

a. następujące „magnetometry” i podukłady:

1. „magnetometry” wykorzystujące „technologie” materiałów „nadprzewodzących” (SQUID) i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. systemy SQUID przeznaczone do działania nieruchomego bez specjalnie zaprojektowanych podukładów do zmniejszenia szumu w ruchu i charakteryzujące się ‘czułością’ równą lub niższą (lepszą) niż 50fT (rms) na pierwiastek kwadratowy Hz przy częstotliwości 1 Hz; lub
 - b. systemy SQUID mające magnetometr ruchu i charakteryzujące się ‘czułością’ równą lub niższą (lepszą) niż 20 pT (średnia wartość kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz przy częstotliwości 1 Hz i specjalnie zaprojektowane do zmniejszenia szumu w ruchu;
2. „magnetometry”, w których zastosowano technologię pompowania optycznego lub precesji jądrowej (proton/Overhauser), charakteryzujące się ‘czułością’ mniejszą (lepszą) niż 20 pT (średnia wartość kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz przy częstotliwości 1 Hz;
3. „magnetometry”, w których zastosowano „technologie” bramkowania strumienia, charakteryzujące się ‘czułością’ mniejszą (lepszą) niż 10 pT (średnia wartość kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz przy częstotliwości 1 Hz;
4. „magnetometry” z cewką indukcyjną, charakteryzujące się ‘czułością’ mniejszą (lepszą) niż którykolwiek z poniższych:
 - a. 0,05 nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz [(średnia wartość kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz] w zakresie częstotliwości poniżej 1 Hz;
 - b. 1×10^{-3} nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz [(średnia wartość kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz] w zakresie częstotliwości 1 Hz lub powyżej, ale nieprzekraczających 10 Hz; lub
 - c. 1×10^{-4} nT rms na pierwiastek kwadratowy Hz w zakresie częstotliwości powyżej 10 Hz;
5. „magnetometry” światłowodowe charakteryzujące się ‘czułością’ mniejszą (lepszą) niż 1 nT (średnia wartość kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

b. podwodne czujniki pola elektrycznego charakteryzujące się ‘czułością’ mniejszą (lepszą) niż 8 nanowoltów na metr na pierwiastek kwadratowy z Hz dla częstotliwości 1 Hz;

c. następujące „mierniki gradientu magnetycznego”:

1. „mierniki gradientu magnetycznego”, w których zastosowano pewną liczbę „magnetometrów” objętych kontrolą według pozycji 6A006.a;
2. światłowodowe „mierniki gradientu magnetycznego właściwego” charakteryzujące się ‘czułością’ gradientu pola magnetycznego mniejszą (lepszą) niż 0,3 nT/m (średnia wartość kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy Hz;

3. „mierniki gradientu magnetycznego właściwego”, w których zastosowano inną „technologię” niż światłowodowa, charakteryzujące się ‘czułością’ gradientu pola magnetycznego mniejszą (lepszą) niż 0,015 nT/m rms na pierwiastek kwadratowy Hz;
- d. „systemy kompensacji” do czujników magnetycznych lub podwodnych czujników pola elektrycznego o parametrach odpowiadających parametrom wymienionych w pozycjach 6A006.a, 6A006.b lub 6A006.c lub przewyższających je;

- e. podwodne odbiorniki elektromagnetyczne zawierające czujniki pola magnetycznego wyszczególnione w pozycji 6A006.a lub podwodne czujniki pola elektrycznego wyszczególnione w pozycji 6A006.b.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 6A006 'czułość' (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenia progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

6A007 Następujące grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 6A107.

- a. grawimetry zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do pomiarów naziemnych i mające dokładność statyczną poniżej (lepszą niż) 10 μ Gal;

Uwaga : Pozycja 6A007.a nie obejmuje kontrolą grawimetrów do pomiarów naziemnych z elementem kwarcowym (Wordena).

- b. grawimetry do stosowania na ruchomych platformach, spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. dokładność statyczna poniżej (lepszą niż) 0,7 mGal; oraz
 2. dokładność eksploatacyjna (robocza) poniżej (lepszą niż) 0,7 mGal przy 'czasie do ustalenia warunków rejestracji' poniżej 2 minut bez względu na sposób kompensacji oddziaływań ubocznych i wpływu ruchu;

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 6A007.b. 'czas do ustalenia warunków rejestracji' (nazywany również czasem reakcji grawimetru) oznacza czas w którym zredukowane zostają zakłócające skutki przyspieszeń wywołanych przez platformę (szum o wysokiej częstotliwości).

- c. mierniki gradientu pola grawitacyjnego.

6A008 Systemy, urządzenia i zespoły radarowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 6A108.

Uwaga: Pozycja 6A008 nie obejmuje kontrolą następujących obiektów:

-pomocniczych radarów kontroli rejonu (SSR),
 -cywilnych radarów samochodowych,
 -wyświetlaczy i monitorów stosowanych w kontroli ruchu powietrznego,
 -radarów meteorologicznych (do obserwacji pogody),
 -urządzeń radiolokacyjnych dokładnej kontroli podejścia do lądowania (PAR) odpowiadających standardom ICAO oraz wyposażonych w sterowalne układy liniowe (jednowymiarowe) lub ustawiane mechaniczne anteny pasywne.

- a. działające w zakresie częstotliwości od 40 GHz do 230 GHz i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. przeciętna moc wyjściowa powyżej 100 mW; lub
 2. dokładność namierzania o zakresie równym 1 m lub mniejszym (lepszym) lub o azymucie równym 0,2 stopnia lub mniejszym (lepszym);

- b. umożliwiające przestrajanie pasma częstotliwości w zakresie powyżej $\pm 6,25\%$ od 'środkowej częstotliwości roboczej';
- Uwaga techniczna:
'Środkowa częstotliwość robocza' równa się połowie sumy najwyższej i najniższej nominalnej częstotliwości roboczej.
- c. zdolne do równoczesnego działania na dwóch lub więcej częstotliwościach nośnych;
 - d. zdolne do działania w trybie z syntezą apertury (SAR), z odwróconą syntezą apertury (ISAR) lub jako radiolokatory pokładowe obserwacji bocznej (SLAR);
 - e. zaopatrzone w sterowany elektronicznie układ antenowy;
 - f. zdolne do określania wysokości niepowiązanych ze sobą celów;
 - g. specjalnie zaprojektowane dla lotnictwa (zainstalowane na balonach lub samolotach) i mające możliwość „przetwarzania sygnałów” dopplerowskich w celu wykrywania obiektów ruchomych;
 - h. zdolne do przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych i wykorzystujące którekolwiek z poniższych:
 1. techniki „rozproszonego widma radiolokacyjnego”; lub
 2. techniki „regulacji częstotliwości sygnałów radiolokacyjnych”;
 - i. zapewniające działania naziemne o maksymalnym „zasięgu roboczym” powyżej 185 km;

Uwaga: Pozycja 6A008.i nie obejmuje kontrolą:

- a. radarów kontroli łowisk rybackich;
 - b. radarowych instalacji naziemnych specjalnie zaprojektowanych do kierowania ruchem lotniczym i spełniających wszystkie poniższe kryteria:
 1. maksymalny „zasięg roboczy” nie większy niż 500 km;
 2. skonfigurowanych w taki sposób, że umożliwiają transmisję danych o celach radarowych tylko w jedną stronę, od miejsca zainstalowania radaru do jednego lub więcej cywilnych ośrodków ATC (kierowania ruchem lotniczym);
 3. niezawierających żadnych elementów umożliwiających zdalne sterowanie szybkością przeszukiwania radaru z ośrodka ATC; oraz
 4. zainstalowanych na stałe.
 - c. meteorologicznych, balonowych radiolokatorów śledzących;
- j. radary „laserowe” lub optyczne (LIDAR) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. są „klasy kosmicznej”;
 2. wykorzystujące koherentne heterodynowe lub homodynowe techniki wykrywania obiektów oraz posiadające rozdzielczość kątową niższą (lepszą niż) 20 μ rad (mikroradianów); lub
 3. przeznaczone do przeprowadzania z powietrza przybrzeżnych pomiarów batymetrycznych zgodnie ze standardem rzędu 1a Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (5. wydanie luty 2008 r.) dla pomiarów hydrograficznych lub lepszym, przy użyciu jednego lub kilku laserów o długości fali przekraczającej 400 nm, ale nieprzekraczającej 600 nm.

Uwaga 1: Urządzenia LIDAR specjalnie zaprojektowane do celów geodezyjnych są wyszczególnione wyłącznie w pozycji 6A008.j.3.

Uwaga 2: Pozycja 6A008.j nie obejmuje kontrolą urządzeń LIDAR specjalnie zaprojektowanych do obserwacji meteorologicznych.

Uwaga 3: Parametry standardu rzędu 1a Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej 5. wydanie luty 2008 r. są podsumowane następująco:
-dokładność pozioma określenia pozycji (na poziomie ufności 95 %) = 5 m + 5 % głębokości
-dokładność określenia głębokości zredukowanej (na poziomie ufności 95 %)

$$= \pm \sqrt{a^2 + (b*d)^2}, \text{ gdzie:}$$

$a = 0,5 \text{ m}$ = stały błąd głębokości,

tj. suma wszystkich stałych błędów głębokości

$b = 0,013$ = współczynnik błędu zależnego od głębokości

$b*d$ = błąd zależny od głębokości,

tj. suma wszystkich błędów zależnych od głębokości

d = głębokość

-wykrywanie obiektów = obiekty kubaturowe > 2 m na głębokości do 40 m;
10 % głębokości na głębokości przekraczającej 40 m.

- k. wyposażone w podukłady do „przetwarzania sygnałów” techniką „kompresji impulsów” i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. wskaźnik „kompresji impulsów” powyżej 150; lub
2. szerokość impulsu poniżej 200 ns; lub

Uwaga: Pozycja 6A008.k.2. nie obejmuje kontrolą dwuwymiarowych ‘radarów morskich’ ani radarów do ‘obsługi ruchu statków’ spełniających wszystkie poniższe kryteria;

- a. wskaźnik „kompresji impulsów” nieprzekraczający 150;
- b. szerokość impulsu powyżej 30 ns;
- c. pojedyncza i obrotowa mechanicznie sterowana antena radarowa;
- d. szczytowa moc wyjściowa nieprzekraczająca 250 W; oraz
- e. niezdolne do „rozrzucania częstotliwości”.

- l. wyposażone w podukłady do przetwarzania danych i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. „automatyczne śledzenie celu” zapewniające, przy dowolnym położeniu kątowym anteny, przewidzenie położenia celu w okresie pomiędzy kolejnymi przejściami wiązki radiolokacyjnej; lub

Uwaga : Pozycja 6A008.l.1 nie obejmuje kontrolą układów ostrzegających przed możliwością zderzenia, wchodzących w skład systemów kontroli ruchu powietrznego lub ‘radaru morskiego’.

2. nieużywane;
3. nieużywane;
4. skonfigurowane tak, aby zapewniać superpozycję (nakładanie) i korelację lub skalanie danych o celu w ciągu sześciu sekund z dwóch lub więcej „rozrzuconych geograficznie” czujników radarowych, aby dzięki temu połączonemu działaniu uzyskać wyniki lepsze niż z pojedynczego czujnika wyszczególnione w pozycji 6A008.f lub 6A008.i.

NB. Zob. także wykaz uzbrojenia.

Uwaga: Pozycja 6A008.l.4 nie obejmuje kontrolą systemów, urządzeń lub zespołów używanych do ‘obsługi ruchu statków’.

Uwagi techniczne:

1. Do celów pozycji 6A008 'radar morski' oznacza radar, który jest wykorzystywany przy nawigacji po morzach i wodach śródlądowych oraz w strefach przybrzeżnych.
2. Do celów pozycji 6A008 'obsługa ruchu statków' oznacza usługę monitorowania i kontroli podobną do kierowania ruchem lotniczym w przypadku statków powietrznych.

6A102 'Detektory' zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niż wyszczególnione w pozycji 6A002, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ochrony przed skutkami wybuchów jądrowych (np. impulsów elektromagnetycznych (EMP), promieniowania rentgenowskiego, kombinowanych efektów podmuchu i udaru termicznego) i znajdujące zastosowanie w „pociskach raketowych”, skonstruowane lub przystosowane w taki sposób, że są w stanie wytrzymać łączną dawkę promieniowania o wartości 5×10^5 radów (Si).

Uwaga techniczna:

W pozycji 6A102 przez pojęcie 'detektora' należy rozumieć urządzenie mechaniczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne, do automatycznej identyfikacji i rejestracji takich bodźców, jak zmiany warunków otoczenia, np. ciśnienie lub temperatura, sygnał elektryczny lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiału radioaktywnego. Obejmuje to urządzenia, które wykrywają bodziec poprzez jednorazowe zadziałanie lub uszkodzenie się.

- 6A107 Następujące grawimetry i podzespoły do mierników grawitacji i mierników gradientu pola grawitacyjnego:
- grawimetry inne niż wyszczególnione w pozycji 6A007.b, zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w lotnictwie lub w warunkach morskich, mające dokładność statyczną lub eksploatacyjną (roboczą) równą lub niższą (lepszą) niż 0,7 miligala (mGal), przy czasie do ustalenia warunków rejestracji równym lub krótszym od 2 minut;
 - specjalnie zaprojektowane podzespoły do grawimetrów wymienionych w pozycjach 6A007.b lub 6A107.a oraz do mierników gradientu pola grawitacyjnego wyszczególnionych w pozycji 6A007.c.
- 6A108 Następujące instalacje radarowe i śledzące, inne niż wyszczególnione w pozycji 6A008:
- instalacje radarowe lub laserowe zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;
- Uwaga: Pozycja 6A108.a obejmuje następujące obiekty:*
- urządzenia do wykonywania map konturowych terenu;*
 - urządzenia czujnikowe obrazów;*
 - urządzenia do wykonywania i korelacji obrazów terenu (analogowe i cyfrowe);*
 - urządzenia do radarowej nawigacji doplerowskiej.*
- następujące precyzyjne instalacje do śledzenia torów obiektów, znajdujące zastosowanie w 'pociskach rakietowych':
 - instalacje do śledzenia torów, wyposażone w translatory kodów współpracujące z instalacjami naziemnymi lub nadziemnymi lub satelitarnymi instalacjami nawigacyjnymi w celu pomiaru w czasie rzeczywistym położenia i prędkości obiektów w locie;
 - radary kontroli obszaru powietrznego współpracujące z instalacjami śledzenia obiektów w zakresie optycznym i podczerwonym, mające wszystkie wymienione poniżej cechy:
 - rozdzielczość kątową lepszą niż 1,5 miliradiana;
 - zasięg 30 km lub większy z rozdzielczością odległości lepszą niż 10 m (średnia kwadratowa);
 - dokładność ustalania prędkości lepszą niż 3 m/s.
- Uwaga techniczna:*
Termin 'pocisk rakiety' w pozycji 6A108.b oznacza kompletną instalację rakiety i systemy bezzalagowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km.
- 6A202 Lampy fotopowielaczowe mające wszystkie następujące cechy:
- powierzchnię fotokatody powyżej 20 cm²; oraz
 - czas narastania impulsu katody poniżej 1 ns.

NB. 1: „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania wydajności kamery lub urządzenia obrazowego, tak by odpowiadały cechom pozycji 6A203.a., 6A203.b. lub 6A203.c. jest wymienione w pozycji 3D203.

NB. 2: „Technologia” w postaci kodów lub kluczy, służąca do poprawy lub wykorzystania wydajności kamery lub urządzenia obrazowego, tak by odpowiadały cechom pozycji 6A203.a., 6A203.b. lub 6A203.c. jest wymieniona w pozycji 3E203.

Uwaga: Pozycje 6A203.a. do 6A203.c. nie obejmują kontrolą kamery lub urządzeń obrazowych, jeśli posiadają osprzęt, „oprogramowanie” lub „technologię”, których pewne cechy ograniczają skuteczność bądź wydajność do poziomu niższego niż określony powyżej, pod warunkiem, że spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. w celu dokonania w nich ulepszeń lub zmniejszenia ograniczeń muszą zostać odesłane do pierwotnego producenta;
2. w celu poprawy lub wykorzystania wydajności, pozwalających na spełnienie wymogów wymienionych w pozycji 6D203 wymagają „oprogramowania” określonego w pozycji 6A203; lub
3. w celu poprawy lub wykorzystania wydajności, pozwalających na spełnienie wymogów wymienionych w pozycji 6E203 wymagają „technologii” w postaci kluczy lub kodów określonej w pozycji 6A203;

a. następujące kamery smugowe i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1. kamery smugowe z prędkościami zapisu powyżej 0,5 mm na mikrosekundę;
2. elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczości czasowej 50 ns lub mniejszej;
3. lampy smugowe do kamer wyszczególnionych w poz. 6A203.a.2;
4. zespoły wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujących, które mają strukturę modułową i które pozwalają na osiągnięcie parametrów wymienionych w pozycjach 6A203.a.1. lub 6A203.a.2.;
5. elektroniczne elementy synchronizujące oraz specjalne zespoły wirników składające się z turbin, zwierciadeł i łożysk specjalnie zaprojektowane do stosowania w kamerach wymienionych w pozycji 6A203.a.1.;

b. następujące kamery obrazowe i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1. kamery filmowe z kadrowaniem z szybkością powyżej 225 000 klatek zdjęciowych na sekundę;
2. kamery obrazowe o czasie naświetlania 50 ns lub krótszym;
3. lampy obrazowe oraz półprzewodnikowe urządzenia obrazowe o czasie bramkowania szybkich obrazów (czasie działania migawki) wynoszącym 50 ns lub mniej, specjalnie zaprojektowane do kamer wyszczególnionych w pozycji 6A203.b.1 lub 6A203.b.2.;
4. zespoły wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer obrazowych, które mają strukturę modułową i które pozwalają na osiągnięcie parametrów wymienionych w pozycjach 6A203.b.1. lub 6A203.b.2.;
5. elektroniczne elementy synchronizujące oraz specjalne zespoły wirników składające się z turbin, zwierciadeł i łożysk specjalnie zaprojektowane do stosowania w kamerach wymienionych w pozycji 6A203.b.1 lub 6A203.b.2.;

Uwaga techniczna:

W pozycji 6A203.b. szybkie kamery jednoklatkowe mogą być używane samodzielnie do wytworzenia pojedynczego obrazu dynamicznego zdarzenia lub kilka takich kamer może być łączone w sekwencyjnie uruchamiany układ w celu wytworzenia szeregu obrazów zdarzenia.

6A203 c.d.

- c. następujące kamery półprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:
 - 1. kamery półprzewodnikowe lub z lampami elektronowymi o czasie bramkowania szybkich obrazów (czasie działania migawki) wynoszącym 50 ns lub mniej;
 - 2. półprzewodnikowe urządzenia obrazowe i lampowe wzmacniacze obrazu o czasie bramkowania szybkich obrazów (czasie działania migawki) wynoszącym 50 ns lub mniej specjalnie zaprojektowane do kamer wymienionych w pozycji 6A203.c.1.;
 - 3. migawki elektrooptyczne z fotokomórkami działającymi na zasadzie efektu Kerra lub Pockela o czasie bramkowania szybkich obrazów (czasie działania migawki) wynoszącym 50 ns lub mniej;
 - 4. zespoły wtykane specjalnie zaprojektowane do kamer, które mają strukturę modułową i które pozwalają na osiągnięcie parametrów wymienionych w pozycjach 6A203.c.1.
- d. kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem oraz soczewki do nich, skonstruowane lub przystosowane w taki sposób, że są w stanie wytrzymać promieniowanie o natężeniu powyżej 50×10^3 Gy (Si) [5×10^6 rad (Si)] bez pogorszenia własności eksploatacyjnych, oraz specjalnie do nich zaprojektowane soczewki.

Uwaga techniczna:

Termin Gy (Si) odnosi się do energii w dżulach na kilogram pochłoniętej przez nieekranowaną próbkę krzemu poddaną promieniowaniu jonizującemu.

6A205 Następujące „lasery”, wzmacniacze „laserowe” i oscylatory, inne niż wymienione w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 i 6A005:

NB.: *W odniesieniu do laserów na parach miedzi zob. pozycja 6A005.b.*

- a. lasery na jonach argonu mające obydwie wymienione poniżej cechy:
 - 1. pracujące w przedziale długości fal od 400 nm do 515 nm; oraz
 - 2. przeciętną moc wyjściową powyżej 40 W;
- b. przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujące w trybie pojedynczym, mające wszystkie następujące cechy:
 - 1. pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;
 - 2. przeciętną moc wyjściową powyżej 1 W;
 - 3. częstotliwości powtarzania powyżej 1 kHz; oraz
 - 4. impuls o szerokości poniżej 100 ns;
- c. przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, mające wszystkie następujące cechy:
 - 1. pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;
 - 2. przeciętną moc wyjściową powyżej 30 W;
 - 3. częstotliwości powtarzania powyżej 1 kHz; oraz
 - 4. impuls o szerokości poniżej 100 ns;

Uwaga : *Pozycja 6A205.c nie obejmuje kontrolą oscylatorów pracujących w trybie pojedynczym.*

- d. impulsowe „lasery” na dwutlenku węgla, mające wszystkie następujące cechy:
 - 1. pracujące w przedziale długości fal od 9 000 nm do 11 000 nm;

2. częstotliwości powtarzania powyżej 250 Hz;
 3. przeciętnej mocy wyjściowej powyżej 500 W; oraz
 4. szerokości impulsu poniżej 200 ns;
- e. przekształtniki na parawodorze działające w paśmie Ramana, przeznaczone do pracy na fali o długości 16 μm z częstotliwością powtarzania powyżej 250 Hz;

6A205

c.d.

- f. „lasery” domieszkowane neodymem (inne niż na szkłe), o wyjściowej długości fali powyżej 1 000 nm i poniżej 1 100 nm, mające którykolwiek z poniższych parametrów:
1. wzbudzane impulsowo i modulowane dobrocią o czasie trwania impulsu równym lub większym niż 1 ns, mające którykolwiek z poniższych parametrów:
 - a. wyjście w trybie jednokrotnego przejścia poprzecznego ze średnią mocą wyjściową ponad 40 W; lub
 - b. wyjście w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego ze średnią mocą wyjściową ponad 50 W; lub
 2. zawierające podwojenie częstotliwości, aby otrzymać wyjściową długość fali powyżej 500 nm i poniżej 550 nm, z przeciętną mocą wyjściową ponad 40 W.
- g. impulsowe „lasery” na tlenku węgla inne niż wymienione w poz. 6A005.d.2. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
1. pracujące w przedziale długości fal od 5 000 nm do 6 000 nm;
 2. częstotliwości powtarzania powyżej 250 Hz;
 3. przeciętnej mocy wyjściowej powyżej 200 W; oraz
 4. szerokości impulsu poniżej 200 ns;

6A225

Interferometry do pomiaru prędkości w zakresie powyżej 1 km/s w odstępach czasowych poniżej 10 mikrosekund.

Uwaga: Pozycja 6A225 obejmuje interferometry do pomiaru prędkości, takie jak VISAR (interferometr do punktowego pomiaru prędkości powierzchni dowolnego rodzaju), DLI (interferometr laserowy) i PDV (urządzenia do pomiaru prędkości dźwięku w powietrzu na podstawie efektu Dopplera).

6A226

Następujące czujniki ciśnienia:

- a. Manometry wstrząsowe zdolne do mierzenia ciśnienia powyżej 10 GPa, w tym przyrządy pomiarowe wykonane z wykorzystaniem manganu, iterbu oraz polifluorku winylenu (PVBF, PVF2);
- b. kwarcowe przetworniki ciśnień do pomiarów ciśnień powyżej 10 GPa.

6B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

6B004 następujące urządzenia optyczne:

- a. urządzenia do pomiaru absolutnego współczynnika odbicia z dokładnością $\pm 0,1 \%$ wartości odbicia;
- b. urządzenia różne od optycznych urządzeń do pomiaru rozpraszania powierzchni, mające nieprzysłoniętą aperturę o wielkości powyżej 10 cm, specjalnie zaprojektowane do bezstykowych pomiarów optycznych figur o przestrzennych (nieplanarnych) powierzchniach optycznych (profilu) z „dokładnością” 2 nm lub większą (lepszą) na danym profilu.

Uwaga: Pozycja 6B004 nie obejmuje kontrolą mikroskopów.

6B007 Urządzenia do produkcji, strojenia i wzorcowania grawimetrów lądowych o dokładności statycznej lepszej niż 0,1 mGal.

6B008 Systemy do impulsowych pomiarów radarowego przekroju czynnego o szerokościach impulsu przesyłowego 100 ns lub mniejszych oraz specjalnie dla nich przeznaczone elementy.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 6A108.

6B108 Systemy specjalnie zaprojektowane do pomiarów radarowego przekroju czynnego znajdujące zastosowanie w ‘pociskach rakietowych’ i ich podzespołach, inne niż wyszczególnione w pozycji 6B008.

Uwaga techniczna:

W pozycji 6B108 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

6C**Materiały**

6C002

Następujące materiały do czujników optycznych:

- a. tellur pierwiastkowy (Te) o poziomie czystości równym lub wyższym niż 99,9995 %;
- b. pojedyncze kryształy którekolwiek z poniższych (łącznie z epitaksjalnymi płytkami);
 1. tellurku kadmu i cynku (kadmowo-cynkowego) (CdZnTe), o zawartości cynku mniej niż 6 % w 'ułamku molowym';
 2. tellurku kadmu (CdTe) o dowolnym poziomie czystości; lub
 3. tellurku kadmu i rtęci (kadmowo-rtęciowego) (HgCdTe) o dowolnym poziomie czystości.

*Uwaga techniczna:**'Ułamek molowy' definiowany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujących się w kryształach.*

6C004

Następujące materiały optyczne:

- a. „półprodukty podłoży” z selenku cynku (ZnSe) i siarczku cynku (ZnS) wytwarzane techniką osadzania z par lotnych i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. objętość powyżej 100 cm³; lub
 2. średnica większa niż 80 mm i grubość równa 20 mm lub większa;
- b. Następujące materiały elektrooptyczne i nieliniowe materiały optyczne:
 1. arsenian potasu i tytanu (potasowo-tytanylowy) (KTA) (CAS 59400-80-5);
 2. selenek srebra i galu (srebrowo-galowy) (AgGaSe₂, znany również pod nazwą AGSE) (CAS 12002-67-4);
 3. selenek talu i arsenu (talowo-arsenowy) (Tl₃AsSe₃, znany również pod nazwą TAS) (CAS 16142-89-5);
 4. fosforek cynku i germanu (ZnGeP₂, znany również jako ZGP); lub
 5. selenek galu (srebrowo-galowy) (GaSe) (CAS 12024-11-2);
- c. Nieliniowe materiały optyczne, inne niż wyszczególnione w pozycji 6C004.b., spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 - a. Dynamiczna (zwana również niestacjonarną) nieliniowa wrażliwość trzeciego rzędu ($\chi^{(3)}$, chi 3) równa 10⁻⁶ m²/V² lub lepsza; oraz
 - b. czas reakcji poniżej 1 ms; lub
 2. Nieliniowa wrażliwość drugiego rzędu ($\chi^{(2)}$, chi 2) równa 3,3×10⁻¹¹ m/V lub lepsza;
- d. „półprodukty podłoży” z osadzonym węglikiem krzemu lub beryl-beryl (Be/Be) o średnicy lub długości osi głównej powyżej 300 mm;
- e. szkło, łącznie ze stopioną krzemionką, szkło fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku cyrkonu (ZrF₄) (CAS 7783-64-4) i fluorku hafnu (HfF₄) (CAS 13709-52-9) spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. stężenie jonów hydroksylowych (OH-) poniżej 5 ppm;
 2. zawartość wtrąceń metalicznych poniżej 1 ppm; oraz
 3. wysoka jednorodność (wahania współczynnika załamania światła) poniżej 5 × 10⁻⁶;
- f. wytwarzany syntetycznie materiał diamentowy o współczynniku pochłaniania poniżej 10⁻⁵ cm⁻¹ dla fal o długościach powyżej 200 nm, ale nie dłuższych niż 14000 nm.

- 6C005 Następujące półprodukty do „laserów” na kryształach syntetycznych:
- a. szafir domieszkowany tytanem;
 - b. nieużywane.

6D Oprogramowanie

6D001 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 6A004, 6A005, 6A008 lub 6B008.

6D002 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 6A002.b lub 6A008, lub 6B008.

6D003 następujące inne „oprogramowanie”:

a. Następujące „oprogramowanie”:

1. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do kształtowania wiązek akustycznych do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzących z pasywnego odbioru za pomocą holowanego zespołu hydrofonów;
2. „kod źródłowy” do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzących z pasywnego odbioru za pomocą holowanego zespołu hydrofonów;
3. „oprogramowanie” specjalnie opracowane do formowania wiązek akustycznych do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych w celu biernej detekcji za pomocą dennych lub międzywřęgowych układów kablowych;
4. „kod źródłowy” do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych dla biernej detekcji dla dennych lub międzywřęgowych układów kablowych;
5. „oprogramowanie” lub „kod źródłowy” specjalnie zaprojektowane do wszystkich poniższych celów:
 - a. „przetwarzanie w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzących z systemów sonarowych wyszczególnionych w poz. 6A001.a.1.e; oraz
 - b. automatyczne wykrywanie, klasyfikacja i ustalanie położenia nurków lub pływaków;

NB.: Systemy wykrywania nurków specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych – zob. wykaz uzbrojenia.

b. nieużywane;

c. „oprogramowanie” zaprojektowane lub zmodyfikowane dla kamer zawierających zaprojektowaną „matrycę detektorowe płaszczyzny ogniskowej” wyszczególnione w pozycji 6A002.a.3.f i zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by znieść ograniczenie szybkości analizy obrazów i zezwolić kamerze na przekroczenie szybkości analizy obrazów wyszczególnione w pozycji 6A003.b.4. Uwaga 3.a.

d. nieużywane;

e. nieużywane;

f. Następujące „oprogramowanie”:

1. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „systemów kompensacji” pola magnetycznego i elektrycznego do czujników magnetycznych przeznaczonych do pracy na ruchomych platformach;

2. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do wykrywania anomalii pola magnetycznego i elektrycznego na ruchomych platformach;
3. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych elektromagnetycznych z wykorzystaniem podwodnych odbiorników elektromagnetycznych wyszczególnionych w pozycji 6A006.e;
4. „kod źródłowy” do „przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych elektromagnetycznych z wykorzystaniem podwodnych odbiorników elektromagnetycznych wyszczególnionych w pozycji 6A006.e;

- g. „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do korygowania wpływu oddziaływań związanych z ruchem na grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego;
- h. Następujące „oprogramowanie”:
 - 1. „programy” aplikacyjne „oprogramowania” do kontroli ruchu powietrznego (ATC) zaprojektowane do zainstalowania na komputerach ogólnego przeznaczenia w centrach kontroli ruchu powietrznego, umożliwiające przyjmowanie danych radiolokacyjnych o obiektach z więcej niż czterech radarów pierwotnych;
 - 2. „oprogramowanie” do projektowania lub „produkcji” kopuł anten radiolokatorów i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. specjalnie zaprojektowane do ochrony „sterowanych elektronicznie fazowanych układów antenowych” wyszczególnionych w pozycji 6A008.e; oraz
 - b. wpływające na charakterystykę promieniowania anteny, mając ‘przeciętny poziom listków bocznych’ większy niż 40 dB poniżej wartości szczytowych wiązki głównej.

Uwaga techniczna:

‘Przeciętny poziom listków bocznych’ w pozycji 6D003.h.2.b mierzony jest dla całego układu, pomijając rozpiętość kątową wiązki głównej i pierwsze dwa listki boczne z każdej strony.

- 6D102 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” „wyrobów” wyszczególnionych w pozycji 6A108.
- 6D103 „Oprogramowanie” do obróbki (po zakończeniu lotu) danych zebranych podczas lotu, umożliwiające określenie położenia pojazdu w każdym punkcie toru jego lotu, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ‘pocisków raketowych’.

Uwaga techniczna:

‘Pocisk raketowy’ w pozycji 6D103 odnosi się do kompletnych systemów raketowych i bezałogowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km.
- 6D203 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu poprawy lub wykorzystania wydajności kamer lub urządzeń obrazowych, tak by odpowiadały cechom pozycji 6A203.a. do 6A203.c.

6E Technologia

6E001 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” urządzeń, materiałów lub „oprogramowania” objętych kontrolą według pozycji 6A, 6B, 6C lub 6D.

6E002 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” urządzeń lub materiałów objętych kontrolą według pozycji 6A, 6B lub 6C.

6E003 Inne „technologie”, takie jak:

a. Następujące „technologie”:

1. „technologie” wytwarzania i obróbki powłok na powierzchniach optycznych „niezbędne” do osiągnięcia ‘grubości optycznej’ o jednorodności 99,5 % lub lepszej na powłokach optycznych o średnicy lub długości osi głównej wynoszącej 500 mm lub więcej i całkowitego współczynnika strat (pochląpanie i rozpraszanie) poniżej 5×10^{-3} ;

NB.: Zob. także pozycja 2E003.f.

Uwaga techniczna:

‘Grubość optyczna’ jest iloczynem wskaźnika refrakcji i fizycznej grubości powłoki.

2. „technologie” wytwarzania elementów optycznych wykorzystujące jednoostrzowe techniki diamentowania, umożliwiające wygładzanie powierzchni z dokładnością lepszą niż 10 nm (wartość średnia kwadratowa) na powierzchniach nie płaskich o polu powyżej $0,5 \text{ m}^2$;

- b. „technologie” „niezbędne” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” specjalnie zaprojektowanych instrumentów diagnostycznych lub obiektów w urządzeniach testujących specjalnie zaprojektowanych do testowania instalacji „urządzeń laserowych bardzo wysokiej mocy” (SHPL) lub testowania lub oceny materiałów napromienionych wiązką z tych systemów.

6E101 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” urządzeń lub „oprogramowania” objętych kontrolą według pozycji 6A002, 6A007.b i c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 lub 6D103.

Uwaga: Pozycja 6E101 obejmuje wyłącznie „technologie” do urządzeń wyszczególnionych w pozycji 6A008 w razie jej przeznaczenia do stosowania w lotnictwie i możliwości zastosowania w „pociskach rakietowych”.

6E201 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” urządzeń wymienionych w pozycjach 6A003, 6A005.a.2, 6A005.b.2, 6A005.b.3, 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2, 6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 lub 6A226.

6E203 „Technologia” w postaci kodów lub kluczy, służąca do poprawy lub wykorzystania wydajności kamer lub urządzeń obrazowych, tak by odpowiadały cechom pozycji 6A203.a. do 6A203.c.

KATEGORIA 7 - NAWIGACJA I AWIONIKA

7 A Systemy, urządzenia i części składowe

NB.: W przypadku automatycznych pilotów do pływających jednostek podwodnych zob. także kategorię 8. W przypadku radarów zob. także kategorię 6.

7A001 Następujące akcelerometry i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoły:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 7A101.

NB.: Akcelerometry kątowe lub obrotowe – zob. pozycja 7A001.b.

- a. akcelerometry liniowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. przeznaczone do działania w warunkach przyspieszeń liniowych mniejszych niż lub równych 15 g i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „stabilność” „wychylenia wstępnego” poniżej (lepszą niż) 130 mikro g względem ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku; lub
 - b. „stabilność” „współczynnika skalowania” poniżej (lepszą niż) 130 ppm względem ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku;
 2. przeznaczone do działania w warunkach przyspieszeń liniowych o wartościach na poziomie wyższym niż 15 g, ale mniejszym niż lub równym 100 g i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. „stabilność” „wychylenia wstępnego” poniżej (lepszą niż) 1 250 mikro g względem ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku; oraz
 - b. „stabilność” „współczynnika skalowania” poniżej (lepszą niż) 1 250 ppm względem ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku; lub
 3. zaprojektowane do użytkowania w inercyjnych systemach nawigacji lub naprowadzania i przeznaczone do działania w warunkach przyspieszeń liniowych o wartościach na poziomie wyższym niż 100 g;
- Uwaga: Pozycje 7A001.a.1 i 7A001.a.2 nie obejmują kontrolą akcelerometrów ograniczonych do pomiarów wyłącznie wibracji lub wstrząsów.
- b. akcelerometry kątowe lub obrotowe przeznaczone do działania w warunkach przyspieszeń liniowych o wartościach na poziomie wyższym niż 100 g.

7A002 Żyroskopy lub czujniki prędkości kątowej spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 7A102.

NB.: Akcelerometry kątowe lub obrotowe – zob. pozycja 7A001.b.

- a. przeznaczone do działania w warunkach przyspieszeń liniowych mniejszych niż lub równych 100 g i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. zakres pomiaru mniejszy niż 500 stopni na sekundę i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „stabilność” „wychylenia wstępnego” wynosząca mniej (lepiej) niż 0,5° na godzinę mierzona w warunkach przyspieszenia równego 1 g w okresie jednego miesiąca i w odniesieniu do ustalonej wartości wzorcowej; lub
 - b. „kąt błędzenia losowego” mniejszy (lepsy) lub równy 0,0035° na pierwiastek kwadratowy godziny; lub

Uwaga: Pozycja 7A002.a.1.b nie obejmuje kontrolą „żyroskopów wirujących”.

2. zakres pomiaru większy lub równy 500° na sekundę i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. „stabilność” „wychylenia wstępnego” wynoszącą poniżej (lepiej niż) 4° na godzinę, mierzoną w warunkach przyspieszenia równego 1 g w okresie 3 minut i w odniesieniu do ustalonej wartości wzorcowej; lub
 - b. „kąt błędzenia losowego” mniejszy (lepiej) lub równy $0,1^\circ$ na pierwiastek kwadratowy godziny; lub

Uwaga: Pozycja 7A002.a.2.b nie obejmuje kontrolą „żyroskopów wirujących”.

- b. przeznaczenie do działania w warunkach przyspieszeń liniowych o wartościach na poziomie powyżej 100 g.

7A003 ‘Inercyjne urządzenia lub systemy pomiarowe’ spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 7A103.

Uwaga 1: ‘Inercyjne urządzenia lub systemy pomiarowe’ obejmują akcelerometry lub żyroskopy do mierzenia zmian prędkości i orientacji, które po ustawieniu nie wymagają zewnętrznych punktów odniesienia do określenia lub utrzymania kierunku lub pozycji.

‘Inercyjne urządzenia lub systemy pomiarowe’ obejmują:

- systemy odniesienia położenia i kursu (AHRS);
- kompasy żyroskopowe;
- inercyjne jednostki pomiarowe (IMU);
- inercyjne systemy nawigacyjne (INS);
- inercyjne systemy odniesienia (IRS);
- inercyjne jednostki odniesienia (IRS);

Uwaga 2: Pozycja 7A003 nie obejmuje kontrolą ‘inercyjnych urządzeń lub systemów pomiarowych’ certyfikowanych do stosowania w „cywilnych statkach powietrznych” przez władze cywilne „państwa uczestniczącego”.

Uwagi techniczne:

1. ‘Urządzenia wspierające służące określaniu pozycji’ niezależnie określają pozycję i obejmują:
 - a. globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS);
 - b. nawigacja oparta na informacjach z bazy danych (DBRN).
2. ‘Krąg równego prawdopodobieństwa’ (‘CEP’) – w kołowym rozkładzie normalnym, promień okręgu zawierającego 50 % poszczególnych wyników pomiarów lub promień okręgu, w którym występuje 50 % prawdopodobieństwo, że obiekt zostanie zlokalizowany.
 - a. zaprojektowane do „statków powietrznych”, pojazdów lądowych i statków, określające pozycję bez wykorzystywania ‘urządzeń wspierających służących określaniu pozycji’, o następującej dokładności pozycjonowania będącej wynikiem normalnego ustawienia:
 1. ‘krąg równego prawdopodobieństwa’ (‘CEP’) wynoszący 0,8 mili morskiej na godzinę (nm/hr) lub mniej (lepiej);
 2. ‘krąg równego prawdopodobieństwa’ (‘CEP’) wynoszący 0,5 % przebytego dystansu lub mniej (lepiej); lub
 3. łączny dryf o wartości ‘kręgu równego prawdopodobieństwa’ (‘CEP’) wynoszącego 1 milę morską lub mniej (lepiej) w okresie 24 godzin;

Uwaga techniczna:

Parametry określone w pozycjach 7A003.a.1., 7A003.a.2. i 7A003.a.3. zazwyczaj stosują się do 'inercyjnych urządzeń lub systemów pomiarowych' zaprojektowanych odpowiednio do „statków powietrznych”, pojazdów i statków. Parametry te są wynikiem wykorzystywania specjalistycznych urządzeń wspierających niesłużących określaniu pozycji (np. wysokościomierza, hodometru, prędkościomierza). Co za tym idzie, podanych wartości nie można dowolnie konwertować między tymi parametrami. Urządzenia zaprojektowane dla różnych platform są oceniane w odniesieniu do każdej mającej zastosowanie pozycji 7A003.a.1., 7A003.a.2., lub 7A003.a.3.

- b. zaprojektowane do „statków powietrznych”, pojazdów lądowych lub statków, z wbudowanym 'urządzeniem wspierającym służącym określaniu pozycji' i wskazujące pozycję po utracie wszystkich 'urządzeń wspierających służących określaniu pozycji' przez okres do 4 minut, o dokładności mniejszej (lepszej) niż 'krąg równego prawdopodobieństwa' ('CEP') wynoszący 10 metrów;

Uwaga techniczna:

Pozycja 7A003.b odnosi się do systemów, w których 'inercyjne systemy lub urządzenia pomiarowe' i inne niezależne 'urządzenia wspierające służące określaniu pozycji' są wbudowane w jeden zespół w celu uzyskania poprawy parametrów.

- c. zaprojektowane do „statków powietrznych”, pojazdów lądowych lub statków, pozwalające określić kierunek lub północ geograficzną i posiadające którąkolwiek z następujących cech:
1. Maksymalna robocza prędkość kątowna mniejsza (niższa) niż 500 deg/s, a dokładność kierunku bez stosowania 'urządzeń wspierających służących określaniu pozycji' równa lub mniejsza (lepsza) niż 0,07 deg sec(Lat) (odpowiednik 6 minut kątowych na 45 stopniach szerokości geograficznej); lub
 2. Maksymalna robocza prędkość kątowna równa lub większa (wyższa) niż 500 deg/s, a dokładność kierunku bez stosowania 'urządzeń wspierających służących określaniu pozycji' równa lub mniejsza (lepsza) niż 0,2 deg sec(Lat) (odpowiednik 17 minut kątowych na 45 stopniach szerokości geograficznej); lub
- d. wykonujące pomiary przyspieszenia lub pomiary prędkości kątowej, w więcej niż jednym wymiarze, i posiadające którąkolwiek z następujących cech:
1. parametry określone w pozycji 7A001 lub 7A002 wzdłuż dowolnej osi, bez użycia żadnych urządzeń wspierających; lub
 2. są klasy kosmicznej i wykonują pomiary prędkości kątowej, w których „kąt błędzenia losowego” wzdłuż dowolnej osi jest mniejszy (lepszy) lub równy $0,1^\circ$ na pierwiastek kwadratowy godziny.

Uwaga: Pozycja 7A003.d.2. nie obejmuje kontrolą 'inercyjnych urządzeń lub systemów pomiarowych', w których „żyroskop wirujący” jest jedynym rodzajem żyroskopu.

7A004 Następujące 'szukacze gwiazd' i ich elementy:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 7A104.

- a. 'szukacze gwiazd' o określonej dokładności pomiaru azymutu równej lub mniejszej (lepszej) niż 20 sekund łuku przez określony czas użytkowania urządzeń;
- b. Następujące elementy specjalnie zaprojektowane do urządzeń wymienionych w pozycji 7A004.a.:
 1. optyczne głowice lub przegrody;
 2. jednostki przetwarzania danych.

Uwaga techniczna:

'Szukacze gwiazd' nazywane są również czujnikami kierowania gwiazdnego lub żyro-astrokompasami.

- 7A005 Urządzenia odbiorcze globalnych satelitarnych systemów nawigacji (GNSS) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 7A105.
- NB.: W przypadku urządzeń zaprojektowanych specjalnie do zastosowań wojskowych zob. wykaz uzbrojenia.
- wyposażenie w algorytm deszyfrujący specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do wykorzystania przez służby rządowe w celu uzyskania dostępu do ciągów rozpraszających pozwalających określić pozycję i czas; lub
 - wyposażenie w ‘systemy anten adaptacyjnych’.
- Uwaga: Pozycja 7A005.b nie obejmuje kontrolą urządzeń odbiorczych GNSS wyposażonych wyłącznie w elementy służące filtrowaniu, przełączaniu lub łączeniu sygnałów z wielu anten dookólnych, w których nie zastosowano technik anten adaptacyjnych.
- Uwaga techniczna:
Do celów poz. 7A005.b ‘systemy anten adaptacyjnych’ dynamicznie wytwarzają jedną przestrzenną wartość zerową lub większą ich liczbę w szyku antenowym przez przetwarzanie sygnału w domenę czasu lub częstotliwości.
- 7A006 Wysokościomierze lotnicze działające poza pasmem częstotliwości od 4,2 do 4,4 GHz łącznie i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 7A106.
- „sterowanie mocą”; lub
 - wyposażenie w zespoły do modulacji z przesunięciem fazy.
- 7A008 Systemy sonarowe do nawigacji podwodnej, posługujące się logami dopplerowskimi lub logami korelacyjnymi zintegrowane z czujnikiem kierunku i mające dokładność pozycjonowania równą lub mniejszą (lepszą) niż 3 % przebytej odległości ‘kręgu równego prawdopodobieństwa’ (‘CEP’) oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.
- Uwaga: Pozycja 7A008 nie obejmuje kontrolą systemów specjalnie zaprojektowanych do zainstalowania na statkach nawodnych lub systemów wymagających pław lub boi akustycznych do dostarczania danych pozycyjnych.
- NB.: Zob. pozycja 6A001.a dla systemów akustycznych oraz pozycja 6A001.b dla urządzeń sonarowych z logami korelacyjnymi i logami dopplerowskimi.
Zob. pozycja 8A002 dla innych systemów okrętowych.
- 7A101 Akcelerometry liniowe, inne niż wyszczególnione w pozycji 7A001, zaprojektowane do stosowania w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach naprowadzania nadających się do zastosowania w ‘pociskach rakietowych’, mające wszystkie z poniższych cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane zespoły:
- „powtarzalność” „wychylenia wstępnego” mniejsza (lepszą) niż 1 250 µg; oraz
 - „powtarzalność” „współczynnika skalowania” mniejsza (lepszą) niż 1 250 ppm.
- Uwaga: Pozycja 7A101 nie obejmuje kontrolą akcelerometrów specjalnie zaprojektowanych i opracowanych jako czujniki MWD (Measurement While Drilling – pomiar podczas wiercenia) stosowanych podczas prac wiertniczych.
- Uwagi techniczne:

1. *W pozycji 7A101 'pocisk raketowy' oznacza kompletne systemy raketowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych, zdolnych do pokonania odległości przekraczającej 300 km.*
2. *W pozycji 7A101 pomiar „wychylenia wstępnego” i „współczynnika skalowania” odnosi się do odchylenia standardowego wielkości 1 sigma w odniesieniu do ustalonej wartości wzorcowej w okresie jednego roku.*

7A102 Wszystkie typy żyroskopów, inne niż wyszczególnione w pozycji 7A002, nadające się do stosowania w ‘pociskach rakietowych’, o ‘stabilności’ „współczynnika dryftu” poniżej 0,5° (1 sigma lub średnia kwadratowa) na godzinę w warunkach przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 7A102 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych, zdolnych do pokonania odległości przekraczającej 300 km.
2. W pozycji 7A102 ‘stabilność’ jest zdefiniowana jako miara zdolności określonego mechanizmu lub współczynnika osiągu, która pozostaje niezmienna w stałym warunku roboczym (IEEE STD 528-2001 ust. 2 247).

7A103 Następujące instrumenty, urządzenia i systemy nawigacyjne, inne niż wyszczególnione w pozycji 7A003, oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:

- a. urządzenia inercyjne lub inne, w których zastosowano poniższe akcelerometry lub żyroskopy, oraz systemy, w których znajdują się urządzenia tego typu:
 1. akcelerometry wymienione w pozycjach 7A001.a.3, 7A001.b, 7A101 lub żyroskopy wymienione w pozycjach 7A002, 7A102; lub
 2. akcelerometry wymienione w pozycjach 7A001.a.1. lub 7A001.a.2., zaprojektowane do wykorzystania w inercyjnych systemach nawigacyjnych lub w dowolnego typu systemach naprowadzania nadających się do zastosowania w ‘pociskach rakietowych’;

Uwaga: Pozycja 7A103.a nie dotyczy urządzeń zawierających akcelerometry wyspecyfikowane w pozycji 7A001 oraz zaprojektowane i opracowane jako czujniki MWD (Measurement While Drilling – pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.

- b. zintegrowane systemy samolotowych przyrządów pokładowych zawierające stabilizatory żyroskopowe lub automatycznego pilota, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w ‘pociskach rakietowych’;
- c. ‘zintegrowane systemy nawigacyjne’ zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowania w ‘pociskach rakietowych’ i zdolne do zapewniania dokładności nawigacyjnej dla kręgu równego prawdopodobieństwa (CEP) wynoszącej 200 m lub mniej;

Uwaga techniczna:

W skład ‘zintegrowanego systemu nawigacyjnego’ zazwyczaj wchodzi następujące elementy składowe:

1. inercyjne urządzenie pomiarowe (np. system wyznaczania położenia i kursu, inercyjny zespół odniesienia lub inercyjny system nawigacyjny);
 2. jeden lub więcej czujników zewnętrznych używanych do aktualizowania położenia i/lub prędkości, albo okresowo lub w sposób ciągły w trakcie lotu (np. satelitarny odbiornik nawigacyjny, wysokościomierze radarowy lub radar dopplerowski); oraz
 3. sprzęt i oprogramowanie scalające.
- d. trójosiowe magnetyczne czujniki kursowe, zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu ich zintegrowania z systemami sterowania lotem i systemami nawigacji, innymi niż wymienione w pozycji 6A006, mające wszystkie poniższe cechy charakterystyczne, oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:
 1. wewnętrzna kompensacja nachylenia wzdłuż osi poprzecznej (+/- 90 stopni) i osi podłużnej (+/- 180 stopni);

2. zdolność do zapewnienia dokładności azymutowej lepszej (mniejszej) niż 0,5 stopni rms na szerokości +/- 80 stopni w odniesieniu do lokalnego pola magnetycznego.

Uwaga: Systemy sterowania lotem i systemy nawigacji w pozycji 7A103.d obejmują stabilizatory żyroskopowe, automatycznego pilota oraz inercyjne systemy nawigacji.

Uwaga techniczna:

W pozycji 7A103 'pocisk raketowy' oznacza kompletne systemy raketowe oraz systemy bezzałogowych statków powietrznych, zdolnych do pokonania odległości przekraczającej 300 km.

- 7A104 Żyro-astrokompasy i inne urządzenia, inne niż wyszczególnione w pozycji 7A004, umożliwiające określanie położenia lub orientację przestrzenną za pomocą automatycznego śledzenia ciał niebieskich lub satelitów oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.
- 7A105 Urządzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GNSS; np. GPS, GLONASS lub Galileo), inne niż wymienione w pozycji 7A005, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów oraz specjalnie zaprojektowane do nich zespoły:
- a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004, bezzałogowych statkach powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104; lub
 - b. zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań lotniczych i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. zdolne do dostarczania danych nawigacyjnych przy prędkościach powyżej 600 m/s;
 2. stosujące deszyfrowanie, zaprojektowane lub zmodyfikowane do zadań wojskowych lub rządowych, w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonych sygnałów/danych GNSS; lub
 3. specjalnie zaprojektowane do stosowania elementów przeciwwzakłóceńowych (np. bezmodemowa antena sterująca lub antena sterowana elektronicznie) do działania w warunkach, w których występuje aktywne lub bierne przeciwdziałanie.

Uwaga: Pozycje 7A105.b.2 i 7A105.b.3 nie obejmują kontrolę urządzeń przeznaczonych do komercyjnego, cywilnego lub 'ratunkowego' dostępu do GNSS (np. integracja danych, bezpieczeństwo lotów).

- 7A106 Wysokościomierze, inne niż wyszczególnione w pozycji 7A006, typu radarowego lub laserowego, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104.
- 7A115 Pasywne czujniki do określania namiaru na określone źródła fal elektromagnetycznych (namierniki) lub właściwości terenu, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104.

Uwaga: Pozycja 7A115 obejmuje czujniki do następujących urządzeń:

- a. urządzenia do wykonywania map konturowych terenu;
- b. czujniki do tworzenia obrazów (zobrazowania) (aktywne i pasywne);

c. interferometry pasywne.

- 7A116 Następujące systemy sterowania lotem i serwozawory, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104.
- a. hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne lub elektromechaniczne systemy sterowania lotem (w tym systemy typu „fly-by-wire”);
 - b. urządzenia do sterowania położeniem;
 - c. serwozawory do sterowania lotem zaprojektowane lub zmodyfikowane do systemów określonych w pozycjach 7A116.a lub 7A116.b oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane do działania w środowisku wibracyjnym o parametrach powyżej 10 g (wartość średnia kwadratowa) pomiędzy 20 Hz i 2 kHz.
- 7A117 „Instalacje do naprowadzania”, znajdujące zastosowanie w „pociskach raketowych”, umożliwiające uzyskanie dokładności instalacji 3,33 % zasięgu lub lepszej (np. „CEP” [Kąg Równego Prawdopodobieństwa] 10 km lub mniej w zasięgu 300 km).

7B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

7B001 Urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie zaprojektowane do urządzeń objętych kontrolą według pozycji 7A.

Uwaga: Pozycja 7B001 nie obejmuje kontrolą urządzeń do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie zaprojektowanych do 'poziomu obsługi I' i 'poziomu obsługi II'.

Uwagi techniczne:

1. 'Poziom obsługi I'
Wykrycie awarii urządzenia nawigacji inercyjnej w samolocie i jej sygnalizowanie przez Jednostkę Sterowania i Wyświetlania (CDU) lub komunikat statusowy z odpowiedniego podukładu. Na podstawie instrukcji producenta można zlokalizować przyczyny awarii na poziomie wadliwego funkcjonowania liniowego elementu wymiennego (LRU). Następnie operator demontuje LRU i zastępuje go częścią zapasową.
2. 'Poziom obsługi II'
Uszkodzony LRU przekazuje się do warsztatu technicznego (u producenta lub operatora odpowiedzialnego za obsługę techniczną na Poziomie II). W warsztacie technicznym LRU poddaje się testom za pomocą różnych, odpowiednich do tego urządzeń, w celu sprawdzenia i lokalizacji uszkodzonego modułu zespołu dającego się wymienić w warsztacie (SRA) odpowiedzialnego za awarię. Następnie demontuje się wadliwy SRA i zastępuje go zespołem zapasowym. Uszkodzony SRA (albo też kompletny LRU) wysyła się do producenta. Na 'poziomie obsługi II' nie przewiduje się demontażu ani naprawy akcelerometrów ani też czujników żyroskopowych objętych kontrolą.

7B002 Następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do określania parametrów zwierciadeł do pierścieniowych żyroskopów „laserowych”:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 7B102.

- a. urządzenia do pomiaru rozproszenia z dokładnością do 10 ppm lub mniej (lepszą);
- b. profilometry o dokładności pomiarowej 0,5 nm (5 angstromów) lub mniej (lepszej).

7B003 Urządzenia specjalnie zaprojektowane do „produkcji” urządzeń ujętych w pozycji 7A.

Uwaga: Pozycja 7B003 obejmuje:
-stanowiska testowe do regulacji żyroskopów,
-stanowiska do dynamicznego wyważania żyroskopów,
-stanowiska do testowania silniczków do żyroskopów,
-stanowiska do usuwania powietrza i napełniania żyroskopów,
-uchwyty odśrodkowe do łożysk do żyroskopów,
-stanowiska do regulacji pozycji osi akcelerometrów,
-nawijarki zwojów do światłowodów.

- 7B102 Reflektometry specjalnie zaprojektowane do wyznaczania charakterystyk zwierciadeł do żyroskopów „laserowych”, mające dokładność pomiarową 50 ppm lub mniej (lepszą).
- 7B103 Następujące „instalacje produkcyjne” i „urządzenia produkcyjne”:
- Specjalnie opracowane „instalacje produkcyjne” do urządzeń określonych w pozycji 7A117;
 - „urządzenia produkcyjne” i inne urządzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, inne niż wymienione w pozycjach 7B001 do 7B003, zaprojektowane lub zmodyfikowane do urządzeń wyszczególnionych w pozycji 7A.
- 7C Materiały**
- Żadne.
- 7D Oprogramowanie**
- 7D001 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju” lub „produkcji” urządzeń wyszczególnionych w pozycji 7A lub 7B.
- 7D002 „Kod źródłowy” do obsługi lub konserwacji wszelkich urządzeń do nawigacji inercyjnej lub układów informujących o położeniu i kursie (‘AHRS’) łącznie z inercyjnymi urządzeniami niewyszczególnionymi w pozycji 7A003 lub 7A004.
- Uwaga: Pozycja 7D002 nie obejmuje kontrolą „kodów źródłowych” do „użytkowania” zawieszonych kardanowo układów ‘AHRS’.
- Uwaga techniczna:
Układy ‘AHRS’ w istotny sposób różnią się od inercyjnych systemów nawigacji (INS), ponieważ układy te (‘AHRS’) dostarczają podstawowych informacji o położeniu i kursie, i zazwyczaj nie dostarczają informacji o przyspieszeniu, prędkości i pozycji, jakich dostarcza układ INS.
- 7D003 następujące inne „oprogramowanie”:
- „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu poprawy parametrów eksploatacyjnych lub zmniejszenia błędów nawigacyjnych systemów do poziomu określonego w pozycjach 7A003, 7A004 lub 7A008;
 - „kod źródłowy” do hybrydowych układów scalonych poprawiający parametry eksploatacyjne lub zmniejszający błędy nawigacyjne systemu do poziomu określonego w pozycji 7A003 lub 7A008 poprzez ciągłą syntezę danych dotyczących kursu z którymkolwiek z następujących:
 - prędkością określaną za pomocą radaru lub sonaru dopplerowskiego;
 - porównywaniem z danymi z globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GNSS); lub
 - informacjami z „bazy danych o terenie”;

- c. nieużywane;
- d. nieużywane;
- e. „oprogramowanie” do komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), specjalnie opracowane do „rozwoju” „układów aktywnego sterowania lotem”, sterowników helikopterowych wieloosiowych systemów sterowania elektronicznego i światłowodowego lub helikopterowych „cyrkulacyjnych układów równoważenia momentu lub cyrkulacyjnych układów sterowania kierunkiem”, których technologie są wymienione w pozycjach 7E004.b, 7E004.c.1 lub 7E004.c.2.

7D004 „Kod źródłowy” obejmujący „rozwój” i „technologie” określone w pozycjach 7E004.a.1. do 7E004.a.6. lub 7E004.b., w odniesieniu do dowolnego z poniższych:

- a. cyfrowych systemów sterowania lotem umożliwiających „kompleksowe sterowanie lotem”;
- b. zintegrowanych systemów sterowania napędem i lotem;
- c. systemów sterowania elektronicznego (fly-by-wire) i światłowodowego;
- d. „aktywnych systemów sterowania lotem”, tolerujących błędy pilotażu lub mających możliwość samoczynnej rekonfiguracji;
- e. nieużywane;
- f. systemów przyrządów pokładowych dostarczających danych dotyczących parametrów powietrza w locie na podstawie pomiarów powierzchniowych parametrów statycznych; lub
- g. trójwymiarowych wyświetlaczy.

Uwaga: Pozycja 7D004. nie obejmuje kontrolą „kodu źródłowego” związanego z popularnymi elementami i funkcjami komputerów (np. przyjmowanie sygnału wejściowego, transmisja sygnału wyjściowego, ładowanie programu komputerowego i danych, wbudowany test, mechanizmy planowania zadań) nie zapewniającego określonej funkcji kontroli lotu.

7D005 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do deszyfrowania ciągów rozpraszających globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS) zaprojektowanego do zastosowań rządowych.

7D101 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” urządzeń wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 lub 7B103.

7D102 „Oprogramowanie” scalające, jak następuje:

- a. „oprogramowanie” scalające do urządzeń wyszczególnionych w pozycji 7A103.b;
- b. „oprogramowanie” scalające specjalnie zaprojektowane do urządzeń wymienionych w pozycjach 7A003 lub 7A103.a;
- c. „oprogramowanie” scalające specjalnie zaprojektowane do urządzeń wyszczególnionych w pozycji 7A103.

Uwaga: Powszechnie spotykaną postacią „oprogramowania” scalającego jest filtrowanie Kalmana.

7D103 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do modelowania lub symulowania działania „instalacji do naprowadzania” wyszczególnionych w pozycji 7A117 lub do ich integrowania konstrukcyjnego z kosmicznymi pojazdami nośnymi wyszczególnionymi w pozycji 9A004 lub z rakietami meteorologicznymi wyszczególnionymi w pozycji 9A104.

Uwaga: „Oprogramowanie” wyszczególnione w pozycji 7D103 podlega kontroli, jeśli jest specjalnie zaprojektowane do sprzętu wymienionego w pozycji 4A102.

7E Technologia

7E001 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” określonych w pozycjach 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 i 7D101 do 7D103.

Uwaga: *Pozycja 7E001 obejmuje „technologię” zarządzania kluczem wyłącznie odnośnie do urządzeń wymienionych w pozycji 7A005.a.*

7E002 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” urządzeń wymienionych w pozycjach 7A lub 7B.

7E003 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do naprawy, regeneracji lub remontowania urządzeń wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A004.

Uwaga: *Pozycja 7E003 nie obejmuje kontrolą „technologii” obsługi technicznej bezpośrednio związanych z wzorcowaniem, usuwaniem lub wymianą uszkodzonych lub nienadających się do użytku liniowych elementów wymiennych (LRU) i warsztatowych zespołów wymiennych (SRA) w „cywilnych statkach powietrznych” zgodnie z opisem w ‘poziomie obsługi I’ lub w ‘poziomie obsługi II’.*

NB.: *Zob. uwagi techniczne do 7B001.*

7E004 Inne „technologie”, takie jak:

a. technologie do „rozwoju” lub „produkcji” któregośkolwiek z poniższych:

1. nieużywane;
2. systemów działających w oparciu o dane dotyczące parametrów powietrza w oparciu wyłącznie o pomiary powierzchniowych parametrów statycznych, tj. dostarczane z konwencjonalnych sond do pomiarów parametrów powietrza;
3. trójwymiarowych wyświetlaczy do „statków powietrznych”;
4. nieużywane;
5. serwomotorów elektrycznych (tj. elektromechanicznych, elektrohydrostatycznych i zintegrowanych) specjalnie opracowanych dla „podstawowego sterowania lotem”;
6. „układów czujników optycznych sterowania lotem” specjalnie opracowanych dla „aktywnych układów sterowania lotem”; lub
7. systemów „DBRN” zaprojektowanych do nawigacji podwodnej przy użyciu sonaru lub baz danych grawitacyjnych zapewniających dokładność pozycjonowania równą 0,4 mil morskich lub mniejszą (lepszą);

b. następujące technologie „rozwoju” „aktywnych systemów sterowania lotem” (łącznie z systemami elektronicznymi lub światłowodowymi) do:

1. „technologii” fotonicznej do wykrywania stanu elementów sterujących statku powietrznego lub lotu, przesyłania danych kontroli lotu lub sterowania ruchem urządzenia uruchamiającego, „wymaganego” w „aktywnych systemach sterowania lotem” opartych na światłowodach;
2. nieużywane;
3. algorytmów używanych w czasie rzeczywistym do analizowania informacji z czujnika części składowych w celu przewidywania i prewencyjnego ograniczania zbliżającego się zużycia i awarii części składowych w „aktywnym systemie sterowania lotem”;

Uwaga: *Pozycja 7E004.b.3. nie obejmuje kontrolą algorytmów stosowanych do celów obsługi w trybie off-line.*

4. algorytmów używanych w czasie rzeczywistym do identyfikowania awarii części składowych i przekonfigurowywania elementów sterowania siłą i momentem w celu ograniczania zużycia i awarii „aktywnego systemu sterowania lotem”;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.4. nie obejmuje kontrolą algorytmów służących eliminowaniu skutków błędów poprzez porównanie źródeł redundantnych danych lub odpowiedzi wstępnie zaplanowanych off-line z przewidywanymi awariami.

5. integracji systemu sterowania cyfrowego, danych z systemu nawigacyjnego i napędowego w jeden system cyfrowego kierowania lotem dla „kompleksowego sterowania lotem”;

Uwaga: Pozycja 7E004.b.5 nie obejmuje kontrolą:

- a. „technologii” „rozwoju” integracji cyfrowych systemów sterowania lotem, danych nawigacyjnych i danych kontrolnych układu napędowego do systemu cyfrowego kierowania lotem w celu „optymalizacji toru lotu”;
- b. „technologii” „rozwoju” przyrządów kontroli lotu dla „statków powietrznych”, zintegrowanych wyłącznie z systemami nawigacyjnymi i podchodzenia do lądowania, takimi jak VOR (radiolatornia kierunkowa wysokiej częstotliwości), DME (radiodalmierz), ILS (system lądowania na przyrządy) lub MLS (mikrofalowy system lądowania).

6. nieużywane;

Uwaga: Pozycja 7E004.b. nie obejmuje kontrolą technologii związanej z popularnymi elementami i funkcjami komputerów (np. przyjmowanie sygnału wejściowego, transmisja sygnału wyjściowego, ładowanie programu komputerowego i danych, wbudowany test, mechanizmy planowania zadań) nie zapewniającej określonej funkcji kontroli lotu.

- c. następujące „technologie” do „rozwoju” systemów do śmigłowców:

1. wieloosiowe systemy sterowania elektronicznego i światłowodowego, w których połączono funkcje co najmniej dwóch z wymienionych poniżej systemów w jeden zespół sterowania:
 - a. system sterowania skokiem ogólnym;
 - b. system sterowania skokiem okresowym łopat;
 - c. system kierowania odchyleniem kursowym;
2. „sterowane cyrkulacyjnie (opływowo) systemy kompensacji momentu lub sterowania kierunkiem lotu”;
3. łopatki wirnika z „profilami o zmiennej geometrii” opracowane do systemów umożliwiających niezależne sterowanie poszczególnymi łopatkami.

7E101 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „użytkowania” urządzeń wymienionych w pozycjach 7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115 do 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 do 7D103.

7E102 Następujące „technologie” do zabezpieczania podzespołów awioniki i elektrycznych przed impulsem elektromagnetycznym (EMP) i zagrożeniem zakłóceniami elektromagnetycznymi ze źródeł zewnętrznych:

- a. „technologie” projektowania ekranowania;

- b. „technologie” projektowania dla konfigurowania odpornych obwodów elektrycznych i podukładów;
- c. „technologie” projektowania dla wyznaczania kryteriów uodporniania w odniesieniu do technologii wymienionych powyżej w pozycjach 7E102.a i 7E102.b.

7E104 „Technologie” scalania danych z systemów sterowania lotem, naprowadzania i napędu w system zarządzania lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.

KATEGORIA 8 - URZĄDZENIA OKRĘTOWE

8A Systemy, urządzenia i części składowe

8A001 Następujące pływające jednostki podwodne lub nawodne:

Uwaga: Poziom kontroli urządzeń do pojazdów podwodnych określono w następujących pozycjach:

- kategoria 5 część 2 „ochrona informacji” – w zakresie szyfrujących urządzeń komunikacyjnych,
- kategoria 6 – w zakresie czujników,
- kategoria 7 i 8 – w zakresie urządzeń nawigacyjnych,
- kategoria 8.A – w zakresie urządzeń podwodnych.

- a. załogowe pojazdy podwodne na uwięzi, zaprojektowane do działania na głębokościach większych niż 1 000 m;
- b. załogowe, swobodne pojazdy podwodne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. zaprojektowane do ‘autonomicznego działania’ i posiadające nośność stanowiącą jednocześnie:
 - a. 10 % lub więcej ich wagi w powietrzu; oraz
 - b. 15 kN lub więcej;
 2. zaprojektowane do działania na głębokościach większych niż 1 000 m; lub
 3. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 - a. zaprojektowane do ciągłego ‘autonomicznego działania’ przez 10 lub więcej godzin; oraz
 - b. o ‘zasięgu’ 25 lub więcej mil morskich;

Uwagi techniczne:

1. Na potrzeby pozycji 8A001.b termin ‘działanie autonomiczne’ dotyczy działań prowadzonych przez pojazd podwodny (mający układ napędowy pracujący pod wodą lub nad wodą) w całkowitym zanurzeniu, bez chrap, przy wszystkich systemach pracujących i krążenia z minimalną prędkością, przy której pojazd podwodny może bezpiecznie regulować dynamicznie głębokość zanurzenia za pomocą wyłącznie sterów głębokości, bez korzystania z pomocy nawodnej jednostki pływającej ani bazy nawodnej, na dnie lub brzegu morza.
 2. Na potrzeby pozycji 8A001.b ‘zasięg’ oznacza połowę maksymalnego dystansu, w jakim pojazd podwodny może ‘działać autonomicznie’.
- c. bezałogowe pojazdy podwodne na uwięzi zaprojektowane do działania na głębokościach większych niż 1 000 m i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. przeznaczenie do manewrowania z własnym napędem za pomocą silników napędowych lub silników odrzutowych objętych kontrolą według pozycji 8A002.a.2; lub
 2. światłowodowe kanały przesyłania danych;
 - d. bezałogowe, swobodne pojazdy podwodne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. możliwość decydowania o kursie względem dowolnego systemu geograficznego bez bieżącej (w czasie rzeczywistym) pomocy człowieka;
 2. akustyczne kanały przesyłania danych lub poleceń; lub
 3. dłuższe niż 1 000 m optyczne kanały przesyłania danych lub poleceń;

- e. oceaniczne urządzenia ratownicze o nośności powyżej 5 MN przeznaczone do ratowania obiektów z głębokości większych niż 250 m i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. dynamiczne systemy ustalania położenia zdolne do utrzymania położenia z dokładnością do 20 m względem danego punktu za pomocą systemu nawigacyjnego; lub
 - 2. systemy nawigacyjne działające względem dna morza i zintegrowane systemy nawigacyjne, przeznaczone do działania na głębokościach większych niż 1000 m i umożliwiające utrzymywanie położenia względem danego punktu z dokładnością do 10 m;
- f. pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana z pełnym fartuchem bocznym) spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - 1. maksymalną prędkość projektową z pełnym obciążeniem przekraczającą 30 węzłów przy falach o wysokości 1,25 m (stan morza 3) lub wyższej;
 - 2. ciśnienie powietrza w poduszce powyżej 3 830 Pa; oraz
 - 3. stosunek masy pustej jednostki pływającej do całkowicie obciążonej poniżej 0,70;
- g. pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi burtami) o maksymalnej prędkości obliczeniowej z pełnym obciążeniem powyżej 40 węzłów przy falach o wysokości 3,25 m (stan morza 5) lub większej;
- h. wodoroloty wyposażone w aktywne systemy automatycznego sterowania położeniem płatów nośnych, o maksymalnej prędkości obliczeniowej z pełnym obciążeniem równej lub wyższej od 40 węzłów przy falach o wysokości 3,25 m (stan morza 5) lub większej;
- i. 'jednostki pływające o małym polu przekroju wodnicowego' spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. wyporność z pełnym obciążeniem powyżej 500 ton i maksymalną prędkość obliczeniową z pełnym obciążeniem powyżej 35 węzłów przy falach o wysokości 3,25 m (stan morza 5) lub większej; lub
 - 2. wyporność z pełnym obciążeniem powyżej 1 500 ton i maksymalną prędkość obliczeniową z pełnym obciążeniem powyżej 25 węzłów przy falach o wysokości 4 m (stan morza 6) lub większej;

Uwaga techniczna:

'Jednostkę pływającą o małym polu przekroju wodnicowego' definiuje się według następującego wzoru: pole przekroju wodnicowego przy konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym mniejsze od $2 \times (\text{wyparta objętość przy konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym})^{2/3}$.

8A002 Następujące systemy okrętowe, urządzenia i elementy składowe:

Uwaga: Podwodne instalacje telekomunikacyjne ujęto w kategorii 5 część 1 – Telekomunikacja.

- a. następujące systemy, urządzenia i elementy składowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do pojazdów podwodnych i przeznaczone do działania na głębokościach większych niż 1 000 m:
 - 1. obudowy ciśnieniowe lub kadłuby sztywne o maksymalnej średnicy wewnętrznej komory powyżej 1,5 m;
 - 2. silniki napędowe na prąd stały lub silniki odrzutowe;

3. kable startowe i łączniki do nich, na bazie włókien optycznych i zaopatrzone w syntetyczne elementy wzmacniające;
4. elementy wyprodukowane z materiałów wyszczególnionych w pozycji 8C001;

Uwaga techniczna:

Cel kontrolowania pozycji 8A002.a.4 nie powinien być omijany przez eksportowanie „pianki syntaktycznej” wymienionej w pozycji 8C001 po zakończeniu pośredniego etapu produkcji, kiedy pianka ta nie ma jeszcze formy ostatecznego elementu składowego.

- b. systemy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycznego sterowania ruchem urządzeń do pojazdów podwodnych objętych kontrolą według pozycji 8A001, korzystające z danych nawigacyjnych, wyposażone w serwomechanizmy sterujące ze sprzężeniem zwrotnym i umożliwiające pojazdowi którekolwiek z poniższych działań:
 - 1. poruszania się w słupie wody w zasięgu 10 m od ściśle określonego punktu;
 - 2. utrzymania położenia w słupie wody w zasięgu 10 m od określonego punktu; lub
 - 3. utrzymania położenia w zasięgu do 10 m od kabla leżącego na dnie lub znajdującego się pod dnem morza;
- c. ciśnieniowe penetratory światłowodowe do kadłubów;
- d. następujące podwodne systemy wizyjne:
 - 1. następujące systemy i kamery telewizyjne:
 - a. instalacje telewizyjne (składające się z kamery, świateł, urządzeń monitorujących i do przesyłania sygnałów) o 'rozdzielczości granicznej' mierzonej w powietrzu powyżej 800 linii i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, że można nimi zdalnie sterować z pojazdów podwodnych;
 - b. podwodne kamery telewizyjne o 'rozdzielczości granicznej' mierzonej w powietrzu powyżej 1 100 linii;
 - c. bardzo czułe kamery telewizyjne (działające przy słabym oświetleniu) specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do działania pod wodą i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - 1. posiadające lampowe wzmacniacze obrazu wyszczególnione w pozycji 6A002.a.2.a; oraz
 - 2. posiadające siatki na elementach półprzewodnikowych z ponad 150 000 „aktywnych pikseli” na powierzchni siatki;

Uwaga techniczna:
'Rozdzielczość graniczna' jest miarą rozdzielczości poziomej, wyrażanej zazwyczaj jako maksymalna liczba linii mieszcząca się w wysokości obrazu, rozróżnianych na karcie testowej, określana według normy IEEE 208/1960 lub dowolnej normy stanowiącej jej odpowiednik.

 - 2. systemy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do zdalnego kierowania z pojazdu podwodnego, w których zastosowano techniki umożliwiające minimalizację zjawiska rozpraszania wstecznego i zawierające iluminatory o regulowanym zakresie lub systemy „laserowe”;- e. aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą, na głębokościach poniżej 150 m, na błony filmowe formatu 35 mm lub większego i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - 1. możliwość zapisu na błonie komentarza w postaci danych ze źródła zewnętrznego względem aparatu fotograficznego;
 - 2. mechanizm do automatycznego korygowania ogniskowej; lub
 - 3. system automatycznego sterowania kompensacją o specjalnej konstrukcji umożliwiającej wykorzystanie obudowy kamery podwodnej na głębokościach większych niż 1 000 m;
- f. nieużywane;
- g. następujące instalacje oświetleniowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą:

1. stroboskopowe instalacje oświetleniowe o energii strumienia świetlnego powyżej 300 J na jeden błysk i o szybkości powtarzania większej niż 5 błysków na sekundę;
2. instalacje oświetleniowe, w których światło wytwarza łuk argonowy, specjalnie zaprojektowane do działania na głębokościach większych niż 1 000 m;

- h. „roboty” specjalnie zaprojektowane do pracy pod wodą, zarządzane za pomocą dedykowanego komputera i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. wyposażenie w układy sterujące „robotem” dzięki informacjom z czujników mierzących siły lub momenty działające na obiekty zewnętrzne lub odległość do zewnętrznego obiektu, lub czujników dotykowych „robot” wyczuwających obiekt zewnętrzny; lub
 2. możliwość działania z siłą 250 N lub większą lub momentem 250 Nm lub większym, i do których budowy zastosowano stopy na osnowie tytanowej lub „kompozytowe” „materiały włókniste lub włókienkowe”;
- i. zdalnie sterowane manipulatory przegubowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w pojazdach podwodnych i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. wyposażenie w układy sterujące ruchem manipulatora na podstawie informacji z czujników mierzących którekolwiek z poniższych:
 - a. moment lub siłę działającą na obiekt zewnętrzny; lub
 - b. dotyk manipulatora do obiektu zewnętrznego; lub
 2. sterowanie na zasadzie proporcjonalnego odtwarzania ruchów operatora oraz posiadanie 5 lub więcej stopni ‘swobody ruchu’;

Uwaga techniczna:

Przy określaniu liczby stopni ‘swobody ruchu’ bierze się pod uwagę wyłącznie te funkcje, w których wykorzystywane jest proporcjonalne sterowanie ruchem z wykorzystaniem pozycyjnego sprzężenia zwrotnego.

- j. następujące układy napędowe niezależne od dopływu powietrza, specjalnie zaprojektowane do działania pod wodą:
1. niezależne od powietrza systemy napędowe z silnikami pracującymi według obiegu Braytona (Joula) lub Rankina, wyposażone w jeden z wymienionych poniżej układów:
 - a. chemiczne układy oczyszczające lub absorpcyjne specjalnie zaprojektowane do usuwania dwutlenku węgla, tlenku węgla i cząstek stałych zawieszonych w gazie wydechowym z silnika pracującego w obiegu z recyrkulacją;
 - b. specjalne układy przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;
 - c. urządzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tłumienia pod wodą szumów o częstotliwościach poniżej 10 kHz, lub specjalne urządzenia mocujące, osłabiające skutki wstrząsów; lub
 - d. systemy spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. specjalnie zaprojektowane do prasowania produktów reakcji lub do regeneracji paliw;
 2. specjalnie zaprojektowane do składowania produktów reakcji; oraz
 3. specjalnie zaprojektowane do usuwania produktów reakcji w warunkach ciśnienia zewnętrznego 100 kPa lub większego;
 2. niezależne od powietrza systemy napędowe z silnikami wysokoprężnymi (obieg Diesla) wyposażone w wszystkie z wymienionych poniżej układów:
 - a. chemiczne układy oczyszczające lub absorpcyjne specjalnie zaprojektowane do usuwania dwutlenku węgla, tlenku węgla i cząstek stałych zawieszonych w gazie wydechowym z silnika pracującego w obiegu z recyrkulacją;
 - b. specjalne układy przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;
 - c. urządzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tłumienia pod wodą szumów o częstotliwościach poniżej 10 kHz, lub specjalne urządzenia mocujące, osłabiające skutki wstrząsów; oraz

- d. specjalne układy wydechowe o nieciągłym odprowadzaniu produktów spalania;

3. niezależne od powietrza układy energetyczne na „ogniwach paliwowych” o mocy powyżej 2 kW i wyposażone w którekolwiek z poniższych:
 - a. urządzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tłumienia pod wodą szumów o częstotliwościach poniżej 10 kHz, lub specjalne urządzenia mocujące, osłabiające skutki wstrząsów; lub
 - b. systemy spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 1. specjalnie zaprojektowane do prasowania produktów reakcji lub do regeneracji paliw;
 2. specjalnie zaprojektowane do składowania produktów reakcji; oraz
 3. specjalnie zaprojektowane do usuwania produktów reakcji w warunkach ciśnienia zewnętrznego 100 kPa lub większego;
4. niezależne od powietrza systemy napędowe z silnikami pracującymi według obiegu Stirlinga, wyposażone we wszystkie z poniższych układów:
 - a. urządzenia lub obudowy specjalnie zaprojektowane do tłumienia pod wodą szumów o częstotliwościach poniżej 10 kHz, lub specjalne urządzenia mocujące, osłabiające skutki wstrząsów; oraz
 - b. specjalne układy wydechowe do usuwania produktów spalania w warunkach ciśnienia zewnętrznego 100 kPa lub większego;
- k. następujące fartuchy boczne poduszkowców, uszczelnienia i inne elementy montażowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 1. wytrzymałe na ciśnienia w poduszce powietrznej 3 830 Pa lub wyższe, działające przy falach o wysokości 1,25 m (stan morza 3) lub większej i specjalnie zaprojektowane do pojazdów na poduszce powietrznej (odmiana z pełnym fartuchem bocznym) objętych kontrolą według pozycji 8A001.f; lub
 2. wytrzymałe na ciśnienia w poduszce powietrznej 6 224 Pa lub wyższe, działające przy falach o wysokości 3,25 m (stan morza 5) lub większej i specjalnie zaprojektowane do pojazdów na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi burtami) objętych kontrolą według pozycji 8A001.g;
- l. dmuchawy nośne o mocy nominalnej powyżej 400 kW specjalnie zaprojektowane do pojazdów na poduszce powietrznej objętych kontrolą według pozycji 8A001.f lub 8A001.i.g;
- m. pracujące w całkowitym zanurzeniu podkawitacyjne lub superkawitacyjne płyty wodne specjalnie zaprojektowane do jednostek pływających objętych kontrolą według pozycji 8A001.h;
- n. układy aktywne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycznej kompensacji wywołanych działaniem wody ruchów jednostek pływających lub pojazdów objętych kontrolą według pozycji 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h lub 8A001.i;
- o. następujące pędniki, układy przenoszenia napędu, generatory mocy i układy tłumienia szumów:
 1. następujące pędniki śrubowe lub układy przenoszenia napędu specjalnie zaprojektowane do pojazdów poduszkowych (zarówno do odmian z pełnym fartuchem bocznym, jak i ze sztywnymi burtami), wodolotów lub ‘jednostek pływających o małym polu przekroju wodnicowego’ wymienionych w pozycjach 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h lub 8A001.i:
 - a. śruby napędowe superkawitacyjne, superwentylowane, częściowo zanurzone lub zanurzone niecałkowicie, o mocy nominalnej powyżej 7,5 MW;
 - b. zespoły śrub napędowych przeciwbieżnych o mocy nominalnej powyżej 15 MW;

- c. układy napędowe, w których do uspokojenia przepływu przez śruby zastosowano zawirowanie wstępne lub wylotowe;
- d. lekkie przekładnie redukcyjne o wysokim przełożeniu (współczynnik przełożenia K powyżej 300);
- e. wałowe układy przeniesienia napędu składające się z elementów wykonanych z materiałów „kompozytowych” i zdolne do przenoszenia mocy powyżej 1 MW;

2. następujące pędniki śrubowe, generatory mocy lub układy przenoszenia napędu zaprojektowane dla jednostek pływających:
 - a. śruby napędowe o regulowanym skoku oraz zespoły piast do śrub o mocy nominalnej powyżej 30 MW;
 - b. elektryczne silniki napędowe z wewnętrznym chłodzeniem cieczowym o mocy wyjściowej powyżej 2,5 MW;
 - c. „nadprzewodnikowe” silniki napędowe lub elektryczne silniki napędowe z magnesami stałymi, o mocy wyjściowej powyżej 0,1 MW;
 - d. wałowe układy przeniesienia napędu składające się z elementów wykonanych z materiałów „kompozytowych” i zdolne do przenoszenia mocy powyżej 2 MW;
 - e. wentylowane lub podobne napędy śrubowe o mocy nominalnej powyżej 2,5 MW;
3. Następujące układy tłumienia szumów, opracowane do użytkowania na jednostkach pływających o wyporności 1 000 ton lub wyższej:
 - a. układy tłumienia szumów podwodnych o częstotliwościach poniżej 500 Hz, składające się ze złożonych systemów montażowych służących do izolacji akustycznej silników wysokoprężnych, zespołów generatorów wysokoprężnych, turbin gazowych, zespołów generatorów gazowych, silników napędowych lub napędowych przekładni redukcyjnych, specjalnie zaprojektowane do tłumienia dźwięków lub wibracji i mające masę stanowiącą ponad 30 % masy urządzeń, na których mają być zamontowane;
 - b. ‘aktywne układy tłumienia lub eliminacji szumów’ lub łożyska magnetyczne, specjalnie zaprojektowane do układów przenoszenia napędu;

Uwaga techniczna:

‘Aktywne układy tłumienia lub eliminacji szumów’ są wyposażone w elektroniczne układy sterowania umożliwiające aktywne zmniejszanie wibracji urządzeń poprzez bezpośrednie generowanie do źródła dźwięków sygnałów tłumiących dźwięki i wibracje.

- p. strugowodne układy napędowe spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
 1. moc wyjściowa powyżej 2,5 MW; oraz
 2. w których, w celu poprawy sprawności napędu lub zmniejszenia rozchodzącego się pod wodą wytworzonego dźwięku, pochodzącego z układu napędowego, zastosowano dysze rozbieżne oraz łopatki kierujące przepływem;
- q. następujące niezależne aparaty do nurkowania i pływania podwodnego:
 1. aparaty o zamkniętym obiegu;
 2. aparaty o półzamkniętym obiegu;

Uwaga: *Pozycja 8A002.q nie obejmuje kontrolą aparatów indywidualnych, kiedy towarzyszą one użytkownikowi do jego osobistego użytku.*

NB.: *W przypadku sprzętu i urządzeń zaprojektowanych specjalnie do zastosowań wojskowych zob. wykaz uzbrojenia.*

- r. akustyczne systemy odstraszania nurków specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, by zakłócać pracę nurków i posiadające poziom ciśnienia akustycznego równy lub przekraczający 190 dB (poziom odniesienia 1 µPa na 1 m) na częstotliwościach 200 Hz i niższych.

Uwaga 1: *Pozycja 8A002.r nie obejmuje kontrolą systemów odstraszania nurków opartych na podwodnych urządzeniach wybuchowych, pistoletach powietrznych lub źródłach spalania.*

Uwaga 2: Pozycja 8A002.r obejmuje akustyczne systemy odstraszania nurków korzystające z iskierników, znane również jako plazmowe źródła dźwięku.

8B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

8B001 Tunele wodne o szumie tła poniżej 100 dB (odpowiednik 1 μ Pa, 1 Hz) w paśmie częstotliwości od 0 do 500 Hz przeznaczone do pomiaru pól akustycznych wytwarzanych przez przepływy cieczy wokół modeli układów napędowych.

8C Materiały

8C001 'Pianka syntaktyczna' (porowata) do użytku pod wodą spełniająca wszystkie poniższe kryteria:

NB.: Zob. również pozycja 8A002.a.4.

- a. przeznaczenie do stosowania na głębokościach większych niż 1 000 m; oraz
- b. gęstość poniżej 561 kg/cm³;

Uwaga techniczna:

'Pianka syntaktyczna' składa się z pustych w środku kuleczek z tworzywa sztucznego lub szkła osadzonych w matrycy z żywicy.

8D Oprogramowanie

8D001 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” urządzeń lub materiałów objętych kontrolą według pozycji 8A, 8B lub 8C;

8D002 „Oprogramowanie” specjalne, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji”, napraw, remontów lub modernizacji (ponownej obróbki skrawaniem) śrub, specjalnie w celu tłumienia generowanych przez nie pod wodą szumów.

8E Technologia

8E001 „Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu lub materiałów wyszczególnionych w pozycji 8A, 8B lub 8C.

8E002 Inne „technologie”, takie jak:

- a. „technologie” do „rozwoju”, „produkcji”, napraw, remontów lub modyfikacji (ponownej obróbki skrawaniem) śrub, specjalnie skonstruowanych w celu tłumienia generowanych przez nie pod wodą szumów.
- b. „technologie” do remontów lub modyfikacji urządzeń objętych kontrolą według pozycji 8A001 lub 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o lub 8A002.p.

KATEGORIA 9 – KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA I NAPĘD

9A Systemy, urządzenia i części składowe

NB.: Dla układów napędowych specjalnie zaprojektowanych lub zabezpieczonych przed promieniowaniem neutronowym lub przenikliwym promieniowaniem jonizującym zob. także wykaz uzbrojenia.

9A001 Następujące lotnicze silniki turbinowe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9A101.

- a. mające jedną z technologii objętych kontrolą według pozycji 9E003.a lub 9E003.h, lub 9E003.i; lub

Uwaga 1: Pozycja 9A001.a nie obejmuje kontrolą silników turbinowych spełniających wszystkie poniższe kryteria:

- a. posiadanie certyfikatu wydanego przez cywilne władze lotnicze „państwa uczestniczącego”; oraz
- b. przeznaczenie do napędzania niewojskowych załogowych „statków powietrznych”, dla których „państwo uczestniczące” wydało którykolwiek z następujących dokumentów, odnoszących się do samolotu wyposażonego w silnik tego właśnie typu:
 1. certyfikat zezwalający na zastosowanie cywilne; lub
 2. równoważny dokument uznawany przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Uwaga 2: Pozycja 9A001.a. nie obejmuje kontrolą lotniczych silników turbinowych zaprojektowanych do pomocniczych jednostek mocy zatwierdzonych przez cywilne władze lotnicze w „państwie uczestniczącym”.

- b. zaprojektowane do napędzania samolotów do lotów z prędkościami 1 Ma lub większymi przez ponad trzydzieści minut.

9A002 ‘Turbinowe silniki okrętowe’ o nominalnej mocy ciągłej określonej według normy ISO wynoszącej 24 245 kW lub więcej i zużyciu jednostkowym paliwa nieprzekraczającym 0,219 kg/kWh w dowolnym punkcie roboczym w zakresie mocy od 35 do 100 %, oraz specjalnie do nich zaprojektowane zespoły i elementy;

Uwaga: Termin ‘turbinowe silniki okrętowe’ obejmuje również turbinowe silniki przemysłowe lub lotnicze, przystosowane do napędzania jednostek pływających lub wytwarzania energii elektrycznej na jednostkach pływających.

9A003 Następujące specjalne zespoły i elementy, w których zastosowano jedną z technologii objętych kontrolą według pozycji 9E003.a, 9E003.h lub 9E003.i, przeznaczone do którejkolwiek z poniższych turbinowych silników napędowych:

- a. wyszczególnione w pozycji 9A001; lub
- b. skonstruowane lub wyprodukowane w krajach innych niż „państwa członkowskie” lub nieznanymi producentowi.

9A004 Kosmiczne pojazdy nośne i „statki kosmiczne”.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9A104.

Uwaga: Pozycja 9A004 nie obejmuje kontrolą ładunku użytecznego.

NB.: Dla określenia poziomu kontroli produktów wchodzących w skład ładunku użytecznego „statku kosmicznego” zob. odpowiednie kategorie.

9A005 Rakietowe systemy napędowe na paliwo ciekłe zawierające jeden z systemów lub elementów wyszczególnionych w pozycji 9A006.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A105 I 9A119.

9A006 Następujące systemy lub elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych układów napędowych na paliwo ciekłe:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A106, 9A108 I 9A120.

- a. chłodziarki kriogeniczne, pokładowe pojemniki Dewara, kriogeniczne instalacje grzewcze lub urządzenia kriogeniczne specjalnie zaprojektowane do pojazdów kosmicznych, umożliwiające ograniczenie strat cieczy kriogenicznych do poziomu poniżej 30 % rocznie;
- b. pojemniki kriogeniczne lub pracujące w obiegu zamkniętym układy chłodzenia umożliwiające utrzymanie temperatur na poziomie 100 K (- 173 °C) lub mniejszym, przeznaczone do „statków powietrznych” zdolnych do rozwijania prędkości powyżej $Ma = 3$, do rakiet nośnych lub „statków kosmicznych”;
- c. urządzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie mieszaniny fazy ciekłej ze stałą (zawiesiny);
- d. wysokociśnieniowe (powyżej 17,5 MPa) pompy turbinowe, ich elementy lub towarzyszące im gazowe lub pracujące w cyklu rozprężnym napędy turbinowe;
- e. wysokociśnieniowe (powyżej 10,6 MPa) komory ciągu silników rakietowych i dysze do nich;
- f. urządzenia do przechowywania paliw napędowych na zasadzie kapilarnej lub wydmuchowej (tj. z elastycznymi przeponami);
- g. wtryskiwacze ciekłych paliw napędowych, w których średnice pojedynczych otworków nie przekraczają 0,381 mm (pole powierzchni $1,14 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ lub mniejsze dla otworków niekolistych) i które są specjalnie zaprojektowane do silników rakietowych na paliwo ciekłe;
- h. wykonane z jednego elementu materiału typu węgiel-węgiel komory ciągu lub wykonane z jednego elementu materiału typu węgiel-węgiel stożki wylotowe, których gęstości przekraczają $1,4 \text{ g/cm}^3$, a wytrzymałości na rozciąganie są większe niż 48 MPa.

9A007 Systemy napędowe rakiet na paliwo stałe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A107 I 9A119.

- a. impuls całkowity powyżej 1,1 MNs;
- b. impuls właściwy 2,4 kNs/kg lub większy w sytuacji wypływu z dyszy do otoczenia w warunkach istniejących na poziomie morza przy ciśnieniu w komorze wyregulowanym na poziomie 7 MPa;
- c. udział masowy stopnia powyżej 88 % i procentowy udział składników stałych w paliwie powyżej 86 %;
- d. elementy objęte kontrolą według pozycji 9A008; lub
- e. wyposażone w układy izolacyjne i wiążące paliwo, w których zastosowano bezpośrednio połączone konstrukcje silnikowe zapewniające ‘silne połączenia mechaniczne’ lub elementy barierowe uniemożliwiające migrację chemiczną pomiędzy paliwem stałym a stanowiącym osłonę materiałem izolacyjnym.

Uwaga techniczna:

‘Silne połączenie mechaniczne’ oznacza wytrzymałość wiązania równą lub większą niż wytrzymałość paliwa.

9A008 Następujące elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych układów napędowych na paliwo stałe:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9A108.

- a. układy izolacyjne i wiążące paliwo, w których zastosowano wykładziny zapewniające ‘silne połączenia mechaniczne’ lub elementy barierowe uniemożliwiające migrację chemiczną pomiędzy paliwem stałym a stanowiącym osłonę materiałem izolacyjnym;

Uwaga techniczna:

‘Silne połączenie mechaniczne’ oznacza wytrzymałość wiązania równą lub większą niż wytrzymałość paliwa.

- b. wykonane z włókien nawojowych „kompozytowe” osłony silników o średnicy powyżej 0,61 m lub o ‘wskaźnikach efektywności strukturalnej (PV/W)’ powyżej 25 km;

Uwaga techniczna:

‘Wskaźnik efektywności strukturalnej (PV/W)’ jest iloczynem ciśnienia wybuchu (P) i pojemności zbiornika (V) podzielonym przez całkowitą wagę zbiornika ciśnieniowego (W);

- c. dysze o ciągach powyżej 45 kN lub szybkości erozyjnego zużycia gardzieli poniżej 0,075 mm/s;
- d. dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciągu za pomocą pomocniczego wtrysku płynów o którychkolwiek z następujących parametrów:
 - 1. ruch okrężny z odchyleniem kątowym powyżej $\pm 5^\circ$;
 - 2. kątowy obrót wektora ciągu rzędu $20^\circ/\text{s}$ lub więcej; lub
 - 3. przyspieszenia kątowe wektora ciągu rzędu $40^\circ/\text{s}^2$ lub większe.

9A009 Hybrydowe systemy napędowe rakiet spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A109 I 9A119.

- a. impuls całkowity powyżej 1,1 MNs; lub
- b. ciąg powyżej 220 kN w warunkach próżni na wylocie.

9A010 Następujące specjalnie opracowane elementy, systemy lub struktury do rakiet nośnych lub systemów napędowych do rakiet nośnych lub „statków kosmicznych”:

NB.: *ZOB. TAKŻE POZYCJE 1A002 I 9A110.*

- a. elementy lub struktury, każda z nich o masie przekraczającej 10 kg, specjalnie zaprojektowane do rakiet nośnych i wytwarzane z „kompozytów” na „matrycy” metalowej, „kompozytów” organicznych, materiałów na „matrycy” ceramicznej lub wzmacnianych wiązaniami międzymetalicznymi, wyszczególnionych w pozycji 1C007 lub 1C010;

Uwaga: *Podany limit masy nie dotyczy ochronnych stożków czołowych rakiet.*

- b. elementy lub struktury specjalnie zaprojektowane do systemów napędowych rakiet nośnych wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009, wytwarzane z materiałów wzmacnianych z wykorzystaniem „matrycy” metalowych, „kompozytów”, „kompozytów” organicznych, „matrycy” ceramicznych lub związków międzymetalicznych, wyszczególnionych w pozycji 1C007 lub 1C010;
- c. części struktur i systemy izolacyjne specjalnie zaprojektowane w celu aktywnej kontroli odpowiedzi dynamicznej lub odkształceń struktur „statków kosmicznych”;
- d. pulsacyjne silniki raketowe na paliwo ciekłe mające stosunek ciągu do masy równy lub większy niż 1 kN/kg i czas odpowiedzi (czas niezbędny do osiągnięcia 90 % całkowitego ciągu znamionowego od chwili rozruchu) mniejszy niż 30 ms.

9A011 Silniki strumieniowe, naddźwiękowe silniki strumieniowe lub silniki o cyklu kombinowanym oraz specjalnie do nich opracowane elementy.

NB.: *ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A111 I 9A118.*

9A012 Następujące „bezzałogowe statki powietrzne” („UAV”), bezzałogowe „pojazdy powietrzne” związane z nimi systemy, sprzęt i komponenty:

- a. „UAV” lub bezzałogowe „pojazdy powietrzne” mające dowolne z następujących cech:
 - 1. autonomiczne sterowanie lotem i prowadzenie nawigacji (np. automatyczny pilot z systemem nawigacji bezwładnościowej); lub
 - 2. możliwość sterowania lotem poza zasięgiem bezpośredniego widzenia z udziałem człowieka (np. telewizyjne zdalne sterowanie);
- b. Powiązane systemy, urządzenia i elementy składowe:
 - 1. sprzęt zaprojektowany specjalnie do zdalnego sterowania „UAV” lub bezzałogowymi „pojazdami powietrznymi”, wyszczególniony w pozycji 9A012.a;
 - 2. systemy nawigacji, wyznaczania położenia, naprowadzania lub sterowania inne niż wyszczególnione w pozycji 7A, specjalnie zaprojektowane do wbudowania w „UAV” lub bezzałogowe „pojazdy powietrzne”, wyszczególnione w pozycji 9A012.a;
 - 3. sprzęt lub elementy specjalnie zaprojektowane do przekształcania załogowego „statku powietrznego” lub załogowego „pojazdu powietrznego” w „UAV” lub bezzałogowy „pojazd powietrzny”, wyszczególnione w pozycji 9A012.a;
 - 4. tłokowe lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania, które potrzebują powietrza do spalania, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane po to, by wynosić

„UAV” lub bezzałogowe „pojazdy powietrzne” na wysokość większą niż 50 000 stóp (15 240 metrów).

- 9A101 Następujące silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe, inne niż wyszczególnione w pozycji 9A001:
- a. silniki spełniające oba poniższe kryteria:
 1. ‘wartość ciągu maksymalnego’ powyżej 400 N (uzyskiwana przed zamontowaniem) z wyłączeniem silników certyfikowanych przez instytucje cywilne, mających ‘wartość ciągu maksymalnego’ powyżej 8 890 N (uzyskiwaną przed zamontowaniem silnika); oraz
 2. jednostkowe zużycie paliwa 0,15 kg/Nh lub mniejsze (przy maksymalnej mocy ciągłej na poziomie morza w warunkach statycznych i w standardowej atmosferze określonej przez ICAO);

Uwaga techniczna:
Do celów pozycji 9A101.a.1. ‘wartość ciągu maksymalnego’ oznacza wykazany przez producenta maksymalny ciąg dla danego typu silnika przed zamontowaniem. Wartość ciągu certyfikowana dla zastosowań cywilnych będzie równa lub niższa niż wykazany przez producenta maksymalny ciąg dla danego typu silnika.
 - b. silniki zaprojektowane do „pocisków rakietowych” lub zmodyfikowane w tym celu lub „bezzałogowe statki powietrzne” wyszczególnione w pozycji 9A012.
- 9A102 ‘Systemy silników turbośmigłowych’ specjalnie zaprojektowane do „bezzałogowych statków powietrznych” wyszczególnionych w pozycji 9A012 oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy o ‘mocy maksymalnej’ powyżej 10 kW.
- Uwaga: Pozycja 9A102 nie obejmuje kontrolą silników certyfikowanych przez instytucje cywilne.
- Uwagi techniczne:
1. Do celów pozycji 9A102 ‘system silników turbośmigłowych’ obejmuje wszystkie poniższe elementy:
 - a. silnik turbowalowy; oraz
 - b. układy przenoszenia napędu służące do przenoszenia mocy na śmigło.
 2. Do celów pozycji 9A102 ‘moc maksymalna’ dla silnika niezainstalowanego osiągnięta jest w warunkach statycznych i w standardowej atmosferze określonej przez ICAO).
- 9A104 Rakiety meteorologiczne (sondujące) o zasięgu co najmniej 300 km.
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9A004.
- 9A105 Następujące silniki rakietowe na paliwo ciekłe:
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9A119.
- a. silniki rakietowe na paliwo ciekłe nadające się do „pocisków rakietowych”, różne od wymienionych w pozycji 9A005 zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu zintegrowania w układach napędowych na paliwo ciekłe mające impuls całkowity równy lub większy niż 1,1 MNs.
 - b. silniki rakietowe na paliwo ciekłe nadające się do kompletnych systemów rakietowych lub bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu co najmniej 300 km, różne od wymienionych w pozycji 9A005 lub 9A105.a zintegrowane lub zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu zintegrowania w układach napędowych na paliwo ciekłe mające impuls całkowity równy lub większy niż 0,841 MNs.

- 9A106 Następujące systemy lub części składowe, inne niż wyszczególnione w pozycji 9A006, specjalnie zaprojektowane do układów napędowych rakiet na paliwo ciekłe:
- a. wykładziny ablacyjne (ciepłochronne) do komór ciągu lub spalania, nadające się do stosowania w „pociskach raketowych”, pojazdach kosmicznych określonych w pozycji 9A004 lub raketach meteorologicznych określonych w 9A104;
 - b. dysze do silników raketowych, nadające się do „pocisków raketowych”, kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub raket meteorologicznych (sondujących) wyszczególnionych w pozycji 9A104;
 - c. podzespoły do sterowania wektorem ciągu, nadające się do stosowania w „pociskach raketowych”;
- Uwaga techniczna:
Do sposobów sterowania wektorem ciągu wyszczególnionych w pozycji 9A106.c należą np.:
1. dysza regulowana;
 2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
 3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
 4. odchylanie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowniczych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; lub
 5. używanie kłapek oporowych.
- d. zespoły do sterowania przepływem płynnych, zawieszinowych i żelowych paliw napędowych (w tym utleniaczy) oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy nadające się do stosowania w „pociskach raketowych”, skonstruowane lub zmodyfikowane pod kątem eksploatacji w środowiskach, w których występują drgania o średniej wartości kwadratowej większej niż 10 g i o częstotliwości od 20 Hz do 2 kHz.
- Uwaga: *Jedynymi objętymi kontrolą w pozycji 9A106.d serwozaworami i pompami elektrohydraulicznymi są:*
- a. serwozawory o objętościowym natężeniu przepływu równym lub większym niż 24 litrów na minutę przy ciśnieniu absolutnym równym lub większym niż 7 MPa i czasie reakcji roboczej poniżej 100 ms;
 - b. pompy do paliw płynnych o prędkościach obrotowych na wale 8 000 lub więcej obrotów na minutę lub o ciśnieniu wylotowym równym lub większym niż 7 MPa.
- 9A107 Silniki raketowe na paliwo stałe nadające się do kompletnych systemów raketowych lub bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu co najmniej 300 km, inne niż wyszczególnione w pozycji 9A007 i mające impuls całkowity równy lub większy niż 0,841 MNs.
- NB.: *ZOB. TAKŻE POZYCJA 9A119.*
- 9A108 Następujące podzespoły, inne niż wyszczególnione w pozycji 9A008 specjalnie zaprojektowane do układów napędowych do rakiet na paliwo stałe:
- a. osłony do silników raketowych i ich części składowe służące do „izolacji”, nadające się do „pocisków raketowych”, kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub raket meteorologicznych (sondujących) wyszczególnionych w pozycji 9A104;
 - b. dysze do silników raketowych, nadające się do „pocisków raketowych”, kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub raket meteorologicznych (sondujących) wyszczególnionych w pozycji 9A104;

- c. podzespoły do sterowania wektorem ciągu, nadające się do stosowania w „pociskach rakietowych”;

Uwaga techniczna:

Do sposobów sterowania wektorem ciągu wyszczególnionych w pozycji 9A108.c należą np.:

1. dysza regulowana;
2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;
4. odchylenie strumienia gazów wylotowych za pomocą łopatek kierowniczych (nastawnych) lub systemów wtryskiwaczy; lub
5. używanie kłapek oporowych.

9A109 Następujące hybrydowe silniki rakietowe oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

- a. hybrydowe silniki rakietowe nadające się do wykorzystania w kompletnych systemach rakietowych lub systemach bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu 300 km, inne niż wyszczególnione w pozycji 9A009, mające impuls całkowity równy lub większy niż 0,841 MNs, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy;
- b. specjalnie zaprojektowane elementy składowe hybrydowych silników rakietowych wyszczególnione w pozycji 9A009 nadające się do „pocisków rakietowych”.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A009 I 9A119.

9A110 Materiały kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, inne niż wyszczególnione w pozycji 9A010, specjalnie zaprojektowane do ‘pocisków rakietowych’ lub podsystemów wymienionych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 lub 9A119.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJĘ 1A002.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9A110 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

9A111 Pulsacyjne silniki odrzutowe nadające się do „pocisków rakietowych” lub bezzałogowych statków powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012, oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A011 I 9A118.

9A115 Następujące urządzenia do wspierania procedury startowej:

- a. aparatura i urządzenia do manipulacji, sterowania, uruchamiania lub odpalania, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004, bezzałogowych statkach powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104;
- b. b. pojazdy do transportu, manipulacji, sterowania, uruchamiania i odpalania, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104.

- 9A116 Następujące statki kosmiczne zdolne do lądowania na ziemi nadające się do „pocisków raketowych” oraz zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do nich podzespoły:
- a. statki kosmiczne zdolne do lądowania na ziemi;
 - b. osłony ciepłochronne i elementy do nich wykonane z materiałów ceramicznych lub ablacyjnych;
 - c. urządzenia pochłaniające ciepło i elementy do nich wykonane z lekkich materiałów o wysokiej pojemności cieplnej;
 - d. urządzenia elektroniczne specjalnie zaprojektowane do statków kosmicznych zdolnych do lądowania na ziemi.
- 9A117 Mechanizmy do łączenia stopni, mechanizmy do rozłączania stopni oraz mechanizmy międzystopniowe, nadające się do wykorzystania w „pociskach raketowych”.
- NB.: Zob. także pozycja 9A121.*
- 9A118 Urządzenia do regulacji spalania w silnikach, nadające się do „pocisków raketowych” lub bezałogowych statków powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012, wymienionych w pozycjach 9A011 lub 9A111.
- 9A119 Pojedyncze stopnie do raket, nadające się do kompletnych systemów raketowych lub bezałogowych statków powietrznych o zasięgu co najmniej 300 km, inne niż wymienione w pozycjach 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 i 9A109.
- 9A120 Zbiorniki na paliwo ciekłe, poza wyszczególnionymi w pozycji 9A006, specjalnie zaprojektowane na paliwa wyszczególnione w pozycji 1C111 lub ‘inne paliwa ciekłe’, stosowane w systemach raketowych o ładunku użytkowym co najmniej 500 kg i zasięgu co najmniej 300 km.
- Uwaga:* W pozycji 9A120 ‘inne paliwa ciekłe’ obejmują paliwa wymienione w wykazie uzbrojenia, ale nie ograniczają się do nich.
- 9A121 Startowe i międzystopniowe łączniki elektryczne specjalnie przeznaczone do „pocisków raketowych”, pojazdów kosmicznych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub do raket meteorologicznych (sondujących) wyszczególnionych w poz. 9A104.
- Uwaga techniczna:*
Łączniki międzystopniowe, o których mowa w pozycji 9A121, obejmują również łączniki elektryczne zamontowane między „pociskiem raketowym”, pojazdem kosmicznym lub raketą meteorologiczną a ich ładunkiem użytecznym.
- 9A350 Układy zraszania lub mgławienia, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, aby nadawały się do samolotów i „pojazdów lżejszych od powietrza” lub bezałogowych statków powietrznych, oraz specjalnie zaprojektowane ich komponenty, jak następuje:
- a. kompletne układy zraszania lub mgławienia mogące zapewniać, z ciekłej zawiesiny, początkową kroplę o ‘VMD’ poniżej 50 µm przy natężeniu przepływu powyżej dwóch litrów na minutę;

- b. rury rozdzielcze z rozpylaczami lub układy jednostek generujących aerozol mogące zapewniać, z ciekłej zawiesiny, początkową kroplę o 'VMD' poniżej 50 µm przy natężeniu przepływu powyżej dwóch litrów na minutę;
- c. jednostki generujące aerozol specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby nadawały się do układów określonych w pozycji 9A350.a i b.

Uwaga: *Jednostki generujące aerozol są urządzeniami specjalnie zaprojektowanymi lub zmodyfikowanymi w taki sposób, aby nadawały się do samolotów, takimi jak: dysze, rozpylacze bębnowe obrotowe i podobne urządzenia.*

Uwaga: *Pozycja 9A350 nie obejmuje kontrolą układów zraszania lub mgławienia oraz elementów, w przypadku których wykazano, że nie nadają się do przenoszenia środków biologicznych w postaci zakaźnych aerozoli.*

Uwagi techniczne:

1. *Wielkość kropli w przypadku urządzeń zraszających lub dysz specjalnie zaprojektowanych do stosowania w samolotach, „pojazdach lżejszych od powietrza” lub bezzałogowych statkach powietrznych powinna być mierzona z zastosowaniem jednej z następujących metod:*
 - a. *metoda lasera dopplerowskiego;*
 - b. *metoda dyfrakcji laserowej.*
2. *W pozycji 9A350 'VMD' oznacza Volume Median Diameter (objętościowa mediana średnicy), a dla układów wodnych jest równoznaczna z Mass Median Diameter (MMD).*

9B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

- 9B001 Następujące urządzenia, oprzyrządowanie i osprzęt specjalnie zaprojektowane do produkcji odlewów łopatek wirujących, łopatek kierowniczych lub „bandaży” do wirników:
- urządzenia umożliwiające kierunkowe krzepnięcie lub wytwarzanie pojedynczych kryształów;
 - rdzenie lub powłoki ceramiczne.
- 9B002 Pracujące w trybie bezpośrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrządowanie (łącznie z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
- specjalnie zaprojektowane do „rozwoju” silników turbogazowych, ich zespołów lub elementów; oraz
 - wykorzystujące „technologie” wymienioną w pozycjach 9E003.h lub 9E003.i.
- 9B003 Urządzenia specjalnie zaprojektowane do „produkcji” lub testowania uszczelnień szczotkowych w turbinach gazowych wirujących z prędkościami obrotowymi odpowiadającymi prędkości liniowej wierzchołka łopatki powyżej 335 m/s i przy temperaturach przekraczających 773 K (500 °C) oraz specjalnie do nich zaprojektowane części lub akcesoria.
- 9B004 Oprzyrządowanie, matryce lub uchwyty do zgrzewania dyfuzyjnego „nadstopu”, tytanu lub międzymetalicznych połączeń profili łopatkowych z tarczą, opisanych w pozycjach 9E003.a.3 lub 9E003.a.6 dla turbin gazowych.
- 9B005 Pracujące w trybie bezpośrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrządowanie (łącznie z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, specjalnie zaprojektowane do stosowania w którychkolwiek z poniższych:

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9B105.

- tunele aerodynamiczne do prędkości $Ma = 1,2$ lub wyższych;

Uwaga: Pozycja 9B005.a nie obejmuje kontrolą tuneli aerodynamicznych zaprojektowanych do celów edukacyjnych i mających ‘wymiar przestrzeni pomiarowej’ (mierzony w kierunku poprzecznym) o wielkości poniżej 250 mm.

Uwaga techniczna:

‘Wymiar przestrzeni pomiarowej’ oznacza średnicę okręgu lub bok kwadratu lub dłuższy bok prostokąta w najszerszym miejscu przestrzeni pomiarowej.

- urządzenia symulujące warunki przepływu przy prędkościach powyżej $Ma = 5$, łącznie z impulsowymi tunelami hiperdźwiękowymi, tunelami plazmowymi, rurami uderzeniowymi, tunelami uderzeniowymi, tunelami gazowymi i rurami uderzeniowymi na gazy lekkie; lub
- tunele lub urządzenia aerodynamiczne, różne od urządzeń z sekcjami dwuwymiarowymi, umożliwiające symulację przepływów, dla których wartość liczby Reynoldsa wynosi powyżej 25×10^6 .

- 9B006 Sprzęt do badań akustycznych wibracji, w którym można wytwarzać ciśnienia akustyczne na poziomie 160 dB lub wyższe (przy poziomie odniesienia 20 μ Pa) o mocy wyjściowej 4 kW lub większej przy temperaturze w komorze pomiarowej powyżej 1 273 K (1 000 °C) oraz specjalnie do niego zaprojektowane grzejniki kwarcowe.
- NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9B106.*
- 9B007 Urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli stanu silników raketowych metodami nieniszczącymi (NDT), z wyłączeniem urządzeń do dwuwymiarowych badań rentgenowskich i badań za pomocą podstawowych metod chemicznych lub fizycznych.
- 9B008 Przetworniki bezpośrednich pomiarów tarcia w warstwie przyściennej specjalnie zaprojektowane do działania w badanym przepływie przy całkowitej temperaturze (spiętrzenia) powyżej 833 K (560 °C).
- 9B009 Oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do wytwarzania elementów wirników silników turbinowych z proszków metali, zdolnych do pracy przy poziomie naprężeń stanowiącym 60 % wytrzymałości na rozciąganie (UTS) lub wyższym i temperaturach metalu wynoszących 873 K (600 °C) lub wyższych.
- 9B010 Sprzęt zaprojektowany specjalnie do wytwarzania „UAV” oraz związanych z nimi systemów, sprzętu i części składowych wyszczególnionych w pozycji 9A012.
- 9B105 ‘Instalacje do testów aerodynamicznych’ do prędkości $Ma = 0,9$ lub wyższych, nadające się do ‘pocisków raketowych’ oraz ich podzespołów.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9B005.

Uwaga: Pozycja 9B105 nie obejmuje kontrolą tuneli aerodynamicznych przeznaczonych do osiągnięcia prędkości nie wyższych niż 3 machy, mających ‘wymiar przestrzeni pomiarowej’ (mierzony w kierunku poprzecznym) o wielkości równej lub mniejszej niż 250 mm.

Uwagi techniczne:

1. W pozycji 9B105 ‘instalacje do testów aerodynamicznych’ obejmują tunele aerodynamiczne i rury uderzeniowe do badania przepływu strumieni powietrza wokół obiektów.
2. W pozycji 9B105 ‘wymiar przestrzeni pomiarowej’ oznacza średnicę okręgu lub bok kwadratu lub dłuższy bok prostokąta lub główną oś elipsy w najszerszym miejscu ‘przekroju przestrzeni pomiarowej’. ‘Przekrój poprzeczny przestrzeni pomiarowej’ oznacza przekrój prostopadły do kierunku przepływu powietrza.
3. W pozycji 9B105 ‘pocisk raketowy’ oznacza kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu powyżej 300 km.

9B106 Następujące komory klimatyczne i komory bezdechowe:

- a. komory klimatyczne umożliwiające symulowanie wszystkich następujących warunków lotu:
 1. spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. warunków na wysokościach równych lub większych niż 15 km; lub
 - b. temperatury w zakresie od poniżej 223 K (-50°C) do powyżej 398 K (+125°C);
 2. wyposażone we wstrząsarkę lub inny sprzęt do badań wibracji lub 'zaprojektowane lub zmodyfikowane' z myślą o wyposażeniu we wstrząsarkę lub taki sprzęt w celu generowania środowiska wibracyjnego o średniej wartości kwadratowej (RMS) na poziomie równym lub wyższym od 10 g przy pomiarach na 'nagim stole', o częstotliwości między 20 Hz a 2 kHz i generującego siły równe 5 kN lub większe;

Uwagi techniczne:

1. *Pozycja 9B106.a.2 określa układy zdolne generować środowisko wibracyjne poprzez pojedynczą falę (np. falę sinusoidalną) oraz układy zdolne generować szerokopasmowe wibracje nieuporządkowane (tj. widmo mocy).*
2. *W pozycji 9B106.a.2 'zaprojektowane lub zmodyfikowane' oznacza, że komora klimatyczna zapewnia odpowiednie interfejsy (np. uszczelnienia), by zostać wyposażona we wstrząsarkę lub inny sprzęt do badań wibracji wyszczególniony w pozycji 2B116.*
3. *W pozycji 9B106.a.2. pojęcie 'nagi stół' oznacza płaski stół lub powierzchnię, bez osprzętu i wyposażenia.*

- b. komory klimatyczne umożliwiające symulowanie następujących warunków lotu:
 1. warunków akustycznych, w których całkowity poziom ciśnienia akustycznego wynosi 140 dB lub więcej (przy poziomie odniesienia 20 µPa) lub o mocy wyjściowej 4 kW lub większej; oraz
 2. warunków na wysokościach równych lub większych niż 15 km; lub
 3. temperatury w zakresie od poniżej 223 K (-50°C) do powyżej 398 K (+125°C);

9B115 Specjalne „urządzenia produkcyjne” do systemów, podsystemów i podzespołów wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 do 9A109, 9A111, 9A116 do 9A120.

9B116 „Instalacje produkcyjne” specjalnie zaprojektowane do kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub systemów, podsystemów i elementów wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 do 9A109, 9A111 lub 9A116 do 9A120 lub 'pocisków rakietowych'.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9B116 'pocisk rakietowy' oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

9B117 Stoiska do prób i stoiska badawcze do rakiet na paliwo stałe lub ciekłe lub do silników rakietowych, mające jedną z następujących cech:

- a. możliwość prowadzenia badań przy wielkościach ciągu powyżej 68 kN; lub
- b. możliwość równoczesnego pomiaru składowych ciągu wzdłuż trzech osi.

9C

Materialy

9C108 Materiały do „izolacji” luzem i „wykładziny wewnętrzne”, poza wyszczególnionymi w pozycji 9A008, do osłon silników raketowych, które można wykorzystać w „pociskach raketowych” lub które specjalnie zaprojektowano do ‘pocisków raketowych’.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9C108 ‘pocisk raketowy’ oznacza kompletne systemy raketowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

9C110 Maty z włókien, impregnowane żywicami, i materiały z włókien powlekanych metalem do tych mat, do produkcji struktur kompozytowych, laminatów i wyrobów wyszczególnionych w poz. 9A110, wytwarzane zarówno na matrycach organicznych, jak i metalowych wykorzystujących wzmocnienia włóknami lub materiałami włókiennkowymi, mające „wytrzymałość właściwą na rozciąganie” większą niż $7,62 \times 10^4$ m i „moduł właściwy” większy niż $3,18 \times 10^6$ m.

NB.: ZOB. TAKŻE POZYCJE 1C010 I 1C210.

Uwaga: Jedynymi matami z włókien impregnowanych żywicami, których dotyczy pozycja 9C110, są te, w których zastosowano żywice o temperaturze zeszklenia (T_g) po utwardzeniu przekraczającej 418K (145°C), jak określono w ASTM D4065 lub jej odpowiedniku.

9D Oprogramowanie

- 9D001 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” sprzętu lub „technologii”, wymienionych w 9A001 do 9A119, 9B lub 9E003.
- 9D002 „Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „produkcji” urządzeń objętych kontrolą według pozycji 9A001 do 9A119 lub 9B.
- 9D003 „Oprogramowanie” zawierające „technologię” objętą kontrolą według pozycji 9E003.h i wykorzystywane do „całkowicie autonomicznych systemów cyfrowego sterowania silnikami” („systemów FADEC”) objętych kontrolą według pozycji 9A lub w urządzeniach objętych kontrolą według pozycji 9B.
- 9D004 następujące inne „oprogramowanie”:
- „oprogramowanie” uwzględniające składowe siły lepkości w dwóch lub trzech wymiarach, zweryfikowane na podstawie badań w tunelach aerodynamicznych lub badań w locie, niezbędne do szczegółowego modelowania przepływu w silnikach;
 - „oprogramowanie” do badania turbogazowych silników lotniczych, zespołów lub elementów do nich, specjalnie zaprojektowane do zbierania, redukcji i analizy danych w czasie rzeczywistym i zdolne do sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, łącznie z dynamiczną regulacją elementów lub warunków badań w czasie trwania testów;
 - „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do sterowania ukierunkowanym krzepnięciem lub wytwarzaniem pojedynczych kryształów;
 - nieużywane;
 - „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby obsługi „UAV” i związanych z nimi systemów, sprzętu i elementów wyszczególnionych w pozycji 9A012;
 - „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do projektowania wewnętrznych kanałów chłodzących łopatek wirujących, łopatek kierowniczych i „bandaży” turbogazowych silników lotniczych;
 - „oprogramowanie” spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - specjalnie zaprojektowane do przewidywania warunków aerotermodynamicznych, aeromechanicznych oraz warunków spalania w turbogazowych silnikach lotniczych; oraz
 - umożliwiające teoretyczne prognozy modelowania warunków aerotermodynamicznych, aeromechanicznych oraz warunków spalania, które zostały potwierdzone przez rzeczywiste dane z osiągnięć (eksperymentalne lub produkcyjne) turbogazowego silnika lotniczego.
- 9D101 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” wyrobów wymienionych w pozycjach 9B105, 9B106, 9B116 lub 9B117.
- 9D103 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub integrowania konstrukcyjnego kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004 lub rakiet meteorologicznych wyszczególnionych w pozycji 9A104, lub podsystemów wymienionych w pozycjach 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 lub 9A119.
- Uwaga: „Oprogramowanie” wyszczególnione w pozycji 9D103 podlega kontroli, jeśli jest specjalnie zaprojektowane do sprzętu wymienionego w pozycji 4A102.
- 9D104 „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” towarów wyspecyfikowanych w pozycjach 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 lub 9A118.

9D105 „Oprogramowanie”, które koordynuje funkcje więcej niż jednego podsystemu, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „użytkowania” w pojazdach kosmicznych określonych w pozycji 9A004 lub rakietach meteorologicznych określonych w 9A104.

9E**Technologia**

Uwaga: „Technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” wyszczególnione w pozycji 9E001 do 9E003 dotyczące silników turbogazowych podlegają kontroli, również w przypadku kiedy są stosowane do napraw lub remontów. Kontroli nie podlegają: dane techniczne, rysunki lub dokumentacja do czynności związanych z obsługą techniczną bezpośrednio dotyczącą wzorcowania, usuwania lub wymiany uszkodzonych lub niezdatnych do użytku elementów wymiennych, łącznie z całym silnikami lub modułami silnikowymi.

9E001 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „rozwoju” urządzeń lub „oprogramowania” objętego kontrolą według pozycji 9A001.b, 9A004 do 9A012, 9A350, 9B lub 9D.

9E002 „Technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” urządzeń wymienionych w pozycjach 9A001.b, 9A004 do 9A011, 9A350 lub 9B.

NB.: Na potrzeby kontroli technologii napraw konstrukcji, laminatów lub materiałów zob. pozycję 1E002.f.

9E003 Inne „technologie”, takie jak:

- a. „technologie” niezbędne do „rozwoju” lub „produkcji” dowolnego z następujących elementów i zespołów do silników turbogazowych:
 1. łopatek wirujących, łopatek kierowniczych lub „bandaży” do turbin gazowych, wytwarzanych techniką ukierunkowanego krzepnięcia (DS) lub ze stopów monokrystalicznych (SC) i mających (w kierunku 001 wskaźników Millera) czas życia do zerwania przy pełzaniu przekraczający 400 godzin przy 1 273 K (1 000 °C) i naprężeniu 200 MPa, oparty na średnich wartościach właściwości fizycznych;
 2. komór spalania spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. izolowane termicznie wykładziny zaprojektowane do pracy w ‘temperaturze na wylocie komory spalania’ przekraczającej 1 883K (1 610°C);
 - b. wykładziny niemetaliczne;
 - c. powłoki niemetaliczne; lub
 - d. wykładziny zaprojektowane do pracy w ‘temperaturze na wylocie komory spalania’ przekraczającej 1 883K (1 610°C), w których znajdują się otwory zgodne z parametrami określonymi w pozycji 9E003.c.;

Uwaga: „Technologia” wymagana w odniesieniu do otworów w pozycji 9E003.a.2. ograniczona jest do pochodzenia geometrii i rozmieszczenia otworów.

Uwaga techniczna:

‘Temperatura na wylocie komory spalania’ jest średnią objętościową całkowitej temperatury (stagnacji) strumienia gazu między płaszczyzną wylotu komory spalania a krawędzią natarcia wlotowych łopatek kierowniczych turbiny (tj. mierzoną na stanowisku silnika T40 zgodnie z definicją w SAE ARP 755A), gdy silnik działa w ‘trybie stanu ustalonego’ pracy w certyfikowanej maksymalnej ciągłej temperaturze roboczej.

NB.: Technologia wymagana do wytwarzania otworów chłodzących – zob. pozycja 9E003.c.

3. elementów wytwarzanych z któregośkolwiek z poniższych:

- a. organicznych materiałów „kompozytowych”, zaprojektowanych do pracy w temperaturach powyżej 588 K (315 °C);
- b. materiałów „kompozytowych” na „matrycy” metalowej, materiałów na „matrycy” ceramicznej, materiałów międzymetalicznych lub materiałów ze wzmocnieniami międzymetalicznymi wyszczególnionych w pozycji 1C007; lub
- c. materiałów „kompozytowych” wyspecyfikowanych w pozycji 1C010 i wytwarzanych z użyciem żywic wymienionych w 1C008;

4. niechłodzonych łopatek wirujących, łopatek kierowniczych, „bandaży” lub innych elementów turbin, zaprojektowanych do pracy w strumieniu gazu o całkowitych temperaturach (stagnacji) 1 323 K (1 050 °C) lub wyższych przy statycznym starcie na poziomie morza (ISA) w ‘trybie stanu ustalonego’ działania silnika;
5. chłodzonych łopatek wirujących, łopatek kierowniczych, „bandaży” innych niż opisane w pozycji 9E003.a.1., zaprojektowanych do pracy w ‘strumieniu gazu o temperaturze’ 1 693 K (1 420°C) lub wyższej;

Uwagi techniczne:

1. ‘Temperatura strumienia gazu’ jest średnią objętościową całkowitej temperatury (stagnacji) strumienia gazu na płaszczyźnie krawędzi wlotu części turbiny, gdy silnik działa w ‘trybie stanu ustalonego’ pracy w certyfikowanej lub określonej maksymalnej ciągłej temperaturze roboczej.

2. Termin ‘tryb stanu ustalonego’ określa warunki działania silnika, w których parametry silnika, takie jak ciąg/moc, ilość obrotów na minutę i inne, nie wykazują znaczących wahań, jeżeli temperatura i ciśnienie powietrza u wlotu silnika są stałe.

6. połączeń profili łopatkowych z tarczą techniką zgrzewania w stanie stałym;
7. elementów silników turbogazowych wytwarzanych techniką „zgrzewania dyfuzyjnego” objętą kontrolą według pozycji 2E003.b;
8. ‘wytrzymałych na uszkodzenia’ elementów wirników silników turbogazowych, wytwarzanych techniką metalurgii proszkowej objętą kontrolą według pozycji 1C002.b; lub

Uwaga techniczna:

‘Wytrzymałe na uszkodzenia’ elementy składowe są projektowane z użyciem metodologii i uzasadnień mających na celu przewidywanie i ograniczanie powstawania spękań.

9. nieużywane;
 10. nieużywane;
 11. drążonych (pustych w środku) łopatek wentylatorowych;
- b. technologie wymagane do „rozwoju” lub „produkcji” któregośkolwiek z poniższych:
1. modeli lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposażonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do przenoszenia danych z czujników do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub
 2. wykonanych z materiałów „kompozytowych” łopat śmigieł lub śmigłowentylatorów zdolnych do rozwijania mocy 2 000 kW przy prędkościach lotu powyżej $Ma = 0,55$;

- c. technologie wymagane do produkcji otworów chłodzących, w elementach silników turbogazowych wykorzystujących którekolwiek z technologii wymienionych w pozycjach 9E003.a.1., 9E003.a.2. lub 9E003.a.5., i spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:

1. wszystkie z poniższych:
 - a. minimalne 'pole przekroju poprzecznego' mniejsze niż $0,45 \text{ mm}^2$;
 - b. 'współczynnik kształtu otworu' większy niż 4,52; oraz
 - c. 'kąt osi otworu' równy lub mniejszy niż 25° ; lub
2. wszystkie z poniższych:
 - a. minimalne 'pole przekroju poprzecznego' mniejsze niż $0,12 \text{ mm}^2$;
 - b. 'współczynnik kształtu otworu' większy niż 5,65; oraz
 - c. 'kąt osi otworu' powyżej 25° ;

Uwaga: Pozycja 9E003.c. nie obejmuje kontrolą „technologii” wytwarzania otworów cylindrycznych o stałym promieniu, które są proste na całej długości oraz zaczynają się i kończą na zewnętrznych powierzchniach elementu.

Uwagi techniczne:

1. Do celów pozycji 9E003.c., 'pole przekroju poprzecznego' oznacza powierzchnię otworu w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu.
2. Do celów pozycji 9E003.c., 'współczynnik kształtu otworu' oznacza nominalną długość osi otworu podzieloną przez pierwiastek kwadratowy jego minimalnego 'pola przekroju poprzecznego'.
3. Dla celów pozycji 9E003.c. 'kąt osi otworu' oznacza kąt ostry mierzony między płaszczyzną styczną do powierzchni profilu a osią otworu w punkcie, w którym oś otworu przebija powierzchnię profilu.
4. Do technik wytwarzania otworów, o których mowa w pozycji 9E003.c, należą „laser”, strumień wody, obróbka elektrochemiczna (ECM) i obróbka elektroiskrowa (EDM).

- d. „technologie” „niezbędne” do „rozwoju” lub „produkcji” układów przenoszenia napędu w śmigłowcach lub układów przenoszenia napędu w „statkach powietrznych” z odchylanymi wirnikami lub skrzydłami;
- e. „technologie” do „rozwoju” lub „produkcji” systemów napędowych pojazdów naziemnych wykorzystujących wysokoprężne silniki tłokowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:
1. 'objętość komory silnikowej' $1,2 \text{ m}^3$ lub mniejsza;
 2. całkowita moc użyteczna powyżej 750 kW, określana według normy 80/1269/EEC, ISO 2534 lub ich krajowych odpowiedników; oraz
 3. gęstość mocy powyżej 700 kW/m^3 'objętości komory silnikowej';

Uwaga techniczna:

'Objętość komory silnikowej' w pozycji 9E003.e oznacza iloczyn trzech prostopadłych do siebie wymiarów mierzonych w następujący sposób:

długość : długość wału korbowego od kołnierza przedniego do czoła koła zamachowego;

szerokość : największy z następujących wymiarów:

- a. odległość zewnętrzna od pokrywy zaworów do pokrywy zaworów;
- b. wymiary zewnętrznych krawędzi głowic cylindrów; lub
- c. średnica obudowy koła zamachowego;

wysokość : największy z następujących wymiarów:

- a. *odległość od osi wału korbowego do górnej płaszczyzny pokrywy zaworów (lub głowicy cylindrów) plus podwójny skok; lub*
- b. *średnica obudowy koła zamachowego.*

- f. następujące „technologie” „niezbędne” do „produkcji” elementów zaprojektowanych specjalnie do silników wysokoprężnych o wysokich osiąгах:
1. „technologie” „niezbędne” do „produkcji” instalacji silnikowych wyposażonych we wszystkie następujące elementy wykonane z materiałów ceramicznych wyszczególnionych w pozycji 1C007:
 - a. wkładki do cylindrów;
 - b. tłoki;
 - c. głowice cylindrów; oraz
 - d. jeden lub więcej innych elementów (łącznie ze szczelinami wylotowymi, turbodoładowarkami, prowadnicami zaworów, zespołami zaworów lub izolowanymi wtryskiwaczami paliwa);
 2. „technologie” „niezbędne” do „produkcji” układów do turbodoładowania wyposażonych w sprężarki jednostopniowe i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. sprężanie (stopień sprężania) 4:1 lub wyższy;
 - b. wydatek (masowe natężenie przepływu) w zakresie od 30 do 130 kg na minutę; oraz
 - c. możliwość zmiany pola przepływu w zespole sprężarki lub turbiny;
 3. „technologie” „niezbędne” do „produkcji” instalacji wtryskowych paliwa ze specjalnymi układami wielopaliwowymi (np. na olej napędowy lub paliwo lotnicze) w zakresie lepkości od paliw do silników wysokoprężnych (2,5 cSt w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)) do paliw benzynowych (0,5 cSt w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)) i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 - a. objętość wtrysku powyżej 230 mm³ na wtrysk na cylinder; oraz
 - b. elektroniczne zespoły sterujące specjalnie zaprojektowane do automatycznego przełączania, za pomocą odpowiednich czujników, charakterystyk regulacyjnych w zależności od właściwości paliwa w celu utrzymania tej samej charakterystyki momentu obrotowego;
- g. „technologie” „niezbędne” do „rozwoju” lub „produkcji” ‘silników wysokoprężnych o wysokich osiąгах’ ze smarowaniem ścianek cylindrów za pomocą smarów stałych, z fazy gazowej lub filmu cieczowego (lub metodą kombinowaną) i umożliwiające pracę silnika do temperatur powyżej 723 K (450 °C), mierzonych na ścianie cylindra w górnym położeniu górnego pierścienia tłokowego;
- Uwaga techniczna:
‘Silniki wysokoprężne o wysokich osiąгах’ oznaczają silniki wysokoprężne (Diesla) o średnim ciśnieniu użytecznym 1,8 MPa lub wyższym przy prędkościach obrotowych 2 300 obrotów na minutę, pod warunkiem że ich prędkość nominalna wynosi 2 300 obrotów na minutę lub więcej.
- h. następujące „technologie” do użytku w „systemach FADEC” sterujących silnikami turbospalinowymi:
1. „technologia” „rozwoju” mająca na celu sformułowanie wymogów funkcjonalnych dla elementów składowych potrzebnych w „systemach FADEC” do regulacji siły ciągu silnika lub mocy na wale (np. stałe czasowe i ustawienia dokładności czujnika sprzężenia zwrotnego, szybkość otwierania i zamykania zaworu paliwa);
 2. „technologia” „rozwoju” lub „produkcji” elementów sterujących i diagnostycznych występujących wyłącznie w „systemach FADEC” i stosowanych do regulacji siły ciągu silnika lub mocy na wale;

3. „technologia” „rozwoju” algorytmów sterowania, w tym „kodów źródłowych” występujących wyłącznie w „systemach FADEC” i stosowanych do regulacji siły ciągu silnika lub mocy na wale;

Uwaga: Pozycja 9E003.h nie obejmuje kontrolą danych technicznych związanych z integracją silnika ze statkiem powietrznym, których publikacja wymagana jest przez organy certyfikacyjne lotnictwa cywilnego do ogólnego wykorzystania w lotnictwie (np. instrukcje instalacji, instrukcje obsługi, instrukcje zachowania sprawności do lotu) lub w związku z funkcjami interfejsu (np. obsługa urządzeń wejścia-wyjścia, zapotrzebowanie na siłę ciągu silnika lub moc na wale w płatowcu).

- i. następująca „technologia” na potrzeby układów o regulowanej ścieżce przepływu zaprojektowanych z myślą o utrzymywaniu stabilności turbin wysokoprężnych, turbowentylatorów lub turbin odbiorczych (niskoprężnych) lub dysz napędowych:
 1. „technologia” „rozwoju” służąca wypracowywaniu kryteriów dla elementów składowych utrzymujących stabilność silnika;
 2. „technologia” „rozwoju” lub „produkcji” na potrzeby elementów składowych specyficznych dla układu o regulowanej ścieżce przepływu, które utrzymują stabilność silnika;
 3. „technologia” „rozwoju” na potrzeby algorytmów sterowania, w tym „kodu źródłowego”, specyficznych dla układu o regulowanej ścieżce przepływu, które utrzymują stabilność silnika.

Uwaga: Pozycja 9E003.i nie obejmuje kontrolą „technologii” „rozwoju” lub „produkcji” odnoszącej się do któregokolwiek z poniższych:

- a. wlotowych łopatek kierowniczych;
- b. wentylatorów o zmiennym skoku lub śmigłowentylatorów;
- c. łopatek kierowniczych o zmiennej geometrii stosowanych w sprężarkach;
- d. zaworów upustowych w sprężarkach; lub
- e. kanałów o zmiennej geometrii opracowanych do odwracaczy ciągu.

- 9E101
- a. „technologie”, zgodne z uwagą ogólną do technologii, służące do „rozwoju” wyrobów wymienionych w pozycjach 9A006.b., 9A006.f., 9A101, 9A102, 9A104 do 9A111 lub 9A115 do 9A121.
 - b. „technologie” według uwagi ogólnej do technologii do „produkcji” ‘UAV’ wyszczególnionych w pozycji 9A012 lub wyrobów wymienionych w pozycjach 9A006.b., 9A006.f., 9A101, 9A102, 9A104 do 9A111 lub 9A115 do 9A121.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E101.b ‘UAV’ oznacza systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

- 9E102
- „Technologie”, zgodne z uwagą ogólną do technologii, służące do „użytkowania” kosmicznych pojazdów nośnych wyszczególnionych w pozycji 9A004, wyrobów wymienionych w pozycjach 9A005 do 9A011, ‘UAV’ wyszczególnionych w pozycji 9A012 lub wyrobów wymienionych w pozycjach 9A101, 9A102, 9A104 do 9A111, 9A115 do 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 lub 9D103.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E102 ‘UAV’ oznacza systemy bezzałogowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.